香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
華虹半導體有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「**本公司**」)於上海證券交易所網站刊發的以下文件，僅供參閱：

1、 董事會決議公告；

2、 華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)修訂說明的公告；

3、 國泰海通證券股份有限公司關於華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問報告(修訂稿)；

4、 上海華力微電子有限公司審計報告；

5、 上海市通力律師事務所關於華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易之法律意見書；

6、 華虹半導體有限公司備考合併財務報表及審閱報告；

7、 獨立董事關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯(連)交易相關事項的獨立意見；

8、 獨立董事關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯(連)交易相關事項的事前認可意見。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事會主席兼執行董事
白鵬先生

中國上海，二零二六年三月三十日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：
白鵬*(董事會主席兼總裁)*

非執行董事：
葉峻
孫國棟
陳博
熊承艷

獨立非執行董事：
張祖同
王桂壎太平紳士
封松林

A 股代码：688347　　A 股简称：华虹公司　　公告编号：2026-021
港股代码：01347　　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2026 年 3 月 30 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已经届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华力微电子有限公司审计报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告》。公司董事会同意将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联（连）董事叶峻、孙国栋、

陈博、熊承艳回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2026 年 2 月 10 日召开的公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，因此本议案无需再次提交公司股东大会审议。

（二）同意《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告对《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联（连）董事叶峻、孙国栋、陈博、熊承艳回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2026 年 2 月 10 日召开的公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，因此本议案无需再次提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

A 股代码：688347　　A 股简称：华虹公司　　公告编号：2026-022
港股代码：01347　　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海华力微电子有限公司 97.4988%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 3 月 30 日，公司召开 2026 年第三次董事会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

公司根据上市公司、标的公司截至 2025 年 12 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《华虹半导体有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。

相较公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告（草案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况说明
释义	补充和更新备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	1、更新本次交易是否构成重大资产重组相关财务指标计算； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序； 4、更新上市公司主要财务指标及摊薄即期回报情况。

章节	修订情况说明
重大风险提示	1、更新本次交易相关的审批风中本次交易尚待履行的决策和审批程序； 2、更新与标的公司相关的毛利率波动的风险。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易是否构成重大资产重组相关财务指标计算； 2、更新本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司股本、前十大股东情况； 2、更新上市公司主要财务数据及财务指标等情况。
第三节 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方截至 2025 年 12 月 31 日的工商信息、历史沿革、对外投资、股权结构等情况； 2、更新交易对方最近两年主要财务数据。
第四节 标的公司基本情况	1、根据基准日变化，更新财务数据、业务数据及相关内容； 2、更新本次交易已取得标的公司股东的同意的进展。
第五节 本次交易发行股份情况	根据基准日变化，更新前次募集资金金额、使用情况及目前剩余情况
第八节 本次交易的合规性分析	1、根据基准日变化，更新上市公司股份数量情况； 2、更新上市公司最近一年注册会计师出具的审计报告文号。
第九节 管理层讨论与分析	1、根据基准日变化，更新上市公司的财务状况和经营成果； 2、根据基准日变化，更新标的公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析； 3、根据基准日变化，更新备考审阅报告涉及的财务数据及本次交易对上市公司的影响。
第十节 财务会计信息	根据基准日变化，更新了财务数据及相关内容
第十一节 同业竞争和关联交易	根据基准日变化，更新了部分关联方关系、关联交易财务数据及相关内容
第十二节 风险因素	1、更新本次交易相关的审批风中本次交易尚待履行的决策和审批程序； 2、更新与标的公司相关的毛利率波动的风险、资产负债率相关的风险、应收账款坏账的风险、汇率波动的风险。
第十三节 其他重要事项	更新“十一、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

国泰海通证券股份有限公司

关于

华虹半导体有限公司

发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之

独立财务顾问报告

（修订稿）

独立财务顾问

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年三月

声明与承诺

国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通”、“独立财务顾问”）受华虹公司的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。

本独立财务顾问声明如下：

1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发表意见是完全独立的；

2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；

3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上出具；

4、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议，对于投资者根据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；

5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问做任何解释或说明；

6、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件；

7、本独立财务顾问报告旨在对本次交易做出独立、客观、公正的评价。本独立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同意，本独立财务顾问报告不得用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。

本独立财务顾问承诺如下：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

目 录

声明与承诺 1

目 录 3

释 义 7

重大事项提示 12

一、本次交易方案概况 12

二、募集配套资金情况 14

三、本次交易的性质 15

四、本次交易对上市公司的影响 16

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 19

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 20

七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 20

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排 21

重大风险提示 25

一、本次交易相关风险 25

二、与标的公司相关的风险 26

三、其他风险 27

第一节 本次交易概况 29

一、本次交易的背景、目的及协同效应 29

二、本次交易的方案概要 31

三、本次交易的性质 33

四、标的资产的评估情况 34

五、本次交易的具体方案 34

六、本次交易对上市公司的影响 40

七、本次交易的决策过程和审批情况 42

八、本次交易相关方所作出的重要承诺 43

第二节 上市公司基本情况 73

一、上市公司基本情况.....73
二、公司设立及股本变动情况.....73
三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况.....78
四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况.....78
五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况.....78
六、上市公司控股股东及实际控制人情况.....78
七、上市公司最近三年主营业务发展情况.....79
八、上市公司主要财务数据.....79
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形.....80
十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况.....80
十一、上市公司遵纪守法情况.....80
第三节 交易对方基本情况.....82
一、发行股份购买资产的交易对方.....82
二、募集配套资金的交易对方.....82
第四节 标的公司基本情况.....113
一、标的公司基本情况.....113
二、标的公司历史沿革.....113
三、标的公司产权结构及控制关系.....122
四、标的公司下属企业情况.....123
五、标的公司主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况.....123
六、标的公司主营业务情况.....127
七、标的公司主要财务数据.....149
八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件.....149
九、标的公司报告期会计政策及相关会计处理.....150
第五节 本次交易发行股份情况.....153
一、发行股份及购买资产.....153

二、本次募集配套资金安排.....155
第六节 标的资产评估作价基本情况.....159
一、本次交易标的评估情况.....159
二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析.....209
三、上市公司独立董事对本次交易评估事项的意见.....214
第七节 本次交易合同的主要内容.....216
一、发行股份购买资产协议及其补充协议.....216
二、减值补偿协议.....218
第八节 独立财务顾问核查意见.....221
一、基本假设.....221
二、本次交易的合规性分析.....221
三、本次交易定价的合理性分析.....232
四、本次交易评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性.....232
五、本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题.....233
六、本次交易对上市公司市场地位、持续发展能力、经营业绩和公司治理机制影响.....236
七、本次交易合同约定的资产交付安排.....237
八、本次交易构成关联交易.....237
九、本次交易标的财务状况和经营成果是否发生重大不利变动及对本次交易的影响的核查意见.....238
十、本次交易是否涉及私募投资基金以及备案情况的核查意见根据交易对方提供的说明，并通过中国证券投资基金业协会平台检索交易对方的基金备案情况，本次交易的交易对方涉及私募投资基金及备案情况如下：.....238
十一、本次交易符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定的核查意见.....239
十二、内幕信息知情人登记制度制定及执行情况/股票交易自查结果.....240
十三、关于相关主体是否存在有偿聘请第三方行为的核查.....250
十四、按照《上海证券交易所发行上市审核业务指南第 4 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》的要求，对相关事项进行的核查情况.....252

第九节 独立财务顾问内核情况 317
一、独立财务顾问内部审核程序 317
二、独立财务顾问的内核意见 317
第十节 独立财务顾问结论性意见 318

释 义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般名词释义		
预案、重组预案	指	《华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书/草案	指	《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）**（修订稿）**》
本独立财务顾问报告/本报告	指	国泰海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告**（修订稿）**
华虹半导体、华虹公司、本公司、公司、上市公司	指	华虹半导体有限公司
本次交易、本次重组、本次收购、本次发行	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司等 4 名交易对方持有的上海华力微电子有限公司 97.4988%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司等 4 名交易对方持有的上海华力微电子有限公司 97.4988%股权
标的公司、华力微	指	上海华力微电子有限公司
标的资产、交易标的	指	上海华力微电子有限公司 97.4988%股权
发行股份购买资产协议	指	公司与交易对方就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
发行股份购买资产协议之补充协议	指	公司与交易对方就本次交易签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
减值补偿协议	指	华虹半导体有限公司与上海华虹（集团）有限公司之减值补偿协议
资产评估报告	指	华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告
华虹集团	指	上海华虹（集团）有限公司
华虹国际	指	Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司）
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
上海集成电路基金	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
国投先导基金	指	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	华虹集团、大基金二期、上海集成电路基金、国投先导基金

华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
华虹 NEC	指	上海华虹 NEC 电子有限公司
中国日电	指	日电（中国）有限公司
张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司
NEC	指	NEC Corporation（日本电气株式会社）
Newport	指	Newport Fab LLC
张江国际	指	Shanghai Zhangjiang International Corporation（上海张江国际有限公司）
鑫芯香港	指	Xinxin （Hongkong） Capital Co., Limited（鑫芯（香港）投资有限公司）
独立财务顾问/国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
法律顾问/律师/通力律师	指	上海通力律师事务所
审计机构/大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
备考审阅机构/安永会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
联华电子	指	联华电子股份有限公司
格芯	指	格芯股份有限公司（原：Global Foundries Inc.）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
定价基准日	指	上市公司 2025 年第六次董事会决议公告日

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司条例》	指	中国香港《公司条例》（香港法例第 622 章）（自 2014 年 3 月 3 日起）及其不时修订
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《华虹半导体有限公司之组织章程细则》
股东大会	指	华虹半导体有限公司股东大会
董事会	指	华虹半导体有限公司董事会
科创板	指	上海证券交易所科创板
A 股	指	在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票
交割日	指	交易对方向上市公司转让标的资产的工商变更登记手续完成，标的资产登记至上市公司名下之日；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移至上市公司
发行日	指	上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之日
过渡期	指	自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）止的期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业名词释义		
晶圆	指	晶圆指制造半导体芯片的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸等规格
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准，线宽越低，则制程水平越高
嵌入式	指	将 IP 模块或工艺模块集成至芯片或基础工艺的简称
嵌入式非易失性存储器	指	Embedded Non-Volatile Memory，缩写为 eNVM，用于满足各种嵌入式系统应用程序的小型芯片，eNVM 被广泛应用于需要存储代码程序、客户数据或其他重要信息的芯片，如智能卡芯片、MCU 等

独立式非易失性存储器	指	Standalone Non-Volatile Memory，缩写为 sNVM，是一种独立于数据处理芯片单独封装的存储器件，其核心特征是断电后数据不丢失，并通过标准化接口（如 USB、PCIe、NVMe）与主机系统通信
高压	指	高压显示驱动
功率器件	指	分立器件板块的一个分支，主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件，如 MOSFET、SJ 和 IGBT
电源管理芯片	指	电源管理芯片（Power Management Integrated Circuits，PMIC），是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片
SONOS	指	硅基-二氧化硅-氮化硅-二氧化硅-多晶硅，一种存储结构
Flash/闪存	指	是一种非易失性存储器的形式，允许在操作中被多次擦或写的存储器
ISP	指	Image Signal Processor，图像信号处理器，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元
MCU	指	Micro controller Unit，微控制单元，又称单片微型计算机或者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
AIoT	指	AI+IoT，即人工智能+物联网
SRAM	指	Static Random Access Memory，静态随机存取存储器，是一种半导体存储器，主要用于芯片内的缓存
IP	指	半导体 IP（Intellectual Property），一般指在集成电路设计中，经过验证的、可重复使用且具备特定功能的集成电路模块
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造工厂，是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商，属于半导体行业的一种业务模式
Foundry	指	泛指晶圆代工模式，专门负责芯片制造，不负责芯片设计，可同时为多家芯片设计公司或 IDM 公司提供代工服务
逻辑电路	指	传递和处理离散信号，以二进制为原理，实现数字信号逻辑运算和操作的电路
射频	指	高频交流变化电磁波的信号处理电路
CIS	指	CMOS Image Sensor，CMOS 图像传感器
PDK	指	Process Design Kit，工艺设计套件，是集成电路设计流程中的重要工具包
NB-IOT	指	Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，是一种由 3GPP 标准化的低功耗广域网（LPWAN）技术，基于蜂窝网络，专为物联网应用设计

FPGA	指	Field Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列，是在PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物，在硬件层面可重复进行编程、以满足多种应用需要
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管显示器
CMOS	指	CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor），互补金属氧化物半导体。CMOS 的制造技术原理主要是利用共存着带 N（带-电）和 P（带+电）级的半导体
nm	指	纳米，10^{-9} 米

除特别说明外，本独立财务顾问报告中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。 公司提醒投资者认真阅读本报告，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概况

（一）本次交易方案

交易形式		发行股份购买资产并募集配套资金	
交易方案简介		上市公司拟通过发行股份方式向华虹集团等 4 名交易对方购买其合计持有的华力微 97.4988%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。	
交易价格（不含募集配套资金金额）		826,790.22 万元	
交易标的	**名称**	上海华力微电子有限公司	
	主营业务	主要从事 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。	
	所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	
	其他	**符合板块定位**	√是 □否 □不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 □否
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否
交易性质		**构成关联交易**	√是 □否
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	□是 √否
		构成重组上市	□是 √否
本次交易有无业绩补偿承诺			□是 √否
本次交易有无减值补偿承诺			√是 □否
其他需特别说明的事项			无

（二）标的资产评估作价情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），本次交易对华力微采用了资产基础法、市场法进行评估，最终选用市场法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果（万元）	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格（万元）	其他说明
华力微	2025 年 8 月 31 日	市场法	848,000.00	323.59%	97.4988%	826,790.22	-

（三）本次交易支付方式

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易股权比例	支付方式				向该交易对方支付总对价
			现金对价	股份对价	可转债	其他	
1	华虹集团	63.5443%	0.00	538,855.12	无	无	538,855.12
2	上海集成电路基金	15.7215%	0.00	133,318.65	无	无	133,318.65
3	大基金二期	10.2503%	0.00	86,922.77	无	无	86,922.77
4	国投先导基金	7.9827%	0.00	67,693.68	无	无	67,693.68
合计		**97.4988%**	**0.00**	**826,790.22**		-	**826,790.22**

（四）发行股份购买资产的具体情况

股票种类	境内人民币普通股（A 股）	**每股面值**	根据《公司条例》第 135条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值
定价基准日	上市公司 2025 年第六次董事会决议公告日	**发行价格**	43.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 80%
发行数量	190,768,392 股，占发行后上市公司总股本的比例为 **9.89%**（不考虑募集配套资金）		
是否设置发行价格调整方案	□是 √否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整）		
锁定期安排	1、华虹集团本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则华虹集团通过本次交易取得的前述上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月； 2、上海集成电路基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如果上海集成电		

	路基金符合《重组管理办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则其本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让； 3、大基金二期、国投先导基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让；如其取得前述上市公司股份时，对于用于认购上市公司股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。 股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。 若上述限售期安排与届时有效的法律、法规、部门规章及规范性文件的规定不相符或与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关规定或监管意见相应调整。

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金概况

募集配套资金金额	755,628.60 万元		
发行对象	不超过 35 名特定对象		
募集配套资金用途	**项目名称**	**拟使用募集资金金额（万元）**	**使用金额占全部募集配套资金金额的比例**
	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
	合计	**755,628.60**	**100.00%**

（二）募集配套资金的具体情况

股票种类	A 股（人民币普通股）	**每股面值**	根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值
定价基准日	本次募集配套资金的发行期首日	**发行价格**	价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除

			权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。
发行数量	上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。		
锁定期安排	本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项增加的，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构（包括但不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符的，将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。		

三、本次交易的性质

（一）本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买华力微 97.4988%股权。本次交易拟购买资产最近一期末经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	资产净额与交易金额孰高	营业收入
华力微 97.4988%股权	826,790.22	826,790.22	**510,114.63**
上市公司	**10,012,329.13**	**4,516,029.04**	**1,729,145.07**
指标占比	**8.26%**	**18.31%**	**29.50%**

注 1：上表华力微 97.4988%股权的“资产总额与交易金额孰高”、“资产净额与交易金额孰高”均取相应交易金额，“营业收入”取华力微 **2025** 年度营业收入；

注 2：上市公司、华力微的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 **2025** 年度财务报表。

如上，本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例均未超过 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会、股东大会审议**本次交易**相关议案时，关联董事、关联股东**均已**回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

标的公司与上市公司均拥有 65/55nm、40nm 制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服

务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至 2025 年 **12 月 31** 日，上市公司总股本为 **1,737,614,193** 股，公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次交易拟向交易对方发行 190,768,392 股。本次交易前后（不考虑募集配套资金）上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	**820,333,688**	**47.21%**	**820,333,688**	**42.54%**
华虹国际	347,605,650	**20.00%**	347,605,650	**18.03%**
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	**9.24%**	160,545,541	8.33%
华虹集团	1,198,517	0.07%	125,530,570	**6.51%**
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78%	68,390,263	3.55%
上海集成电路基金	-	-	30,761,109	1.60%
国投先导基金	-	-	15,619,216	0.81%
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	**11,020,000**	**0.63%**	**11,020,000**	**0.57%**

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,697,339	0.62%	10,697,339	0.55%
香港中央结算有限公司	9,267,853	0.53%	9,267,853	0.48%
海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	6,077,517	0.35%	6,077,517	0.32%
其他股东	306,223,839	17.62%	306,223,839	15.88%
合计	1,737,614,193	100.00%	1,928,382,585	100.00%

注：重组前股份数量、持股比例为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

本次交易完成后，公司直接控股股东仍为华虹国际，间接控股股东仍为华虹集团，实际控制人仍为上海市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及安永会计师出具的《备考审阅报告》，不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
资产总额	10,012,329.13	10,610,932.80	8,793,523.15	9,356,042.83
负债总额	3,702,853.87	4,092,273.00	2,521,468.25	2,965,008.50
归属于母公司股东权益	4,516,029.04	4,725,213.57	4,360,233.22	4,474,671.92
营业收入	1,729,145.07	2,228,795.71	1,438,830.77	1,927,405.55
利润总额	-65,100.61	11,125.88	-98,831.81	-36,817.13
净利润	-80,714.30	-4,487.81	-103,218.38	-41,203.70

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
归属于母公司股东净利润	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的子公司，根据模拟测算本次交易完成后上市公司资产规模、收入规模、盈利能力均有较大提升。

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

截至本报告签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已经上市公司 2025 年第六次董事会会议、2025 年第九次董事会会议、**2026 年第三次董事会会议**审议通过；

2、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；

3、本次交易已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；

4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；

5、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案；

6、上市公司股东大会审议通过本次交易；

7、香港证监会及联交所必要的审批程序。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本报告签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审

核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见

上市公司直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团已出具《关于上市公司本次交易的原则性意见》，原则性同意本次交易。

七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东已出具《关于股份减持计划的承诺函》

上市公司直接控股股东华虹国际已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业无减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持上市公司股份。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

上市公司间接控股股东华虹集团已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业无主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份，前述股份包括原持有的上市

公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

（二）上市公司董事、高级管理人员已出具《关于股份减持计划的承诺函》

上市公司董事、高级管理人员已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本人承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

4、本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规的要求履行了现阶段必要的信息披露义务。上市公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求，及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司已聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保本次交易的定价公允、公平、合理，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（三）严格执行相关决策程序

本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中规定的程序进行决策审批。

（四）网络投票安排和中小股东单独计票

根据有关规定，上交所通过交易系统和互联网投票系统向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。

针对审议本次交易的股东大会投票情况，上市公司**对** A 股股东单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（五）关联董事、关联股东回避表决

根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会审议本次交易时，已提请关联董事回避表决相关议案；上市公司**在**召开**股东大会**审议本次交易时，**已**提请关联股东回避表决相关议案，从而充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）股份锁定安排

本次重组交易对方就认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

本次发行结束之日后，交易对方基于本次发行而享有的上市公司送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，将根据相关监管规定进行相应调整。锁定期届满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

（七）本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施

根据上市公司财务报告及安永会计师出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后，上市公司每股收益的变化情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度	
	交易前	备考数	交易前	备考数
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

如上市公司或标的公司未来盈利能力不及预期，本次交易存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了充分保护公司公众股东的利益，公司制定了防止本次交易摊薄即期回报的相关填补措施。公司制定填补回报措施不等于对未来利润作出保证。具体如下：

1、有效整合标的资产，加快释放协同效应

上市公司和标的公司均从事晶圆代工业务，本次交易系同行业并购整合，交易双方在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面均具有显着的协同效应。交易完成后，上市公司将在资产、业务、人员、财务、机构等方面实施整合计划，充分发挥协同效应，增强上市公司盈利水平和抗风险能力。

2、进一步加强经营管理和内部控制，提高经营效率

本次交易完成后，公司将根据实际情况进一步完善公司的治理体系、管理体系和制度建设，加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高

上市公司日常运营效率，降低运营成本，更好地维护上市公司整体利益，有效控制上市公司经营和管理风险。

3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

本次交易完成后，上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策的基础上，将根据中国证监会的相关规定，结合公司经营情况与发展规划，持续完善利润分配政策，优化投资回报机制，在保证上市公司可持续发展的前提下给予股东合理的投资回报，更好地维护上市公司股东及投资者利益。

4、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

根据中国证监会相关规定，公司直接控股股东、间接控股股东和公司董事、高级管理人员为确保公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺，具体内容详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本报告的其他内容和与本报告同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

一、本次交易相关风险

（一）审批风险

截至本报告签署日，本次交易尚未履行的决策程序及批准程序包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

由于本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。在本次交易推进过程中，市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，则本次交易可能无法按期进行或需重新进行，面临重新定价的风险。

除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；

2、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险；

3、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投

资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险

作为交易方案的一部分，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得上交所审核通过、证监会的注册尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

（四）收购整合的风险

本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司管理及合并范围，上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大，上市公司也将面临经营管理方面的挑战。本次交易完成后，上市公司能否通过整合保持标的资产原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，提请投资者关注相关风险。

二、与标的公司相关的风险

（一）半导体行业周期性波动的风险

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关，其下游市场需求受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，存在一定的周期性。未来，如果宏观经济环境持续低迷，或者通信、消费电子等下游市场需求发生波动，将可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。

（二）国际贸易摩擦的风险

近年来国际政治、经济形势日益复杂，国际贸易摩擦不断升级。有关国家针对半导体设备、材料、技术等领域颁布了一系列出口管制政策，对半导体行业相关的技术和服务作出限制。若国际贸易摩擦持续或进一步加剧，标的公司生产经

营可能受到不利影响。

（三）核心技术人员流失的风险

标的公司所处的晶圆制造行业属于技术密集型、人才密集型行业，优秀的研发人员团队是标的公司的核心竞争力及未来发展保障。在资本涌入和市场竞争日趋激烈背景下，半导体领域人才的竞争愈加激烈，若标的公司未能提供良好的发展路径、有吸引力的薪酬待遇及相应的激励考核机制，可能面临核心技术人员流失的风险，进而对标的公司技术研发能力与市场拓展能力产生负面影响。

（四）毛利率波动的风险

报告期各期，标的公司综合毛利率分别为 16.51%和 23.69%，标的公司的毛利率逐年有所提升。标的公司产品毛利率波动受诸多因素影响，未来，如果半导体行业整体情况发生不利变化，客户需求未达预期，从而影响到标的公司晶圆代工业务的产能利用率、销量及价格；或主要原材料价格大幅上涨等不利情况发生，标的公司在未来一定时期内可能面临毛利率波动的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内外政治经济形势、资金供求关系、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，对本次交易事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，上市公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息供投资者做出投资判断，提请广大投资者注意投资风险。

（二）不可抗力的风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景、目的及协同效应

（一）本次交易的背景

1、多项政策出台鼓励上市公司并购重组，收购华力微适逢其时

2024 年 4 月，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确将优化资源配置，更大力度支持科技企业高水平发展，具体措施包括优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资及并购重组；依法依规支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市；以及推动科技型企业高效实施并购重组，适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，助力科技型企业提质增效、做优做强。

2024 年 6 月，中国证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，主要内容包括更大力度支持并购重组，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，以及建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”。

2024 年 12 月，为深入贯彻党的二十届三中全会精神，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，落实资本市场改革任务，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，进一步提高资源配置效率，推动重大产业战略升级，深化上海“五个中心”建设，上海市人民政府办公厅制定《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027 年）》。

宏观政策和监管环境持续优化，上市公司启动并购重组适逢其时。

2、本次重组践行华虹公司上市承诺，符合市场预期

华虹公司科创板上市时，华虹集团曾向市场公开承诺“自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在

履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人。”本次重组，是华虹集团对于华虹公司科创板上市公开承诺的践行，符合市场预期。

（二）本次交易的目的

1、履行避免同业竞争承诺，切实保护中小股东利益

本次交易通过注入华力微，上市公司与华力微之间在 65/55nm、40nm 的同业竞争得到实质性解决。上市公司的资产规模和盈利能力将进一步增强，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、提高上市公司资产质量和经营能力

华虹半导体聚焦于特色工艺，目前已覆盖至 65/55nm、40nm；华力微聚焦于 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺，并在此基础上进一步开发特色工艺。本次重组完成后，华力微的 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺及特色工艺技术将直接注入上市公司，上市公司将新增 3.8 万片/月的 65/55nm、40nm 产能，提高上市公司市场地位。本次并购重组将进一步提高上市公司资产质量，增强持续经营能力，符合全体股东利益。

3、提升股东价值回报，符合全体股东利益

本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围。预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于上市公司进一步扩充产能，提高持续经营能力。本次交易是上市公司优化产业布局、提高上市公司的竞争力，提高股东回报的重要举措，符合全体股东，特别是中小股东利益。

（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性

1、标的公司具备科创属性

标的公司从事晶圆代工业务，主要工艺节点为 65/55nm、40nm，主要覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为计算

机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），标的公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条中的“（一）新一代信息技术领域：半导体和集成电路行业”，符合科创板行业定位要求。

2、标的公司与上市公司主营业务具有协同效应

上市公司与标的公司同属于晶圆代工领域，属于同行业。双方在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面均具有显着的协同效应。

工艺平台方面，华力微的 65/55nm、40nm 覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台，本次交易完成后，上市公司将进一步丰富工艺平台种类，满足市场多样化需求。

客户及供应商方面，不同客户对晶圆代工要求不同，本次交易完成后，上市公司工艺平台、技术等进一步丰富，有利于满足不同客户的多样化需求，提升整体竞争力；半导体设备、半导体材料供应商的全球行业集中度较高，本次交易完成后，公司规模将进一步扩大，产业链地位进一步增强。

技术及产能方面，本次交易有利于上市公司进一步丰富主营业务所需的 65/55nm、40nm 制程的相关技术，加速产品迭代、开发进程。标的公司拥有 3.8 万片/月产能，本次交易完成后，上市公司总产能将进一步提升，满足客户需求。

综上所述，上市公司与标的公司在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面具有协同效应，本次交易将提升上市公司资产质量、增厚上市公司利润，有利于维护上市公司中小股东利益。

二、本次交易的方案概要

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资

金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

（一）发行股份购买资产

上市公司拟以发行股份的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金 4 名交易对方合计持有的华力微 97.4988%股权。本次交易完成后，华力微将成为上市公司全资子公司。

根据东洲评估出具的《评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），本次交易对华力微采用市场法、资产基础法进行评估，最终选用市场法结论作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微所有者权益评估值为 848,000.00 万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定华力微 97.4988%股权的最终交易价格为 826,790.22 万元。

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易股权比例	支付方式				向该交易对方支付总对价
			现金对价	股份对价	可转债	其他	
1	华虹集团	63.5443%	0.00	538,855.12	无	无	538,855.12
2	上海集成电路基金	15.7215%	0.00	133,318.65	无	无	133,318.65
3	大基金二期	10.2503%	0.00	86,922.77	无	无	86,922.77
4	国投先导基金	7.9827%	0.00	67,693.68	无	无	67,693.68
合计		**97.4988%**	**0.00**	**826,790.22**	**-**	-	**826,790.22**

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 755,628.60 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行的股份数量将

在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会注册批复后，由上市公司董事会或授权代表根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
2	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
3	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
合计		**755,628.60**	**100.00%**

本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。在本次募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由公司自筹解决。

三、本次交易的性质

（一）本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买华力微 97.4988%股权。本次交易拟购买资产最近一期末经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	资产净额与交易净额孰高	营业收入
华力微 97.4988%股权	826,790.22	826,790.22	**510,114.63**
上市公司	**10,012,329.13**	**4,516,029.04**	**1,729,145.07**
指标占比	**8.26%**	**18.31%**	**29.50%**

注 1：上表华力微 97.4988%股权的“资产总额与交易金额孰高”、“资产净额与交易净额孰高”均取相应交易金额，“营业收入”取华力微 **2025** 年度营业收入；

注 2：上市公司、华力微的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 **2025** 年度财务报

表。

如上，本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例均未超过 50%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易预计构成关联交易。

上市公司召开董事会、**股东大会**审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东**均已**回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

四、标的资产的评估情况

根据东洲评估出具的《评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），本次交易对华力微采用市场法、资产基础法进行评估，最终选用市场法结论作为最终评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定华力微 97.4988%股权的最终交易价格为 826,790.22 万元。

五、本次交易的具体方案

（一）发行股份购买资产

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

2、发行对象

本次发行股份购买资产的发行股份对象为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金 4 名交易对方。

3、发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量＝以发行股份形式向各交易对方购买标的资产对应的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量＝向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由上市公司现金补足。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易中，华力微股权的最终交易价格为 826,790.22 万元，均以股份方式支付，不足一股部分，现金补足。按照本次发行股票价格 43.34 元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为 190,768,392 股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	股份数量（股）
1	华虹集团	538,855.12	124,332,053
2	上海集成电路基金	133,318.65	30,761,109
3	大基金二期	86,922.77	20,056,014
4	国投先导基金	67,693.68	15,619,216
合计		**826,790.22**	**190,768,392**

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

4、定价基准日和发行价格

（1）定价基准日

本次发行股份的股票定价基准日为公司 2025 年第六次董事会决议公告日。

（2）发行价格

根据《重组管理办法》，本次发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。

5、锁定期安排

交易对方通过本次交易取得上市公司股份的锁定期在严格遵守《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的相关规定，以及中国证监会、上交所等证券监管机构要求的基础上，由上市公司与交易对方协商一致确定。具体股份锁定情况详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（二）交易对方作出的重要承诺”。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

6、过渡期损益安排

本次交易评估基准日至标的资产交割日内标的资产在运营过程中产生的收益及亏损均由上市公司享有。

7、滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

8、减值测试补偿

本次交易的减值测试期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，在减值测试期间每个会计年度结束后，由上市公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对减值测试标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。

如减值测试标的资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值，则补偿方应按如下约定向上市公司进行补偿：期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。补偿方应向上市公司补偿的金额=补偿方在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。

补偿方将优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。补偿方在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的，补偿方应以现金进行补偿。

若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上市公司应回购的股份数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×(1+送股或转增比例)。若补偿股份数量出现小数的情况，则应当向上取整作为补偿方应补偿股份的数量。补偿方在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额＝补偿股份截至补偿前每股已获得的现

金股利(以税后金额为准)×补偿股份数量。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

2、发行对象及发行股份数量

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 755,628.60 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。

3、发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

4、锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如前述锁定期的安排与监管机构的最新监管要求不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

5、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
2	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
3	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
合计		**755,628.60**	**100.00%**

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

6、滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发

行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

标的公司与上市公司均拥有 65/55nm、40nm 制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司总股本为 1,737,614,193 股，公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次交易拟向交易对方发行 190,768,392 股。本次交易前后（不考虑募集配套资金）上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	820,333,688	47.21%	820,333,688	42.54%
华虹国际	347,605,650	20.00%	347,605,650	18.03%
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	9.24%	160,545,541	8.33%
华虹集团	1,198,517	0.07%	125,530,570	6.51%
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78%	68,390,263	3.55%
上海集成电路基金	-	-	30,761,109	1.60%
国投先导基金	-	-	15,619,216	0.81%
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	11,020,000	0.63%	11,020,000	0.57%
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,697,339	0.62%	10,697,339	0.55%
香港中央结算有限公司	9,267,853	0.53%	9,267,853	0.48%
海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	6,077,517	0.35%	6,077,517	0.32%
其他股东	306,223,839	17.62%	306,223,839	15.88%
合计	1,737,614,193	100.00%	1,928,382,585	100.00%

注：重组前股份数量、持股比例为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

本次交易完成后，公司直接控股股东仍为华虹国际，间接控股股东仍为华虹集团，实际控制人仍为上海市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及安永会计师出具的《备考审阅报告》， 不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
资产总额	**10,012,329.13**	**10,610,932.80**	8,793,523.15	9,356,042.83
负债总额	**3,702,853.87**	**4,092,273.00**	2,521,468.25	2,965,008.50
归属于母公司股东权益	**4,516,029.04**	**4,725,213.57**	4,360,233.22	4,474,671.92
营业收入	**1,729,145.07**	**2,228,795.71**	1,438,830.77	1,927,405.55
利润总额	**-65,100.61**	**11,125.88**	-98,831.81	-36,817.13
净利润	**-80,714.30**	**-4,487.81**	-103,218.38	-41,203.70
归属于母公司股东净利润	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的子公司，根据模拟测算本次交易完成后上市公司资产规模、收入规模、盈利能力均有较大提升。

七、本次交易的决策过程和审批情况

（一）已履行完毕的审批程序

截至本报告签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已经上市公司 2025 年第六次董事会会议、2025 年第九次董事会会议、**2026 年第三次董事会会议**审议通过；

2、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；

3、本次交易已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；

4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；

5、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案；

6、上市公司股东大会审议通过本次交易；

7、香港证监会及联交所必要的审批程序。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

截至本报告签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易相关方所作出的重要承诺

本次交易相关方做出的重要承诺如下：

（一）上市公司及其董事、高级管理人员作出的重要承诺

1、上市公司作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其各自控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业及本企业董事、高级管理人员已向本次交易的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证本企业及本企业董事、高级管理人员所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业及本企业董事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业及本企业董事、高级管理人员将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业及本企业董事、高级管理人员关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为依据中国香港法律适当设立且存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、截至本承诺函出具之日，本企业不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形：（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次交易涉及重大资产重组的除外；（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 3、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会或其他有权部门立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本企业不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的

	情形；本企业不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 4、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本企业少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、本企业及本企业相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、本企业多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。在本企业召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、本企业与交易对方签署《保密协议》，此外，公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。本企业与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。
关于不存在违规担保、关联方资金占用等情形的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业合并报表范围内子公司不存在违反相关法律、法规、规范性文件及本企业内部管理制度等规定违规对外提供担保的情况。 2、截至本承诺函出具日，本企业及本企业合并报表范围内子公司不存在资金、资产被本企业控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，不存在为本企业控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的情况。 3、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证不影响和干扰审核的承诺函	1、本企业保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本企业保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利

	益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本企业保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本企业保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

2、上市公司全体董事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本人及本人控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本人已向本次交易的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

	3、根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
关于股份减持计划的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。 3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本人承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 4、本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门立案调查的情形。最近三十六个月内，本人不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本人不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本人最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本人上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本人在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施。 2、本人在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本人严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知

	情人登记管理制度》等相关规定进行内幕信息知情人登记。 4、本人保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来上市公司如实施股权激励计划，在本人合法权限范围内，促使拟公告的股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
关于减少和规范关联交易的承诺函	1、在本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交易，对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其控制的企业按照公平、公允等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务； 2、本人保证本人及本人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其控制的企业进行交易，不利用关联交易非法挪用、侵占、转移上市公司及其控制的企业的资金、利润、资产及其他资源，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其控制的企业及上市公司股东合法权益的行为； 3、本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的法律责任。上述各项承诺在本承诺人作为上市公司董事/高级管理人员期间持续有效且不可撤销。
关于保证不影响和干扰审核的承	1、本人保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以

诺函	下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本人保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本人保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本人保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

（二）交易对方作出的重要承诺

1、华虹集团

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际

	控制人、董事、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的

	过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本企业通过本次交易取得的前述上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。

	2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、未来如果本企业将承担业绩承诺及补偿义务，本企业所持有的上述股份还应遵守相关业绩承诺及补偿协议中对于锁定期的要求。 4、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 5、对于在本次交易前本企业已经持有的华虹半导体人民币普通股股份（以下简称“A 股股份”），自本次交易实施完成之日起十八个月内不得进行转让（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月的限制）。本企业在本次交易前所持华虹半导体 A 股股份所派生的股份，如因上市公司进行权益分派、公积金转增股本所增加之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。 6、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 7、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。
关于本次交易减值补偿的承诺函	1、本企业确认，本次交易的标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，因此上市公司在本次交易中拟取得的华力微 97.4988%股权（以下简称“减值测试标的资产”）应进行减值测试，如发生减值情形，本企业将依法承担相应的补偿义务。 2、本企业同意并承诺，本次交易的减值测试期间为本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度（以下简称“减值测试期间”）。 3、本企业同意，在减值测试期间每个会计年度结束之日起 3 个月内，由上市公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对减值测试标的资产进行评估，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告（以下简称“减值测试专项审核报告”）。 4、本企业同意，如减值测试标的资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值（以下简称“期末减值额”），在符合适用法律法规的前提下, 则本企业承诺按如下约定向上市公司进行补偿： 期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 本企业应向上市公司补偿的金额（以下简称“补偿金额”）=本企业在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。 本企业承诺，将优先以本企业在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。

	在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。 本企业在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的,本企业将以现金进行补偿。 若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上市公司应回购的股份数量应调整为：按上述公式计算的应补偿股份数量×（1+送股或转增比例）。若补偿股份数量出现小数的情况，则应当向上取整作为本企业应补偿股份的数量。 5、本企业承诺，在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式如下：返还金额＝补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×补偿股份数量。 6、本企业承诺，在上市公司确定本企业需补偿的金额并予以公告之日起三十（30）个工作日内，在符合适用法律法规的前提下，将本企业用于补偿的上市公司股份由上市公司以总价 1 元的对价回购，或将现金补偿金额足额支付至上市公司指定账户。 7、本企业承诺，不得通过转让、赠与、设定质押、股票收益权转让或其他权利限制等方式处置本企业于本次交易过程中取得的、处于锁定期内的上市公司股票。

2、上海集成电路基金

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信

和完整性的承诺函	息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公

	司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。 5、在标的资产权属变更登记至华虹半导体名下之前，本企业将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，并尽合理的商业努力促使标的公司按照正常方式经营。未经过华虹半导体的事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。 6、本企业承诺及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业自行承担。 7、本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给华虹半导体造成的一切损失。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于股份锁定期	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股

的承诺函	份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如果本企业符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 5、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。

3、大基金二期

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信

和完整性的承诺函	息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公

	司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。 5、在标的资产权属变更登记至华虹半导体名下之前，本企业将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，并尽合理的商业努力促使标的公司按照正常方式经营。未经过华虹半导体的事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。 6、本企业承诺及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业自行承担。 7、本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给华虹半导体造成的一切损失。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层及必要的执行人员，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如本企业取得前述华虹半导体股份时，对于用于认购华虹半导体股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的华虹半导体股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 5、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。

4、国投先导基金

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、监事（如适用）、高级管理人员/本企业的执行事务合伙人、主要管理人员、能够控制本企业的合伙人以及前述主体各自控制的机构如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于所持标的公司股权权属的承诺函	1、本企业合法拥有标的公司相应股权的全部权益（以下简称“标的资产”），包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经华虹半导体同意，本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。 2、本企业对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形，标的公司历次股权变更均符合中国法律要求，真实、有效，不存在出资瑕疵、纠纷或潜在纠纷。 3、本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍，同时，本企业保证此种状况持续至标的资产登记至华虹半导体名下。 4、标的资产不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排，包括但不限

	于标的公司或本企业签署的所有协议或合同不存在禁止转让、限制转让的其他利益安排、阻碍本企业转让标的资产的限制性条款；标的公司《公司章程》《股东协议》（如有）、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中，以及标的公司股东之间签订的合同、协议或其他文件中，不存在阻碍本企业转让所持标的资产的限制性条款。 5、在标的资产权属变更登记至华虹半导体名下之前，本企业将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，并尽合理的商业努力促使标的公司按照正常方式经营。未经过华虹半导体的事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。 6、本企业承诺及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业自行承担。 7、本企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给华虹半导体造成的一切损失。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业与上市公司就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。 2、本企业及本企业相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。 3、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 4、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 5、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 6、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。 3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 4、本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所监管措施、纪律处分的情况，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益或其他重大违法行为等情况。 5、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和

	重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于股份锁定期的承诺函	1、本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如本企业取得前述华虹半导体股份时，对于用于认购华虹半导体股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的华虹半导体股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。 2、在上述股份锁定期内，本企业本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份因上市公司进行权益分派、公积金转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份锁定安排。 3、上述股份锁定期届满后，该等股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 4、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份锁定或股份交易出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 5、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。本企业承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。

（三）标的公司及其董监高作出的重要承诺

1、标的公司作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其各自控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、本企业及本企业董事、高级管理人员已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证本企业及本企业董事、

函	高级管理人员所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业及本企业董事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业及本企业董事、高级管理人员将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业及本企业董事、高级管理人员关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，具备相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。 2、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本企业不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；本企业不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 3、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁； 4、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本企业采取了必要且充分的保密措施，知悉本次交易的人员仅限于本企业少数核心管理层，限制了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围。本企业及本企业相关人员严格遵守了保密义务。 2、本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向上市公司提交。 3、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。

2、标的公司董事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺事项	承诺内容
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本人及本人控制的机构（如有）不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与重大资产重组的情形。 3、本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本人已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本人关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形；最近三十六个月内，本人不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；本人不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本人最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

	3、本人上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、本人在本次交易中严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循《上海华力微电子有限公司章程》及内部管理制度的规定，采取了必要且充分的保密措施。 2、本人严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定进行内幕信息知情人登记。 3、本人保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。

（四）上市公司控股股东作出的重要承诺

1、华虹集团

承诺事项	承诺内容
关于上市公司本次交易的原则性意见	本次交易将有利于提高上市公司资产质量，促进上市公司未来的业务发展，有利于增强上市公司竞争力，符合上市公司及全体股东的利益，本企业原则性同意本次交易。
关于股份减持计划的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本企业无主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份，前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。 2、本企业将严格遵守相关法律法规和上市公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向本企业提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其

	他股东的合法权益。 3、本企业违反上述承诺的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。
关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的除华虹半导体及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”），与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。 2、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，本企业及本企业控制的其他企业将采取有效措施避免新增与华虹半导体及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。 3、本企业如违反上述承诺的，愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给华虹半导体及其控股子公司造成的所有直接和间接损失。 4、上述承诺在本企业作为华虹半导体间接控股股东期间有效。
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚

	假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、针对本次交易，本企业采取了必要且充分的保密措施。 2、本企业严格控制本次交易参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易内幕信息知情人员的范围，做好内幕信息知情人员的登记；本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向华虹半导体提交。 3、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证上市公司独立性的承诺函	1、本次交易完成后，本企业在作为上市公司间接控股股东期间将严格遵守法律法规、规范性文件的要求，依法行使股东权利并履行股东义务，不利用间接控股股东地位谋取不当利益，本企业控制的其他企业与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 2、本企业如因不履行或不适当履行上述承诺给上市公司及其相关股东造成损失的，应依法承担相应的赔偿责任。 3、本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司的间接控股股东期间持续有效。
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函	1、本企业承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及相

	关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3、本企业承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
关于不存在违规担保、关联方资金占用等情形的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）不存在违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产的情形，不存在对上市公司及其控股子公司非经营性资金占用的情形，不存在上市公司及其控股子公司为本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）提供担保的情形； 2、本次交易完成后，本企业及本企业的关联方将继续规范运作，未来不以任何形式违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产或要求上市公司及其控股子公司违规提供担保； 3、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证不影响和干扰审核的承诺函	1、本企业保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本企业保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本企业保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本企业保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

2、华虹国际

承诺事项	承诺内容
关于上市公司本次交易的原则性意见	本次交易将有利于提高上市公司资产质量，促进上市公司未来的业务发展，有利于增强上市公司竞争力，符合上市公司及全体股东的利益，本企业原则性同意本次交易。
关于股份减持计划的承诺函	1、截至本承诺函出具之日，本企业无减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持上市公司股份。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。 2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。 3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。 2、本企业将严格遵守相关法律法规和上市公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向本企业提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、本企业违反上述承诺的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。
关于避免同业竞争的承诺函	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的除华虹半导体及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”），与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。 2、本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，本企业及本企业控制的其他企业将采取有效措施避免新增与华虹半导体及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。 3、本企业如违反上述承诺的，愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给华虹半导体及其控股子公司造成的所有直接和间接损失。 4、上述承诺在本企业作为华虹半导体控股股东期间有效。
关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	1、本企业及本企业控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任而不得参与任

	何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 3、本企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。 4、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1、本企业已向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2、本企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、根据本次交易的进程，本企业将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 4、本企业关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。 5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业承诺不转让在华虹半导体拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代本企业向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
关于无违法违规行为的声明与承诺函	1、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门立案调查的情形；最近三十六个月内，本企业不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重的情形，不存在受到刑事处罚的情形；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处

	罚的情形，不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施的情形；不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 2、本企业最近三年内诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等情况，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、本企业上述所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明	1、针对本次交易，本企业采取了必要且充分的保密措施。 2、本企业严格控制本次交易参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易内幕信息知情人员的范围，做好内幕信息知情人员的登记；本企业按照法律法规要求，配合华虹半导体收集本次交易内幕信息知情人员相关信息，并向华虹半导体提交。 3、本企业保证不泄露本次交易内幕信息，在内幕信息依法披露之前，不公开或者泄露信息，不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。 4、在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，本企业严格遵守了保密义务。 5、如因本企业违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证上市公司独立性的承诺函	1、本次交易完成后，本企业在作为上市公司控股股东期间将严格遵守法律法规、规范性文件的要求，依法行使股东权利并履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，本企业控制的其他企业与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 2、本企业如因不履行或不适当履行上述承诺给上市公司及其相关股东造成损失的，应依法承担相应的赔偿责任。 3、本承诺函一经本企业签署即对本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本企业作为上市公司的直接控股股东期间持续有效。
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函	1、本企业承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、自本承诺函出具之日至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺； 3、本企业承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

关于不存在违规担保、关联方资金占用等情形的承诺函	1、截至本承诺函出具日，本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）不存在违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产的情形，不存在对上市公司及其控股子公司非经营性资金占用的情形，不存在上市公司及其控股子公司为本企业及本企业的关联方（上市公司及其控股子公司除外）提供担保的情形； 2、本次交易完成后，本企业及本企业的关联方将继续规范运作，未来不以任何形式违规占用上市公司及其控股子公司资金、资产或要求上市公司及其控股子公司违规提供担保； 3、上述承诺内容真实、完整、准确，如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。
关于保证不影响和干扰审核的承诺函	1、本企业保证遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及上海证券交易所上市审核委员会（以下简称“上市委”）委员、并购重组审核委员会（以下简称“重组委”）委员、科技创新咨询委员会（以下简称“咨询委”）委员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。 2、本企业保证不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、上海证券交易所上市委委员、重组委委员、咨询委委员或者其他利益关系人输送不正当利益： （1）以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利； （2）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利； （3）安排显着偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （4）直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动； （5）其他输送不正当利益的情形。 3、本企业保证不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。 4、本企业保证遵守法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

公司名称	华虹半导体有限公司
英文名称	HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
证券简称	华虹公司
证券代码	688347.SH
股票上市地	上海证券交易所
注册地址	中国香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 2212 室
办公地址	中国上海张江高科技园区哈雷路 288 号
法定代表人	-
成立日期	2005 年 1 月 21 日
上市日期	2023 年 8 月 7 日
公司网站	www.huahonggrace.com
联系电话	86-21-38829909
电子信箱	IR@hhgrace.com
邮政编码	201203

二、公司设立及股本变动情况

（1）公司设立及收购华虹 NEC

经国务院于 2004 年 12 月批示同意，为华虹 NEC 重组上市目的，华虹 NEC 中方股东华虹集团、张江集团、上海贝岭拟将其持有的华虹 NEC 股权划转到境外，并与华虹 NEC 外方股东合资设立拟上市公司，自行选择有利时机，到境外发行股票并在香港上市。

2005 年 1 月 21 日，公司在中国香港依据《公司条例》注册，设立时公司名称为“华虹半导体有限公司（Hua Hong Semiconductor Limited）”，设立时已发行股份数为 1 股，每股面值为 0.01 美元，该等已发行股份由 Harefield Limited 持有。

2005 年 3 月 3 日，华虹 NEC 相关股东、公司签订股权转让相关协议，约定华虹 NEC 当时全体注册于境内的股东分别将其持有的华虹 NEC 股权划转、转让

予相关境外主体，并由华虹公司向前述划转或转让完成后的华虹 NEC 全体股东发行股份购买其合计持有的华虹 NEC100%股权，前述事宜的具体情况如下表所示：

单位：万美元

华虹 NEC 原股东情况			第一步：华虹 NEC 境内股东将股权划转、转让予境外主体			第二步：公司发行股份购买华虹 NEC 全部股权		
股东名称	出资额	持股比例（%）	划入方/受让方	出资额	持股比例（%）	出售方	出售比例（%）	对价股份（股）
华虹集团	50,000	55.92	华虹国际	50,000	55.92	华虹国际	61.42	350,401,100
华虹国际	4,480	5.01	-	-	-			
张江集团	437	0.49	华虹国际	437	0.49			
中国日电	7,000	7.83	NEC	7,000	7.83	NEC	17.36	99,038,800
NEC	8,520	9.53	-	-	-			
上海贝岭	10,030	11.22	香港海华	10,030	11.22	香港海华	11.22	64,010,100
Newport	8,941	10.00	-	-	-	Newport	10.00	57,050,000
合计	**89,408**	**100.00**	-	**89,408**	**100.00**	-	**100.00**	**570,500,000**

注 1：根据华虹集团、华虹国际与张江集团、张江国际于 2005 年 3 月 3 日签订的境外信托契据及华虹集团、华虹国际与张江集团于 2005 年 3 月 3 日签订的股权托管及划转协议，张江集团将华虹 NEC 0.49%股权（即“华虹 NEC 权益”）委托华虹集团代管并划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹 NEC 权益置换为公司 0.49%股权（对应公司 2,795,450 股，即“公司权益”）；股权置换后，由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理公司权益，并代表张江集团行使公司权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江集团根据协议约定保留公司权益项下的处分权、收益权等股东权利，并承担相应义务。

注 2：其中华虹国际所持有的公司 1 股股份系自 Harefield Limited 处以 0.01 美元的价格受让取得。

国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹 NEC 中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。

中华人民共和国商务部分别于 2005 年 3 月 31 日、2005 年 4 月 30 日、2005

年 7 月 28 日核发商合批[2005]178 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。

中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2005 年 5 月 8 日核发发改外资[2005]730 号《国家发展改革委关于上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。

华虹国际、NEC、香港海华及 Newport 已于 2005 年 6 月 1 日被登记为公司股东，华虹 NEC 之股权已于 2005 年 10 月 9 日变更登记至公司名下。

上述华虹 NEC 收购完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	华虹国际	350,401,100 （其中 2,795,450 股系为张江集团托管）	61.42
2	NEC	99,038,800	17.36
3	香港海华	64,010,100	11.22
4	Newport	57,050,000	10.00
合计		**570,500,000**	**100.00**

（2）2014 年 10 月公司在香港联交所首次公开发行股票并上市

公司股东大会于 2014 年 9 月 20 日作出决议，同意公司公开发行股票，同时批准董事行使公司配发、发行及处置股份的一切权力（包括作出要约、订立协议、或授出将会或可能须配发及发行股份的证券的权力）。

根据公司公开披露的相关信息，公司于 2014 年 10 月以 11.25 港币/股的价格公开发行合计 228,696,000 股股份；本次发行完成后，公司已发行股份总数增至 1,033,871,656 股。2014 年 10 月 15 日，公司在香港联交所主板挂牌上市。

（3）2015 年 9 月第一期期权激励计划

公司股东特别大会于 2015 年 9 月 1 日作出决议，同意采纳股票期权计划，

并授权董事会自计划批准日 7 年内任何时间决定授予参与者按行权价认购一定数量公司股票的权利；该股票期权计划项下拟授出的所有期权及公司任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数，合计不得超过当时的已发行股本总数的 10%，且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过公司总股本的 3%。

上海市国资委已于 2015 年 8 月 14 日出具沪国资委分配（2015）278 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》，原则同意上述期权激励计划。

根据公司股东大会的上述授权，公司董事会于 2015 年 9 月 4 日作出决议，同意于 2015 年 9 月 4 日向董事及雇员授出股票期权。公司本次授出 30,250,000 份期权，前述期权可按行权价 6.912 港元认购合计最多 30,250,000 股股票，本次期权分三期归属，并将于 2022 年 9 月 3 日失效。

（4）2018 年 11 月增资

公司于 2018 年 1 月 3 日与大基金签订《认购协议》，约定大基金（无论是通过其自身或是通过其指定人士）认购公司 242,398,925 股股份，认购价为每股 12.9002 港元；公司股东特别大会于 2018 年 2 月 14 日作出决议，同意前述股份认购事宜。大基金指定的主体鑫芯香港已于 2018 年 11 月 7 日完成前述股份认购。

华虹集团于 2017 年 12 月 15 日召开一届五十三次党委会，同意鑫芯香港入股公司；大基金已于 2017 年 12 月 15 日召开第二十次董事会审议通过鑫芯香港入股公司事宜，并就前述事宜于 2017 年 12 月 15 日出具了《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》。本次增资完成后，公司已发行股份总数增至 1,283,750,891 股。

（5）2018 年 12 月第二期股票期权计划第一次授予

公司董事会于 2018 年 12 月 18 日作出决议，同意于 2018 年 12 月 24 日及 2019 年 12 月 23 日向若干雇员和/或董事配发股票期权，但该等期权计划的实施须根据国资监管部门的要求取得公司股东大会的批准为前提。公司于 2018 年 12

月 24 日向公司若干员工及当时的董事授出 34,500,000 份期权（该等期权须经公司股东大会批准后方可生效）。前述期权可按行权价 15.056 港元认购合计最多 34,500,000 股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员（连同董事）而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属；前述期权将于 2025 年 12 月 23 日失效。

上海市国资委于 2019 年 3 月 12 日出具沪国资委分配（2019）44 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划（二期）的批复》，原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划（二期）方案》，并应按有关规定提交公司股东大会审议。

公司股东特别大会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意根据公司于 2018 年 12 月 24 日授出 34,500,000 份股票期权，并同意于 2019 年 12 月 23 日或前后进一步授出 4,000,000 份股票期权。

（6）2019 年 3 月第二期股票期权计划第二次授予

根据上述上海市国资委的批复及公司股东大会的授权，公司董事会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意于 2019 年 3 月 29 日向唐均君授出 500,000 份期权，前述期权可按行权价 18.40 港元认购合计最多 500,000 股股票；本次期权分四期归属，并将于 2026 年 3 月 28 日失效。

（7）2019 年 12 月第二期股票期权计划第三次授予

根据上述上海市国资委的批复及公司股东大会的授权，公司董事会于 2019 年 11 月 12 日作出决议，同意于 2019 年 12 月 23 日向华虹无锡具有重要技术专长及/或担任核心管理职位的 101 名员工授予 2,482,000 份期权。前述期权可按行权价 17.952 港元认购合计最多 2,482,000 股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属。前述期权将于 2026 年 12 月 22 日失效。

（8）2021 年 11 月公司股票期权计划调整

公司股东特别大会于 2021 年 11 月 26 日作出决议，鉴于现有股票期权计划限额已多数获使用，为使公司能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励，同意将公

司股票期权计划授出限额调整为 130,047,036 股股票。

（9）2023 年 8 月公司在上交所首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2023]1228 号《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，华虹公司向社会公开发行人民币普通股 407,750,000 股，每股发行价格 52 元。经上交所同意，华虹公司境内发行股票总数为 407,750,000 股，其中 103,974,252 股于 2023 年 8 月 7 日起在上交所科创板上市交易。

截至 2025 年 **12 月 31 日**，公司上交所 A 股股票总数未发生变动，为 407,750,000 股，联交所股票总数为 **1,329,864,193** 股，其变动系公司股票期权计划行权所致。

三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况

截至本报告签署日，最近三十六个月，上市公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委，未发生控制权变动。

四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况

上市公司最近三年不存在重大资产重组的情形。

五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况

本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。

六、上市公司控股股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31** 日，上市公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	**820,333,688**	**47.21**
2	华虹国际	347,605,650	**20.00**

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
3	联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	**9.24**
4	华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78
5	**招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金**	**11,020,000**	**0.63**
6	**中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司**	**10,697,339**	**0.62**
7	**中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金**	**9,267,853**	**0.53**
8	海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47
9	国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47
10	**中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金**	**6,077,517**	**0.35**
合计		**1,430,191,837**	**82.31**

七、上市公司最近三年主营业务发展情况

华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

最近三年，上市公司主营业务未发生变更。

八、上市公司主要财务数据

（一）主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	**1,729,145.07**	1,438,830.77	1,623,187.40
营业利润	**-65,192.80**	-98,935.59	117,791.99
利润总额	**-65,100.61**	-98,831.81	117,754.41
净利润	**-80,714.30**	-103,218.38	84,736.19

归属于母公司股东的净利润	**37,661.14**	38,057.62	193,623.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**22,893.89**	24,528.05	161,402.82
经营活动产生的现金流量净额	**506,542.13**	360,828.97	510,498.80
现金及现金等价物净增加额	**234,357.02**	-750,413.47	2,556,791.76
项目	**2025 年 12 月 31 日**	**2024 年 12 月 31 日**	**2023 年 12 月 31 日**
资产合计	**10,012,329.13**	8,793,523.15	7,622,635.11
负债合计	**3,702,853.87**	2,521,468.25	2,073,554.56
所有者权益合计	**6,309,475.27**	6,272,054.90	5,549,080.55
归属于母公司所有者权益合计	**4,516,029.04**	4,360,233.22	4,335,425.24

注：最近三年财务数据经审计。

（二）主要财务指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
基本每股收益（元）	**0.22**	0.22	1.31
稀释每股收益（元）	**0.22**	0.22	1.30
加权平均净资产收益率（%）	**0.85**	0.88	6.49
资产负债率（%）	**36.98**	28.67	27.20
毛利率（%）	**18.72**	17.43	27.10

九、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本报告签署日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况

截至本报告签署日，最近三年内，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形。

十一、上市公司遵纪守法情况

截至本报告签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

第三节 交易对方基本情况

一、发行股份购买资产的交易对方

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的交易对方为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。

（一）华虹集团

1、基本信息

企业名称	上海华虹（集团）有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号
法定代表人	秦健
注册资本	**1,352,148.449311 万**元
统一社会信用代码	91310000132263312B
成立日期	1996 年 4 月 9 日
经营范围	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注：上述注册资本为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）1996 年 4 月，设立

华虹集团成立于 1996 年 4 月，注册资本为 400,000 万元，其中中国电子信息产业集团有限公司出资 210,000 万元，上海仪电控股（集团）公司出资 190,000 万元，设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国电子信息产业集团有限公司	210,000.00	52.50%
2	上海仪电控股(集团)公司	190,000.00	47.50%
合计		**400,000.00**	**100.00%**

（2）2009 年 3 月，分立减资

2009 年 3 月，经公司股东会决议（沪华虹股【2009】第 1 号）和《关于上海华虹（集团）有限公司之分立协议》，公司将所持上海华虹集成电路有限责任公司（占 90.28%）、北京华虹集成电路设计有限责任公司（占 10.00%）、上海新鑫投资有限公司（占 36.36%）、上海信虹投资管理有限公司（占 50.00%）、宁波钲芯科技有限责任公司（占 80.00%）和上海贝岭（占 27.80%）等 6 家公司的股权和货币资金 1,000.00 万元分立由中国电子信息产业集团有限公司持有，相应减少中国电子信息产业集团有限公司对公司的出资额 104,769.73 万元，同时增加上海金桥（集团）有限公司对公司的出资份额 357.92 万元，增加上海仪电（集团）有限公司对公司的出资份额 8,153.21 万元，增加上海联和投资有限公司对公司的出资份额 9,068.00 万元，资产交割日为 2009 年 6 月 30 日。另根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产【2009】20 号）批复，上海久事公司将持有公司 20.53%的股权及对应的出资额 100,000.00 万元无偿划转给上海联和投资有限公司。至此公司注册资本变更为 399,809.40 万元。

分立减资后华虹集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国电子信息产业集团有限公司	188,230.27	47.08%
2	上海联和投资有限公司	109,068.00	27.28%
3	上海仪电控股(集团)公司	98,153.21	24.55%
4	上海金桥（集团）有限公司	4,357.92	1.09%
合计		**399,809.40**	**100.00%**

（3）2009 年 12 月，股份划转

2009 年 12 月，根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产【2009】679 号）批复，上海仪电（集团）有限公司将持有公司的股权 19.80%无偿划转给上海联和投资有限公司。

划转后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	188,230.27	47.08%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	中国电子信息产业集团有限公司	188,230.27	47.08%
3	上海仪电控股（集团）公司	18,990.95	4.75%
4	上海金桥（集团）有限公司	4,357.92	1.09%
合计		**399,809.40**	**100.00%**

（4）2018 年 9 月，股权转让

2018 年 9 月 14 日，根据国务院国有资产监督管理委员会文件（国资产权【2018】644 号）批复，中国电子信息产业集团有限公司将 47.08%股权以非公开协议方式分别转让给上海国盛（集团）有限公司 23.54%股权，转让给上海国际集团有限公司 23.54%股权。2018 年 12 月 25 日，根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会文件（浦国资委【2018】154 号）批复，上海金桥（集团）有限公司将 1.09%股权以非公开协议方式转让至上海联和投资有限公司。

划转后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	192,588.19	48.17%
2	上海国盛（集团）有限公司	94,115.13	23.54%
3	上海国际集团有限公司	94,115.13	23.54%
4	上海仪电（集团）有限公司	18,990.95	4.75%
合计		**399,809.40**	**100.00%**

（5）2019 年 11 月，增资

2019 年 11 月 21 日，根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产权（2019）308 号）批复，上海联和投资有限公司将其持有上海华力微电子有限公司 50.2283%股权和 1.8 亿元现金以非公开协议方式对华虹集团进行增资。该增资以华虹集团、华力微 2018 年 12 月 31 日经备案的净资产评估值为依据。增资完成后，华虹集团注册资本增加至 1,110,229.62 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	903,008.41	81.34%
2	上海国盛（集团）有限公司	94,115.13	8.48%
3	上海国际集团有限公司	94,115.13	8.48%
4	上海仪电（集团）有限公司	18,990.95	1.71%
合计		**1,110,229.62**	**100.00%**

（6）2019 年 12 月，增资

2019 年 12 月 30 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2019）375 号），上海市国资委以华虹集团 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 15,000.00 万元，其中 15,425.75 万元计入实收资本，425.75 万元冲减资本公积。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海联和投资有限公司	903,008.41	80.22%
2	上海国盛（集团）有限公司	94,115.13	8.36%
3	上海国际集团有限公司	94,115.13	8.36%
4	上海仪电（集团）有限公司	18,990.95	1.69%
5	上海市国资委	15,425.75	1.37%
合计		**1,125,655.37**	**100.00%**

（7）2020 年 6 月，股权划转

2020 年 6 月 8 日，根据上海市国资委文件（沪国资委产权（2020）126、127、128、129 号），上海联和投资有限公司将其持有华虹集团全部股权无偿划转给上海市国资委，该划转以 2019 年 12 月 31 日为基准日，以大华会计师出具的大华审字[2020]002645 号 2019 年年度审计报告为依据；同时，上海市国资委将其持有的华虹集团 10%、10%和 10%的股权分别无偿划转至上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司和上海仪电（集团）有限公司，上述划转以 2020 年 1 月 1 日为基准日，以中介机构出具的 2019 年年度审计报告为依据。

股权划转后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	580,737.55	51.59%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	18.36%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	18.36%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	11.69%
合计		**1,125,655.37**	**100.00%**

（8）2020 年 9 月，增资

2020 年 9 月 18 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2020）247 号），上海市国资委以**华虹集团** 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 50,000.00 万元，其中 50,792.36 万元计入实收资本，792.36 万元冲减资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,176,447.73 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	631,529.91	53.68%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	17.57%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	17.57%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	11.18%
合计		**1,176,447.73**	**100.00%**

（9）2020 年 12 月，增资

2020 年 12 月 24 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2020）427 号），上海市国资委以华虹集团 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 30,000.00 万元，其中 30,475.42 万元计入实收资本，475.42 万元冲减资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,206,923.15 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	662,005.33	54.86%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	17.12%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	17.12%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	10.90%
合计		**1,206,923.15**	**100.00%**

（10）2021 年 12 月，增资

2021 年 12 月 31 日，根据上海市国国资委文件（沪国资委评价（2021）411 号），上海市国资委以华虹集团 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 113,000.00 万元，其中 114,499.95 万元计入实收资本，1,499.95 万元冲减资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,321,423.10 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	776,505.27	58.76%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.64%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.64%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.96%
合计		**1,321,423.10**	**100.00%**

（11）2022 年 12 月，增资

2022 年 12 月 30 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2023）8 号），上海市国资委以华虹集团 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 15,000.00 万元，其中 5,894.37 万元计入实收资本，9,105.63 万元计入资本公积，增资后华虹集团注册资本变更为 1,327,317.47 万元，相应股权结构变更为：上海市国资委出资 782,399.65 万元（占 58.95%），上海仪电（集团）有限公司出资 131,556.48 万元（占 9.91%），上海国盛（集团）有限公司出资 206,680.67 万元（占 15.57%），上海国际集团有限公司出资 206,680.67 万元（占 15.57%）。2023 年 7 月 11 日，根据股东会关于公司增加资本金及《公司章程》变更的决议，华虹集团确认实收资本及资本公积。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	782,399.65	58.95%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.57%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.57%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.91%
合计		**1,327,317.47**	**100.00%**

（12）2023 年 12 月，增资

2023 年 12 月 14 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2023）289 号），上海国有资产监督管理委员会以华虹集团 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 28,580 万元，其中 11,168.43 万元计入实收资本，17,411.57 万元计入资本公积。2024 年 2 月 20 日，根据上海市国资委文件（沪国资委评价（2024）40 号），上海市国资委以华虹集团 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 16,499 万元，其中 6,447.44 万元计入实收资本，10,051.56 万元计入资本公积。增资后华虹集团注册资本变更为 1,344,854.52 万元。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国资委	799,936.70	59.48%
2	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.37%
3	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.37%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.78%
合计		**1,344,854.52**	**100.00%**

（13）2024 年 11 月，股权划转

2024 年 11 月 6 日，根据上海国有资产监督管理委员会文件（沪国资委产权（2024）204 号），将市国资委所持上海华虹（集团）有限公司 8%股权无偿划转至上海临港经济发展（集团）有限公司。上述股权划转以 2023 年 12 月 31 日经审计的被划转企业净资产值为依据，作为国家资本金（包括资本公积）处理。

本次划转后，华虹集团的股东情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国有资产监督管理委员会	692,348.34	51.48%
2	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.37%
3	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.37%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.78%
5	上海临港经济发展（集团）有限公司	107,588.36	8.00%
合计		**1,344,854.52**	**100.00%**

（14）2025 年 1 月，增资

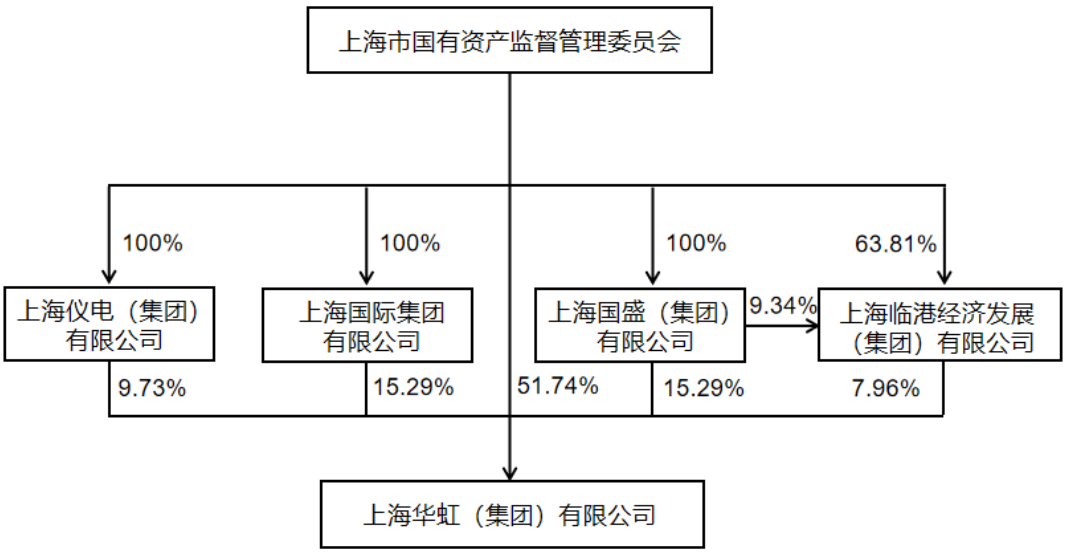
2025 年 1 月 15 日，根据上海市国有资产监督管理委员会文件（沪国资委评价（2025）14 号），上海国有资产监督管理委员会以华虹集团 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，增加国有资本金 23,555 万元，其中 7,293.92 万元计入实收资本，16,261.08 万元计入资本公积。2025 年 3 月，根据华虹集团股东会决议，华虹集团本次增资后注册资本变更为 1,352,148.45 万元，并于 2025 年 9 月完成工商变更登记。

增资后华虹集团的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海市国有资产监督管理委员会	699,642.26	51.74%
2	上海国际集团有限公司	206,680.67	15.29%
3	上海国盛（集团）有限公司	206,680.67	15.29%
4	上海仪电（集团）有限公司	131,556.48	9.73%
5	上海临港经济发展（集团）有限公司	107,588.36	7.96%
合计		1,352,148.45	100.00%

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，华虹集团产权控制关系如下：



截至 2025 年 12 月 31 日，华虹集团不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

4、主要股东及实际控制人情况

截至 2025 年 12 月 31 日，**华虹集团**的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

5、主营业务发展情况

华虹集团旗下业务包括集成电路制造、电子元器件分销、智能化系统应用等板块，最近三年主营业务未发生变更。

6、主要对外投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，除华力微外，华虹集团持股比例 30%以上的主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
1	华虹国际	100.00%	主要从事投资控股
2	上海华虹虹日电子有限公司	51.00%	主要从事电子元器件分销业务

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
3	上海华虹计通智能系统股份有限公司	25.61%	公司的经营范围：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统，自动售检票设备及系统，电子收款机及系统，相关智能仪器仪表及设备并提供安装服务；从事自行车租赁系统、智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工，建筑工程设计、各类工程建设活动，软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，人工智能应用软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，非居住房地产租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4	上海华虹科技发展有限公司	50.00%	公司经营范围:电子技术、计算机、化工科技和生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理商务咨询、企业管理咨询(除经纪)，电子产品的销售，物业管理，【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
5	公司 A	63.54%	公司经营范围：开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
6	上海华虹投资发展有限公司	60.00%	经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	上海华虹挚芯电子科技有限公司	93.02%	经营范围包括集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、是否属于私募基金及备案情况

华虹集团不属于私募基金，无需进行私募基金备案。

（二）上海集成电路基金

1、基本信息

企业名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A 单元
法定代表人	李鑫

注册资本	2,480,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000MA1FL3AW02
成立日期	2016 年 12 月 7 日
经营范围	股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注：上述注册资本为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016 年 12 月，设立

上海集成电路基金系由上海科技创业投资(集团)有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、上海嘉定创业投资管理有限公司共同投资组建的股份有限公司(非上市、国有控股)，于 2016 年 12 月 7 日在上海市工商局登记注册，取得 91310000MA1FL3AW02 号企业法人营业执照。

设立时，上海集成电路基金的股东及其出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	1,000,000.00	35.0877%
2	上海汽车集团股权投资有限公司	600,000.00	21.0526%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海国际信托有限公司	300,000.00	10.5263%
5	上海国盛（集团）有限公司	200,000.00	7.0175%
6	上海国际集团有限公司	200,000.00	7.0175%
7	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
8	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（2）2020 年 2 月，股权转让

2020 年 2 月，上海科技创业投资（集团）有限公司持有**部分**份额转让至上海国盛（集团）有限公司、上海国际集团有限公司，经上述股权转让后，上海集

成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	875,000.00	30.7018%
2	上海汽车集团股权投资有限公司	600,000.00	21.0526%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海国际信托有限公司	300,000.00	10.5263%
5	上海国盛（集团）有限公司	262,500.00	9.2105%
6	上海国际集团有限公司	262,500.00	9.2105%
7	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
8	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（3）2021 年 7 月，股权转让

2021 年 7 月，上海国际信托有限公司持有部份额转让至中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司，经上述股权转让后，上海集成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	875,000.00	30.7018%
2	上海汽车集团股权投资有限公司	600,000.00	21.0526%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海国盛（集团）有限公司	262,500.00	9.2105%
5	上海国际集团有限公司	262,500.00	9.2105%
6	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
7	上海国际信托有限公司	180,000.00	6.3158%
8	中保投齐芯(嘉兴)集成电路产业投资有限责任公司	120,000.00	4.2105%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（4）2023 年 11 月-12 月，股权转让

2023 年 11 月，上海汽车集团股权投资有限公司、上海国盛（集团）有限公司将其持有份额转让至中国人寿资产管理有限公司；2023 年 12 月，上海国际集

团有限公司将其持有的部分份额转让至中国中信金融资产管理股份有限公司，经上述股权转让后，上海集成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	875,000.00	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司	862,500.00	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	300,000.00	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	200,000.00	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	180,000.00	6.3158%
6	上海国际集团有限公司	151,170.49	5.3042%
7	中保投齐芯(嘉兴)集成电路产业投资有限责任公司	120,000.00	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	111,329.51	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	50,000.00	1.7544%
合计		**2,850,000.00**	**100.00%**

（5）2024 年 6 月，减资

2024 年 6 月，上海集成电路基金召开 2024 年度第三次临时股东大会，决定将基金减持回收的资金及历年的利息收益等以减资的方式进行分配，共计减资分配 24 亿元。根据《发起人决议》及公司章程的规定，本次减资金额将按照减资时点各股东的实缴出资比例进行分配，减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	801,315.68	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司	789,868.32	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	274,736.88	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	183,158.00	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	164,842.08	6.3158%
6	上海国际集团有限公司	138,440.41	5.3042%
7	中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司	109,894.80	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	101,954.39	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	45,789.44	1.7544%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
合计		**2,610,000.00**	**100.00%**

（6）2024 年 12 月，股权转让

2024 年 12 月，上海国际集团有限公司将其持有份额转让至中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），经上述股权转让后，上海集成电路基金股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	801,315.68	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司	789,868.32	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	274,736.88	10.5263%
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	183,158.00	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	164,842.08	6.3158%
6	中保投智集芯(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	138,440.41	5.3042%
7	中保投齐芯(嘉兴)集成电路产业投资有限责任公司	109,894.80	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	101,954.39	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	45,789.44	1.7544%
合计		**2,610,000.00**	**100.00%**

（7）2025 年 1 月，减资

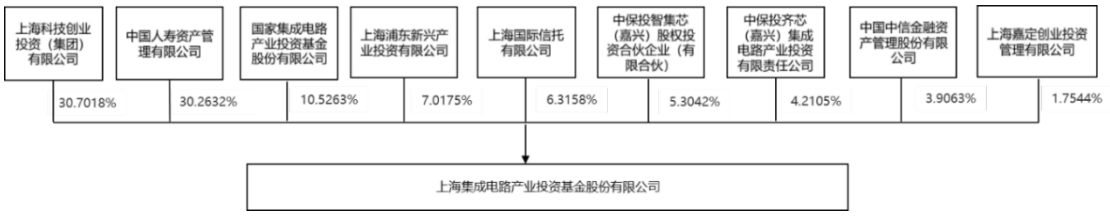
2025 年 1 月，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，决定将基金减持回收的资金及历年的利息收益等以减资的方式进行分配，共计减资分配 13 亿元。根据《发起人决议》及公司章程的规定，本次减资金额将按照减资时点各股东的实缴出资比例进行分配，减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海科技创业投资（集团）有限公司	761,403.34	30.7018%
2	中国人寿资产管理有限公司（代表“中国人寿-沪发 1 号股权投资计划”）	750,526.16	30.2632%
3	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	261,052.69	10.5263%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	174,035.25	7.0175%
5	上海国际信托有限公司	156,631.54	6.3158%
6	中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业(有限合伙)	131,544.95	5.3042%
7	中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司	104,421.15	4.2105%
8	中国中信金融资产管理股份有限公司	96,876.20	3.9063%
9	上海嘉定创业投资管理有限公司	43,508.72	1.7544%
合计		**2,480,000.00**	**100.0000%**

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上海集成电路基金产权控制关系如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，上海集成电路基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

4、主要股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，经查阅上海集成电路基金的营业执照、公司章程等资料，并登录国家企业信用信息公示系统查询，上海集成电路基金股权结构比较分散，任一单一股东无法对上海集成电路基金的股东大会、董事会形成控制，且各股东之间无一致行动关系，因此上海集成电路基金无控股股东和实际控制人。

5、主营业务发展情况

上海集成电路基金成立于 2016 年 12 月，系为促进集成电路产业发展设立的公司制私募股权基金，最近三年主营业务未发生变更。

6、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务数据

最近两年，上海集成电路基金主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	**4,667,857.14**	4,073,378.12
净资产	**4,162,087.09**	3,729,529.83
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	**-**	80,835.70
净利润	**562,557.26**	30,847.73

注：**2024 年**财务数据为经**审计的合并财务报表数据，2025 年财务数据为未经**审计的合并财务报表数据。

（2）最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
流动资产	**69,837.69**
非流动资产	**4,598,019.45**
资产总额	**4,667,857.14**
流动负债	**3,691.71**
非流动负债	**502,078.34**
负债总额	**505,770.05**
所有者权益	**4,162,087.09**

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度
营业收入	**-**
利润总额	**749,720.47**
净利润	**562,557.26**

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	-701.80
投资活动产生的现金流量净额	-59,918.77
筹资活动产生的现金流量净额	-130,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-190,620.57

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

7、主要对外投资情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，上海集成电路基金持股比例 30%**及**以上的主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
1	上海海临微集成电路有限公司	30.00%	一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、是否属于私募基金及备案情况

上海集成电路基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SEJ523。上海集成电路基金的基金管理人上海集成电路产业投资基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1068675。

（三）大基金二期

1、基本信息

企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6
法定代表人	张新

注册资本	20,415,000 万元
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
成立日期	2019 年 10 月 22 日
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注：上述注册资本为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2019 年 10 月，设立

大基金二期总募集规模 2,041.50 亿元，由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、上海国盛（集团）有限公司、浙江富浙集成电路产业发展有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都天府国集投资有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京国谊医院有限公司、江苏聿泉集成电路产业投资有限公司、中移资本控股有限责任公司、安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）、福建省国资集成电路投资有限公司、深圳市深超科技投资有限公司、广州产业投资基金管理有限公司、黄埔投资控股（广州）有限公司、中国电信集团有限公司、联通资本投资控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）、福建三安集团有限公司、北京建广资产管理有限公司、协鑫资本管理有限公司、华芯投资管理有限责任公司共同发起，于 2019 年 10 月 22 日正式设立。

设立时，大基金二期的股东及其出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	中华人民共和国财政部	2,250,000.00	11.0213%
2	国开金融有限责任公司	2,200,000.00	10.7764%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
3	中国烟草总公司	1,500,000.00	7.3475%
4	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000.00	7.3475%
5	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000.00	7.3475%
6	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000.00	7.3475%
7	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	7.3475%
8	成都天府国集投资有限公司	1,500,000.00	7.3475%
9	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000.00	4.8984%
10	北京国谊医院有限公司	1,000,000.00	4.8984%
11	江苏聿泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000.00	4.8984%
12	中移资本控股有限责任公司	1,000,000.00	4.8984%
13	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
14	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
15	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000.00	1.4695%
16	深圳市深超科技投资有限公司	300,000.00	1.4695%
17	广州产业投资基金管理有限公司	300,000.00	1.4695%
18	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000.00	0.9797%
19	中国电信集团有限公司	150,000.00	0.7348%
20	联通资本投资控股有限公司	100,000.00	0.4898%
21	中国电子信息产业集团有限公司	50,000.00	0.2449%
22	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000.00	0.0490%
23	上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	0.0490%
24	福建三安集团有限公司	10,000.00	0.0490%
25	北京建广资产管理有限公司	10,000.00	0.0490%
26	协鑫资本管理有限公司	10,000.00	0.0490%
27	华芯投资管理有限责任公司	15,000.00	0.0735%
合计		20,415,000.00	100.0000%

（2）股东变更

2020 年 12 月，大基金二期召开股东大会，同意上海武岳峰浦江二期股权投

资合伙企业（有限合伙）与上海硅启企业管理合伙企业（有限合伙）完成股份转让后，对公司章程中的股东名称及附录联系方式进行修正。2022 年 12 月，大基金二期召开股东大会，同意根据中国电子信息产业集团有限公司将其持有的0.2449%股份（对应认股金 5.00 亿元）无偿划转至中电金投控股有限公司事宜对章程中记载股东信息进行修改。2022 年 12 月，大基金二期签署了章程修正案。2024 年 6 月，大基金二期召开股东大会，同意根据深圳市深超科技投资有限公司将其持有的 1.4695%股份（对应认股金 30.00 亿元）无偿划转至深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)事宜对章程中记载股东信息进行修改。**2025 年 11 月，大基金二期召开股东大会，审议通过关于引入广西投资引导基金有限责任公司（以下简称“广西引导基金”）并修正公司章程的提案，同意大基金二期引入广西投资引导基金作为公司股东，并完成涉及修改股东名册的章程修正案。**

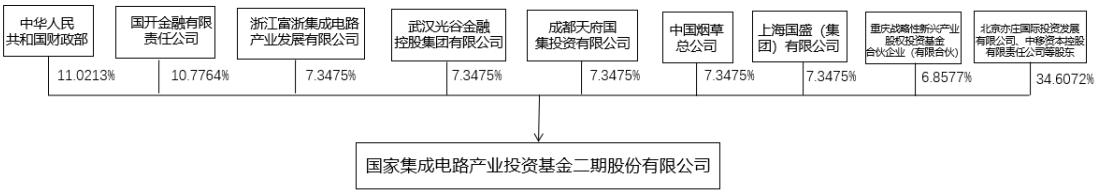
前述变更完成后，大基金二期的股东及其出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中华人民共和国财政部	2,250,000.00	11.0213%
2	国开金融有限责任公司	2,200,000.00	10.7764%
3	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000.00	7.3475%
4	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000.00	7.3475%
5	成都天府国集投资有限公司	1,500,000.00	7.3475%
6	中国烟草总公司	1,500,000.00	7.3475%
7	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000.00	7.3475%
8	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	**1,400,000.00**	**6.8577%**
9	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000.00	4.8984%
10	中移资本控股有限责任公司	1,000,000.00	4.8984%
11	北京国谊医院有限公司	1,000,000.00	4.8984%
12	江苏聿泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000.00	4.8984%
13	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%
14	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000.00	3.6738%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
15	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000.00	1.4695%
16	深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	300,000.00	1.4695%
17	广州产业投资基金管理有限公司	300,000.00	1.4695%
18	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000.00	0.9797%
19	中国电信集团有限公司	150,000.00	0.7348%
20	联通资本投资控股有限公司	100,000.00	0.4898%
21	**广西投资引导基金有限责任公司**	**100,000.00**	**0.4898%**
22	中电金投控股有限公司	50,000.00	0.2449%
23	华芯投资管理有限责任公司	15,000.00	0.0735%
24	福建三安集团有限公司	10,000.00	0.0490%
25	协鑫资本管理有限公司	10,000.00	0.0490%
26	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000.00	0.0490%
27	北京建广资产管理有限公司	10,000.00	0.0490%
28	上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	0.0490%
合计		**20,415,000.00**	**100.0000%**

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，大基金二期的产权控制结构图如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，大基金二期不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

4、主要股东及实际控制人情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，经查阅大基金二期的营业执照、公司章程等资料，并登录国家企业信用信息公示系统查询，大基金二期股权结构比较分散，任一单一股东无法对大基金二期的股东大会、董事会形成控制，且各股东之间无一致行

动关系，因此大基金二期无控股股东和实际控制人。

5、主营业务发展情况

大基金二期成立于 2019 年 10 月，系为促进集成电路产业发展设立的公司制私募股权基金，最近三年主营业务未发生变更。

6、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务数据

最近两年，大基金二期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	23,329,380.21	21,401,558.72
净资产	22,513,016.10	20,565,686.59
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	9,628.28	19,300.97

注： 上述财务数据均为未经审计的合并财务报表数据。

（2）最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
流动资产	23,329,367.18
非流动资产	13.03
资产总额	23,329,380.21
流动负债	1,306.96
非流动负债	815,057.15
负债总额	816,364.11
所有者权益	22,513,016.10

注：上述财务数据为未经审计的合并财务报表数据。

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度
营业收入	9,628.28
利润总额	-152,676.20

注：上述财务数据为未经审计的合并财务报表数据。

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	-29,942.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,139,092.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,103,493.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-65,541.97

注：上述财务数据为未经审计的合并财务报表数据。

7、主要对外投资情况

截至 2025 年 12 月 31 日，大基金二期持股比例 30%以上的主要对外投资情况如下：

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
1	华润润安科技（重庆）有限公司	38.04%	许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，电子元器件制造，电子元器件批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	杭州长川智能制造有限公司	33.33%	一般项目：半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

序号	企业名称	出资比例	经营范围/主营业务
3	润西微电子（重庆）有限公司	33.00%	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，科技中介服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	杭州富芯半导体有限公司	31.22%	一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车充电销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5	合肥沛顿存储科技有限公司	31.05%	半导体器件和晶圆开发、设计、封装和测试及制造服务；电子器件开发、组装、测试服务；电子产品销售及服务；向第三方（包括股东及其关联方）提供咨询、技术支持及技术服务；自营和代理各类货物或技术进出口服务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、是否属于私募基金及备案情况

大基金二期系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SJU890。大基金二期的基金管理人华芯投资管理有限责任公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1009674。

（四）国投先导基金

1、基本信息

名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADTAPYB6E
类型	有限合伙企业
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1699 号 28 层 02 单元

执行事务合伙人	上海国投先导私募基金管理有限公司
认缴出资额	4,500,100.00 万元
成立日期	2024 年 7 月 22 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：上述认缴出资额为截至 2025 年 **12 月 31 日**数据。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2024 年 7 月，设立

国投先导基金系由上海国投先导私募基金管理有限公司、上海国经投资发展有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、上海国有资本投资有限公司、上海汽车工业（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、海通创新证券投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、上海申能诚毅股权投资有限公司和上海国际信托有限公司共同投资组建的有限合伙企业，于 2024 年 7 月 22 日在上海市工商局登记注册，取得 91310000MADTAPYB6E 号企业法人营业执照。

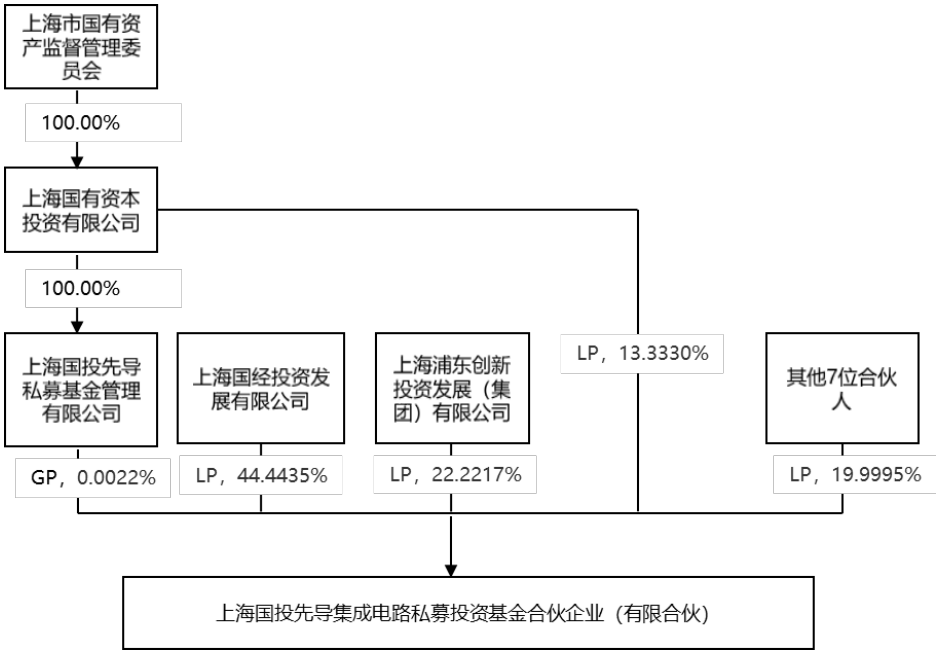
设立时，国投先导基金的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海国投先导私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.0022%
2	上海国经投资发展有限公司	有限合伙人	2,000,000.00	44.4435%
3	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	有限合伙人	1,000,000.00	22.2217%
4	上海国有资本投资有限公司	有限合伙人	600,000.00	13.3330%
5	上海汽车工业（集团）有限公司	有限合伙人	250,000.00	5.5554%
6	上海国际集团有限公司	有限合伙人	250,000.00	5.5554%
7	上海国盛（集团）有限公司	有限合伙人	200,000.00	4.4443%
8	海通创新证券投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%
9	国泰君安证裕投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%
10	上海申能诚毅股权投资有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
11	上海国际信托有限公司	有限合伙人	50,000.00	1.1111%
合计			**4,500,100.00**	**100.00%**

3、产权及控制关系

截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金产权控制关系如下：



截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

国投先导基金系在中国证券投资基金业协会备案的有限合伙型私募股权投资基金（产品备案编号：SAMQ44）。作为一家有限合伙企业，国投先导基金的合伙人来自财政资金出资平台、国有企业、证券公司另类子公司、上市公司等多元化出资主体，无单一持有合伙份额 50%及以上的合伙人，亦无通过一致行动协议实际行使半数以上合伙人大会表决权的合伙人。此外，虽然上海国投先导私募基金管理有限公司作为国投先导基金的基金管理人、执行事务合伙人，但上海国投先导私募基金管理有限公司并未在国投先导基金的投资决策委员会、顾问委员会中委派半数以上委员，亦不能够单方面决定投资决策委员会、顾问委员会的表决结果。

综上所述，国投先导基金无实际控制人。

4、执行事务合伙人基本情况

国投先导基金的执行事务合伙人为上海国投先导私募基金管理有限公司，截至 2025 年 **12 月 31 日**，其基本情况如下：

企业名称	上海国投先导私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路 1699 号第 28 层（实际楼层第 24 层）01 单元
法定代表人	温治
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000MADKU0K187
成立日期	2024 年 5 月 14 日
营业期限	2024 年 5 月 14 日至长期
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、穿透至最终出资人的情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金穿透至最终持有人情况如下：

层级	各层合伙人/出资人/股东	是否为最终持有人	最终持有人类型
1	上海国经投资发展有限公司	是	国有控股或管理主体
2	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
3	上海国有资本投资有限公司	是	国有控股或管理主体
4	上海国际集团有限公司	是	国有控股或管理主体
5	上海汽车工业（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
6	上海国盛（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
7	上海申能诚毅股权投资有限公司	-	-
7-1	申能（集团）有限公司	是	国有控股或管理主体
8	海通创新证券投资有限公司	-	-
8-1	国泰海通证券股份有限公司	是	上市公司

层级	各层合伙人/出资人/股东	是否为最终持有人	最终持有人类型
9	上海国际信托有限公司	-	-
9-1	上海浦东发展银行股份有限公司	是	上市公司
9-2	上海汽车集团股权投资有限公司	-	-
9-2-1	上海汽车集团股份有限公司	是	上市公司
9-3	上海新黄浦实业集团股份有限公司	是	上市公司
10	国泰君安证裕投资有限公司	-	-
10-1	国泰海通证券股份有限公司	是	上市公司
11	上海国投先导私募基金管理有限公司	-	-
11-1	上海国有资本投资有限公司	是	国有控股或管理主体

6、主营业务发展情况

国投先导基金主营业务为股权投资，成立以来主营业务未发生变化。

7、最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务数据

最近两年，国投先导基金主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	**2,205,956.15**	679,675.09
净资产	**2,206,214.09**	679,666.56
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	**-**	2,817.52
净利润	**137,400.26**	1,566.56

注：**2024 年**财务数据为经**审计的合并财务报表数据，2025 年财务数据为未经**审计的合并财务报表数据。

（2）最近一年简要财务报表

①简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
流动资产	2,205,956.15
非流动资产	-
资产总额	2,205,956.15
流动负债	-257.94
非流动负债	-
负债总额	-257.94
所有者权益	2,206,214.09

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

②简要合并利润表

单位：万元

项目	2025 年度
营业收入	-
利润总额	137,400.26
净利润	137,400.26

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

③简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度
经营活动产生的现金流量净额	252.86
投资活动产生的现金流量净额	-536,933.50
筹资活动产生的现金流量净额	720,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	183,319.36

注：上述财务数据为**未经**审计的合并财务报表数据。

8、主要对外投资情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，国投先导基金不存在持股比例 50%以上的对外投资。

9、是否属于私募基金及备案情况

国投先导基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管

理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为SAMQ44。国投先导基金的基金管理人上海国投先导私募基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为P1074817。

（五）其他事项说明

1、交易对方之间的关联关系及情况说明

截至本报告书签署日，交易对方之间不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（上证发〔2025〕60号）等项下的关联关系。

2、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事、高级管理人员情况

交易对方与上市公司的关联关系情况如下：

（1）上海华虹（集团）有限公司为上市公司间接控股股东；

（2）上海集成电路产业投资基金股份有限公司的原董事孙国栋同时担任上市公司董事。

除此之外，截至本报告书签署日，交易对方与上市公司之间不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（上证发〔2025〕60号）等项下的关联关系。

本次交易对方华虹集团系上市公司间接控股股东。截至本报告书签署日，上市公司现任董事白鹏、陈博、熊承艳由华虹集团推荐，上市公司高级管理人员均由上市公司董事会聘任。除此之外，本次交易对方不存在其他向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

3、交易对方及其主要负责人最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署日，交易对方及其主要负责人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况，也未涉及与经济纠纷有

关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、交易对方及其主要负责人最近五年的诚信情况

截至本报告书签署日，交易对方及其主要负责人最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

二、募集配套资金的交易对方

本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的同意注册文件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

第四节 标的公司基本情况

上市公司拟向华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金发行股份形式购买华力微 97.4988%股权，并通过子公司华虹宏力间接持有华力微 2.5012%股权，从而直接及间接合计持有华力微 100%股权，标的公司具体情况如下：

一、标的公司基本情况

公司名称	上海华力微电子有限公司
公司性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号
法定代表人	秦健
成立日期	2010 年 01 月 18 日
注册资本	2,036,192,198.06 元
统一社会信用代码	913100005500570876
经营范围	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、标的公司历史沿革

（一）历史沿革

1、2010 年 1 月，华力微设立

华力微系由上海联和投资有限公司、华虹集团、华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司共同出资于 2010 年 1 月 18 日设立，设立时的注册资本为 660,000 万元，其中，上海联和投资有限公司出资 450,000 万元，持有华力微 68.1817%的股权；华虹集团出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；华虹 NEC 出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；上海宏力半导体制造有限公司出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；首期由上海联和投资有限公司出资 200,000 万元，其余部分由上海联和投资有限公司和其他各方股东在 2 年内出资完成。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 13 日出具的中瑞岳华

沪验字[2010]第 004 号《验资报告》，截至 2010 年 1 月 13 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的首期注册资本 200,000 万元。

2010 年 1 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

华力微设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2	华虹集团	70,000	-	10.61
3	华虹 NEC	70,000	-	10.61
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	-	10.61
合计		**660,000**	**200,000**	**100.00**

2、2010 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 15 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1010 号《验资报告》，截至 2010 年 4 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第二期注册资本 35,000 万元。

2010 年 4 月 29 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2	华虹集团	70,000	-	10.61
3	华虹 NEC	70,000	-	10.61
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		**660,000**	**235,000**	**100.00**

3、2010 年 10 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 8 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1035 号《验资报告》，截至 2010 年 9 月 30 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第三期注册资本 100,000 万元。

2010 年 10 月 13 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	450,000	300,000	68.18
2	上海华虹（集团）有限公司	70,000	-	10.61
3	上海华虹 NEC 电子有限公司	70,000	-	10.61
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		**660,000**	**335,000**	**100.00**

4、2010 年 12 月第一次增资

2010 年 11 月 20 日，华力微股东会作出决议，同意华力微注册资本由 660,000 万元增至 790,000 万元，新增注册资本 130,000 万元由上海联和投资有限公司以 130,000 万元的价格认缴。

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 26 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1039 号《验资报告》，截至 2010 年 11 月 25 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第四期注册资本 58,083 万元。

2010 年 12 月 1 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	358,083	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86

3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**393,083**	**100.00**

5、2011 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 28 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1011 号《验资报告》，截至 2011 年 4 月 28 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第五期注册资本 127,550 万元。

2011 年 4 月 28 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	485,633	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86
3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**520,633**	**100.00**

6、2011 年 8 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 2 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1020 号《验资报告》，截至 2011 年 8 月 2 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第六期注册资本 71,917 万元。

2011 年 8 月 5 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	557,550	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86

3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**592,550**	**100.00**

7、2011 年 11 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1030 号《验资报告》，截至 2011 年 11 月 14 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第七期注册资本 22,450 万元。

2011 年 11 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹集团	70,000	-	8.86
3	华虹 NEC	70,000	-	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**615,000**	**100.00**

8、2012 年 1 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 16 日出具的沪立信佳诚验字（2012）第 1002 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 16 日，华力微已收到华虹集团和华虹 NEC 以货币缴纳的第八期注册资本 140,000 万元。

2012 年 1 月 17 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹集团	70,000	70,000	8.86

3	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**755,000**	**100.00**

9、2014 年 2 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2014 年 2 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2014）第 1001 号《验资报告》，截至 2014 年 2 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第九期注册资本 35,000 万元。

2014 年 2 月 19 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹集团	70,000	70,000	8.86
3	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	70,000	8.86
合计		**790,000**	**790,000**	**100.00**

10、2016 年 4 月股东变更

根据华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司于 2012 年 4 月 23 日签订的《上海华虹 NEC 电子有限公司与上海宏力半导体制造有限公司合并协议》，双方以新设合并方式设立公司，名称为“上海华虹宏力半导体制造有限公司”，合并后，华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司解散，其债权、债务全部由华虹宏力承继。据此，华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司持有的华力微股权均变更为由合并后的华虹宏力持有。

2016 年 4 月 7 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913100005500570876 的《营业执照》。

本次股东变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2	华虹宏力	140,000	140,000	17.72
3	华虹集团	70,000	70,000	8.86
合计		**790,000**	**790,000**	**100.00**

11、2016 年 12 月第二次增资

2016 年 11 月 18 日，华力微股东会作出《关于同意上海华力微电子有限公司增资的决议》，同意华力微注册资本由 790,000 万元增至 2,190,000 万元，其中上海联和投资有限公司以 520,000 万元的价格认缴新增注册资本 520,000 万元，上海集成电路产业基金以 880,000 万元的价格认缴新增注册资本 880,000 万元。

2016 年 12 月 14 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000055005708 76 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海联和投资有限公司	1,100,000	1,100,000	50.23
2	上海集成电路产业基金	880,000	880,000	40.18
3	华虹宏力	140,000	140,000	6.39
4	华虹集团	70,000	70,000	3.20
合计		**2,190,000**	**2,190,000**	**100.00**

12、2019 年 12 月第一次股权转让及第三次增资

2019 年 12 月 13 日，华力微股东会作出《关于上海华力微电子有限公司股权变更和增资的决议》，同意上海联和投资有限公司将其所持有的华力微 50.2283%股权（对应注册资本 1,100,000 万元）以 1,148,510 万元的价格转让给华虹集团；同意华力微注册资本由 2,190,000 万元增至 2,207,239.727995 万元，新增 17,239.727995 万元注册资本由华虹集团以 18,000.00 万元的价格进行认缴。

2019 年 12 月 25 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管

理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	华虹集团	1,187,239.727995	1,187,239.727995	53.79
2	上海集成电路产业基金	880,000	880,000	39.87
3	华虹宏力	140,000	140,000	6.34
合计		**2,207,239.727995**	**2,207,239.727995**	**100.00**

13、2023 年 11 月第四次增资

2023 年 11 月 18 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团，大基金二期。

2023 年 11 月 28 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例（%）
1	上海华虹（集团）有限公司	53.85
2	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	30.98
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	10.24
4	上海华虹宏力半导体制造有限公司	4.93
合计		**100.00**

14、2025 年 4 月第五次增资

2025 年 3 月 28 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团，国投先导基金，大基金二期。

2025 年 4 月 30 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例（%）

1	上海华虹（集团）有限公司	63.54
2	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	15.72
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	10.25
4	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）	7.98
5	上海华虹宏力半导体制造有限公司	2.50
合计		**100.00**

15、2025 年 8 月，华力微分立

2025 年 6 月 26 日，华力微股东会通过了《关于公司分立的决议》（沪华力微股（2025）第 4 号），同意华力微进行分立，分立基准日为 2024 年 11 月 30 日，分立后华力微继续存续，同时将华力微的长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定权利义务依法分出给新设公司；分立后，华力微的注册资本变更为 203,619.219806 万元，分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致，分立前的债务由分立后的华力微及新设公司承担连带责任。

2025 年 6 月 26 日，华力微于报纸发布了关于华力微分立事宜的公告。2025 年 6 月 27 日至 2025 年 7 月 4 日，华力微向债权人发出《债权人通知书》。

2025 年 8 月 21 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次分立完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	华虹集团	129,388.277164	129,388.277164	63.54
2	上海集成电路产业基金	32,012.074045	32,012.074045	15.72
3	大基金二期	20,871.634314	20,871.634314	10.25
4	国投先导基金	16,254.404321	16,254.404321	7.98
5	华虹宏力	5,092.829962	5,092.829962	2.50
合计		**203,619.219806**	**203,619.219806**	**100.00**

（二）股东出资及合法存续情况

华力微历次股权变更均依法履行了工商管理部门登记和备案手续。截至本报

告签署日，华力微为合法设立并有效存续的企业法人，主体资格合法、有效，现有股东合法持有华力微的股权。

（三）最近三年增减资、改制及评估情况

最近三年，标的公司共发生两次增资，未发生股权转让或改制情况，具体情况如下：

时间	事项	交易各方	交易内容	定价依据	评估情况	是否履行必要的审议和批准程序
2023年11月	增资	华虹集团、大基金二期	具体情况详见本节之“二、/（一）历史沿革”	以评估报告为依据，协商定价	根据东洲评估出具的《上海华力微电子有限公司拟进行非同比例增资涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第2214号）作为定价依据	是
2025年4月	增资	华虹集团、大基金二期、国投先导基金	具体情况详见本节之“二、/（一）历史沿革”	以评估报告为依据，协商定价	根据东洲评估出具的《上海华力微电子有限公司拟进行非同比例增资所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第2784号）作为定价依据	是

（四）最近三年申请首次公开发行股票并上市或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况

最近三年内，标的公司不存在首次公开发行股票并上市的情况，且不存在作为上市公司重大资产重组交易标的的情况。

三、标的公司产权结构及控制关系

（一）股权结构

截至本报告签署日，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	华虹集团	1,293,882,771.64	63.5443%
2	上海集成电路基金	320,120,740.45	15.7215%
3	大基金二期	208,716,343.14	10.2503%
4	国投先导基金	162,544,043.21	7.9827%
5	华虹宏力	50,928,299.62	2.5012%
合计		**2,036,192,198.06**	**100.0000%**

截至本报告签署日，华虹集团持有华力微 63.5443%的股权，系华力微的控股股东，上海市国资委为标的公司实际控制人。

（二）标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排、是否存在影响资产独立性的协议或其他安排

截至本报告签署日，标的公司《公司章程》不存在可能对本次交易产生影响的内容，不存在对本次交易产生影响的相关投资协议，不存在可能对本次交易产生影响的设置或高级管理人员安排，亦不存在其他影响其资产独立性的协议或其他安排。

四、标的公司下属企业情况

截至本报告签署日，标的公司无下属企业。

五、标的公司主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况

（一）主要资产

1、主要固定资产

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司的固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产	账面原值	账面净值	成新率
厂务设施	**126,490.91**	**7,479.04**	**5.91%**
机器设备	**1,396,912.40**	**138,499.70**	**9.91%**
工具器具	**1,206.80**	**236.94**	**19.63%**

电脑通讯设备	**20,207.23**	**1,642.42**	**8.13%**
办公设备	**94.00**	**15.43**	**16.42%**
运输设备	**72.33**	**23.77**	**32.86%**
合计	**1,544,983.66**	**147,897.29**	**9.57%**

截至 2025 年 12 月 31 日，标的公司无自有房屋建筑物，主要经营性租赁物业情况如下：

出租方	租赁地址	租赁面积	租赁期限	用途
华虹宏力	上海市浦东新区张江高科技园区 13 街坊 2 丘厂房	91,563.11 平方米	2010 年 3 月 1 日至 2030 年 2 月 28 日	厂房
		化学品仓库、动力厂房和生产厂房	自验收合格交付之日起 20 年	
		192 平方米	2021 年 6 月 1 日至 **2026** 年 12 月 31 日	厂房

华力微以租赁方式使用上述房屋不违反法律、行政法规的强制性规定。

2、主要无形资产

公司生产经营所使用的无形资产主要包括专利权、IP 授权。

（1）专利权

截至 2025 年 **12 月 31 日**，华力微共拥有 **1,933** 项境内已授权专利，**148** 项境外已授权专利，具体情况详见重组报告书附件一表 1、2。

（2）IP 授权

华力微通过与第三方 IP 供应商的合作，为客户提供不同种类的标准单元库、存储器编译器和其他 IP 类型。截至 2025 年 **12 月 31 日**，华力微获得的 IP 授权主要类型包括标准单元库、可编程存储类 IP、嵌入式非易失性存储 IP 及模拟、接口 IP 等。

（二）主要负债及或有负债情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，华力微主要负债情况如下：

单位：万元、%

项目	金额	占比
应付账款	**71,583.60**	**16.37**

项目	金额	占比
合同负债	10,571.94	2.42
应付职工薪酬	9,811.54	2.24
应交税费	378.46	0.09
其他应付款	7,888.69	1.80
一年内到期的非流动负债	56,308.32	12.88
其他流动负债	1,196.00	0.27
流动负债	157,738.56	36.08
长期借款	247,225.00	56.54
租赁负债	30,528.01	6.98
预计负债	127.56	0.03
递延收益	1,611.00	0.37
非流动负债	279,491.57	63.92
合计	437,230.13	100.00

1、主要负债情况

截至 2025 年 **12 月 31 日，**标的公司主要负债为长期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。

2、或有负债情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司不存在或有负债的情况。

（三）对外担保情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司不存在对外担保情况。

（四）资产的权利限制情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司抵押借款具体情况如下：

借款合同编号	借款人	贷款人	借款金额（万元）	借款期限	借款用途	借款利率	担保情况
3100201606100000054、3100201606100	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；	300,000.00	2016 年 8 月 4 日-2026 年 8 月 3 日	产线建设	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 152,243.77 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保

00054001		受托贷款人：国家开发银行股份有限公司					
310020150610000015、310020150610000001501	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	100,000.00	2015 年 11 月 24 日-2030 年 11 月 23 日	产线投建	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 116,263.96 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保
310020230110000 2961	华力微	国家开发银行上海市分行、交通银行股份有限公司上海新区支行、上海银行股份有限公司徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行	96,000.00	2023 年 2 月-2031 年 2 月	研发	3%	华力微以评估值合计 29,052.85 万元的设备向贷款人提供抵押担保

（五）标的资产其他情况

1、是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况或者存在妨碍权属转移的其他情况

本次交易标的是华力微 97.4988%股权，截至本报告签署日，标的公司不涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

2、行政处罚或刑事处罚情况

报告期内，标的公司不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚或刑事处罚的情形。

3、被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况

截至本报告签署日，标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

4、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关事项

本次交易不涉及其他立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等相关报批事项。

5、债权债务转移情况

本次交易完成后，标的公司仍作为独立存续的法人主体开展经营活动，所涉及的债权债务仍由标的公司承担，不涉及标的公司债权债务转移的情况。

6、涉及土地使用权、矿业权等资源类权利的说明

截至本报告签署日，标的公司不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利。

7、交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况

截至本报告签署日，华力微不存在许可他人使用自己重要资产的情况。除被授权使用 IP 核等专有技术外，不存在作为被许可方使用他人资产的情况。

六、标的公司主营业务情况

（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、所处行业的行业主管部门及监管体制

标的公司主要从事半导体晶圆代工业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所处行业为第四条（一）中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。

公司所处行业的主管部门为工信部，主要职责为：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优

化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

中国半导体行业协会是半导体行业的主要自律组织和协调机构，其主要职责包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；调查、研究、预测本行业产业与市场，汇集企业要求，反映行业发展呼声；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等任务。

2、主要法律法规政策及产业政策

半导体行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台各类法规政策，规范产业发展，鼓励产业成长。

半导体行业近期涉及的主要法律、法规和规范性文件如下：

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
1	2020 年	国务院	《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件产业诸多优惠政策。明确在一定时期内，集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产企业）进口自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零配件，免征进口关税。
2	2021 年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
3	2021 年	发改委	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路	享受税收优惠政策的企业条件和项目标准为集成电路线宽小于 65

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
			企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413 号）	纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业。
4	2022 年	发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局	《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2022〕390 号）	2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。
5	2023 年	发改委	《产业结构调整指导目录》（2024 本）	将“新型电子元器件：片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件”等纳入鼓励级
6	2025 年	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》	2025－2026 年，主要预期目标是：规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到 5%以上。到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4000 亿元，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进。

（二）主要产品及用途情况

1、主营业务情况

华力微以逻辑工艺为基础，同时深耕特色工艺，为设计公司、IDM 公司和其他系统公司提供包括逻辑与射频、嵌入式/独立式非易失性存储器、高压等多元化工艺平台的晶圆代工及配套服务。

华力微在半导体制造领域拥有超过 15 年的技术积累，长期坚持自主创新，不断研发并掌握了特色工艺的关键核心技术，目前拥有中国大陆第一条全自动 12 英寸集成电路 Foundry 生产线，工艺水平达到 65/55nm、40nm 技术等级，设计产能 3.8 万片/月。

华力微广泛的工艺组合为客户提供完整的技术解决方案，应用于通信、消费电子等终端产品市场，生产的芯片产品涵盖基带处理器、图像传感器、中小尺寸液晶屏驱动芯片、触控屏控制器、触控和显示驱动二合一芯片、无线连接射频、微处理器、智能卡、机顶盒集成芯片、电源管理芯片等。

2、主要产品及服务

报告期内，标的公司为客户提供的产品及服务未发生变化，主要向客户提供 12 英寸晶圆的特色工艺代工服务，在不同工艺平台上，按照客户需求为其制造多种类的半导体产品；同时为客户提供包括设计、测试等配套服务。

（1）晶圆代工服务

华力微紧密围绕市场需求，立足成熟技术节点与特色工艺平台，通过集中优势研发力量进行针对性攻关，持续深化与拓展其技术平台。通过多年不断地技术积累，现已涵盖逻辑与射频、嵌入式/独立式存储器、高压等多元化工艺平台。

1）逻辑与射频

华力微依托自身成熟的 55nm 逻辑工艺技术与量产经验，成功自主研发了 55nm 超低功耗工艺技术。该技术作为实现物联网与可穿戴设备芯片制造的关键，通过与国际领先的集成电路设计公司合作，重点优化了器件工作电压与漏电流控制，并开发出超高阈值电压器件，从而快速完成了工艺认证并实现量产出货。此项自主创新技术平台的建立，不仅助力华力微在超低功耗领域抢占市场先机，切入物联网与可穿戴设备市场，更以此为基点，向 40nm 技术节点延伸，成功开发了 40nm 低功耗逻辑平台及成套生产工艺。该平台采用超浅结、激光退火与多孔超低介电常数材料等先进技术，在性能与功耗之间实现优异平衡，并已进入量产阶段。平台不仅通过 Grade1 汽车电子级认证，助力公司获得 IATF16949 体系认证，更具备完善的设计环境，可支持丰富的单元库与 IP，多款产品已通过大规模量产验证，性能表现卓越。自 2015 年 3 月首批产品出货以来，华力微在汽车电子、数字电视、视频监控、蓝牙耳机等领域持续拓展，并于 2019 年实现射频工艺平台量产。

华力微依托 55nm 低功耗逻辑平台，像素工艺采用与客户合作开发的方式，

2013 年成功打造了 55nmCIS 平台并成功导入首颗 CIS 手机类产品，2014 年起手机类产品开始规模量产。后续几年间华力微不断拓展 CIS 应用范围，成功开发了安监类、医疗类等产品。尤其是近 3 年，近红外监控、0.7 微米极小像素类等产品的开发和量产，使得华力微 CIS 应用进一步拓宽，范围涵盖旗舰手机前摄、PC、高端安防、指纹识别、车载等诸多领域。

2）嵌入式/独立式存储器

华力微基于自主开发的 55nm 低功耗平台，构建了 55nm 嵌入式闪存平台，通过引入 SONOS 工艺并优化 2T+SONOS 结构，显着提升了能效表现与工作灵活性，增强了系统兼容性并有效控制了成本。作为华力微的特色工艺，55nm 嵌入式闪存平台建立了完整的 SPICE 模型与 PDK，具备完善的设计数据库与 IP 资源，能够充分满足客户的多元化需求。相较于传统合封 MCU 方案，55nm 嵌入式闪存平台所实现的 MCU 类产品在工艺复杂度、成本结构及系统兼容性方面均表现出显着优势，具备更强的市场竞争力。目前，该平台主要聚焦于 MCU 类产品的工艺开发与性能提升，相关产品已广泛应用于消费电子、智能家居及工业控制等领域。

自 2017 年实现 55nmSONOS 存储技术大规模量产以来，华力微持续推进技术迭代，并于 2020 年成功突破 40nmSONOS 存储技术。55nmSONOS 技术具备低成本、低功耗与高可靠性等核心优势，产品覆盖低功耗存储、触控、高速 MCU、嵌入式 FPGA、智能卡、安全芯片及 NB-IOT 等多个领域，对我国实现信息安全和产业技术升级具有重要战略意义。

3）高压

华力微 55nm 高压工艺平台基于成熟的 55nm 低功耗平台构建，通过工艺流程架构的优化，成功集成了 1.2V 低压、5V/6V/8V 中压以及 32V 高压三类器件。这些器件在电气特性上相互独立，互不制约，可分别进行灵活调试，为不同系列产品的研发提供了充分的设计空间。该平台集成度高，能够全面满足液晶驱动芯片设计的多样化需求，性能达到业界领先水平。

基于此 55nm 高压平台，华力微成功开发了全国产 OLED 及其他全系列应用

驱动芯片。通过与国内设计公司及知名面板厂商的紧密合作，华力微有效支持了本土设计企业的发展，共同构建了全系列驱动芯片完整产业链。依托驱动芯片市场的广阔前景以及华力微扎实的制造基础，该平台形成了具有自主知识产权的技术体系，可满足从低端到高端各类终端应用的需求，为“物联网”建设的持续推进提供了坚实支撑。

（2）配套服务

1）多元化设计服务

华力微建立了较为完善的设计服务支持平台，包括流片支持、内部 IP 设计、版图及验证、失效分析、测试设计等，能够为设计公司提供良好的设计流程、技术文件、IP 开发等必不可少的支持，为客户量产提供高效高质量的服务工作。

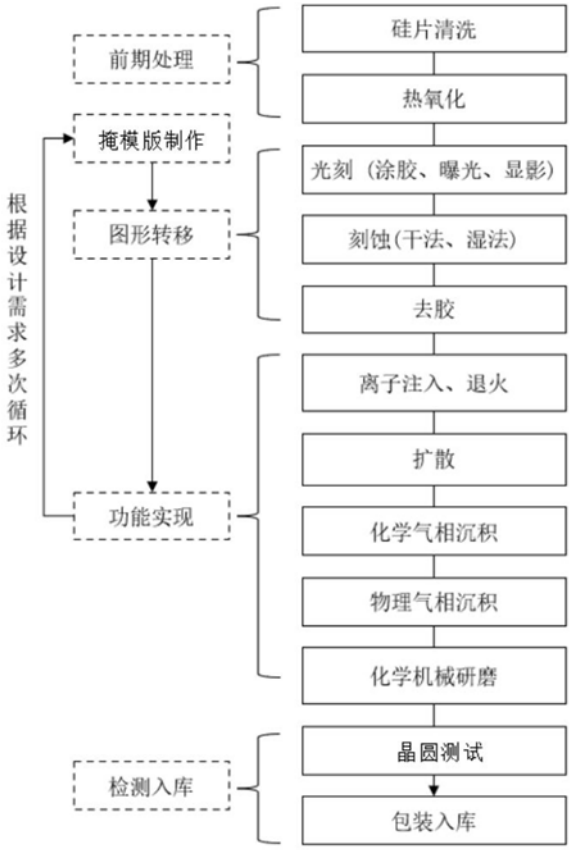
2）测试服务

华力微打造了一整套先进的测试、评估、分析平台，建设了涵盖产品工程、测试工程、可靠性工程、失效分析等精密设备硬件基础，为客户提供一站式设计验证、测试开发、电性物性分析、良率提升等配套服务。

（三）主要产品的工艺流程

1、主要产品工艺流程图

标的公司主要以晶圆代工模式从事半导体制造业务，一般性工艺流程如下：



2、工艺流程介绍

（1）前期处理

①硅片清洗

使用喷淋或沉浸的方式，先用多种化学品对半导体硅片进行清洗，再用超纯水对半导体硅片进行二次清洗去除残留的化学液。清洗工序的目的是去除半导体硅片表面的尘埃颗粒、残留有机物、表面金属离子等杂质，提高后续生长热氧化层的质量，保证后续工艺的稳定性（后续每步操作后亦有清洗工序）。

②热氧化

在高温氧气和惰性气体的环境下，在半导体硅片表面生成二氧化硅薄膜。

（2）掩模版制作

掩模版由其他专业厂商生产，标的公司当前不涉及掩模版制造业务。

（3）图形转移

①光刻

光刻主要由涂胶、曝光和显影三个步骤组成：A 涂胶：将光刻胶均匀地涂布在旋转的半导体硅片上；B 曝光：利用光刻机，通过特定波长的光线的照射，改变光刻胶的性质，将光掩模版上的电路图形转移到光刻胶上；C 显影：利用显影液，去除曝光后光刻胶中的可溶解部分，准确地使光刻胶上形成图形。

②刻蚀

刻蚀是在光刻后，有选择性地去除半导体硅片上未被光刻胶覆盖区域的材料。常见的刻蚀方法包括湿法刻蚀和干法刻蚀，其中：湿法刻蚀使用液态化学品进行刻蚀，干法刻蚀利用等离子体进行刻蚀。

③去胶

刻蚀完成后，去除半导体硅片上未被溶解的光刻胶。

（4）器件结构形成与功能实现

①离子注入、退火

在真空、低温的环境下，将特定种类的杂质离子以高能离子束的形式植入晶圆表面的特定区域，常见的离子元素种类包括硼、磷、砷等。离子注入后，在高温环境下消除离子注入导致的晶格缺陷，改变晶圆表面及内部的微观结构，以实现特定性能。

②扩散

在高温环境下，使杂质离子在不同离子浓度的区域间发生转移，改变和控制晶圆内杂质的类型、浓度和分布，形成不同电特性的区域，改变晶圆的电特性。

③化学气相沉积

利用不同分压的气态化学原材料在晶圆表面发生化学反应，并在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

④物理气相沉积

利用溅射镀膜、真空蒸发、离子体镀膜、分子束外延等物理方法，轰击靶材，

在晶圆表面沉积一层固态薄膜。

⑤化学机械研磨

利用机械摩擦和化学反应对晶圆进行抛光，使晶圆表面平坦化。

（5）检测入库

①晶圆测试

晶圆加工完成后，使用探针等检测设备对晶圆性能进行测试，验证其功能是否符合工艺平台的规格要求。

②包装入库

将检测合格的晶圆真空包装后入库。

（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式

1、采购模式

标的公司制定《采购审批制度》《采购管理规程》等制度规范采购行为，建立完善的采购管理体系和规程。标的公司采购活动，均按照年度预算的要求，由需求部门或主管部门根据实际的投资需求、运营需求，以请购单方式提出并经过审批，其中，生产用原材料和备件的请购由生产计划部物料控制科根据生产计划、库存量和交货期等提出。

生产计划部采购科收到请购需求后，核对请购单准确性，确认无误后依据采购需求开展采购活动。华力微根据不同采购类别确定恰当的采购方式和标准，依法开展招标采购活动与直接采购活动，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，达到科学、择优的采购目的，保证采购质量，提高经济效益，最大限度降低综合采购成本，所有采购行为均依据公司制度由相应的采购审批机构进行审批。

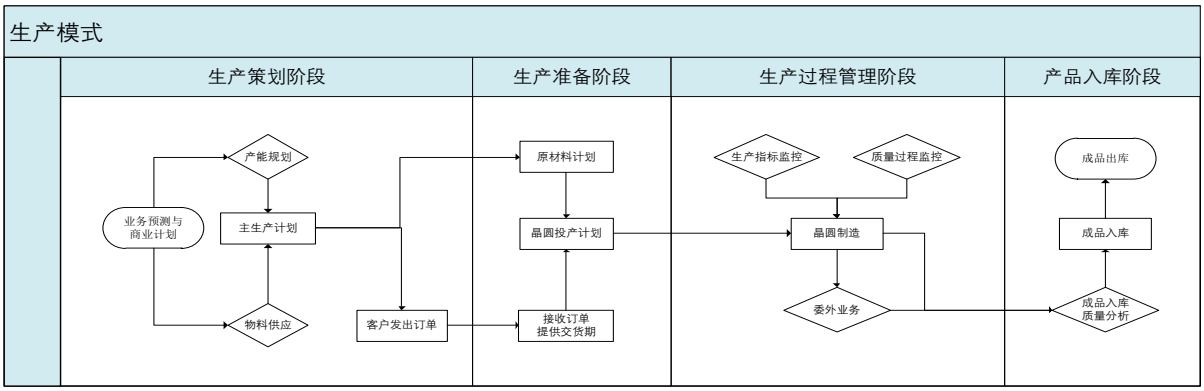
生产计划部采购科与供应商签署采购订单并跟踪交期，物流科负责运输、报关工作，仓储科负责来料的接收、存储工作，品质与可靠性部负责原材料的质量检验工作，固定资产、无形资产、服务等由用户部门进行检查、验收。各部门通力协作开展多元化、国产化工作，不断导入备选供应商，健全供应链体系，针对

关键物料的供应风险进行评估并制定相应对策，降低采购风险，以保持业务连续性。

2、生产模式

标的公司根据销售预测规划产能并确定主生产计划（即生产计划，依据市场预测与产能情况规划产品生产计划），按客户订单需求进行投产，产品从生产策划到成品出库主要经过四个阶段，分别为生产策划阶段、生产准备阶段、生产过程管理阶段以及产品入库阶段，具体流程如下：

（1）生产策划阶段



在生产策划阶段，销售部提供从客户处获取的未来的业务预测以及与客户达成的商业计划，生产计划部按照业务预测以及产能规划，根据客户需求、客户订单、产能、原材料供应情况和工艺技术准备情况，制定主生产计划。

（2）生产准备阶段

在生产准备阶段，物料控制科根据主生产计划制定原材料计划并协同采购及时准备原材料。生产计划部根据主生产计划及原材料计划制定投产计划。

（3）生产过程管理阶段

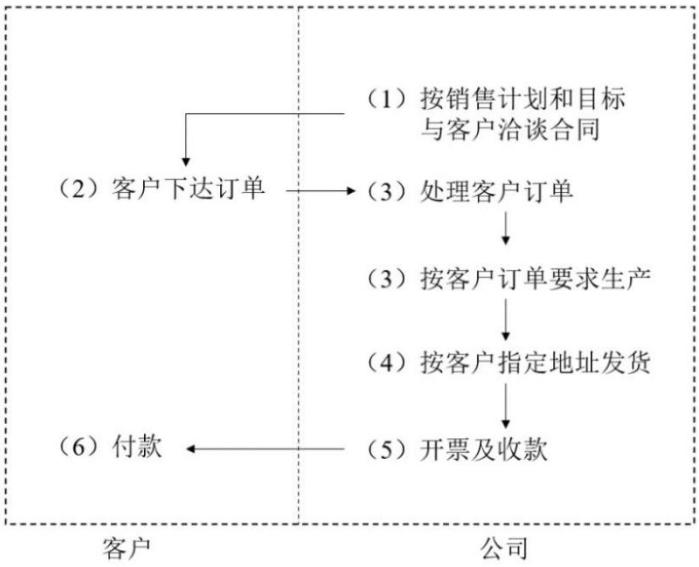
在生产过程管理阶段，制造部根据主生产计划及投产计划安排和管理晶圆生产，生产计划部监督生产周期、生产进度，产量等指标，品质与可靠性部负责产品的质量管控。生产计划部根据客户委外业务需求，安排晶圆相应委外业务。

（4）产品入库阶段

在产品入库阶段，完成全部生产流程的产品经检验合格后入库。

3、销售及结算模式

标的公司采用直销模式开展销售业务，与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案，最终达成与客户签订订单。销售流程如下：



（1）制定销售计划

销售部门基于市场信息与客户需求拟订公司年度销售计划后，销售部门按照计划目标和客户沟通，并定期更新客户需求预测和情况，将客户需求的变化反馈回公司相关部门。

（2）签订合同和处理订单

与客户签订合同，达成业务关系后，销售人员根据客户需求将公司主管核准的报价单提供给客户，客户通过邮件或传真等方式向销售人员/客户服务人员下达订单，客户服务人员将订单下达到内部进行生产，并反馈预计交货时间给客户。

（3）生产制造

销售部门收到客户订单后按业务计划安排生产，生产计划部根据此业务计划结合产能情况制定相应的投入和产出计划并生成产品交货日期，公司根据客户的要求通过系统或邮件的方式及时告知客户产品的生产状态。

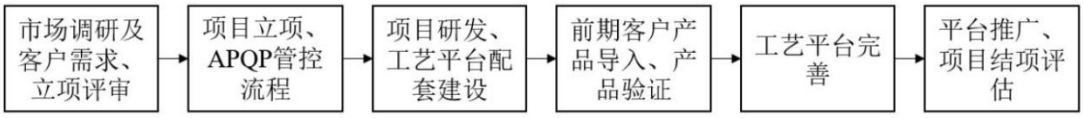
（4）发货与收款开票

产品生产完毕后通常由客户服务人员根据客户要求安排发货至指定地点或

客户上门提货。客户依据协议的付款周期安排付款，财务部在收到客户的付款后，进行财务复核并完成相关账务处理。

4、研发模式

标的公司的研发策略主要依靠自主研发对各类工艺平台进行技术创新与升级。公司为规范并加强项目运行过程的管理，建立了较为完善的研发体系及项目管理流程，明确项目组成员职责及目标，从项目的立项、研发及结案全过程进行规范，并通过新项目立项申请流程、产品质量先期策划规程等进行分阶段、系统性管理。公司的具体研发流程如下：



注：APQP 指 Advanced Product Quality Program，即产品质量先期策划。

5、盈利模式

公司主要从事基于不同工艺节点、不同技术的工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务从而实现收入和利润。

（五）主要产品生产及销售情况

1、主要产品的产能、产量、销量情况

报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

单位：万片

项目	2025 年度	2024 年度
产能	45.60	45.60
产量	**46.82**	42.82
产能利用率	**102.68%**	93.89%
销量	**50.80**	47.94
产销率	**108.50%**	111.98%

注 1：产能、产量、销量按照 12 英寸统计，下同。

2、主要产品价格情况

报告期内，公司主要产品为晶圆，价格情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度
晶圆代工销售收入（万元）	486,616.87	427,226.82
销售数量（万片）	50.80	47.94
平均销售单价（元/片）	9,578.88	8,910.88

2025 年度销售单价较 2024 年度有所提升，主要系随着半导体市场逐步复苏，整体价格逐步调整上涨，2025 年度标的公司的平均销售价格相对较高。

3、主要产品及服务销售收入情况

报告期内，标的公司向客户提供多工艺平台的晶圆代工服务。标的公司按照工艺平台分类的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
逻辑与射频	318,956.69	63.01%	276,767.85	61.79%
独立式非易失性存储器	82,205.81	16.24%	65,732.64	14.68%
高压	48,858.69	9.65%	52,954.99	11.82%
嵌入式非易失性存储器	36,595.69	7.23%	31,771.34	7.09%
其他	19,571.89	3.87%	20,685.64	4.62%
合计	506,188.77	100.00%	447,912.46	100.00%

4、报告期内前五大客户销售情况

报告期内，标的公司的前五大客户情况如下：

单位：万元

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2025 年度	1	客户 A	123,973.29	24.30%
	2	客户 B	116,671.86	22.87%
	3	客户 C	87,497.76	17.15%
	4	客户 D	24,159.44	4.74%
	5	华虹集团	23,112.24	4.53%
	合计		375,414.59	73.59%
2024 年度	1	客户 A	127,858.15	25.63%

期间	序号	客户名称	销售收入	占营业收入比例
	2	客户 B	**91,370.45**	18.32%
	3	华虹集团	**77,183.93**	**15.47%**
	4	客户 C	74,730.06	14.98%
	5	客户 F	18,805.10	3.77%
	合计		**389,947.69**	**78.18%**

注：客户按最终控制方合并计算及列示。

报告期内，标的公司不存在向单个客户销售比例超过当年销售总额 50%的情况。

截至本报告签署日，除受华虹集团控制的客户外，标的公司的董事、高级管理人员和核心技术人员、交易对方在上述客户中不存在持有 5%以上股份的情况。

（六）主要原材料、能源采购及供应情况

1、主要原材料采购情况

（1）主要材料采购情况

报告期内，标的公司生产经营所需的原材料主要包括硅片、化学品、气体、靶材等，主要原材料采购情况如下：

种类	项目	2025 年度	2024 年度
硅片	数量（万片）	**62.04**	44.85
	金额（万元）	**47,697.79**	37,765.22
	单价（元/片）	**768.85**	841.99
光刻类化学品	数量（L）	**1,144,682.15**	1,142,434.00
	金额（万元）	**31,435.96**	30,711.77
	单价（元/L）	**274.63**	268.83
化学品	数量（吨）	**14,299.73**	14,163.75
	金额（万元）	**17,166.45**	20,564.07
	单价（万元/吨）	**1.20**	1.45
研磨垫和研磨盘	数量（个）	**25,605.00**	30,603.00
	金额（万元）	**5,650.22**	8,685.62
	单价（万元/个）	**0.22**	0.28

种类	项目	2025 年度	2024 年度
大宗气体	数量（万立方米）	**13,254.82**	13,089.74
	金额（万元）	**7,490.96**	7,672.87
	单价（元/立方米）	**0.57**	0.59

注 1：列示的硅片为用于生产晶圆的硅片；
注 2：硅片、靶材单价按照 12 英寸统计

（2）主要材料价格变动情况

报告期内，标的公司主要原材料和能源的平均采购价格的变动情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度
	平均采购单价	变动幅度	平均采购单价
硅片（元/片）	**768.85**	**-8.69%**	841.99
光刻类化学品（元/L）	**274.63**	**2.16%**	268.83
化学品（万元/吨）	**1.20**	**-17.24%**	1.45
研磨垫和研磨盘（万元/个）	**0.22**	**-21.43%**	0.28
大宗气体（元/立方米）	**0.57**	**-3.39%**	0.59

报告期内，标的公司硅片采购单价逐年下降，主要系上游供应商产能扩张，市场供应量增加，市场价格逐年下降。

光刻类化学品价格等原材料均属于较为常见的半导体材料，其价格随市场供需情况波动。

2、主要能源供应情况

报告期内，标的公司生产经营所需的能源主要为电、天然气和水：

种类	项目	2025 年度	2024 年度
电	数量（万度）	**26,239.11**	25,964.96
	金额（万元）	**16,441.46**	16,496.24
	单价（元/度）	**0.63**	0.64
天然气	数量（万立方米）	**387.18**	418.40
	金额（万元）	**1,606.18**	1,678.83
	单价（元/立方米）	**4.15**	4.01
水	数量（万吨）	**281.09**	280.48

种类	项目	2025 年度	2024 年度
	金额（万元）	**1,657.34**	1,653.77
	单价（元/吨）	**5.90**	5.90

报告期内，主要能源采购单价变动较小，**变动**系因市场价格波动所致。

3、报告期内前五大原材料及备品备件供应商采购情况

报告期内，标的公司前五大原材料及备品备件供应商情况如下：

单位：万元

序号	供应商	主要采购内容	金额	占比
2025 年度				
1	**供应商 A**	**硅片、研磨液、光刻类化学品**	**25,609.47**	**14.24%**
2	**供应商 B**	**硅片**	**18,602.30**	**10.35%**
3	**供应商 C**	**光刻类化学品、研磨液、研磨垫和研磨盘**	**12,230.93**	**6.80%**
4	**供应商 D**	**硅片**	**8,196.44**	**4.56%**
5	**供应商 E**	**光刻类化学品、化学品等**	**7,362.55**	**4.10%**
合计			**72,001.69**	**40.05%**
2024 年度				
1	供应商 A	硅片、研磨液、光刻类化学品	24,020.25	13.54%
2	供应商 C	光刻类化学品、研磨液、研磨垫和研磨盘	15,859.66	8.94%
3	供应商 B	硅片	14,965.19	8.44%
4	供应商 E	光刻类化学品、化学品等	8,417.91	4.75%
5	供应商 F	备品备件	7,616.96	4.30%
合计			**70,879.97**	**39.97%**

注：供应商按最终控制方合并计算并列示。

报告期内，标的公司不存在向单个供应商采购比例超过当年采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。

截至本报告签署日，标的公司的董事、高级管理人员和核心技术人员、交易对方不存在控制上述供应商的情况。

（七）境外生产情况

报告期内，标的公司不存在在境外生产经营的情况。

（八）安全生产和环境保护情况

1、安全生产情况

报告期内，标的公司严格遵守国家有关安全生产方面的法律、法规、规章及其他规范性文件规定，建立并严格执行《华力安全生产责任制管理程序》《上海华力安全检查和隐患排查量化管理规程》《上海华力微电子有限公司生产安全事故应急救援综合预案》等制度。截至本报告签署日，标的公司不存在因违反安全生产方面的法律、法规、规章及其他规范性文件规定而受到行政处罚的情形。未来，标的公司还将根据生产经营需要继续加大安全生产方面的投入。

2、环境保护情况

公司生产经营涉及的主要污染物包括废水、废气和固体废物。废水主要包括工艺设备产生的酸碱废水、含氟废水、含氨废水、有机废水、无机回收水、有机回收水、研废水、含铜废水，设备自带特气处理装置排水，工艺冷却水排水，空调洗净及冷凝水，纯水制备排水，循环冷却塔排水，酸性废气洗涤塔排水、碱性废气洗涤塔排水、酸性粉尘废气洗涤塔排水以及生活污水等；废气主要包括工艺酸性废气、碱性废气、有机废气、特殊气体工艺尾气、酸性粉尘废气、锅炉烟气、化学品供应废气、污水处理区废气等，固体废物主要包括危险废物、一般固废和生活垃圾。

报告期内，标的公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护的相关法律法规。标的公司已建立完善的环境保护内控管理制度，在生产环节已避免产品对环境的影响，在生产过程根据环保要求配置了相应的环保设施并采取了必要的控制措施。

标的公司主要废水处理设施包括一般废水处理系统有机废水处理系统、含氟废水处理系统、高浓度含氨废水处理系统、低浓度含氨废水处理系统研磨废水处理系统、含铜废水处理系统、浓水回收系统、有机回收水系统、无机回收水系统等；主要废气处理设施包括酸性废气处理系统碱性废气处理系统、有机废气处理系统、特殊工艺废气处理系统、酸性粉尘废气处理系统等。对于固废，生活垃圾

统一收集，暂存于单独设置的垃圾箱内，由环卫部门定期清运；危险废物，分类贮存于专用容器中，放置于独立的危险废物暂存间、废化学品空桶暂存区、专用废液储罐内，建立危险废物管理台账，及时委托有资质的危险废物经营单位进行处理处置，并严格执行转移联单制度；一般工业固废，放置于独立的一般固废暂存间内，委托具有资质的物资回收公司利用或由供应商定期回收。报告期内，上述环保设施、控制设施正常运行，生产过程中产生的废水、废气、噪声能够达到国家相关排放标准。

报告期内，标的公司不存在因违反安全和环境保护相关法律法规而被相关主管部门处以重大行政处罚的情形。公司生产经营符合国家和地方安全和环保要求。

（九）主要产品和服务的质量控制情况

1、质量控制标准

标的公司建立了完善的产品质量控制体系，已经通过的质量管理体系认证情况如下：

序号	认证标准	证书编号	有效期
1	IATF 16949:2016	209667-2016-AQ-RGC-IATF	2023-12-20 至 2026-12-19
2	GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	107019-2011-AQ-RGC-UKAS	2023-12-2 至 2026-12-1

2、质量控制措施

华力微根据 IATF 16949:2016、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 等质量管理体系相关要求制定了详细的质量控制制度，对产品生产和销售全过程实施严格的质量控制。华力微的控制措施覆盖了生产、采购、销售、研发等各个环节，涵盖了经营过程中的主要部门，通过多部门的有力协作和互相监督有效的确保了产品的质量控制。

3、质量纠纷情况

报告内，华力微持续优化各项流程，获得了客户的广泛认可，不存在因质量方面问题而导致重大纠纷或因质量方面的违法行为而受到过行政处罚的情形。

（十）核心技术及核心技术保护情况

1、主要产品生产技术阶段及使用核心技术情况

标的公司以自身发展战略与竞争优势为依托，经过长期技术积累与工艺迭代，在主要业务领域形成并掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术。标的公司核心技术来源主要通过自主研发，由自身研发团队进行研发与创新，对工艺流程及参数指标进行优化，形成了标的公司现有核心技术平台。

其中，标的公司在逻辑与射频、独立式/嵌入式非易失性存储器、高压等领域的多项核心技术达到国内领先或国际领先水平，并已大量应用于标的公司产品的批量生产中。

截至 2025 年 **12 月 31 日**，标的公司的主要核心技术平台情况如下：

序号	工艺平台	制程范围及核心技术平台	技术工艺特征及先进性表征	技术先进性	技术来源	生产阶段
1	逻辑与射频	55nm 和 40nm 低功耗逻辑与射频工艺、55nm 超低功耗工艺	标的公司与比利时微电子研发中心（IMEC）签订了 65nm 等 CMOS 芯片制造工艺联合开发与转移合作协议，以国际合作成果为基础，建立持续的技术开发和创新能力，自主研发 **55nm** 和 40nm 低功耗工艺、提供多样的工艺器件选择，满足不同应用产品的设计需求。射频工艺与逻辑工艺兼容，技术节点覆盖 55nm 和 40nm，具有金属氧化物金属电容器（MOM）、高 Q 电感以及噪声隔离深 N 阱结构等特色，可满足无线射频类芯片产品高灵敏度的需要。55nm 超低功耗工艺基于 55nm 低功耗工艺平台开发，核心工作电压降至 0.9V，功耗降低约 30%。	国内领先	自主研发	大批量生产
2		55nm 图像传感器芯片	标的公司具备全系列像素图像传感器工艺平台，像素尺寸覆盖 24 微米到 0.7 微米范围，像素分辨率覆盖 25 万到 5000 万像素范围，产品应用于智能手机，高端相机，安防监控，车载，医疗等多个领域	国内领先	自主研发	大批量生产
3	嵌入式非易失性存储器	SONOS 嵌入式非易失性存储器	与业界闪存技术合作方 Cypress 共同合作开发 55nmSONOS 嵌入式非易失性存储器工艺，在 CMOS 工艺上加入 4 张光罩，为客户提供集高可靠性、低功耗和低成本优势于一身的差异化解决方案。标的公司提供两种版本工艺：1.2V/2.5V 和 1.2V/5V，1.2V/2.5V 主要针对微型控制器和物联网产品，1.2V/5V 版本主要针对智能卡、金融卡、触控芯片等微控制器。	国际领先	自主研发	大批量生产
4	独立式非易失性存储器	独立式非易失性存储器	标的公司于 2016 年通过 SPI NOR Flash 产品验证，并进入大规模量产。65nmNOR Flash 已通过 IATF16949 认证。标的公司在 65nmNOR Flash 基础上，持续微缩尺寸，相继推出 55nm、50nm 以及 45nm 工艺技术并量产，45nmNOR flash 存储单元为当前全球最小	国内领先	自主研发	大批量生产
5	高压	55nm 面板驱动芯片 55HV	55nm 高压工艺既有 32V 高压器件，又为 AMOLED 屏提供 8V 中压器件，为 LCD 屏提供 6V 中压器件，应用于主流的高分辨率的 DDIC 和 TDDI 需求，提	国内领先	自主研发	大批量生产

序号	工艺平台	制程范围及核心技术平台	技术工艺特征及先进性表征	技术先进性	技术来源	生产阶段
			供两种 SRAM cell 尺寸，满足智能手机、可穿戴设备等的应用差异需求			

2、核心技术保护情况

（1）知识产权保护

标的公司为保护无形资产完整，明确科研成果归属，制定了知识产权管理的相关制度，建立了专利注册申请、商业秘密保护的多层次的知识产权管理体系。根据上述规定，对于通过标的公司职务工作形成的技术发明，以标的公司为主体向国家知识产权局申请注册专利，并对专利发明人发放奖金激励；如技术发明不适宜进行公开披露，由专利暨商秘评审委员会审议通过后可将其列为商业秘密保护。

（2）保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，标的公司与其主要技术人员在劳动合同、保密协议中约定相应保密及竞业条款，约束其对职务工作中形成的技术成果、商业信息负有保密责任。对于核心技术人员的离职情况将约定相应的提前通知期和竞业限制期限，离职人员在竞业限制期内不得设立、经营、参与任何与标的公司竞争的实体，不得在该等实体工作或提供服务、咨询等工作。

3、研发投入情况

（1）总体情况

报告期内，公司研发费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
研发费用	**24,495.07**	32,553.50
营业收入	**510,114.63**	498,797.09
研发费用占比	**4.80%**	**6.53%**
政府补助抵减的研发费用	**-1,398.10**	-1,292.30
政府补助抵减前的研发费用占比	**5.08%**	**6.79%**

公司坚持技术和产品的持续创新，报告期内始终保持较高的研发费用投入。报告期内分别为 32,553.50 万元和 **24,495.07** 万元，占各年营业收入的比例分别为 6.53%、**4.80%**。标的研发投入占营业收入比例逐年下降主要系标的公司前期已投入较多的研发工作，凭借持续的研发投入标的公司已经在成熟制程的基础上建立了较为完善的自有工艺平台，65/55nm、40nm 工艺已达到业界主流水平，因此研发投入逐年下降。

（2）研发费用构成

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	**11,689.55**	**47.72%**	13,168.36	40.45%
研究测试费用	**5,591.22**	**22.83%**	8,955.42	27.51%
折旧费用	**3,344.15**	**13.65%**	5,179.22	15.91%
摊销费用	**2,064.28**	**8.43%**	2,817.85	8.66%
维修维护费	**2,439.23**	**9.96%**	2,556.29	7.85%
燃料动力及水电费	**764.74**	**3.12%**	1,168.66	3.59%
政府补助抵减研发费用	**-1,398.10**	**-5.71%**	-1,292.30	-3.97%
合计	**24,495.07**	**100.00%**	**32,553.50**	**100.00%**

4、研发人员情况

标的公司建立了研发相关体系，辅以测试与外包、品质保证及工程验证等部门开展研发工作，并与制造与生产相关部门围绕制造工艺的各个环节展开配套衔接，以保障公司从研发目标到实现工艺升级和晶圆制造的整个过程。

截至报告期末，标的公司拥有 **1,265** 名员工，其中包括 **134** 名研发技术人员，占员工总数比例为 10.60%。截至报告期末，标的公司共有 3 名核心技术人员。

（十一）核心技术人员情况

公司综合考虑员工职责、参与研发项目情况、在核心技术开发中所承担的角

色与贡献程度等多方面因素，确定对公司发展有突出贡献、在公司主要产品研发中具有重要作用的员工为核心技术人员。

报告期内，标的公司核心技术人员稳定，未发生变动，共有 3 名核心技术人员，基本情况如下：

姓名	职务
王智	总裁
陈力钧	副厂长
孙昌	副厂长

上述核心技术人员的简历如下：

（1）王智

王智先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，工程师。王智先生曾任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2010 年加入上海华力微电子有限公司，现任上海华力微电子有限公司总裁（首席技术专家）。

（2）孙昌

孙昌先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。孙昌先生曾任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、格罗方德半导体股份有限公司，2010 年加入上海华力微电子有限公司，现任上海华力微电子有限公司副厂长（首席技术专家）。

（3）陈力钧

陈力钧先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、联华电子（新加坡分公司）有限公司，2010 年加入上海华力微电子有限公司，现任上海华力微电子有限公司副厂长（首席技术专家）。

标的公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术领域具有丰富的研发经验。其核心技术人员队伍稳定，其出色的研发能力保证了公司的市场敏锐度和科研水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足

客户终端产品的创新需求。在标的公司核心技术人员带领下，公司近几年先后取得上海市科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖、国家企业技术中心、第三十四届上海市优秀发明选拔赛优秀创新金奖等诸多荣誉及奖项。

标的公司高度重视核心**技术人员**的激励。为打造稳定、高效、专业的研发团队，促进研发人员的科研创新热情，锁定核心员工，标的公司制定了一系列员工激励措施，以稳固公司的核心技术团队。

上述核心技术人员均与标的公司签署了劳动合同、保密与竞业限制合同。报告期内，标的公司核心技术人员队伍保持稳定，报告期内未发生变动。

七、标的公司主要财务数据

标的公司最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	**663,273.27**	625,889.26
负债总额	**437,230.13**	499,195.99
所有者权益	**226,043.14**	126,693.27
归属于母公司股东权益	**226,043.14**	126,693.27
项目	**2025 年度**	**2024 年度**
营业收入	**510,114.63**	498,797.09
利润总额	**77,326.52**	52,152.40
净利润	**77,326.52**	52,152.40

八、本次交易已取得标的公司其他股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件

（一）公司章程规定的股权转让前置条件

标的公司现行有效的公司章程关于股权转让的约定中，涉及本次交易的相关内容如下：

“第三十五条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股

权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”

（二）本次交易已取得标的公司股东的同意

标的公司已召开股东会，同意上市公司以发行股份的方式收购华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金所持有的华力微 97.4988%股权。

九、标的公司报告期会计政策及相关会计处理

（一）收入的确认原则和计量方法

1、收入确认的一般原则

标的公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中标的公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

标的公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，标的公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在标的公司履约的同时即取得并消耗标的公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制标的公司履约过程中在建的商品；（3）标的公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且标的公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，标的公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，标的公司根据商品和劳务的性质，采用

产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度/投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，标的公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、收入确认的具体方法

（1）销售商品

标的公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品由客户签收或确认时商品的控制权转移，标的公司在该时点确认收入实现。

（2）提供服务

标的公司向客户提供的服务主要为测试服务等，在服务已完成，客户取得相关服务控制权时确认收入。

（二）标的公司会计政策和会计估计与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利润的影响

经查阅同行业上市公司年报等资料，标的公司主要会计政策和会计估计与同行业上市公司不存在重大差异，对标的公司利润无重大影响。

（三）模拟报表编制基础

1、模拟财务报表的编制基础

除下述事项外，标的公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制模拟财务报表。

（1）模拟华力微在本报告期内均已完成存续分立。华力微于 2025 年 8 月 21 日完成存续分立，华力微（分立前主体）分立为分立后的华力微（现存续主体）和新设主体。标的公司对 2025 年 8 月 21 日之前的报告期财务报表数据按照分立

拆分原则，进行模拟拆分：即假设华力微于报告期初即已完成了存续分立，按照分立协议约定分立拆分原则完成财务数据的拆分。

（2）标的公司模拟于报告期期初即已执行华虹公司的会计估计及会计政策，并已作了追溯调整。

2、持续经营

标的公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

3、记账基础和计价原则

标的公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）标的公司会计政策和会计估计与上市公司之间的差异及对拟购买资产利润的影响

标的公司的主要会计政策和会计估计与上市公司不存在重大差异。

（五）行业特殊的会计处理政策

标的公司所处行业不涉及行业特殊的会计处理政策。

第五节 本次交易发行股份情况

一、发行股份及购买资产

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

（二）发行对象

本次发行股份购买资产的发行股份对象为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金 4 名交易对方。

（三）发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量＝以发行股份形式向各交易对方购买标的资产对应的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量＝向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由上市公司现金补足。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量也随之进行调整。

本次交易中，华力微股权的最终交易价格为 826,790.22 万元，均以股份方式支付，不足 1 股部分，现金补足。按照本次发行股票价格 43.34 元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为 190,768,392 股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份对价（万元）	股份数量（股）
1	华虹集团	538,855.12	124,332,053
2	上海集成电路基金	133,318.65	30,761,109
3	大基金二期	86,922.77	20,056,014
4	国投先导基金	67,693.68	15,619,216

序号	交易对方	股份对价（万元）	股份数量（股）
合计		826,790.22	190,768,392

本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

（四）定价基准日和发行价格

1、定价基准日

本次发行股份的股票定价基准日为公司 2025 年第六次董事会决议公告日。

2、发行价格

根据《重组管理办法》，本次发行股份购买资产的股份发行价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。

（五）锁定期安排

交易对方通过本次交易取得上市公司股份的锁定期在严格遵守《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的相关规定，以及中国证监会、上交所等证券监管机构要求的基础上，由上市公司与交易对方协商一致确定。具体股份锁定情况详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”之“（二）交易对方作出的重要承诺”。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则

办理。如前述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（六）过渡期损益安排

本次交易评估基准日至标的资产交割日内标的资产在运营过程中产生的收益及亏损均由上市公司享有。

（七）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

二、本次募集配套资金安排

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，根据《公司条例》第 135 条，公司本次发行的人民币普通股（A 股）股票无面值，上市地点为上交所。

（二）发行对象及发行股份数量

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 755,628.60 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。

在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。

（三）发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

（四）锁定期安排

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如前述锁定期的安排与监管机构的最新监管要求不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

（五）募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集资金具体用途如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
2	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
3	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%

合计	**755,628.60**	**100.00%**

如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前，上市公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（六）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

（七）配套募集资金必要性分析

本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目，特色工艺研发及产业化项目，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。

其中，支付本次交易补充流动资金将有利于上市公司增加研发投入和营运资金，提高经营效率，增强经营能力，对公司发展战略的实施提供充分的资金支持。标的公司符合科创板定位，用于标的公司技术升级改造项目和特色工艺研发及产业化项目建设均系资金用于科技创新领域；特色工艺平台的丰富性是衡量半导体晶圆代工企业综合实力的重要考虑因素，标的公司亟需通过 12 英寸特色工艺技术升级改造项目和特色工艺研发及产业化项目提升相关工艺平台产品深度及广度，进一步提高公司核心竞争力以及抗风险能力；此外，为提升部分特色工艺平台的柔性制造能力，标的公司亟需优化现有工厂生产线、工艺程序、升级 12 英寸厂的部分老旧和产能瓶颈生产线设备，通过设备改造/替换提升产能利用率，将现有 12 英寸生产线全面升级，以满足多种特色工艺平台的柔性产能需求，进一步提高公司核心竞争力以及抗市场波动的风险能力。

综上所述，本次配套募集资金有利于缓解本次交易的资金支付压力、加大研发投入、提高经营效率、增强核心竞争力及提高抗风险能力，为上市公司未来发展提供资金支持。

（八）前次募集资金金额、使用情况及目前剩余情况

1、前次募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半

导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 28,232.30 万元（含税）后，募集资金净额为 2,092,067.70 万元，上述资金于 2023 年 7 月 31 日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153_B02 号”《验资报告》。

2、前次募集资金使用情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	累计投入比例
1	华虹制造（无锡）项目	1,250,000.00	**1,236,651.71**	98.93%
2	8 英寸厂优化升级项目	200,000.00	**49,666.21**	**24.83%**
3	特色工艺技术创新研发项目	250,000.00	**97,606.37**	**39.04%**
4	补充流动资金	100,000.00	**100,045.30**	**100.05%**
5	超额募集资金	292,067.70	-	-
	合计	**2,092,067.70**	**1,483,969.59**	**70.93%**

注：补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额 **45.30** 万元，系募集资金专户产生的利息。

3、前次募集资金剩余情况

截至 2025 年 **12 月 31 日**，公司募投项目累计支出为 1,**483,969.59** 万元，募集资金账户余额为 **630,503.77** 万元。

第六节 标的资产评估作价基本情况

一、本次交易标的评估情况

（一）评估的基本情况

1、评估概况

本次交易中，标的资产的评估基准日为 2025 年 8 月 31 日，评估对象为华力微股东全部权益价值。标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果确定。

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，评估机构采用资产基础法和市场法对华力微股东全部权益价值进行评估，并以市场法结果作为本次评估结论。截至评估基准日，华力微所有者权益账面值为 200,191.38 万元，股东全部权益价值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

2、评估方法的选择

依据《资产评估执业准则—企业价值》，“执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法。”“对于适合采用不同评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进行评估。”

资产基础法适用性分析：资产基础法的基本思路是按现行条件重建或重置被评估资产，潜在的投资者在决定投资某项资产时，所愿意支付的价格不会超过购建该项资产的现行购建成本。本评估项目能满足资产基础法评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史经营资料。采用资产基础法可以满足本次评估的价值类型的要求。

市场法适用性分析：市场法的基本思路是通过与可比公司比较、修正来获取被评估单位市场价值。目前资本市场与被评估单位可比的上市公司满足数量条件，且披露信息相对充分，本次适合采用市场法评估。

收益法适用性分析：被评估单位系晶圆代工企业，晶圆代工行业受国际关系和宏观环境影响重大、行业周期性及不确定性较强、未来盈利情况难以可靠预测的情况。并且在当前国际半导体设备进口管制背景下，国内晶圆制造企业普遍依赖定期维护和部件更换等方式延长设备使用周期以维持生产连续性。然而，随着技术迭代加速、半导体设备国产化进程推进，以及老旧设备运维成本上升、经济性逐步下降等多重因素共同作用，华力微未来的设备维护与更新路径面临延续定期维护或是设备更替等多种情景，不同情景对应的设备清单、国产化比例及资本投入预算差异较大，因而存在较大不确定性。此类不确定性将导致企业未来的资本性支出计划与生产成本结构预测难度增大，相关风险也难以可靠量化。

收益法的适用前提是能够对企业未来收益及相关风险做出合理、可靠的预测。鉴于华力微在评估基准日时点所面临的上述设备更替与资本支出不确定性较高，管理层认为，在当前条件下对华力微未来年度的经营收益及风险无法形成具备合理依据的预测基础，因此本次评估不具备采用收益法的前提条件。

综上分析，本次评估确定采用资产基础法、市场法进行评估。

3、评估结果

（1）资产基础法评估结果

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位所有者权益账面值 200,191.38 万元，评估值 782,761.17 万元，评估增值 582,569.79 万元，增值率 291.01%。其中，总资产账面值 725,850.28 万元，评估值 1,306,836.22 万元，评估增值 580,985.94 万元，增值率 80.04%。总负债账面值 525,658.90 万元，评估值 524,075.05 万元，评估减值 1,583.85 万元，减值率 0.30%。

（2）市场法评估结果

采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，得出的评估基准日的评估结果如下：

被评估单位所有者权益账面值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

（3）不同方法评估结果的差异分析

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 848,000.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 782,761.17 万元高 65,238.83 万元。

不同评估方法的评估结果差异的原因主要是各种评估方法对资产价值考虑的角度不同，资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算；市场法是从现时市场可比价格角度进行测算，导致各评估方法的评估结果存在差异。

（4）评估结论的选取

根据《资产评估执业准则—企业价值》，对同一评估对象采用多种评估方法时，应当结合评估目的、不同评估方法使用数据的质量和数量，采用定性或者定量的方式形成评估结论。

鉴于华力微属于晶圆加工产业，其主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源的贡献。由于资产基础法的特性，其评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了价值评估，并不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值，对于被评估单位的工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源价值一般也难以在资产基础法中体现，资产基础法评估结果较市场法存在一定局限性。其次，市场法的数据采用可比上市公司的公开数据，近年来随着中国的股市日臻成熟，相对成熟的资本市场环境也提供了市场法定价的基础。

通过以上分析，我们选用市场法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币 8,480,000,000.00 元。大写：人民币捌拾肆亿捌仟万元整。

4、评估增值的主要原因

本次评估采用市场法的评估结论，正是基于采用市场法评估结论的原因，该公司拥有企业账面值上未反映的工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源价值，因此采用市场法**的评估价值**比账面值增值较大。

（二）评估假设

1、基本假设

（1）交易假设

交易假设是假定所有评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据评估资产的交易条件等模拟市场进行价值评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

（2）公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

（3）企业持续经营假设

企业持续经营假设是假设被评估单位在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。

（4）资产按现有用途使用假设

资产按现有用途使用假设是指假设资产将按当前的使用用途持续使用。首先假定被评估范围内资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。

2、一般假设

（1）本次评估假设评估基准日后国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

（2）本次评估没有考虑被评估单位及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估结论的影响。

（3）假设被评估单位所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率

等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。

（4）被评估单位现在及将来的经营业务合法合规，并且符合其营业执照、公司章程的相关约定。

3、市场法评估特别假设

（1）假设被评估单位严格遵循企业会计准则及其相关规定，评估基准日及历史各期财务数据均真实、可靠；

（2）假设所选可比上市公司披露的财务与经营数据真实、可靠；

（3）除特殊说明外，假设资本市场的交易行为均基于公开、公平、自愿及公允的原则；

（4）未考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响，也未考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的影响。

（5）未考虑将来可能承担的抵押、担保事宜。

（三）资产基础法评估情况

1、货币资金

货币资金账面价值 3,003,522,065.14 元，包括现金、银行存款和其他货币资金。

（1）现金

现金存放在华力微财务室内，对于人民币现金按照账面值确定评估值，对于外币现金根据原币金额结合基准日相应外币汇率确认评估值。

（2）银行存款

银行存款为存放于各家银行的存款，分别按人民币账户和外币账户确认评估值，对人民币账户以核实后的账面值确认为评估值，对外币账户，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

（3）其他货币资金

其他货币资金系定期保证金和应收利息，以核实后的账面值确认评估值。

货币资金评估值为 3,003,522,065.14 元。

2、应收票据

应收票据账面价值 242,000.00 元，系企业因销售商品而收到的票据，以核实后的账面值确认评估值。

应收票据评估值为 242,000.00 元。

3、应收账款

应收账款账面价值 623,982,305.77 元，核算内容为货款。

在对应收账款核实无误的基础上，按照账龄分析法，估计出评估风险损失作为扣除额后，按预计可能收回的数额确定评估值。原坏账准备评估为零。

应收账款评估值为 623,982,305.85 元。

4、预付账款

预付账款账面价值 1,567,964.74 元，系预付的保险费、材料款等。

对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值；对外币款项，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

预付账款评估值为 1,567,242.43 元。

5、其他应收款

其他应收款账面价值 395,760.58 元，系代收服务费、押金等。

在对其他应收款核实无误的基础上，评估人员进行了款项性质分析，其他应收款基本为关联单位的代收服务费、押金等款项，坏账的可能性很小，本次按照账面值确定评估值。

其他应收款评估值为 395,760.58 元。

6、存货

存货账面余额 1,400,621,922.38 元，已计提跌价准备 23,439,416.93 元，账面净额 1,377,182,505.45 元，包括原材料、在产品和产成品。

（1）原材料

原材料账面价值 695,209,853.26 元，主要为硅片、晶圆、化学原料等。

原材料根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用确定评估值。被评估单位原材料采用实际成本核算，账面价值包括购置价及其他合理费用。对于价格变动较大的原材料，以评估基准日近期的市场价格并考虑合理费用作为评估值；对于价格变动不大的原材料，以核实后的账面值作为评估值。

原材料评估值为 695,209,853.26 元。

（2）产成品

产成品账面余额 274,336,075.41 元，计提跌价准备 23,439,416.93 元，系企业生产对外销售的芯片等产品。

产成品根据企业提供不含税售价，结合产品的销售费用、营业利润情况，按照正常产成品进行评估。

正常产品的评估值＝产成品数量×不含增值税销售单价－销售费用－销售税金及附加－所得税－部分净利润

＝产成品数量×不含税的销售单价×[1－销售费用率－销售税金及附加率－销售利润率×所得税税率－销售利润率×（1－所得税税率）×净利润折减率]

原账面计提的产成品跌价准备评估为零。

产成品评估值为 328,942,095.28 元。

（3）在产品

在产品账面价值 431,075,993.71 元，为在生产过程中的晶圆。

正常在产品根据企业提供不含税售价，结合产品的销售费用、营业利润情况，参考在产品的完工进度进行评估。

正常在产品的评估值=产成品数量×不含税的销售单价×产品完工进度×[1－销售费用率－销售税金及附加率－销售利润率×所得税税率－销售利润率×（1－所得税税率）×净利润折减率]

各项参数选取同产成品。

在产品评估值为 592,741,742.10 元。

综上，存货评估值为 1,616,893,690.64 元。

7、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产账面价值 5,358,247.40 元，系一年内到期的长期应收款，以核实后的账面值确定评估值。

一年内到期的非流动资产评估值为 5,358,247.40 元。

8、其他流动资产

其他流动资产账面价值 9,846,229.24 元，系预提的增值税留抵税额，本次经过核实涉及无形资产的定价依据确认账面金额属实，本次按账面值评估。

其他流动资产评估值为 9,846,229.24 元。

9、长期应收款

长期应收款账面价值 63,624,638.57 元，系华力微长期出租设备的租赁收入，以核实后的账面值确认评估值。

长期应收款评估值为 63,624,638.57 元。

10、固定资产

（1）评估范围

纳入本次评估范围的设备类资产包括机器设备、运输设备和电子及其他设备。华力微拥有的账面记录的设备 28,122 台（套），按其不同用途分为机器、车辆、电子设备及其他设备三类。

1）机器设备 2,756 台（套），主要有：半导体器件加工专用设备等集成电路科研生产设备及其配套设施，以及安保系统、变配电设备、纯水废水废液系统、公用动力设备、化学品输运系统、洁净室系统及一般机电系统、特气系统、消防系统等配套系统，集成电路科研生产设备及其配套设施均为企业自行采购，经安装调试完成验收后投入使用，分布于净化车间，运行状况良好；配套系统主要分布于辅助生产楼。

2）车辆 2 辆，为别克商务车、本田奥德赛混合动力多用途乘用车各 1 辆。

3）电子设备及其他设备 25,364 台（套），主要有：光罩盒、叉车、磁盘列阵等网络设备、成像仪等仪器设备、办公家具、空调、投影仪、复印机、电视机、冰箱、电脑等，主要分布于辅助生产楼和各职能部门。

上述设备中 20,234 台（套）设备账面原值为零值，主要包括：机器设备 138 台（套），电子设备及其他设备 20,096 台（套）。账面原值为零值的原因包括供应商无偿赠送、因模拟报表口径变化原因调整部分资产一次性费用化处理，以及采用政府补助净额法核算等原因。

（2）评估方法

1）评估方法的选择

根据评估人员对企业设备资产进行了解后，由于该企业的设备除车辆外所涉及的设备市场交易面不活跃，难以获取可比的案例，故不适合采用市场法评估；委估设备系整体用于企业经营，不具有单独获利能力，或获利能力无法量化，故不适合采用收益法评估；企业设备资产资料较为完整，市场价格信息渠道较为丰富，各类贬值因素能较为可靠的计量，具备采用成本法评估的条件。

结合本次评估目的、经济行为以及价值类型，本次对设备资产主要采用成本法评估，对市场交易面较活跃的车辆采用市场法评估。

2）成本法介绍

成本法评估计算公式为：

评估值＝重置全价－实体性贬值－功能性贬值－经济性贬值

＝重置全价×综合成新率

①重置全价的确认

A、进口设备重置全价的确认

重置全价＝CIF 价×外汇中间价＋关税额＋增值税额＋外贸手续费＋银行财务费＋运杂费＋基础费＋安装调试费＋其他合理费用－可抵扣增值税额

B、国产设备重置全价的确认

重置全价＝重置现价＋运杂费＋基础费＋安装调试费＋其他合理费用－可抵扣增值税额

②综合成新率的确认

A、价值量较大的重点、关键设备成新率的确定

在年限法理论成新率的基础上，再结合各类因素进行调整，最终合理确定设备的综合成新率，计算公式：

综合成新率＝理论成新率×调整系数 K

其中：

理论成新率＝尚可使用年限÷（已使用年限＋尚可使用年限）×100%

调整系数 K＝K1×K2×K3×K4×K5 等，即：

综合成新率＝理论成新率×K1×K2×K3×K4×K5

各类调整因素主要为设备的原始制造质量、维护保养（包括大修理等）情况、设备的运行状态及故障频率、设备的利用率、设备的环境状况等。

尚可使用年限依据设备的实际运行状态确定。

B、价值量较小的一般设备及电子类设备成新率的确定

对于价值量较小的一般电子及其他设备，直接采用年限法确定成新率。

3）市场法介绍

对市场交易面较活跃的车辆采用市场法评估。

市场比较法是根据替代原理，将评估对象与在近期发生交易的类似车辆加以比较对照，从已发生交易的类似车辆的交易价格，通过交易日期、交易情况、个别因素等的修正，修正得到评估对象价值的一种评估方法，车辆市场法计算公式如下：

车辆市场价值＝可比交易实例不含税价×交易日期修正系数×交易情况修正系数×个别因素修正系数

关于车辆牌照费的确定：为加强上海市机动车总量控制，规范非营业性客车额度管理，根据上海市人民政府关于沪府发〔2016〕37 号《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》，非营业性客车额度是指通过拍卖方式取得，允许在本市中心城区通行的个人自用、单位公务等之需的非营业性客车上牌指标，包括个人客车额度和单位客车额度。

由于运用了拍卖这一市场化手段配置，从而使得上海客车牌照商品化，所以目前上海客车牌照除沪 C 和新能源客车外，单位公务之需的非营业性“沪”字客车牌照均需通过拍卖方式取得，根据目前我国牌照管理现状，近年陆续有广州、杭州、深圳、天津等牌照通过拍卖方式取得，以对其城市机动车进行总量控制，所以客车牌照市场价值客观存在。

综上所述，本次对上海非沪 C 客车、非新能源客车牌照的评估中，拟参照市场行情，考虑单位公务之需的非营业性客车牌照的价值。

车辆牌照费按上海国际商品拍卖有限公司公布的评估基准日当月上海市单位非营业性客车额度拍卖成交均价评估。

车辆牌照费不计成新率，直接加计入评估值中。

（3）评估结果

纳入本次评估范围的设备类资产评估结果概况如下表所示：

单位：元

设备名称	账面净值	评估净值	增值额	增值率%
机器设备	1,475,417,151.78	5,501,963,223.00	4,026,546,071.22	272.91
车辆	283,460.04	649,332.00	365,871.96	129.07
电子设备	34,177,178.98	83,123,022.00	48,945,843.02	143.21
合计	**1,509,877,790.80**	**5,585,735,577.00**	**4,075,857,786.20**	**269.95**

本次评估增值原因如下：

1）由于企业财务对设备类资产计提折旧较快，评估依据设备的经济寿命结合设备的实际状况确定成新率，比较客观地反映了设备的实际价值，二者有差异，致使评估增值，其次，企业目前共有 20,234 台（套）设备账面原值为零值，主要包括：机器设备 138 台（套），电子设备及其他设备 20,096 台（套）。账面原

值为零值的原因包括供应商无偿赠送、采购后一次性费用化处理，以及采用政府补助净额法核算等原因，本次将上述设备纳入评估范围。

2）车辆账面价值中不包含车辆牌照费用，评估过程中将牌照的市场价值纳入评估范围，致使评估增值。

11、在建工程

（1）评估范围

在建工程-设备安装工程账面价值 137,406,487.45 元，为物理气相沉积氮化钽、铜薄膜设备、高覆盖率多晶硅成膜设备、技术授权及 IP 共享服务平台建造项目等，共 111 项。

（2）评估方法

根据本次在建工程—设备安装工程中的设备状况，评估方法阐述如下：

评估值＝设备费评估值＋安装费及其他评估值＋资金成本评估值

资金成本评估值＝在建工程含税重置价×贷款年利率×资金占用周期/2

对于账面金额在 50 万元以下的设备安装工程，由于金额较小，本次不再计算资金成本。

（3）评估结果

在建工程—设备安装工程账面值 137,406,487.45 元，评估值 138,164,520.65 元，增值 758,033.20 元，增值率 0.55%，本次评估考虑了自有资金投入的资金成本致使评估增值。

12、使用权资产

使用权资产账面值 381,184,687.24 元，系承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，以核实后账面值确定评估值。

使用权资产评估值为 381,184,687.24 元。

13、无形资产—其他无形资产

（1）评估范围

无形资产—其他无形资产账面原值 511,322,687.50 元，账面净值 129,892,439.12 元，主要为用于企业生产经营、日常管理和研发的软件、IP 和 License。

此外，华力微拥有账面未记录的无形资产共 2777 项，包括 2477 项专利（其中 2043 项已授权，434 项在实质审查阶段）和 10 项集成电路布图。

（2）评估方法

1）外购软件、IP：该类账面无形资产近年来价格变动幅度较小，虽在会计记账角度已计提摊销，实际仍可无限期使用，本次按照评估基准日的市场价格确定评估值。

2）License：该类账面无形资产近年来价格变动幅度较小，且账面已根据其许可使用年限进行摊销，在核实受益期和受益额无误的基础上按尚存受益期确定评估值。

3）专利及集成电路布图：根据形成无形资产的全部投入，考虑无形资产价值与成本的相关程度，通过计算其合理的成本、利润和相关税费后确定其重置成本，并考虑其贬值因素后得到评估对象无形资产市场价值。计算公式为：

评估值＝重置成本×（1－贬值率）

（3）评估结果

无形资产—其他无形资产的评估值为 1,623,460,317.71 元。

14、长期待摊费用

长期待摊费用账面价值 5,261,059.99 元，系厂房的装修费用摊销，以核实后的账面值确认评估值。

长期待摊费用评估值为 5,261,059.99 元。

15、其他非流动资产

其他非流动资产账面价值 9,158,613.76 元，系预付的设备款和房租。对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值，对外币款项根据原币金额结合基准日相应外币汇率确认评估值。

其他非流动资产评估值为 9,123,906.56 元。

16、应付账款

应付账款账面值 739,718,274.62 元，主要系应付的材料款项、服务费等。对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值；对外币款项，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

应付账款评估值为 739,718,275.18 元。

17、合同负债

合同负债账面值 122,937,129.98 元，系企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。对于人民币款项以核实后的账面值确认评估值；对外币款项，在核实原币金额的基础上，按评估基准日汇率计算确认评估值。

合同负债评估值为 123,208,639.40 元。

18、应付职工薪酬

应付职工薪酬账面值 6,380,958.76 元，主要系应付职工的保险费用，以核实后账面值确认评估值。

应付职工薪酬评估值为 6,380,958.76 元。

19、应交税费

应交税费账面值 7,712,047.55 元，主要系个人所得税、印花税和进口关税，以核实后的账面值确认评估值。

应交税费评估值为 7,712,047.55 元。

20、其他应付款

其他应付款账面值 112,634,872.55 元，主要系应付设备款、工程款、暂估职工奖金、服务费等，以核实后的账面值确认评估值。

其他应付款评估值为 112,634,872.55 元。

21、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债账面值 1,039,071,751.37 元，系一年内到期的借款、一年内到期的租赁负债和截止基准日应支付的借款利息，以核实后账面值确认评估值。

一年内到期的非流动负债评估值为 1,039,071,751.37 元。

22、其他流动负债

其他流动负债账面值 12,624,885.19 元，系与合同负债相应的销项税款，以核实后的账面值确认评估值。

其他流动负债评估值为 12,624,885.19 元。

23、长期借款

长期借款账面值 2,897,337,500.00 元，系向银行借入的长期借款，以核实后的账面值确认评估值。

长期借款评估值为 2,897,337,500.00 元。

24、租赁负债

租赁负债账面值 300,806,837.99 元，系承租人在租入资产确认使用权资产的同时确认的租赁负债，等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值，以核实后账面值确认评估值。

租赁负债评估值为 300,806,837.99 元。

25、预计负债

预计负债账面值 1,254,766.58 元，系企业计提的使用权资产到期后进行拆除内装并恢复原样的费用，以核实后的账面值确认评估值。

预计负债评估值为 1,254,766.58 元。

26、递延收益

递延收益账面值 16,110,000.00 元，主要系课题补助及项目补助等。

经清查，对于递延收益中的款项，华力微相关义务已完成，该补助未来无需归还，故本次评估为零。公司自成立之日起至今处于累计亏损状态，递延收益所

涉及企业实际所得税率为零，故本次评估对相关递延收益评估为零而产生的递延所得税负债评估为零。

递延收益评估值为 0.00 元。

27、资产基础法评估结论

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位所有者权益账面值 200,191.38 万元，评估值 782,761.17 万元，评估增值 582,569.79 万元，增值率 291.01%。其中，总资产账面值 725,850.28 万元，评估值 1,306,836.22 万元，评估增值 580,985.94 万元，增值率 80.04%。总负债账面值 525,658.90 万元，评估值 524,075.05 万元，评估减值 1,583.85 万元，减值率 0.30%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示：

单位：万元

项　　目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	502,209.71	526,180.75	23,971.04	4.77
非流动资产	223,640.57	780,655.47	557,014.90	249.07
长期应收款	6,362.46	6,362.46	0.00	0.00
固定资产	150,987.78	558,573.56	407,585.78	269.95
在建工程	13,740.65	13,816.45	75.80	0.55
使用权资产	38,118.47	38,118.47	0.00	0.00
无形资产	12,989.24	162,346.03	149,356.79	1,149.85
长期待摊费用	526.11	526.11	0.00	0.00
其他非流动资产	915.86	912.39	-3.47	-0.38
资产总计	**725,850.28**	**1,306,836.22**	**580,985.94**	**80.04**
流动负债	204,107.99	204,135.14	27.15	0.01
非流动负债	321,550.91	319,939.91	-1,611.00	-0.50
负债总计	**525,658.90**	**524,075.05**	**-1,583.85**	**-0.30**
所有者权益（净资产）	**200,191.38**	**782,761.17**	**582,569.79**	**291.01**

（四）市场法评估情况

1、市场法应用简介

（1）市场法定义

市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较以确定评估对象价值的评估方法。市场法实质是利用活跃交易市场上已成交的类似案例的交易信息或合理的报价数据，通过对比分析的途径确定委估企业或股权价值的一种评估技术。

市场法中常用的两种方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。上市公司比较法中的可比企业应当是公开市场上正常交易的上市公司，评估结论应当考虑流动性对评估对象价值的影响。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。运用交易案例比较法时，应当考虑评估对象与交易案例的差异因素对价值的影响。

（2）市场法特点

1）评估数据直接来源于市场，评估过程简单、直观；

2）评估方法以市场为导向，评估结果说服力强。

（3）市场法适用前提条件

1）必须有一个充分发展、活跃的资本市场；

2）存在三个及三个以上相同或类似的可比企业，可比企业应当与被评估企业属于同一行业，或者受相同经济因素的影响；

3）可比企业与被评估企业的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

（4）市场法评估假设

1）假设被评估单位严格遵循企业会计准则及其相关规定，评估基准日及历史各期财务数据均真实、可靠；

2）假设所选可比上市公司披露的财务与经营数据真实、可靠；

3）除特殊说明外，假设资本市场的交易行为均基于公开、公平、自愿及公允的原则；

4）未考虑遇有自然力及其他不可抗力因素的影响，也未考虑特殊交易方式可能对评估结论产生的影响；

5）未考虑将来可能承担的抵押、担保事宜。

（5）市场法评估模型

1）上市公司比较法

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

2）交易案例比较法

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

鉴于 A 股资本市场可收集到至少三个与评估对象同行业的可比上市公司，且可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，本次选择上市公司比较法。

2、评估技术思路

本次上市公司比较法的基本评估思路如下：

（1）确定可比参照企业

由于被评估单位是一家非上市公司，其股权不具备公开交易流通市场，因此不能直接确定其市场价值。我们采用在国内上市公司中选用可比企业，可比企业的筛选过程如下：

1）根据被评估单位所在的行业、主要经营模式及产品类型进行初步筛选，筛选标准为：

①截至评估基准日至少有两年的上市历史，以避免市场信息不够充分及 IPO 效应、市场预期等因素造成的股价波动影响。

②与被评估单位同属于半导体制造或晶圆代工行业，主要经营模式为大规模投资、高资本支出及技术工艺持续投入的 IDM 或 Foundry 模式，且产品应用领域相似。

③评估基准日近期股票正常交易，未处于停牌等非正常交易状态，或未因基准日近期发生并购重组交易而使得股票价格异常波动。

④鉴于 ST 股票较可能因市场中的投机、炒作等因素使得股票价格较大程度偏离其实际价值，故将 ST 股票剔除出可比公司范围。

本次评估人员筛选与被评估单位同属于所属申银万国行业分类--电子--半导体--分立器件、集成电路制造的上市公司，共计 25 家上市公司，结合上述筛选标准进行筛选，具体如下所示：

证券代码	证券名称	上市日期	筛选过程
688249.SH	**晶合集成**	**2023-05-05**	**主要为 Foundry 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688347.SH	华虹公司	2023-08-07	基准日近期存在停牌等非正常交易状态，剔除
688396.SH	**华润微**	**2020-02-27**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688469.SH	芯联集成	2023-05-10	基准日近期发生并购重组，剔除
688691.SH	灿芯股份	2024-04-11	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688981.SH	中芯国际	2020-07-16	主要为 Foundry 模式，工艺制程存在较大差异，剔除
300456.SZ	赛微电子	2015-05-14	主要为 Foundry 模式，产品应用领域存在差异，剔除
600360.SH	*ST 华微	2001-03-16	ST 股票，股票价格较大程度偏离其实际价值，剔除
600460.SH	**士兰微**	**2003-03-11**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
600745.SH	闻泰科技	1996-08-28	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
603290.SH	斯达半导	2020-02-04	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
605111.SH	新洁能	2020-09-28	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688048.SH	长光华芯	2022-04-01	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688167.SH	炬光科技	2021-12-24	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688172.SH	**燕东微**	**2022-12-16**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688230.SH	芯导科技	2021-12-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688261.SH	东微半导	2022-02-10	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688498.SH	源杰科技	2022-12-21	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688689.SH	银河微电	2021-01-27	主要为半导体封测，经营模式差异较大，剔除
688693.SH	锴威特	2023-08-18	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688711.SH	宏微科技	2021-09-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300046.SZ	台基股份	2010-01-20	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300373.SZ	**扬杰科技**	**2014-01-23**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**

证券代码	证券名称	上市日期	筛选过程
300623.SZ	**捷捷微电**	**2017-03-14**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300831.SZ	派瑞股份	2020-05-07	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除

初步筛选后，符合上述参照标准的公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
688249.SH	晶合集成	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	集成电路晶圆制造代工：98.5703%；其他业务：1.4020%；其他：0.0277%
688396.SH	华润微	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	产品与方案：50.9277%；制造与服务：46.3278%；其他业务：2.7445%
600460.SH	士兰微	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	分立器件产品：48.4601%；集成电路：36.5858%；发光二极管产品：6.8476%；其他业务：4.4177%；其他：3.6887%
688172.SH	燕东微	北京燕东微电子股份有限公司的主营业务是产品与方案和制造与服务两类业务。公司的主要产品是产品与方案、制造与服务。	产品与方案：47.1756%；制造与服务：43.9067%；其他：5.7855%；其他业务：3.1323%
300373.SZ	扬杰科技	扬州扬杰电子科技股份有限公司的主营业务是功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试研发、生产、销售。公司的主要产品是半导体器件、半导体芯片、半导体硅片。	半导体器件：86.2474%；半导体芯片：8.3270%；半导体硅片：3.0766%；其他业务收入：2.3490%
300623.SZ	捷捷微电	江苏捷捷微电子股份有限公司的主营业务是功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列、MOSFET 系列、IGBT 系列、厚模组件、碳化硅器件、其他。	功率半导体器件：66.9693%；功率半导体芯片：31.0471%；其他业务收入：1.3637%；功率器件封测：0.6199%

2）鉴于被评估单位是一家独立的晶圆代工厂，若可比上市公司的业务规模小于被评估单位且差距较大，则其可比性将相应减弱。此外，考虑到被评估单位在评估基准日的固定资产账面价值已基本计提完折旧，且其主要生产经营场所均来源于租赁，未拥有自有厂房及土地，本次筛选过程中选取设备类固定资产账面原值规模可比的样本。

经计算各公司设备类固定资产账面原值具体如下：

单位：亿元

证券代码	证券名称	设备类固定资产账面原值
688249.SH	晶合集成	373.37
688396.SH	华润微	208.96
600460.SH	士兰微	114.24
688172.SH	燕东微	67.74
300373.SZ	扬杰科技	47.07
300623.SZ	捷捷微电	54.72
被评估单位	**华力微**	**153.59**

最终筛选确定的可比上市公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	上市日期	公司简介	主营业务
688249.SH	晶合集成	2023-05-05	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	12 英寸晶圆代工业务。
688396.SH	华润微	2020-02-27	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营。
600460.SH	士兰微	2003-03-11	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	电子元器件的研发、生产和销售。

（2）对被评估单位和可比参照企业的差异进行必要的调整

利用从公开、合法渠道获得的可比参照企业经营业务和财务各项信息，与被评估单位的实际情况进行比较、分析，并做必要的差异调整。

（3）选择确定价值比率

1）价值比率选择

价值比率通常包括资产价值比率、盈利价值比率、收入价值比率和其他特定价值比率，根据被评估单位所属行业特征、所处经营阶段等因素，在其中选择适用的价值比率，并计算各可比上市公司的价值比率。在选择过程中充分考虑了下述因素：选择的价值比率有利于合理确定评估对象的价值；计算价值比率的数据口径及计算方式一致；应用价值比率时尽可能对可比参照企业和被评估单位间的差异进行合理调整。本次价值比率选取如下：

①资产价值比率

如市净率（P/B）、企业价值与总资产比率（EV/TBVIC）等。由于截止基准日被评估单位的主要固定资产账面净值率较低，导致基准日的净资产和总资产金额处于企业生命周期中的相对低位。相比之下，所选可比上市公司的平均净值率约为 50%，两者在资产基础上存在较大差异。尽管净资产和总资产受行业周期性波动的影响相对有限，但其数值在企业生命周期的不同阶段往往呈现显著差别。被评估单位当前的低净值状态反映了其资产已多年累计折旧、账面价值较低的现实，若此时采用 P/B 或 EV/TBVIC 等基于账面价值的价值比率进行评估，容易导致评估结果失真。因此本次评估未采用资产价值比率。

②盈利价值比率

如市盈率（P/E）、企业价值与息税前利润比率（EV/EBIT）、企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）等。被评估单位作为一家晶圆代工企业，具有资本投入高、回报周期长的典型特征，在扣除高额折旧与摊销费用后，常于净利润及息税前利润（EBIT）层面呈现暂时性亏损或利润水平偏低的现象。此情况会导致市盈率（P/E）及企业价值与息税前利润比率（EV/EBIT）等价值比率失真。因此，上述价值比率不适用于本次评估。相比之下，企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）通过将折旧摊销加回，消除了高资本支出特征对利润率的影响，更能公允地衡量被评估单位的持续盈利能力。因此本次评估采用企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）。

③收入价值比率

如市销率（P/S）、企业价值与营业收入比率（EV/S）等。收入价值比率隐含的估值逻辑是企业的核心价值与其销售收入规模之间存在直接、稳定的线性关

系。然而，对于晶圆代工企业而言，其核心价值主要取决于技术工艺等要素，最终综合体现为企业的持续盈利能力。盈利价值比率与晶圆代工行业的估值逻辑更为契合，因此，本次评估未采用收入价值比率。

2）相关性测试

评估人员对所选取的三家可比公司，以企业价值（EV）为因变量、息税折旧摊销前利润（EBITDA）为自变量，进行了 EV/EBITDA 价值比率的线性回归分析，相关分析结果如下表所示：

检验指标	EV/EBITDA
R	0.9461
R 方	0.8951

经相关性测试，EV/EBITDA 的 R 方较高，一般认为 R 方在 0.7 到 0.9 之间具有较高的拟合，意味着息税折旧摊销前利润与企业价值存在较强的正相关关系，故本次评估宜采用 EV/EBITDA 作为价值比率。

（4）确定评估结论

在调整并计算可比企业的价值比率后，结合被评估单位相应的财务数据或指标，计算得出被评估单位的企业价值，并通过对被评估单位的非经营性资产、负债和溢余资产价值进行调整，最终得到被评估单位股东全部权益价值。

（5）对流动性及控制权的考虑

本次市场法评估采用上市公司比较法，由于选取的可比公司为上市公司，而被评估单位为非上市公司，评估中考虑了流动性对评估对象价值的影响。

由于暂无针对中国市场的比较可靠且能让市场参与者均予认可的控制权溢价率或缺乏控制权折价率权威统计数据，本次市场法评估未考虑控制权对评估对象价值的影响。

3、市场法计算公式

企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA）

股东全部权益价值＝经营性企业价值（不含货币资金）－付息债务－少数股东权益＋非经营性资产、负债＋货币资金

经营性企业价值（不含货币资金）＝被评估单位息税折旧摊销前利润×被评估单位 EV/EBITDA

其中，被评估单位 EV/EBITDA＝修正后可比公司 EV/EBITDA 的加权平均值

＝Σ 可比公司 EV/EBITDA×可比公司 EV/EBITDA 修正系数×权重

可比公司 EV/EBITDA 修正系数＝∏影响因素 Ai 的调整系数

影响因素 Ai 的调整系数＝被评估单位系数/可比公司系数

4、市场法评估过程

（1）可比企业的选择

由于被评估单位是一家非上市公司，其股权不具备公开交易流通市场，因此不能直接确定其市场价值。我们采用在国内上市公司中选用可比企业，可比企业的筛选过程如下：

1）根据被评估单位所在的行业、主要经营模式及产品类型进行初步筛选，筛选标准为：

①截至评估基准日至少有两年的上市历史，以避免市场信息不够充分及 IPO 效应、市场预期等因素造成的股价波动影响。

②与被评估单位同属于半导体制造或晶圆代工行业，主要经营模式为大规模投资、高资本支出及技术工艺持续投入的 IDM 或 Foundry 模式，且产品应用领域相似。

③评估基准日近期股票正常交易，未处于停牌等非正常交易状态，或未因基准日近期发生并购重组交易而使得股票价格异常波动。

④鉴于 ST 股票较可能因市场中的投机、炒作等因素使得股票价格较大程度偏离其实际价值，故将 ST 股票剔除出可比公司范围。

本次评估人员筛选与被评估单位同属于所属申银万国行业分类--电子--半导体--分立器件、集成电路制造的上市公司，共计 25 家上市公司，结合上述筛选标准进行筛选，具体如下所示：

证券代码	证券名称	上市日期	筛选过程
688249.SH	**晶合集成**	**2023-05-05**	**主要为 Foundry 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688347.SH	华虹公司	2023-08-07	基准日近期存在停牌等非正常交易状态，剔除
688396.SH	**华润微**	**2020-02-27**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688469.SH	芯联集成	2023-05-10	基准日近期发生并购重组，剔除
688691.SH	灿芯股份	2024-04-11	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688981.SH	中芯国际	2020-07-16	主要为 Foundry 模式，工艺制程存在较大差异，剔除
300456.SZ	赛微电子	2015-05-14	主要为 Foundry 模式，产品应用领域存在差异，剔除
600360.SH	*ST 华微	2001-03-16	ST 股票，股票价格较大程度偏离其实际价值，剔除
600460.SH	**士兰微**	**2003-03-11**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
600745.SH	闻泰科技	1996-08-28	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
603290.SH	斯达半导	2020-02-04	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
605111.SH	新洁能	2020-09-28	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688048.SH	长光华芯	2022-04-01	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688167.SH	炬光科技	2021-12-24	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688172.SH	**燕东微**	**2022-12-16**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
688230.SH	芯导科技	2021-12-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688261.SH	东微半导	2022-02-10	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688498.SH	源杰科技	2022-12-21	主要为 IDM 模式，产品应用领域存在差异，剔除
688689.SH	银河微电	2021-01-27	主要为半导体封测，经营模式差异较大，剔除
688693.SH	锴威特	2023-08-18	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
688711.SH	宏微科技	2021-09-01	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300046.SZ	台基股份	2010-01-20	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除
300373.SZ	**扬杰科技**	**2014-01-23**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300623.SZ	**捷捷微电**	**2017-03-14**	**主要为 IDM 模式，产品应用领域相似，进一步筛选**
300831.SZ	派瑞股份	2020-05-07	主要为 Fabless 模式，经营模式差异较大，剔除

初步筛选后，符合上述参照标准的公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
688249.SH	晶合集成	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	集成电路晶圆制造代工：98.5703%；其他业务：1.4020%；其他：0.0277%
688396.SH	华润微	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导	产品与方案：50.9277%；制造与服务：46.3278%；其他业务：2.7445%

证券代码	证券名称	公司简介	主营业务构成
		体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	
600460.SH	士兰微	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	分立器件产品：48.4601%；集成电路：36.5858%；发光二极管产品：6.8476%；其他业务：4.4177%；其他：3.6887%
688172.SH	燕东微	北京燕东微电子股份有限公司的主营业务是产品与方案和制造与服务两类业务。公司的主要产品是产品与方案、制造与服务。	产品与方案：47.1756%；制造与服务：43.9067%；其他：5.7855%；其他业务：3.1323%
300373.SZ	扬杰科技	扬州扬杰电子科技股份有限公司的主营业务是功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试研发、生产、销售。公司的主要产品是半导体器件、半导体芯片、半导体硅片。	半导体器件：86.2474%；半导体芯片：8.3270%；半导体硅片：3.0766%；其他业务收入：2.3490%
300623.SZ	捷捷微电	江苏捷捷微电子股份有限公司的主营业务是功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列、MOSFET 系列、IGBT 系列、厚模组件、碳化硅器件、其他。	功率半导体器件：66.9693%；功率半导体芯片：31.0471%；其他业务收入：1.3637%；功率器件封测：0.6199%

2）鉴于被评估单位是一家独立的晶圆代工厂，若可比上市公司的业务规模小于被评估单位且差距较大，则其可比性将相应减弱。此外，考虑到被评估单位在评估基准日的固定资产账面价值已基本计提完折旧，且其主要生产经营场所均来源于租赁，未拥有自有厂房及土地，本次筛选过程中选取设备类固定资产账面原值规模可比的样本。

经计算各公司设备类固定资产账面原值具体如下：

单位：亿元

证券代码	证券名称	设备类固定资产账面原值
688249.SH	晶合集成	373.37
688396.SH	华润微	208.96
600460.SH	士兰微	114.24
688172.SH	燕东微	67.74
300373.SZ	扬杰科技	47.07

证券代码	证券名称	设备类固定资产账面原值
300623.SZ	捷捷微电	54.72
被评估单位	**华力微**	**153.59**

最终筛选确定的可比上市公司概况如下表所示：

证券代码	证券名称	上市日期	公司简介	主营业务
688249.SH	晶合集成	2023-05-05	合肥晶合集成电路股份有限公司的主营业务是 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司的主要产品是 DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic。	12 英寸晶圆代工业务。
688396.SH	华润微	2020-02-27	华润微电子有限公司的主营业务是功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司的主要产品是 MOSFET、IGBT、功率二极管、物联网应用专用 IC、功率 IC、光电耦合及传感、SiC、GaN。	芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营。
600460.SH	士兰微	2003-03-11	杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。	电子元器件的研发、生产和销售。

（2）可比企业财务概况

可比企业一：士兰微（600460.SH）

公司全称：杭州士兰微电子股份有限公司

1）资产负债表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动资产：			
货币资金	613,122.98	452,033.46	444,510.01
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	244,610.00	303,671.42	327,813.76
应收款项融资	93,839.37	151,269.10	192,637.98

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
预付款项	4,152.76	3,582.99	3,654.47
其他应收款合计	2,552.38	2,253.64	2,387.59
合同资产	0.00	0.00	0.00
存货	373,203.41	389,894.30	378,229.34
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,720.00	960.00	1,200.00
其他流动资产	15,329.26	31,437.47	13,912.33
流动资产合计	1,348,530.16	1,335,102.39	1,364,345.47
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	3,610.00	2,650.00	1,750.00
长期股权投资	67,830.28	127,834.49	147,654.84
其他权益工具投资	2,250.71	2,226.29	2,380.90
其他非流动金融资产	56,623.79	43,886.84	41,555.06
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	643,080.08	687,001.45	686,726.42
在建工程合计	149,717.00	180,666.10	207,442.93
使用权资产	1,221.08	763.74	839.25
无形资产	47,186.51	36,951.98	31,462.31
开发支出	2,619.90	4,872.77	9,382.82
商誉	24,535.99	24,507.00	24,507.00
长期待摊费用	10,177.79	7,209.44	6,702.13
递延所得税资产	10,736.87	15,788.13	14,577.91
其他非流动资产	22,638.42	10,236.49	11,561.12
非流动资产合计	1,042,228.41	1,144,594.71	1,186,542.71
资产总计	2,390,758.57	2,479,697.11	2,550,888.18
流动负债：			
短期借款	181,056.81	149,163.93	161,461.23
交易性金融负债	111.63	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	217,922.27	310,155.65	315,075.33

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	2,409.47	2,526.23	2,390.84
应付职工薪酬	38,896.57	41,966.48	29,584.98
应交税费	11,017.49	9,956.03	11,030.06
其他应付款合计	6,981.88	7,593.75	9,987.80
一年内到期的非流动负债	105,257.17	196,825.01	192,653.20
其他流动负债	227.62	295.63	160.50
流动负债合计	563,880.92	718,482.72	722,343.95
非流动负债：			
长期借款	343,094.60	260,300.26	347,305.44
应付债券	0.00	0.00	0.00
租赁负债	784.06	504.01	490.86
长期应付款合计	26,741.41	12,047.05	5,408.06
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	10,714.38	5,843.59	4,736.08
递延收益-非流动负债	11,857.93	13,584.62	15,085.78
其他非流动负债	91,684.17	86,576.66	89,016.44
非流动负债合计	484,876.54	378,856.18	462,042.65
负债合计	1,048,757.47	1,097,338.90	1,184,386.59
所有者权益(或股东权益)：			
归属于母公司所有者权益合计	1,202,160.63	1,221,478.52	1,230,102.77
少数股东权益	139,840.48	160,879.69	136,398.81
所有者权益合计	1,342,001.10	1,382,358.20	1,366,501.59

2）利润表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
一、营业总收入	933,953.80	1,122,086.90	633,576.61
二、营业总成本	898,089.78	1,100,739.99	597,538.91
营业成本	726,479.50	907,870.61	504,223.06
税金及附加	3,829.74	5,271.47	2,532.51

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
销售费用	16,685.01	17,877.47	8,593.39
管理费用	37,866.14	46,075.83	23,036.89
研发费用	86,377.31	103,448.04	47,820.57
财务费用	26,852.08	20,196.56	11,332.50
公允价值变动收益	-61,282.20	-13,625.32	-2,331.78
投资收益	21,622.84	-775.48	-2,841.70
净敞口套期收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	1,108.96	-274.65	60.88
资产减值损失	9,387.11	30,833.39	20,329.81
信用减值损失	2,459.33	4,554.64	2,825.29
其他收益	9,655.22	18,643.15	8,592.32
三、营业利润	-4,877.60	-10,073.42	16,362.31
加：营业外收入	116.34	445.96	185.88
减：营业外支出	926.56	1,097.17	128.36
四、利润总额	-5,687.81	-10,724.63	16,419.83
减：所得税费用	767.95	-8,338.44	3,136.22
五、净利润	-6,455.76	-2,386.19	13,283.62
减：少数股东损益	-2,877.19	-24,372.98	-13,196.15
归属于母公司所有者的净利润	-3,578.58	21,986.78	26,479.77

上述数据摘自于士兰微历史定期报告。

可比企业二：晶合集成（688249.SH）

公司全称：合肥晶合集成电路股份有限公司

1）资产负债表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动资产：			
货币资金	652,622.76	582,775.72	310,395.47
交易性金融资产	154,842.49	106,612.55	157,389.87
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
应收票据及应收账款	85,720.04	99,257.58	95,632.97
应收款项融资	377.71	13.07	258.65
预付款项	8,439.72	3,750.70	3,354.56
其他应收款合计	2,571.80	5,245.43	4,170.25
合同资产	0.00	0.00	0.00
存货	149,268.54	150,332.06	164,554.75
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	3,180.48	6,360.97
其他流动资产	140,689.44	23,219.06	41,381.92
流动资产合计	1,194,532.50	974,386.65	783,499.39
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	10,000.00	17,711.10	27,354.45
其他权益工具投资	10,366.92	13,424.43	17,444.90
其他非流动金融资产	30,653.50	60,738.86	50,616.15
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	2,287,260.63	2,479,217.17	2,671,579.01
在建工程合计	1,095,959.78	1,322,186.48	1,334,338.64
使用权资产	355.91	85.70	0.00
无形资产	135,802.02	131,341.88	137,113.98
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	8.87	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	50,687.84	40,765.67	98,702.02
非流动资产合计	3,621,095.46	4,065,471.30	4,337,149.12
资产总计	4,815,627.96	5,039,857.94	5,120,648.52
流动负债：			
短期借款	65,834.90	129,114.81	67,937.17
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	799,976.35	219,372.58	271,923.94
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	87,737.18	64,851.59	28,811.36
应付职工薪酬	11,638.49	17,094.28	21,061.78
应交税费	9,478.67	9,544.18	7,800.98
其他应付款合计	284,185.04	147,583.25	114,429.79
一年内到期的非流动负债	140,334.36	150,494.10	171,357.91
其他流动负债	2,475.00	4,521.77	6,656.28
流动负债合计	1,401,659.99	742,576.55	689,979.22
非流动负债：			
长期借款	1,151,003.04	1,558,942.96	1,669,458.48
应付债券	0.00	79,988.88	99,991.02
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款合计	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	977.20	700.83	1,225.90
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
递延收益-非流动负债	48,171.21	48,751.98	45,663.14
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,200,151.45	1,688,384.65	1,816,338.54
负债合计	2,601,811.44	2,430,961.20	2,506,317.76
所有者权益(或股东权益)：			
归属于母公司所有者权益合计	2,140,980.47	2,087,031.10	2,102,478.03
少数股东权益	72,836.05	521,865.65	511,852.73
所有者权益合计	2,213,816.52	2,608,896.75	2,614,330.76

2）利润表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
一、营业总收入	724,354.14	924,925.23	519,845.47

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
二、营业总成本	724,299.13	889,949.83	497,180.83
营业成本	567,817.38	689,047.20	385,910.05
税金及附加	3,186.36	3,232.45	1,957.68
销售费用	5,019.63	5,483.66	2,817.30
管理费用	27,119.33	34,063.15	18,333.08
研发费用	105,751.18	128,397.52	69,482.02
财务费用	15,405.24	29,725.86	18,680.70
公允价值变动收益	1,133.40	771.60	997.75
投资收益	7,319.44	4,118.22	1,357.56
净敞口套期收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	2.34	0.07	0.00
资产减值损失	8,108.60	2,404.05	6,205.87
信用减值损失	-10.61	-174.97	13.74
其他收益	11,145.40	10,560.26	4,244.29
三、营业利润	11,557.58	48,196.47	23,044.63
加：营业外收入	601.39	217.73	160.07
减：营业外支出	224.93	168.25	0.00
四、利润总额	11,934.04	48,245.94	23,204.70
减：所得税费用	17.56	26.31	4.74
五、净利润	11,916.48	48,219.63	23,199.96
减：少数股东损益	-9,246.44	-5,064.43	-10,012.92
归属于母公司所有者的净利润	21,162.91	53,284.06	33,212.88

上述数据摘自于晶合集成历史定期报告。

可比企业三：华润微（688396.SH）

公司全称：华润微电子有限公司

1）资产负债表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动资产：			

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
货币资金	1,173,652.79	868,294.30	893,689.13
交易性金融资产	6,200.08	2,978.39	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据及应收账款	155,442.95	185,302.92	209,681.80
应收款项融资	67,164.99	54,183.15	74,844.21
预付款项	6,302.52	5,474.46	6,939.98
其他应收款合计	1,803.39	319.26	701.31
合同资产	0.00	0.00	0.00
存货	196,574.29	209,642.48	213,370.04
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	3,587.57	8,808.96	9,479.90
流动资产合计	1,610,728.57	1,335,003.92	1,408,706.38
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	392,166.99	601,169.18	574,644.09
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	50,227.69	44,054.32	44,310.49
投资性房地产	279.81	3,840.81	3,757.76
固定资产合计	654,105.14	775,116.93	750,960.71
在建工程合计	76,476.36	34,865.18	43,587.64
使用权资产	10,417.80	8,342.90	7,683.92
无形资产	36,062.04	36,594.23	35,465.17
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	18,532.66	52,543.54	52,543.54
长期待摊费用	3,094.94	3,848.03	2,728.98
递延所得税资产	9,781.77	10,316.94	10,396.03
其他非流动资产	59,652.22	4,986.99	19,209.26
非流动资产合计	1,310,797.41	1,575,679.04	1,545,287.61
资产总计	2,921,525.98	2,910,682.95	2,953,993.99

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
流动负债：			
短期借款	2,244.42	3,382.05	4,779.00
交易性金融负债	0.00	8,167.02	8,167.02
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	118,231.87	132,429.98	139,053.35
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	17,420.67	17,797.24	22,956.91
应付职工薪酬	57,776.56	56,308.37	45,534.33
应交税费	7,930.70	6,589.45	8,899.89
其他应付款合计	203,009.22	173,668.21	173,964.37
一年内到期的非流动负债	6,530.00	2,426.67	2,143.53
其他流动负债	13,645.44	12,535.73	13,611.27
流动负债合计	426,788.86	413,304.71	419,109.68
非流动负债：			
长期借款	90,665.96	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
租赁负债	7,728.96	6,422.44	6,032.96
长期应付款合计	0.00	0.00	48.20
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	1,455.59	2,177.20	2,056.48
递延所得税负债	9,510.27	7,394.97	7,261.25
递延收益-非流动负债	21,927.62	35,137.56	39,047.92
其他非流动负债	403.81	16,650.77	16,337.67
非流动负债合计	131,692.20	67,782.93	70,784.48
负债合计	558,481.06	481,087.65	489,894.17
所有者权益(或股东权益)：			
归属于母公司所有者权益合计	2,155,805.67	2,230,621.31	2,270,626.79
少数股东权益	207,239.24	198,974.00	193,473.03
所有者权益合计	2,363,044.92	2,429,595.31	2,464,099.82

2）利润表（合并报表）

单位：万元

项目	2023/12/31	2024/12/31	2025/6/30
一、营业总收入	990,060.39	1,011,852.58	521,817.88
二、营业总成本	852,588.28	917,504.73	471,978.20
营业成本	671,021.63	736,683.88	387,973.12
税金及附加	8,406.13	8,350.37	4,802.85
销售费用	16,717.28	15,819.09	7,965.26
管理费用	65,511.45	52,316.06	26,337.17
研发费用	115,411.23	116,711.32	54,794.38
财务费用	-24,479.45	-12,375.99	-9,894.58
公允价值变动收益	-698.23	-2,846.35	256.17
投资收益	8,574.85	-38,259.80	-23,155.15
净敞口套期收益	0.00	0.00	0.00
汇兑收益	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	-494.02	-409.44	20.29
资产减值损失	2,553.45	7,423.00	2,147.16
信用减值损失	783.83	-136.26	85.41
其他收益	25,169.91	33,114.56	10,730.37
三、营业利润	166,687.33	78,660.07	35,458.78
加：营业外收入	2,256.61	986.55	251.26
减：营业外支出	267.85	183.12	18.60
四、利润总额	168,676.08	79,463.50	35,691.43
减：所得税费用	24,861.52	13,293.21	7,791.06
五、净利润	143,814.56	66,170.29	27,900.37
减：少数股东损益	-4,112.01	-10,075.70	-5,979.16
归属于母公司所有者的净利润	147,926.57	76,245.99	33,879.53

上述数据摘自于华润微历史定期报告。

（3）规范被评估单位和可比公司的财务报表

对于任何一个企业，其资产负债表可能既包括经营性资产、负债，又包括非经营性资产、负债和溢余资产；其利润表可能既包括与经营性资产相关的营业收入和支出，又包括与非经营性资产、负债和溢余资产相关的收入和支出。评估专业人员在用于市场法进行企业价值评估时，由于非经营收入和支出，非

经营性资产、负债和溢余资产及其相关的收入和支出的影响，可能导致基于财务报表计算的价值比率不具有可比性，因此，本次评估运用市场法进行企业价值评估时，按照统一口径对可比对象和被评估企业财务报表中的非经营性资产、负债和溢余资产及其相关的收入和支出进行剥离，然后在最终的评估结果中加回非经营性资产、负债及溢余资产的价值。

有鉴于可比企业的非经营性资产和非经营性损益，无法像委估企业一样通过详细尽调获得，考虑到数据的可获得性，我们本次对非经营性资产和非经常性损益主要限定在以下会计科目：

1）非经营性资产（负债）

非经营性资产主要包括交易性金融资产、衍生金融资产、持有待售资产、债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产等会计科目，上述科目的全部金额一般都作为非经处理。

非经营性负债主要包括交易性金融负债、衍生金融负债、递延收益等会计科目，上述科目的全部金额一般都作为非经处理。

受制于数据的可获得性，非经营性资产和负债的评估值均等于账面值。

2）非经常性损益

调整后的经营性营业利润＝营业利润－需要调整的非持续营业收入＋需要调整的非持续营业成本和期间费用－其他收益－投资收益－净敞口套期收益－公允价值变动收益－信用减值损失－资产减值损失－资产处置收益

调整的非经常性损益主要包括其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益等。

（4）价值比率的计算

经过上述分析过程，价值比率的计算如下：

单位：万元

具体指标	公式	待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
股价（元/股）	A		26.86	21.97	47.74
总股本（万股）	B		166,407.18	200,613.52	132,752.94
缺乏流动性折扣率	C		39.26%	39.26%	39.26%

具体指标	公式	待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
扣除流动性折扣后市值	D=A×B×(1-C)		2,715,100.00	2,676,700.00	3,849,500.00
基准日非经营性资产、负债净额	E		193,340.81	252,780.46	608,688.12
经营性股权价值	F=D-E		2,521,759.19	2,423,919.54	3,240,811.88
付息债务	G		706,452.88	2,003,102.12	4,827.20
少数股东权益	H		136,398.81	511,852.73	193,473.03
货币资金	I		444,510.01	310,395.47	893,689.13
不含资金的经营性企业价值 EV	J=F+G+H-I		2,920,100.87	4,628,478.92	2,545,422.98
EBITDA	K	87,781.97	173,149.07	426,382.53	216,387.18
EV/EBITDA 值	L=J÷K		16.86	10.86	11.76

1）经营性股权价值的计算

经营性股权价值＝股东全部权益价值（上市公司市值）－非经营性资产负债评估值

其中：股东全部权益价值＝基准日股本总额×基准日前120日成交均价×（1－流动性折扣率）

2）非流通性折扣

由于选取的上市公司的价值是通过流通股的价格计算的，而委评公司非上市公司，因此通过修正后的价值比率计算出来的经营性股权价值需要考虑非流通折扣。

一般认为不可流通股与流通股之间的价格差异主要由下列因素造成：

①承担的风险

流通股的流通性很强，一旦发生风险后，流通股持有者可以迅速出售所持有股票，减少或避免风险。非流通股持有者在遇到同样情况后，则不能迅速做出上述反应而遭受损失。

②交易的活跃程度

流通股交易活跃，价格上升。非流通股缺乏必要的交易人数，另外非流通股一般数额较大，很多投资者缺乏经济实力参与非流通股的交易，因而，与流通股相比，交易缺乏活跃，价格较低。

由于选取的上市公司的价值是通过流通股的价格计算的，而委估企业是非上市公司，因此通过可比公司所在的流通市场计算得到的市值需要修正。

对于流动性折扣，评估人员参考新股发行定价估算方式进行测算，所谓新股发行定价估算方式就是根据国内上市公司新股IPO的发行定价与该股票正式上市后的交易价格之间的差异来研究缺乏流动性的方式。

评估人员根据筛选后可比公司的细分行业分类，收集了在该行业分类下距评估基准日上市满一年的所属行业公司新股的发行价，分别研究其与上市后第90交易日、120交易日、250交易日收盘价之间的关系，相关概况信息如下表所示：

证券代码	证券名称	首发价格	上市后90日收盘价	上市后120日收盘价	上市后250日收盘价	第90日流动性折扣	第120日流动性折扣	第250日流动性折扣
600360.SH	*ST 华微	8.4200	23.1000	19.7000	16.0900	63.55%	57.26%	47.67%
600460.SH	士兰微	11.6000	16.1000	16.6000	35.0900	27.95%	30.12%	66.94%
603290.SH	斯达半导	12.7400	190.3266	215.5800	242.4160	93.31%	94.09%	94.74%
605111.SH	新洁能	19.9100	170.5000	166.5800	170.9505	88.32%	88.05%	88.35%
688048.SH	长光华芯	80.8000	141.5232	110.8839	116.9314	42.91%	27.13%	30.90%
688167.SH	炬光科技	78.6900	99.7400	152.8600	93.7300	21.10%	48.52%	16.05%
688172.SH	燕东微	21.9800	22.8200	23.8300	17.5000	3.68%	7.76%	-25.60%
688230.SH	芯导科技	134.8100	90.5500	88.9800	83.7498	-48.88%	-51.51%	-60.97%
688249.SH	晶合集成	19.8600	18.5700	16.6800	14.3600	-6.95%	-19.06%	-38.30%
688261.SH	东微半导	130.0000	259.8600	299.8257	243.1371	49.97%	56.64%	46.53%
688347.SH	华虹公司	52.0000	43.4700	35.0100	31.3794	-19.62%	-48.53%	-65.71%
688396.SH	华润微	12.8000	58.0960	50.2398	61.5187	77.97%	74.52%	79.19%
688469.SH	芯联集成	5.6900	5.3300	5.2800	3.9300	-6.75%	-7.77%	-44.78%
688498.SH	源杰科技	100.6600	221.3500	437.8892	209.0988	54.52%	77.01%	51.86%
688689.SH	银河微电	14.0100	30.6329	40.8573	38.5684	54.26%	65.71%	63.67%
688691.SH	灿芯股份	19.8600	44.2566	55.5099	61.9895	55.13%	64.22%	67.96%
688693.SH	锴威特	40.8300	44.4300	26.1600	23.9836	8.10%	-56.08%	-70.24%
688711.SH	宏微科技	27.5100	120.8700	96.5443	89.8930	77.24%	71.51%	69.40%
688981.SH	中芯国际	27.4600	58.6400	61.5900	51.8800	53.17%	55.41%	47.07%
300046.SZ	台基股份	41.3000	36.2176	47.7013	59.1849	-14.03%	13.42%	30.22%
300373.SZ	扬杰科技	19.5000	54.4516	52.0239	52.3650	64.19%	62.52%	62.76%

证券代码	证券名称	首发价格	上市后90日收盘价	上市后120日收盘价	上市后250日收盘价	第90日流动性折扣	第120日流动性折扣	第250日流动性折扣
300456.SZ	赛微电子	14.0100	103.2000	103.2000	86.9700	86.42%	86.42%	83.89%
300623.SZ	捷捷微电	27.6300	63.8216	70.0792	63.6609	56.71%	60.57%	56.60%
300831.SZ	派瑞股份	3.9800	19.7037	25.3133	10.1774	79.80%	84.28%	60.89%
均值						**40.09%**	**39.26%**	**31.63%**

本次评估采用上市后第90交易日、120交易日、250交易日流动性折扣率中位数39.26%确定为缺乏流动性折扣率。

3）不含资金的经营性企业价值EV

考虑到企业一方面可能有付息债务，而另一方面又存在货币资金，而这个和企业对于货币资金管理方式、风险偏好、运营资金季节性变动有关，因此为了剔除该因素的影响，在计算企业价值时剔除货币资金的影响，得出不含货币资金的企业价值用于计算各项价值比率，即本次企业价值EV均为不含货币资金的价值（为方便表述，以下除非专门指出，则企业价值EV均为不含货币资金的价值）即：

企业价值EV＝全口径企业价值EV－非经营性资产负债评估值

全口径企业价值EV＝经营性股权价值＋付息债务＋少数股东权益－货币资金

受制于数据的可获得性以及数据的非重要性，少数股东权益的评估值均等于账面值。

4）经营性损益

本次评估基准日为2025年8月31日，鉴于各可比公司截止基准日仅披露了2025年中期财务报告，为确保经营数据在完整会计期间内具有可比性，本次评估被评估单位及各可比公司统一采用2024年度的财务数据作为损益比较基础。

（5）价值比率修正

本次评估依据从财务指标及非财务指标两个维度对被评估单位与可比公司间的差异进行量化。其中，财务指标主要涵盖企业的经营规模、偿债能力、营运能力及盈利能力；非财务指标涵盖企业的交易日期、交易情况、所处发展阶

段、研发投入、设备成新度、主要经营模式等方面。在此基础上，结合行业特性和所选价值比率的内涵，我们对各项指标赋予了相应的权重。具体情况如下表所示：

特性指标			权重
财务指标	经营规模	资产总计	50%
		营业收入	50%
	偿债能力	资产负债率	50%
		流动比率	50%
	营运能力	流动资产周转次数	50%
		总资产周转次数	50%
非财务指标	交易日期		100%
	交易情况		100%
	发展阶段		100%
	研发投入		100%
	设备净值率		100%
	主要经营模式		100%

修正体系解释如下：

1）经营规模修正

不同企业经营规模是有差异的，在衡量市场地位、市场份额方面，营业收入、总资产是非常重要的指标。并购者在其他条件相同的情况下，会对经营规模更大的企业产生更大的并购动机。

本次经营规模的衡量指标采用营业收入、总资产等。本次通过对影响经营规模的两个指标进行打分修正，并根据各指标影响企业经营规模的重要程度赋予相应的权重，以修正后的打分加权分值来确定各指标的修正系数。

经营规模的修正是正向的，即经营规模越大，则向上修正，反之则向下修正。

2）偿债能力修正

企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力，是企业能否健康生存和发展的关键，反映企业财务状况和经营风险的重要标志。静态的讲，就是用企业资产清偿企业债务的能力；动态的讲，就是用企业资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。

偿债能力的衡量指标主要有流动比率、资产负债率等。本次通过对影响偿债能力的两个指标进行打分修正，并根据各指标影响企业偿债能力的重要程度赋予相应的权重，以修正后的打分加权分值来确定各指标的修正系数。

资产负债率修正的方向是反向的，即资产负债率越高，则向下修正；反之则向上修。流动比率修正的方向是正向的，即该指标越高，则向上修正，反之则向下修正。

3）运营能力修正

运营能力是指企业基于外部市场环境的约束，通过内部人力资源和生产资料的配置组合而对财务目标实现所产生作用的大小，通俗来讲，就是企业运用各项资产以赚取利润的能力。

企业营运能力的财务分析比率有：总资产周转次数、流动资产周转次数等。这些比率揭示了企业资金运营周转的情况，反映了企业对经济资源管理、运用的效率高低。企业资产周转越快，流动性越高，资产获取利润的速度就越快。

本次通过对总资产周转次数、流动资产周转次数进行打分修正，并根据各指标影响企业偿债能力的重要程度赋予相应的权重，以修正后的打分加权分值来确定各指标的修正系数。

运营能力修正是正向的，即周转率越高，则向上修正；反之则向下修正。

4）盈利能力修正

本次采用企业价值与息税折旧摊销前利润比率（EV/EBITDA），由于该指标本身就是盈利类的价值比率，因此不宜再将盈利能力作为修正因素，因此该价值比率不进行盈利能力修正。

5）交易日期修正

资产的价格会因为不同的时间而发生变化，而可比企业的成交日期与评估时点通常不同。因此需要将可比企业在其成交日期时的价格调整到在评估时点的价格。这种对可比企业成交价格进行的调整，称为“市场状况调整”，或称“交

易日期修正”。经过这一调整或修正之后，就将可比企业在其成交日期的价格变成了在评估时点的价格。

本次采用上市公司比较法，且计算口径均为评估基准日近期股票交易均价，因此不需要进行交易日期修正。

6）交易情况修正

可比企业的成交价格是实际发生的，它可能是正常的、公允的市场价值，也可能是某些特定条件、交易条款下的价格。由于要求评估对象价值是客观、公允的，所以可比企业的成交价格如果是不正常的，则应把它修正为正常的。这种对可比企业成交价格进行的修正，称为交易情况修正。

经过核查，评估人员认为，上市公司的交易价格均为活跃、公开交易下的正常市场交易价格，不需要进行交易情况修正。

7）发展阶段修正

可比公司可能处于不同的发展阶段，发展阶段对于企业价值的影响本质上源于市场对企业未来收益增长预期的差异。资本市场无论是对于企业的并购对价的估值逻辑还是对上市公司股权走势的判断均依赖于这一预期：增长预期越高，则估值水平相应提升；反之，则估值水平下调。

鉴于被评估单位目前已基本处于满产状态，其未来收益的增长将主要依赖于市场整体发展所带动的产品价格提升，进而推动收入与利润的同步增长。相比之下，本次所选的可比上市公司均处于发展期至成熟期，其增长驱动来源于产能扩张等多重因素，预期增长高于被评估单位。因此我们根据资本市场对于可比企业预期收益增长情况，对发展阶段进行修正。

我们对于发展阶段修正的修正幅度最大值为10个单位。

8）研发投入修正

研发投入指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各种费用，包括：研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用；企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以

及外聘兼职研发人员的劳务费；用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧或租赁费用等等。

衡量研发投入的重要的一个指标为研发费用率，即研发费用占营业收入的比率。研发费用率越高，代表着企业在创新能力和技术研发上的投入意愿越高，对企业未来保持先进性和盈利能力是利好。

研发费用率的修正是正向的，即研发费用率越高，则向上修正；反之则向下修**正**。

9）设备净值率修正

生产设备净值率是衡量企业固定资产质量与技术状态的关键指标。净值率越高，表明设备的物理损耗越低，综合运行效率越可靠，通常也意味着其投产时间较近，具备更高的技术先进性与工艺水平。

对于晶圆代工企业而言，生产设备是其核心生产要素。较高的设备净值率不仅直接关联到更优异的产能性能，此外较新的设备状态通常预示着未来短期内所需的维护维修成本及大规模更新资本支出相对较低，有利于企业维持较好的现金流。

基于上述逻辑，本次对生产设备净值率进行修正。考虑到半导体设备的财务折旧年限短于使用寿命而使得账面净值率偏低，本次通过平均使用寿命调整财务折旧年限后再进行修正。

设备净值率对企业价值的影响为正向关系。净值率越高，则向上修正；反之则向下修**正**。

10）其他因素参数

在半导体制造领域，主要存在两种商业模式：垂直整合制造模式（IDM）、代工模式（Foundry），二者在产业链定位、运营逻辑与价值创造上存在一定差异，具体对比如下：

①垂直整合制造模式（IDM）

IDM模式覆盖了从芯片设计、制造到封装测试的全产业链环节。

核心优势：

A、产业链整合能力：通过内部整合设计、制造与封测环节，IDM企业能够实现全流程的协同优化，有助于充分发掘技术潜力，并在产品性能、功耗及成本间取得最佳平衡。

B、产能自主与供应链安全：在市场供需紧张时，其自有产能可以优先保障内部需求，同时能快速响应市场价格变动，具备显著的供应链安全与竞争优势。

C、深层技术壁垒：由于覆盖了设计和制造，能够积累更多的技术和经验，从而形成更高的技术壁垒和核心竞争力。

经营风险：

A、运营风险较高：需要覆盖设计、制造与封测环节全产业链的生产流程，在市场波动尤其在下行周期，易导致利用率不足，运营风险较为集中。

B、管理复杂性与技术迭代速度不足：管理覆盖多领域的庞大组织，可能带来效率损耗。同时，由于需要覆盖设计、制造与封测环节全产业链的研发迭代和技术创新，其创新速度可能不及高度专业化的分工模式。

②代工模式（Foundry）

Foundry模式专注于芯片的制造、封装等单一或多个环节，不从事芯片设计，而是为专业的芯片设计公司（Fabless）提供服务。

核心优势：

A、技术快速迭代能力：通过专注于制造与封装环节的工艺技术，代工厂能够实现技术平台的快速迭代与优化，从而更敏捷地响应市场需求。

B、规模效应与成本优势：仅承担代工的职能，通过承接来自全市场的芯片设计公司订单，能够最大化地提升产能利用率，摊薄单位成本，实现规模效应。

C、开放的合作伙伴生态：因其不涉足竞争性的芯片设计业务，能够与众多Fabless公司建立合作关系，构建开放的产业生态。

经营风险：

A、产业链附加值不足：处于产业链中游，其附加值的实现依赖于Fabless公司的设计与终端市场需求，在响应特定客户深度定制需求时，能力可能受限。

B、抗市场波动能力较弱：产能利用率与盈利能力直接受下游订单波动影响，在行业景气度下行时面临的业绩压力更为直接。

综合上述因素考虑，虽然IDM模式存在运营风险集中、管理复杂与技术迭代速度不足的劣势，但其凭借全产业链整合所带来的协同优化、供应链自主可控以及更高的技术附加值，相较Foundry模式仍具备一定的优势。本次对IDM模式作向上修正，但考虑到商业模式不同也会影响到各自的财务指标，因此对商业模式的差异修正的最大值为5个点。

11）比较和打分表

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
价值比率 EV（不含货币资金）/EBITDA			16.86	10.86	11.76
交易日期修正	交易指数	100	100	100	100
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0
交易情况修正	交易情况	正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易	正常市场交易
	打分系数	100.0	100.0	100.0	100.0
发展阶段修正	预期收益增长	成熟期	发展期-成熟期	发展期-成熟期	发展期-成熟期
	打分系数	100.0	110.0	110.0	110.0
经营规模修正	资产总计（万元）	718,952.0	2,357,547.4	4,867,843.2	2,331,281.7
	打分系数	100.0	105.0	105.0	105.0
	营业收入	451,697.1	1,122,086.9	924,925.2	1,011,852.6
	打分系数	100.0	105.0	105.0	105.0
	小计	100.0	105.0	105.0	105.0
偿债能力修正	资产负债率	72.9%	49.6%	50.5%	19.0%
	打分系数	100.0	102.0	102.0	104.0
	流动比率	2.5	1.9	0.9	3.4
	打分系数	100.0	99.0	97.0	102.0
	小计	100.0	100.5	99.5	103.0
运营能力修正	流动资产周转次数	0.9	0.8	1.5	0.7
	打分系数	100.0	99.0	103.0	99.0

项目		待估对象	案例一	案例二	案例三
		华力微	士兰微	晶合集成	华润微
	总资产周转次数	0.6	0.5	0.2	0.4
	打分系数	100.0	99.0	97.0	98.0
	小计	100.0	99.0	100.0	98.5
研发投入修正	研发费用率	7.2%	9.2%	13.9%	11.5%
	打分系数	100.0	101.0	105.0	103.0
设备净值率修正	设备净值率	60.6%	78.1%	85.0%	68.8%
	打分系数	100.0	103.0	104.0	101.0
其他因素修正	商业模式	Foundry	IDM	Foundry	IDM
	打分系数	100.0	105.0	100.0	105.0

5、市场法评估结果

采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，得出的评估基准日的评估结果如下：

项目	案例一	案例二	案例三
	士兰微	晶合集成	华润微
价值比率 EV（不含货币资金）/EBITDA	16.86	10.86	11.76
交易日期修正	100/100	100/100	100/100
交易情况修正	100/100	100/100	100/100
发展阶段修正	100/110	100/110	100/110
经营规模修正	100/105	100/105	100/105
偿债能力修正	100/100.5	100/99.5	100/103
运营能力修正	100/99	100/100	100/98.5
盈利能力修正	100/100	100/100	100/100
研发投入修正	100/101	100/105	100/103
设备净值率修正	100/103	100/104	100/101
其他因素修正	100/105	100/100	100/105
修正后价值比率 EV/EBITDA	13.43	8.65	9.19
权重	33%	33%	33%
修正后价值比率×权重	4.48	2.88	3.06
加权修正后价值比率 EV/EBITDA	**10.42**		
标的企业 EBITDA	87,781.97		
全口径经营性企业价值（不含货币资金）	914,688.16		

项目	案例一	案例二	案例三
	士兰微	晶合集成	华润微
减：付息债务			373,753.75
减：少数股东权益			0.00
经营性不含货币资金股权价值			540,934.41
加：非经营性资产、负债			6,898.29
加：货币资金			300,352.21
评估值			**848,000.00**

被评估单位股东权益账面值为 200,191.38 万元，评估值 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

（五）评估结论

1、资产基础法评估结果

采用资产基础法对企业股东全部权益价值进行评估，得出被评估单位在评估基准日的评估结果如下：

评估基准日，被评估单位所有者权益账面值 200,191.38 万元，评估值 782,761.17 万元，评估增值 582,569.79 万元，增值率 291.01%。其中，总资产账面值 725,850.28 万元，评估值 1,306,836.22 万元，评估增值 580,985.94 万元，增值率 80.04%。总负债账面值 525,658.90 万元，评估值 524,075.05 万元，评估减值 1,583.85 万元，减值率 0.30%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示：

单位：万元

项　　目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	502,209.71	526,180.75	23,971.04	4.77
非流动资产	223,640.57	780,655.47	557,014.90	249.07
长期应收款	6,362.46	6,362.46	0.00	0.00
固定资产	150,987.78	558,573.56	407,585.78	269.95
在建工程	13,740.65	13,816.45	75.80	0.55
使用权资产	38,118.47	38,118.47	0.00	0.00
无形资产	12,989.24	162,346.03	149,356.79	1,149.85
长期待摊费用	526.11	526.11	0.00	0.00
其他非流动资产	915.86	912.39	-3.47	-0.38

项　　目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
资产总计	**725,850.28**	**1,306,836.22**	**580,985.94**	**80.04**
流动负债	204,107.99	204,135.14	27.15	0.01
非流动负债	321,550.91	319,939.91	-1,611.00	-0.50
负债总计	**525,658.90**	**524,075.05**	**-1,583.85**	**-0.30**
所有者权益（净资产）	**200,191.38**	**782,761.17**	**582,569.79**	**291.01**

2、市场法评估结果

采用市场法对企业股东全部权益价值进行评估，得出的评估基准日的评估结果如下：

被评估单位所有者权益账面值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。

3、评估结论

本次评估采用市场法得出的股东全部权益价值为 848,000.00 万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值 782,761.17 万元高 65,238.83 万元。

不同评估方法的评估结果差异的原因主要是各种评估方法对资产价值考虑的角度不同，资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算；市场法是从现时市场可比价格角度进行测算，导致各评估方法的评估结果存在差异。

鉴于华力微属于晶圆加工产业，其主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源的贡献。由于资产基础法的特性，其评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了价值评估，并不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值，对于被评估单位的工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资源价值一般也难以在资产基础法中体现，资产基础法评估结果较市场法存在一定局限性。其次，市场法的数据采用可比上市公司的公开数据，近年来随着中国的股市日臻成熟，相对成熟的资本市场环境也提供了市场法定价的基础。

通过以上分析，我们选用市场法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。

经评估，在评估基准日，上述各项假设条件成立的前提下，被评估单位股东全部权益价值为人民币 8,480,000,000.00 元。大写人民币：捌拾肆亿捌仟万元整。

（六）引用其他评估机构报告的内容

本次评估未引用其他评估机构或估值机构的报告。

（七）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明

1、华力微分立事项

2025 年 6 月 26 日，根据沪华力微股（2025）第 4 号股东会决议，全体股东一致同意公司存续分立的方案，采取存续分立的形式，将公司分立为存续公司华力微及新设公司。分立后的华力微继续运营位于中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号的 12 英寸晶圆厂晶圆代工等相关的业务，并承继与之相关的资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务，新设公司承继长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务。分立后的华力微与新设公司保持业务、资产、人员、财务、机构等方面的相互独立。公司于 2025 年 8 月 21 日完成了分立行为。分立后的华力微注册资本与新设公司的注册资本之和等于本次分立前华力微的注册资本。各股东在分立后的华力微与新设公司的持股比例，与本次分立前在华力微的持股比例一致。分立后的华力微为本次重组拟注入华虹公司的标的资产。

本次评估对象为分立后的华力微，基于此，评估工作以华力微在分立框架下编制的模拟财务报表及反映的业务实质为基础展开。

2、抵质押事项

截至评估基准日，华力微涉及的抵押、担保等事项如下：

借款合同编号	借款人	贷款人	借款金额（万元）	借款期限	借款用途	借款利率	担保情况
3100201606100000054 号借款合同	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	300,000.00	2016 年 8 月 4 日-2026 年 8 月 3 日	产线建设	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 152,243.77 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保

3100201506100000015001 号借款合同	华力微	委托贷款人：国开发展基金有限公司；受托贷款人：国家开发银行股份有限公司	100,000.00	2015 年 11 月 24 日-2030 年 11 月 23 日	产线投建	年利率 1.2%	华力微以评估值合计 116,263.96 万元的设备向委托贷款人提供抵押担保
310020230110000 2961	华力微	国家开发银行上海市分行、交通银行股份有限公司上海新区支行、上海银行股份有限公司徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行	96,000.00	2023 年 2 月-2031 年 2 月	研发	3%	华力微以评估值合计 29,052.85 万元的设备向贷款人提供抵押担保

本次未考虑上述抵押或质押事项对评估结果的可能影响，提请报告使用人注意。

3、或有事项

截至2025年8月31日，华力微银行保函业务担保余额为人民币10,000,000.00元，最后一笔将于2026年2月10日到期。

截至 2025 年 8 月 31 日，华力微未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额美元 1,360,050.00（等值人民币 9,660,435.15 元），最后一笔将于 2026 年 1 月 13 日到期。

本次评估未考虑上述或有事项对评估值的影响。

（八）评估基准日至重组报告书签署日之重要变化事项及其对评估及交易作价的影响

本次评估基准日至重组报告书出具日之间未发生对评估结果有重大影响的相关事项。

二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析

（一）董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的意见

1、评估机构的独立性

本次交易的评估机构东洲评估符合《证券法》的相关规定。东洲评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的或可预期的利害关系或冲突；评估机构具有独立性。

2、评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，所选用的评估方法合理，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。

4、评估定价的公允性

本次交易的交易各方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格，标的资产的评估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允，未损害中小投资者利益。

评估价值分析原理、采用的模型、选取的估值指标等重要评估参数符合标的公司的实际情况，评估依据及评估结论合理。

综上，本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

（二）评估合理性的分析

标的资产所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况等内容详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”。

本次交易评估作价综合考虑了标的资产历史年度经营业绩、财务情况、所在行业发展前景、行业竞争地位和经营情况，具有合理性。

（三）交易标的后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的变化趋势及应对措施及其对评估的影响

截至重组报告书签署日，标的公司在后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、重大合作协议、经营许可、技术许可、税收优惠等方面不存在重大不利变化。

（四）敏感性分析

在市场法评估模型中，可比公司评估基准日交易均价及缺乏流动性折扣率对市场法评估结果有较大的影响，故对可比公司评估基准日交易均价及缺乏流动性折扣率进行了敏感性分析，结果如下：

1、可比公司评估基准日均价变动的敏感性分析

以当前各可比公司评估基准日交易均价为基准，假设其他测算参数均保持不变，可比公司评估基准日交易均价变动对市场法评估值的敏感性分析如下（假设各可比公司评估基准日交易均价均变动幅度一致）：

单位：万元

股价变动率	评估值	股价每 1.0%变动评估值变动金额	评估值变动率	股价每 1.0%变动评估值变动率
-3.00%	821,000.00	10,000.00	-3.18%	1.18%
-2.00%	831,000.00	8,000.00	-2.00%	0.94%
-1.00%	839,000.00	9,000.00	-1.06%	1.06%
0.00%	848,000.00	-	-	-
1.00%	858,000.00	10,000.00	1.18%	1.18%
2.00%	867,000.00	9,000.00	2.24%	1.06%
3.00%	876,000.00	9,000.00	3.30%	1.06%
平均值		**9,166.67**	**-**	**1.08%**

从上表可知，在其他测算参数均保持不变的前提下，可比公司评估基准日股

票交易均价每增长 1.0%对评估值的影响约为 9,166.67 万元，评估值变动率约为 1.08%。

2、缺乏流动性折扣率变动的敏感性分析

以当前缺乏流动性折扣率为基准，假设其他测算参数均保持不变，缺乏流动性折扣率变动对市场法评估值的敏感性分析如下：

单位：万元

缺乏流动性折扣率变动率	评估值	缺乏流动性折扣率每 1.0%变动评估值变动金额	评估值变动率	缺乏流动性折扣率每 1.0%变动评估值变动率
-3.00%	867,000.00	7,000.00	2.24%	0.83%
-2.00%	860,000.00	5,000.00	1.42%	0.59%
-1.00%	855,000.00	7,000.00	0.83%	0.83%
0.00%	848,000.00	-	-	-
1.00%	843,000.00	5,000.00	-0.59%	0.59%
2.00%	837,000.00	6,000.00	-1.30%	0.71%
3.00%	831,000.00	6,000.00	-2.00%	0.71%
平均值		**6,000.00**	**-**	**0.71%**

从上表可知，在其他测算参数均保持不变的前提下，缺乏流动性折扣率每降低 1.0%对评估值的影响约为 6,000.00 万元，评估值变动率约为 0.71%。

上述敏感性分析计算仅为揭示评估参数估计的不确定性对评估值的影响，以及说明评估结论存在的不确定性，但并不影响评估师基于已掌握的信息资料对相关评估参数作出的估计判断，也不影响评估结论的成立。

（五）交易标的与上市公司的协同效应

关于交易标的与上市公司的协同效应，详见本报告“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性”之“2、标的公司与上市公司主营业务具有协同效应”。

（六）定价公允性分析

1、本次交易定价以评估值为基础，经充分市场博弈确定

本次交易拟购买资产为华力微 97.4988%股权。根据东洲评估出具的《资产评估报告》，评估机构采用资产基础法和市场法两种评估方法对华力微股东全部权益价值进行评估，最终选取市场法评估结果作为评估结论。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，华力微合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为 200,191.38 万元，评估值为 848,000.00 万元，评估增值 647,808.62 万元，增值率 323.59%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方充分协商，本次交易标的资产的最终交易价格为 826,790.22 万元。

本次交易最终交易定价以评估机构出具的评估值为参考，并经上市公司与交易对方基于标的公司历史业绩、未来发展战略与规划、行业发展趋势等多项因素综合协商确定，定价过程经过了充分市场博弈，交易定价合理、公允，未损害中小投资者利益。

2、可比上市公司分析

本次采用盈利价值比率 EV/EBITDA 对交易定价的公允性进行分析，考虑到被评估单位作为一家晶圆代工企业，具有资本投入高、回报周期长的典型特征，在扣除高额折旧与摊销费用后，常于净利润及息税前利润（EBIT）层面呈现暂时性亏损或利润水平偏低的现象。企业价值与息税折旧摊销前利润比率通过将折旧摊销加回，消除了高资本支出特征对利润率的影响，更能公允地衡量被评估单位的持续盈利能力，采用 EV/EBITDA 价值比率分析交易定价公允性具有合理性。

截至 2025 年 8 月 31 日，华力微及可比上市公司的 EV/EBITDA 价值比率情况如下表所示：

单位：万元

证券代码	证券简称	剔除货币资金经营性企业价值（EV）	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	EV/EBITDA
600460.SH	士兰微	2,920,100.87	173,149.07	16.86
688249.SH	晶合集成	4,628,478.92	426,382.53	10.86
688396.SH	华润微	2,545,422.98	216,387.18	11.76
平均值		-	-	**13.16**
中位数		-	-	**11.76**
华力微 100%股权		**914,688.16**	**87,781.97**	**10.42**

注1：可比公司剔除货币资金经营性企业价值（EV）=评估基准日总市值*（1－缺乏流动性折扣率）＋付息债务＋少数股东权益－非经营性资产、负债净额－货币资金，其中总市值采

用截至2025年8月31日的交易数据计算，总市值以外的数据采用截至2025年6月30日的财务数据计算；
注2：息税折旧摊销前利润（EBITDA）数据采用2024年年度的财务数据计算。

综上，截至评估基准日，可比上市公司 EV/EBITDA 价值比率（已考虑缺乏流动性折扣）的平均值为 13.16 倍，中位数为 11.76 倍，本次交易华力微对应的 EV/EBITDA 价值比率为 10.42 倍，低于可比上市公司的 EV/EBITDA 价值比率。因此，本次交易作价合理，保护了上市公司全体股东的合法权益。

综上所述，本次评估标的资产股东全部权益价值评估结果客观反映了标的公司股权的市场价值，本次交易定价具有合理性。

三、上市公司独立董事对本次交易评估事项的意见

根据《重组管理办法》，上市公司独立董事对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性发表如下意见：

（一）本次评估机构的独立性

本次交易的评估机构东洲评估符合《证券法》的相关规定。东洲评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的或可预期的利害关系或冲突；评估机构具有独立性。

（二）本次评估假设前提的合理性

评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，所选用的评估方法合理，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。

（四）评估定价的公允性

本次交易的交易各方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格，标的资产的评估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允，未损害中小投资者利益。

评估价值分析原理、采用的模型、选取的估值指标等重要评估参数符合标的公司的实际情况，评估依据及评估结论合理。

综上，本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

第七节 本次交易合同的主要内容

一、发行股份购买资产协议及其补充协议

（一）合同主体、签订时间

2025 年 8 月 29 日，华虹半导体与华虹集团、上海集成电路产业基金、大基金二期、国投先导基金签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于 2025 年 12 月 31 日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，其中甲方为华虹半导体，乙方、丙方、丁方、戊方分别为华虹集团、上海集成电路产业基金、大基金二期、国投先导基金（以下合称为“资产出售方”）。

（二）交易价格及定价依据

标的资产的交易价格以甲方聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国资监管有权单位备案的评估结果作为参考，由交易各方协商确定。

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），东洲评估以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，标的公司的股东全部权益评估值为 848,000.00 万元，交易各方参考该评估值，协商确定本次交易价格为 826,790.22 万元。

（三）支付方式

甲方以发行股份方式购买资产出售方合计持有的标的公司 97.4988%股份，交易总对价为 826,790.22 万元，均为股份支付。经各方协商一致，本次交易中标的资产的具体支付方式如下：

资产出售方	出售华力微股权比例(%)	总对价(万元)	支付方式及数额	
			股份对价(万元)	向该资产出售方发行的股份(股)
乙方	63.5443	538,855.12	538,855.12	124,332,053
丙方	15.7215	133,318.65	133,318.65	30,761,109
丁方	10.2503	86,922.77	86,922.77	20,056,014
戊方	7.9827	67,693.68	67,693.68	15,619,216
合计	**97.4988**	**826,790.22**	**826,790.22**	**190,768,392**

（四）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

各方同意，过渡期内标的资产的盈利、亏损由甲方享有或承担。

（五）过渡期安排

过渡期内，资产出售方保证持续拥有标的资产的合法、完整的所有权，不以任何形式处置标的资产，确保标的资产不存在司法冻结、质押或其他类型权利负担；未经甲方事先书面同意，不会自行放弃任何因标的资产形成的物权或债权，亦不以标的资产承担任何其自身或他方的债务；未经甲方事先书面同意，不减少、增加华力微的注册资本，不对华力微采取任何合并、分立、中止经营、并购、重组、清算、申请破产或类似其他影响华力微经营的行为，不从事任何非正常的导致华力微价值减损的行为；未经甲方事先书面同意，宣布分配或者实际分配华力微的利润、股息或红利；未经甲方事先书面同意，不发起、寻求、磋商、谈判或进行其他任何形式的与华力微相关的股权性融资活动；未经甲方事先书面同意，不对华力微公司章程进行对本次交易构成实质性影响的调整；在华力微的日常经营过程中，保证华力微将谨慎、合理地对待其所拥有的资产和负担的债务，避免因未尽管理职责而发生的资产减损、负债增加的情形。

（六）标的资产交割

1、本次交易经中国证监会注册后，各方应根据相关法律法规的规定在中国证监会注册文件的有效期内共同负责办理完毕本次交易的实施工作。

2、各方确认交割审计基准日为标的资产交割日所在月份之前一个月的最后一日，甲方应聘请具有相关资质的审计机构对标的资产进行交割审计，并出具资产交割审计报告，该报告应作为各方确认标的资产过渡期损益的依据，相关审计费用由甲方承担。

3、各方同意，对标的资产的交割进行如下安排:

（1）自标的资产根据本协议的约定完成了过户至甲方名下的市场监督管理部门变更登记手续之日（简称“标的资产交割日”）起，即视为标的资产交割完毕，各方同意自标的资产交割日起，甲方按照华力微章程享有股东权利并承担相应的义务。资产出售方应协调华力微向甲方提交出资证明书并将甲方记载于华力微的股东名册中；

（2）如后续各方就过渡期损益进行了约定的，相关方应根据具体协议的要

求履行损益补偿义务（如需）。

4、各方同意，于标的资产完成交割后，甲方应依据上交所及登记结算机构的证券登记业务规则尽快办理将本次交易新增股份登记于资产出售方名下的证券登记手续。本次交易对价中现金支付部分的付款时间由各方另行友好协商确定。

（七）与资产相关的人员安排

本次交易不影响标的公司与其员工的劳动关系，原劳动合同继续履行。标的公司作为独立法人的身份不因本次交易而发生变化，因此，除非相关方另有约定，本次交易不涉及标的公司人员安置。

（八）合同的生效条件和生效时间

补充协议自各方签署之日起成立，除补充协议另有约定外，补充协议自发行股份购买资产协议生效之日起生效。

二、减值补偿协议

（一）合同主体、签订时间

2025 年 12 月 31 日，华虹半导体与华虹集团签署了减值补偿协议，华虹集团作为补偿方。

（二）减值测试资产

根据《评估报告》，本次交易的标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，因此上市公司在本次交易中拟取得的华力微 97.4988%股权（以下简称“减值测试标的资产”）应进行减值测试。

（三）减值测试及补偿测算

1、本次交易的减值测试期为本次交易完成当年及其后两个会计年度（以下简称“减值测试期”）。

2、减值测试期届满后，上市公司应当聘请符合《证券法》规定的评估机构对减值测试标的资产进行减值测试，并出具专项评估报告。根据评估结果，由上市公司对减值测试标的资产的合计价值在每个会计年度进行减值测试，并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。如减值测试标的

资产在减值测试期间任何一个会计年度发生减值(以下简称“期末减值额”)，则补偿方应按如下约定向上市公司进行补偿：

（1）期末减值额=本次交易总对价-该会计年度期末标的资产的评估值并扣除减值测试期间内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

（2）补偿方应向上市公司补偿的金额（以下简称“补偿金额”）=补偿方在本次交易中应获得的交易对价占本次交易总对价比例×期末减值额。

（3）补偿方将优先以其在本次交易中获得的上市公司的股份进行补偿，补偿股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销，每年补偿的股份数量为：补偿金额/发行价格-减值测试期间内已补偿股份总数。

（4）在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的股份不冲回。

（5）补偿方在本次交易中获得的上市公司的股份不足以补偿的，补偿方应以现金进行补偿。

3、若上市公司在减值测试期间实施送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 则上市公司应回购的股份数量应调整为: 按上述公式计算的应补偿股份数量×(1+送股或转增比例)。若补偿股份数量出现小数的情况, 则应当向上取整作为补偿方应补偿股份的数量。

4、补偿方在减值测试期间内就补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还，计算公式如下：

返还金额＝补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×补偿股份数量。

（四）补偿方案的实施

1、上市公司应在减值测试专项审核报告公开披露后三十个工作日或上市公司确定的其他期限内，依据本协议的计算公式计算并确定补偿方需补偿的金额并予以公告（以下简称“补偿公告”)。补偿方应在补偿公告公开披露之日起三十个工作日内，将其用于补偿的上市公司股份由上市公司以总价 1 元的对价回购，或将现金补偿金额足额支付至上市公司指定账户。

2、补偿方承诺，其不得通过转让、赠与、设定质押、股票收益权转让或其他权利限制等方式处置其于本次交易过程中取得的、处于锁定期内的上市公司股票。

3、补偿方于本协议项下向上市公司补偿的金额总额累计不应超过其在本次交易中取得的总对价。

（五）合同的生效时间

本协议自双方签署之日起成立，自发行股份购买资产协议及其补充协议全部条款生效之日起生效。

（六）违约责任

1、本协议生效后，任何一方未能按本协议的约定履行其义务，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

2、若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照本协议的规定应当取得的利益，该违约方应当向守约方赔偿守约方预期取得的一切利益。

第八节 独立财务顾问核查意见

一、基本假设

本独立财务顾问报告就华虹公司本次交易发表的意见，主要依据如下假设：

（一）本次交易各方均遵循诚实信用的原则，均按照有关协议条款全面履行其应承担的责任；

（二）独立财务顾问报告依据的资料真实、准确、完整及合法；

（三）有关中介机构对本次交易所出具的法律意见书、审计报告、评估报告等文件真实可靠；

（四）国家现行法律、法规、政策无重大变化，宏观经济形势不会出现恶化；

（五）本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

（六）交易各方所属行业的国家政策及市场环境无重大的不可预见的变化；

（七）无其他不可预测的因素造成的重大不利影响发生。

二、本次交易的合规性分析

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定

（1）本次交易符合国家产业政策

本次交易拟购买标的资产为华力微 97.4988%股权。华力微主要从事集成电路晶圆代工业务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司所处行业不属于限制类、淘汰类产业。因此，本次交易符合国家产业政策的规定。

（2）本次交易符合环境保护、土地管理相关规定

本次交易不涉及环境保护报批事项。标的公司的主营业务不属于高耗能、高

排放、重污染行业，报告期内不存在违反国家有关环境保护法律和行政法规规定而受到重大行政处罚的情形。本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

本次交易标的资产为华力微 97.4988%股权，不涉及土地使用权交易事项。

（3）本次交易符合反垄断相关规定

本次交易中，参与集中的上市公司、标的公司上一年度营业额已达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》所规定的申报经营者集中的营业额标准；但本次交易前华虹集团直接持有标的公司 63.5443%的股权，本次交易后标的公司将成为上市公司的全资子公司，由于华虹集团仍系上市公司的间接控股股东，华虹集团将通过上市公司间接控制标的公司，因此本次交易未导致标的公司最终控制权发生变更。

通力律师已于 2025 年 9 月通过经营者集中反垄断业务系统提交本次交易是否需履行经营者集中申报义务的商谈申请。根据上海市市场监督管理局（国家市场监督管理总局授权的华东地区行政监管单位）负责本次交易商谈申请的审查人员回复，本次交易前后，标的公司控制权未发生变更的情形下，无需履行经营者集中申报程序。

（4）本次交易符合外商投资、对外投资相关规定

上市公司系注册于中国香港特别行政区的红筹企业，交易对方与标的公司均为内资企业。上市公司与标的公司均主要从事晶圆代工业务，均不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》所列的领域。本次交易涉及外商投资事宜、不涉及对外投资，需就外商投资事宜履行外商投资信息报告程序，上市公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易整体符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》《上市规则》等规定，上市公司股权分布发生变化不再具备

上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币4亿元的，社会公众持股的比例低于10%。社会公众不包括：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人”。

根据截至2025年12月31日股份数量，本次交易完成后，华虹公司的股份总数最高将增加至**1,928,382,585**股，社会公众股股东持有的股份不低于华虹公司股本总额的10%，华虹公司仍然符合上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为定价参考依据，并由交易各方协商确定。上市公司董事会和独立董事均已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估价值的公允性发表肯定性意见。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则并履行合法程序，充分保护全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易标的资产为华力微97.4988%股权。交易对方合法持有华力微股权，交易对方持有的华力微股份权属清晰，不存在被质押、查封、冻结等限制转让的

情形，标的资产的过户和转移不存在法律障碍。

因此，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，本次交易不涉及债权债务处理事项，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

标的公司与上市公司均拥有 65/55nm、40nm 制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

因此，本次交易有利于上市公司增强其持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司已经按照有关法律、法规以及规范性文件的规定建立

了法人治理结构和独立运营的公司管理体系，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于实际控制人及其关联人。本次交易完成后，华力微将成为华虹公司的全资子公司，华虹公司的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于其实际控制人及其关联人。

因此，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会对上市公司的独立性造成不利影响，上市公司独立性符合相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

上市公司已经按照《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。华虹公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，华虹公司仍将保持其健全有效的法人治理结构。

因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

（二）本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形

本次交易前后，上市公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委，本次交易预计不会导致公司控制权变更。因此不会构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

1、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70013197_B01 号，华虹公司不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见、

否定意见或者无法表示意见的情形。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。

2、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本报告签署日，上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

（四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

（1）本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化

根据安永会计师出具的备考审阅报告，本次交易完成后，上市公司资产规模、收入规模、盈利能力将进一步增加。通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化。

（2）本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

1）关联交易

本次交易前，上市公司已依照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及

中国证监会、上交所的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。与此同时，上市公司独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易发表必要意见。

本次交易完成后，标的公司华力微将成为上市公司全资子公司，上市公司将继续按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，规范本次交易完成后的关联交易，并按照有关法律、法规和监管规则等规定进行信息披露，以确保相关关联交易的合理性、必要性及定价公允，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

本次交易前标的公司的关联交易及本次交易前后关联交易变化情况详见重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、/（四）本次交易前后上市公司关联交易的变化情况”。

2）同业竞争

本次交易通过注入华力微，上市公司与控股股东控制的除上市公司及其控股子公司外其他公司在 65/55nm、40nm 的同业竞争得到实质性解决。本次重组是上市公司就之前的消除上述同业竞争问题承诺作出的具体行动，后续仍将遵守同业竞争承诺。

本次交易对上市公司同业竞争的影响详见重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争情况”，本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不会新增同业竞争。

综上，本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、上市公司所购买资产与现有主营业务具有显着协同效应

本次交易标的公司所从事业务与上市公司业务之间具有显着协同效应，具体详见本报告 “第一节 本次交易概况”之“一、/（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性”。

3、上市公司已针对本次分期发行股份支付购买资产对价的履约保障措施作出了安排

本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价的情况。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定。

（五）本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定

根据《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的相关规定和要求：

1、上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金。上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过 100%的，一并适用上市公司发行股份融资（以下简称“再融资”）的审核、注册程序。“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途除外。

2、考虑到募集资金的配套性，所募资金主要用于标的公司项目建设，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用，标的公司项目建设。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。上市公司本次交易收购标的公司 97.4988%股份的交易价格为 826,790.22 万元，以股份方式支付，不足一股部分，现金补足。本次拟募集配套资金的金额不超过 755,628.60 万元，未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。

本次交易募集配套资金以询价方式发行，募集配套资金拟用于标的公司项目建设，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%，募集资金用途符合上述规定。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的规定的要求。

（六）本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定

本次交易上市公司发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日（即华虹公司 2025 年第六次董事会会议决议公告日）前 120 个交易日华虹公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

（七）本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定

本次交易的各交易对方已根据《重组管理办法》第四十七条的规定做出了股份锁定承诺，详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、/（二）交易对方作出的重要承诺”。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定。

（八）本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《科创板股票上市规则》第 11.2 条和《重组审核规则》第八条的规定

根据《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应。

1、标的公司所处行业与上市公司处于同行业，符合科创板定位

标的公司从事晶圆代工业务，主要工艺节点为 65/55nm、40nm，主要覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），标的公司所处行业为战略性新兴产业

分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条中的“（一）新一代信息技术领域：半导体和集成电路行业”，符合科创板行业定位要求。

2、标的公司与上市公司具有协同效应

本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务具有协同效应，详见本报告“第一节 本次交易概况”之“一、/（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司的业务协同性”。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《科创板股票上市规则》第 11.2 条和《重组审核规则》第八条的规定。

（九）本次交易符合《发行注册管理办法》相关规定

1、本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定

上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体而言：

（1）上市公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情况；

（2）上市公司最近一年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条第（二）项规定的情形；

（3）上市公司现任董事、高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，且最近一年未受到过证券交易所公开谴责；

（4）截至本报告签署日，上市公司或其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；

（5）最近三年上市公司控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利

益或上市公司投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年上市公司不存在严重损害投资者合法权益或者社会公众利益的重大违法行为。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定。

2、本次交易募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金拟用于标的公司技术升级改造项目，特色工艺研发及产业化项目，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。本次募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；并非用于财务性投资，亦未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本次募集配套资金项目实施后，将不会与上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易，不会严重影响上市公司生产经营的独立性。

因此，本独立财务顾问认为：本次交易符合《发行注册管理办法》第十二条的规定。

3、本次重组募集资金使用符合《发行注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条的规定

根据上市公司 2025 年第九次董事会会议审议通过的本次重组方案，本次募集配套资金拟向不超过 35 名（含 35 名）的特定对象发行。特定对象包括符合中国法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等，符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定。

根据上市公司 2025 年第九次董事会会议审议通过的本次重组方案，本次募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，

并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定，符合《发行注册管理办法》第五十六条和第五十七条第一款的规定和第五十八条第一款的规定，不适用第五十七条第二款以及第五十八条第二款的规定。

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

因此，本独立财务顾问认为：本次募集配套资金的相关安排符合《发行注册管理办法》五十九条的规定。

综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易符合《发行注册管理办法》相关规定。

三、本次交易定价的合理性分析

（一）本次重组标的资产定价依据

本次交易标的资产交易价格以评估机构出具的评估报告所载明的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

（二）评估合理性分析

标的资产交易定价合理性分析详见本报告“第六节 标的资产评估作价情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性分析”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易作价合理、公允，充分保护了上市公司全体股东的合法权益。

四、本次交易评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性

（一）评估方法的适当性

根据东洲评估出具的《资产评估报告》，东洲评估以2025年8月31日为评估基准日，对标的公司采用了市场法、资产基础法进行评估。

本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。

（二）评估假设前提的合理性

评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，具有合理性。

（三）重要评估参数取值的合理性

重要评估参数取值情况详见本报告“第六节 标的资产评估作价基本情况”，本次交易评估重要评估参数取值参考了评估准则、市场数据、行业惯例等，具备合理性。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易评估方法适当、评估假设前提合理、重要评估参数取值合理。

五、本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题

（一）本次交易完成后上市公司的财务状况及经营成果分析

1、本次交易完成后上市公司的财务状况分析

根据上市公司财务报告及安永会计师出具的《备考审阅报表》，不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司财务状况的影响如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
流动资产	**4,643,715.08**	**5,092,411.97**	4,192,636.15	4,567,887.28
非流动资产	**5,368,614.05**	**5,518,520.83**	4,600,887.00	4,788,155.55
资产总计	**10,012,329.13**	**10,610,932.80**	8,793,523.15	9,356,042.83
流动负债	**1,304,701.43**	**1,446,995.92**	1,122,998.90	1,321,600.79
非流动负债	**2,398,152.44**	**2,645,277.08**	1,398,469.36	1,643,407.71

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		2024 年 12 月 31 日/2024 年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
负债合计	**3,702,853.87**	**4,092,273.00**	2,521,468.25	2,965,008.50
流动比率（倍）	**3.56**	**3.52**	3.73	3.46
速动比率（倍）	**3.15**	**3.06**	3.29	2.96
资产负债率	**36.98%**	**38.57%**	28.67%	31.69%

注：上述指标均以合并财务报表的数据为基础，计算公式如下：
（1）资产负债率=总负债期末数/总资产期末数；
（2）流动比率=流动资产期末数/流动负债期末数；
（3）速动比率=（流动资产期末数-存货期末数） /流动负债期末数。

根据《备考审阅报告》，本次交易完成后上市公司资产负债率将有所提升。本次交易完成后，上市公司货币资金等流动性资产较为充裕，偿债能力较强，本次交易不会对上市公司财务安全性造成重大不利影响。

综上，本次交易不会对上市公司的资产、负债结构、偿债能力产生重大不利影响。

2、本次交易完成后上市公司的经营成果分析

根据上市公司财务报告及安永会计师出具的《备考审阅报表》，不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司主要盈利指标的影响如下：

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		2024 年度/2024 年 12 月 31 日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
营业收入	**1,729,145.07**	**2,228,795.71**	1,438,830.77	1,927,405.55
利润总额	**-65,100.61**	**11,125.88**	-98,831.81	-36,817.13
净利润	**-80,714.30**	**-4,487.81**	-103,218.38	-41,203.70
归属于母公司股东净利润	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

本次交易完成后，上市公司的营业收入、净利润等盈利指标均得到一定的程度的提升。

本次交易完成后，上市公司资产规模、收入规模、盈利能力将进一步增加。通过本次交易，上市公司将进一步提升公司 12 英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶

圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。

综上，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力。

（二）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析

1、本次交易后，上市公司每股收益等财务指标分析

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，以及上市公司 2024 年度、**2025 年度**审计报告，上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动如下：

项目	2025 年度		2024 年度	
	交易前	交易后（备考合并）	交易前	交易后（备考合并）
归属于母公司股东权益（万元）	**4,516,029.04**	**4,725,213.57**	4,360,233.22	4,474,671.92
归属于母公司所有者的净利润（万元）	**37,661.14**	**118,428.37**	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	**0.22**	**0.62**	0.22	0.50

注：上述备考合并财务数据未考虑募集配套资金的影响。

如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东权益、归属于母公司所有者净利润及基本每股收益等将会有较大提升。

2、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响及初步拟定的融资计划

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，标的公司的未来资本性支出将纳入上市公司整体资本支出规划中。上市公司将结合其资金状况和未来发展计划，合理规划和统筹标的公司的资本性支出。同时，上市公司将利用自身上市主体的融资功能，通过自有资金、再融资、银行贷款等多种方式筹集资金，以满足上市公司和标的公司未来的资本性支出需求。

3、职工安置方案对上市公司的影响

本次交易不涉及职工安置方案。

4、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易所产生的相关税费由相关各责任方承担，为本次交易提供服务的相关中介服务费用主要包括：财务顾问费、审计验资费、资产评估费、律师服务费

等，上述费用均为本次交易所需必要费用，相关费用参考市场价格确定，不存在价格不公允、利益输送等情形。整体而言，本次交易费用不会对上市公司相关财务指标造成较大影响。

综上，本独立财务顾问认为：本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、改善上市公司财务状况，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益的问题。

六、本次交易对上市公司市场地位、持续发展能力、经营业绩和公司治理机制影响

（一）本次交易对上市公司市场地位的影响

本次交易完成后，上市公司将新增 3.8 万片/月的 65/55nm、40nm 产能，提高上市公司产能及市场地位。

工艺平台方面，华力微的 65/55nm、40nm 覆盖独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频、高压等工艺平台，本次交易完成后，上市公司将进一步丰富工艺平台种类，满足市场多样化需求。

客户及供应商方面，不同客户对晶圆代工要求不同，本次交易完成后，上市公司工艺平台、技术等进一步丰富，有利于满足不同客户的多样化需求，提升整体竞争力；半导体设备、半导体材料供应商的全球行业集中度较高，本次交易完成后，公司规模将进一步扩大，产业链地位进一步增强。

技术及产能方面，本次交易有利于上市公司进一步丰富主营业务所需的 65/55nm、40nm 制程的相关技术，加速产品迭代、开发进程。标的公司拥有 3.8 万片/月产能，本次交易完成后，上市公司总产能将进一步提升，满足客户需求华虹半导体聚焦于特色工艺，目前已覆盖至 65/55nm、40nm；华力微聚焦于 65/55nm 及 40nm 逻辑工艺，并在此基础上进一步开发特色工艺。

综上，本次交易有利于进一步巩固上市公司在晶圆代工领域的领先地位，提高竞争实力和行业地位。

（二）本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易前，上市公司已建立了完善的公司治理机制和内部控制制度，具备

完善的股东大会、董事会制度和议事规则，董事会专门委员会运行良好，公司内部机构较为完善，在资产、业务、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人运行，有利于保证上市公司、中小股东合法权益，避免大股东利益侵占。

本次交易完成后，上市公司仍会根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《科创板股票上市规则》等相关规定保持其健全有效的法人治理结构。

综上，本独立财务顾问认为：本次交易有利于上市公司提升市场地位和经营业绩，有利于增强上市公司的持续发展能力，有利于健全完善上市公司治理机制。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易有利于提升上市公司盈利水平，增强上市公司的持续经营能力，健全完善公司治理机制，符合《上市公司治理准则》等法规、准则的要求。

七、本次交易合同约定的资产交付安排

上市公司与交易对方签署的发行股份购买资产协议及其补充协议对交割、标的资产价格、标的资产过户之登记和违约责任等作了明确的约定，交易合同的约定详见本报告“第七节 本次交易合同的主要内容”。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易约定的资产交付安排不会导致上市公司在本次交易后无法及时获得标的资产的风险，标的资产交付安排相关的违约责任切实有效。

八、本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会、股东大会审议**本次交易**相关议案时，关联董事、关联股东**均已**回避表决。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易构成关联交易，关联交易定价和程序履行符合相关规定；本次交易有助于上市公司持续、稳定发展，具有必要性；

本次关联交易符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。

九、本次交易标的财务状况和经营成果是否发生重大不利变动及对本次交易的影响的核查意见

本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务指标和非财务指标等方面的影响分析，详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”。

上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。标的公司主要为客户提供 12 英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案，具备较好发展前景。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易标的公司财务状况和经营成果未发生重大不利变动。本次交易完成后上市公司具备持续经营能力，本次交易不会对上市公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，本次交易有利于上市公司的持续发展。

十、本次交易是否涉及私募投资基金以及备案情况的核查意见根据交易对方提供的说明，并通过中国证券投资基金业协会平台检索交易对方的基金备案情况，本次交易的交易对方涉及私募投资基金及备案情况如下：

上海集成电路基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SEJ523。上海集成电路基金的基金管理人上海集成电路产业投资基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1068675。

大基金二期系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理

暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SJU890。大基金二期的基金管理人华芯投资管理有限责任公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1009674。

国投先导基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SAMQ44。国投先导基金的基金管理人上海国投先导私募基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1074817。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的部分交易对方属于私募投资基金，相关交易对方已完成私募投资基金备案手续。

十一、本次交易符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定的核查意见

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，为保护投资者利益、防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东的回报能力，上市公司将继续完善公司治理结构，并积极采取填补每股收益的相关措施，保护中小股东权益。具体措施如下：

1、有效整合标的资产，加快释放协同效应

上市公司和标的公司均从事晶圆代工业务，本次交易系同行业并购整合，交易双方在工艺技术平台、客户资源、供应链管理、技术及产能等方面均具有显著的协同效应。交易完成后，上市公司将在资产、业务、人员、财务、机构等方面实施整合计划，充分发挥协同效应，增强上市公司盈利水平和抗风险能力。

2、进一步加强经营管理和内部控制，提高经营效率

本次交易完成后，公司将根据实际情况进一步完善公司的治理体系、管理体系和制度建设，加强企业经营管理和内部控制，健全激励与约束机制，提高上市公司日常运营效率，降低运营成本，更好地维护上市公司整体利益，有效控制上市公司经营和管理风险。

3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

本次交易完成后，上市公司在继续遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策的基础上，将根据中国证监会的相关规定，结合公司经营情况与发展规划，持续完善利润分配政策，优化投资回报机制，在保证上市公司可持续发展的前提下给予股东合理的投资回报，更好地维护上市公司股东及投资者利益。

4、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

根据中国证监会相关规定，公司直接控股股东、间接控股股东和公司董事、高级管理人员为确保公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具了相关承诺，具体内容详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

十二、内幕信息知情人登记制度制定及执行情况/股票交易自查结果

（一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3、公司按照上海证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料

4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务。

（二）本次交易的内幕信息知情人自查期间

根据《重组管理办法》《格式准则第 26 号》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，上市公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为申请股票停牌日前 6 个月至重组报告书披露之前一日止，即 2025 年 2 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“自查期间”）。

（三）本次交易的内幕信息知情人核查范围

1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；

2、上市公司控股股东；

3、交易对方及其主要负责人及有关知情人员；

4、标的公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；

5、相关中介机构及具体业务经办人员；

6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

7、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

（四）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

1、法人买卖华虹公司股票的情况

除国泰海通外，其他内幕信息知情机构在自查期间不存在通过二级市场买卖上市公司股票的情形。自查期间内，国泰海通买卖华虹公司股票具体情况如下：

单位：股

名称	部门/子公司	业务类型	股份变动数量	自查期末持股数
国泰海通	证券衍生品投资部	证券买入	2,407,458	19,385
		证券卖出	2,506,481	
		ETF 赎回成分券增加	40,400	
		ETF 申购成分券减少	17,983	
	权益客需部	证券买入	9,490,689	1,896,549
		证券卖出	7,698,352	
	国泰海通资产管理有	证券买入	3,169,602	308,989

名称	部门/子公司	业务类型	股份变动数量	自查期末持股数
	限公司	证券卖出	3,710,535	
	上海海通证券资产管理有限公司	证券买入	-	-
		证券卖出	400	
	国泰君安国际控股有限公司	证券买入	659,722	14,294
		证券卖出	657,600	
	海通国际证券集团有限公司	自营持仓买入	50,911	2,944
		自营持仓卖出	50,911	
		代客持仓买入	314,520	
		代客持仓卖出	311,576	

针对上述股票买卖行为，国泰海通作出如下说明和承诺：“本公司严格遵守了中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规的要求，建立了严格的信息隔离墙制度，各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户等方面独立运作、分开管理，以控制内幕信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及公司员工与公司、客户之间的利益冲突。

上述股票买卖行为与本次重组事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，本公司也未泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

除上述买卖情况外，本公司在自查期间内无买卖上市公司股票的行为；本公司无泄漏有关信息或者建议他人买卖华虹公司股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。”

2、自然人买卖华虹公司股票情况

自查期间内，相关自然人买卖上市公司股票的情况具体如下：

单位：股

序号	姓名	职务/关系	交易日期/期间	期间累计买入	期间累计卖出	自查期末持股数
1	雷海波	标的公司董事	2025 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 5 日	1,400	900	500
2	雷书懿	标的公司董事雷海波之子女	2025 年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 24 日	4,300	4,300	0

3	倪立华	曾任标的公司执行副总裁	2025 年 2 月 17 日至 2025 年 5 月 13 日	343,529	363,529	0
4	柯陈宾	曾任标的公司执行副总裁	2025 年 7 月 15 日至 2025 年 9 月 2 日	30,000	30,000	0
5	王惠贤	曾任标的公司董事冯雪静之母亲	2025 年 3 月 26 日至 2025 年 5 月 29 日	1,370	1,370	0
6	张莉琴	曾任标的公司高级副总裁邵华之配偶	2025 年 9 月 3 日、2025 年 9 月 24 日	4,643	4,643	0
7	卞达开	交易对方相关人员	2025 年 11 月 3 日、2025 年 11 月 4 日	782	782	0

针对上述自查期间买卖股票的行为,该等人员均已分别出具自查报告或说明与承诺，相关主要内容如下：

（1）雷海波

针对前述交易情况，雷海波出具声明与承诺如下：

“1、本人买卖股票的账户实际系由本人亲属操作，本人对其通过本人股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人未向本人亲属泄露本次交易的信息，亦未以明示或暗示的方式建议其买卖上市公司的股票；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的

股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对雷海波亲属使用其股票账户进行交易的情况，其亲属出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户均系由本人实际操作，本人亲属对本人通过其股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情；本人在自查期间内通过前述账户交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息，本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的,不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（2）雷书懿

针对前述交易情况，雷书懿出具声明与承诺如下：

“1、本人买卖股票的账户实际系由本人亲属操作，本人对其通过本人股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对雷书懿亲属使用其股票账户进行交易的情况，其亲属出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户均系由本人实际操作，本人亲属对本人通过其股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情；本人在自查期间内通过前述账户交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息，本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内

幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的,不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（3）倪立华、柯陈宾、卞达开

针对前述交易情况，倪立华、柯陈宾、卞达开分别出具声明与承诺如下：

“1、本人用于购买上市公司股票的账户系本人自有账户。本人在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人不存在泄漏有关内幕信息或者委托或建议他人购买上市公司股票、

从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（4）王惠贤

针对前述交易情况，王惠贤出具声明与承诺如下：

“1、本人用于购买上市公司股票的账户系本人自有账户。本人在自查期间内通过前述账户交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息，本人自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的,不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易

期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对王惠贤股票账户交易情况，其亲属冯雪静出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户系其自有账户。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的,不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他买卖上市公司股票的情形。

3、本人未向本人亲属泄露本次交易的信息，亦未以明示或暗示的方式建议其买卖上市公司的股票；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

（5）张莉琴

针对前述交易情况，张莉琴出具声明与承诺如下：

“1、本人买卖股票的账户实际系由本人亲属操作，本人对其通过本人股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人亲属在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人亲属自查期间内买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于其对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人不存在其他买卖上市公司股票的行为。

3、本人在自查期间不存在自本人亲属、本次交易内幕信息知情人处或通过其他途径获得本次交易相关内幕信息的情况，不存在本次交易内幕信息知情人明示或暗示本人买卖上市公司股票的情况；本人不存在泄露有关信息或者委托或建议他人买卖上市公司股票、从事市场操作等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人同意督促本人亲属将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

针对张莉琴股票账户交易情况，其亲属邵华出具声明与承诺如下：

“1、本人亲属用于购买上市公司股票的账户实际由本人操作，本人亲属对本人通过其股票账户买卖上市公司股票的行为并不知情。本人在自查期间内交易上市公司股票时，不知悉本次交易的未公开信息；本人自查期间内通过本人亲属之股票账号买卖上市公司股票的行为，是在未获知本次交易未披露信息及其他内幕信息的情况下，基于对股票二级市场的交易情况、公开信息及投资价值的自行判断而进行的，不存在利用本次交易的内幕信息而买卖上市公司股票

的情形。

2、在自查期间，除已出具说明中所述的买卖上市公司股票的情形外，本人及本人直系亲属不存在其他通过本人账户或操作他人账户买卖上市公司股票的情形。

3、本人未向本人亲属泄露本次交易的信息，亦未以明示或暗示的方式建议其买卖上市公司的股票；本人不存在泄漏有关内幕信息或者委托或建议他人购买上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

4、若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、法规或证券主管机构发布的规范性文件或被有关部门认定有不当之处，本人愿意将上述自查期间买卖上市公司股票所得的收益全部上缴上市公司所有。

5、本人承诺至上市公司本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关发布的规范性文件规范交易行为，不会以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。

6、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，以及本次交易相关内幕信息知情人提供的自查报告、相关股票买卖主体出具的说明与承诺，经充分核查，本独立财务顾问认为：

在上述相关内幕信息知情人出具的自查报告、说明及承诺之内容和相关信息均为真实、准确、完整的前提下，上述相关主体在自查期间内买卖华虹公司股票的行为不属于利用内幕信息进行内幕交易的行为，该等行为不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十三、关于相关主体是否存在有偿聘请第三方行为的核查

（一）本次交易中独立财务顾问直接或间接有偿聘请第三方的核查

本次交易的独立财务顾问根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请

第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）及相关规定的要求，就国泰海通本次交易中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行了充分必要的核查。

经核查，国泰海通在本项目中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。

（二）本次交易中上市公司有偿聘请第三方的核查

本次交易中，上市公司聘请国泰海通担任本次交易独立财务顾问，聘请上海市通力律师事务所担任本次交易法律顾问，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易标的公司审计机构，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易上市公司备考审阅机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任本次交易资产评估机构。以上机构均为本项目依法需聘请的证券服务机构。除此之外，发行人还存在如下有偿聘请第三方行为：

1、聘请了创升融资有限公司提供香港独立财务顾问服务；

2、聘请了 Herbert Smith Freehills Kramer（境外律所）就公司及本次交易的相关合规性事项、本次交易在香港规则项下相关程序性要求等事项提供香港法律意见；

3、聘请了大华国际（香港）会计师事务所有限公司担任本项目标的公司港股审计机构；

4、聘请安永会计师事务所担任本次交易上市公司港股备考审阅机构；

5、聘请了北京向实启源管理咨询有限公司为公司提供申报文件制作、底稿电子化等服务。

除前述情况外，上市公司不存在其他为本次交易直接或间接有偿聘请第三方的行为。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为；发行人上述有偿聘请其他第三方的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意

见》相关规定的要求。

十四、按照《上海证券交易所发行上市审核业务指南第 4 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》的要求，对相关事项进行的核查情况

（一）关于交易方案

1、交易必要性及协同效应

（1）本次交易的商业逻辑，是否存在不当市值管理行为；上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次交易披露前后是否存在股份减持情形或者大比例减持计划；本次交易是否具有商业实质，是否存在利益输送的情形

①基本情况

本次交易的必要性及协同效应详见本报告“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”。

上市公司控股股东、董事、高级管理人员在本次交易披露前后的股份减持情况详见本报告“重大事项提示”之“七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了发行股份购买资产协议及其补充协议；审阅了上市公司控股股东、董事、高级管理人员出具的关于减持计划的承诺函。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的商业逻辑清晰，不存在不当市值管理行为；上市公司的控股股东、董事、高级管理人员在本次交易披露前后不存在减持 A 股股份情形或者大比例减持计划；本次交易具有商业实质，不存在利益输送的情形。

（2）上市公司所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应的，核查最近十二个月的规范运作情况，是否满足上市公司产业转型升级、寻求第二增长曲线

等需求，是否符合商业逻辑，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）第四十四条第二款的相关规定

①基本情况

本次交易的协同效应具体情况详见本报告“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景、目的及协同效应”之“（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应”。

②核查情况

访谈上市公司、标的公司主要管理人员、核心技术人员等，了解交易双方的协同效应的具体体现。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司所购买资产与现有主营业务具备显著协同效应。

（3）科创板上市公司发行股份购买资产的，核查拟购买资产所属行业是否符合科创板行业定位、与上市公司是否处于同行业或者上下游，以及拟购买资产主营业务与上市公司主营业务是否具有协同效应

①基本情况

本次交易上市公司为上交所科创板上市公司。本次交易的标的公司从事晶圆代工业务，属于战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2），符合科创板定位，所属行业与上市公司处于同行业，标的资产与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进上市公司主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力，具体内容详见本报告“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景和目的”之“（三）本次交易标的公司的科创属性，与上市公司主营业务的协同效应”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了重组报告书，审阅了上市公司所属板块信息，核对了《重组审核规则》第十六条的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易上市公司为上交所科创板上市公司，标的资产属于半导体和集成电路行业，符合科创板定位，所属行业与上市公司处于同行业，标的资产与上市公司主营业务具有协同效应。本次交易符合《科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条和《重组审核规则》第八条的规定。

2、支付方式

（1）上市公司发行股份购买资产的，核查发行价格是否符合《重组管理办法》第四十六条的规定，价格调整机制是否符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关要求

①基本情况

本次发行股份购买资产的发行价格具体情况详见本报告“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议；核对了《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定及要求。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易发行股份的发行价格符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定。

（2）上市公司通过发行优先股、定向权证、存托凭证等购买资产的，核查发行价格等安排是否符合《优先股试点管理办法》等相关规定

①基本情况

本次交易不涉及发行可转债、优先股、定向权证、存托凭证购买资产。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行可转债、优先股、定向权证、存托凭证。

（3）涉及现金支付的，上市公司是否具有相应的支付能力。资金主要来自借款的，核查具体借款安排及可实现性，相关财务成本对上市公司生产经营的影响

①基本情况

本次交易以股份方式支付，不足一股部分，现金支付，上市公司的资金实力详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议、审阅了上市公司财务报表等。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易以股份方式支付，不足一股部分，现金支付，上市公司具有相应的支付能力。

3、发行定向可转债购买资产

①基本情况

本次交易不涉及发行定向可转债购买资产。

②核查情况

独立财务顾问查阅本次交易的相关董事会议案及决议文件、查阅重组报告书交易方案部分。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行定向可转债购买资产。

4、吸收合并

①基本情况

本次交易不涉及吸收合并。

②核查情况

独立财务顾问查阅本次交易的相关董事会议案及决议文件、查阅重组报告书交易方案部分。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及吸收合并。

5、募集配套资金

独立财务顾问应对以下事项进行核查，并在《独立财务顾问报告》中发表明确核查意见：（1）核查募集配套资金的规模、用途、补充流动资金及偿还债务金额占比（如有）是否符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-1 的规定；（2）核查本次募集配套资金的必要性，是否存在现金充裕且大额补流的情形；涉及募投项目的，核查募投项目的具体投资构成明细、各项投资支出的必要性和合理性；（3）募投项目的审批、批准或备案情况、相关进展以及是否存在重大不确定性。

（1）基本情况

上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 755,628.60 万元，不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金主要用于补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用，标的公司特色工艺研发及产线升级改造项目。本次交易募集资金用途详见本报告“第一节 本次交易概况”之“二、/（二）募集配套资金”。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了《重组报告书》，并核对了《监管规则适用指引--上市

类第 1 号》《发行注册管理办法》第五十六条、第五十七相关要求；获取募投项目的具体投资构成明细，分析各项投资支出的必要性和合理性**；取得项目备案表、环境影响评价报告表**等。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次募集配套资金的规模、用途、补充流动资金占比符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-1 的规定；本次募集配套资金具备必要性，不存在现金充裕且大额补流的情形；本次募集配套资金涉及募投项目，具体投资构成明细具备合理性，各项投资支出具备必要性；募投项目**已完成**项目备案，**华力微技术升级改造项目已获批**。

6、是否构成重组上市

（1）上市公司控制权最近 36 个月内是否发生变更；本次交易是否导致上市公司控制权发生变更

①基本情况

本次交易前后，上市公司实际控制人均为上海市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

②核查情况

独立财务顾问查阅上市公司本次交易具体方案，包括发行股份数量、交易对方、发行价格等情况；计算本次交易前后上市公司股东持股比例变化情况，核实本次交易是否会导致上市公司控制权发生变化。

③核查意见

经核查，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

（2）根据《重组办法》第十三条、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》（以下简称《证券期货法律适用意见第 12 号》）、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-1 等相关规定，核查本次交易是否构成重组上市

①基本情况

本次交易前后，上市公司实际控制人均为上海市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

②核查情况

独立财务顾问查阅查阅上市公司本次交易具体方案，包括发行股份数量、交易对方、发行价格等情况；计算本次交易前后上市公司股东持股比例变化情况，核实本次交易是否会导致上市公司控制权发生变化。

③核查意见

经核查，本次交易不构成重组上市。

（3）如上市公司控制权最近 36 个月内发生变更，或者本次交易导致上市公司控制权发生变更，且认为本次交易不构成重组上市的，审慎核查不构成重组上市的原因及依据充分性

①基本情况

上市公司最近 36 个月内不存在控制权发生变更的情形，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

②核查情况

独立财务顾问查阅查阅上市公司本次交易具体方案，包括发行股份数量、交易对方、发行价格等情况；计算本次交易前后上市公司股东持股比例变化情况，核实本次交易是否会导致上市公司控制权发生变化；查阅上市公司最近 36 个月内控股股东、实际控制人情况，核实上市公司最近 36 个月内是否存在控制权变更的情形。

③核查意见

经核查，上市公司最近 36 个月内不存在控制权发生变更的情形，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

7、业绩承诺（如有）

（1）核查业绩承诺的相关协议，业绩承诺的具体内容，业绩承诺补偿安排的合规性、合理性，业绩承诺的可实现性，业绩补偿义务人确保承诺履行相关安

排的可行性

①基本情况

本次交易标的公司采用市场法评估结果作为评估结论。上市公司与交易对方华虹集团签订了减值补偿协议，就补偿金额的确定及补偿的实施方式进行了明确约定。本次交易减值补偿情况详见本报告“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、减值补偿协议”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、《资产评估报告》、减值补偿协议及重组报告书。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具之日，华虹集团作为间接控股股东及交易对方之一已在本次交易中作出减值补偿承诺，具有可实现性，承诺方具备履行能力，本次交易方案中已经设置较为充分的履约保障措施。

（2）根据相关资产的利润预测数约定分期支付安排的，是否就分期支付安排无法覆盖的部分签订补偿协议（如适用）

①基本情况

本次交易不涉及分期支付安排。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司审议本次交易方案的董事会决议文件、发行股份购买资产协议及其补充协议、减值补偿协议。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及根据相关资产的利润预测数约定分期支付安排的情形。

（3）核查是否涉及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-2 的业绩补偿范围，如涉及，业绩承诺具体安排、补偿方式以及保障措施是否符合《重组办

法》第三十五条、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-2 的规定

①基本情况

本次交易涉及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-2 的业绩补偿范围，业绩补偿具体安排、补偿方式等详见本报告“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、减值补偿协议”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了减值补偿协议、重组报告书，查阅了《重组办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-2 的业绩补偿范围，业绩补偿具体安排、补偿方式等符合《重组办法》第三十五条、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-2 的规定。

8、业绩奖励（如有）

（1）基本情况

本次交易方案不涉及业绩奖励。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议、重组报告书；核对了《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关规定。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易方案不涉及业绩奖励。

9、锁定期安排

（1）核查特定对象以资产认购取得上市公司股份的锁定期是否符合《重组管理办法》第四十七条第一款的规定；特定对象以资产认购取得可转债的锁定期是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第七条的规定

①基本情况

本次交易股份锁定安排具体情况详见本报告“第五节 本次交易发行股份情况”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了发行股份购买资产协议及其补充协议、出具的承诺函；核对了《重组管理办法》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易以资产认购取得上市公司股份的锁定期符合《重组管理办法》第四十七条第一款的规定。

（2）涉及重组上市的，核查相关主体的股份锁定期是否符合《重组管理办法》第四十七条第二款的规定

①基本情况

截至本独立财务顾问报告出具日，上市公司最近三十六个月内控制权未发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易不涉及重组上市。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议；审阅了上市公司历史沿革、招股说明书以及上市以来的年度报告；测算本次交易前后上市公司股权结构情况。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及重组上市。

（3）特定对象为私募投资基金的，核查相关锁定期安排是否符合《重组办法》第四十七条第三款相关规定

①基本情况

本次交易中，以资产认购取得股份的特定对象中存在私募投资基金，其锁定期安排详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了发行股份购买资产协议及其补充协议、私募投资基金出具的承诺函；核对了《重组管理办法》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及私募投资基金为特定对象，其锁定期安排适用《重组办法》第四十七条第一款、第二款的相关规定。交易对方上海集成电路基金为私募投资基金，其已承诺本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让，上海集成电路基金用于认购股份的部分标的资产持续拥有权益的时间已满四十八个月，如果其符合《重组管理办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则其本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让。大基金二期、国投先导基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让；如其取得前述上市公司股份时，对于用于认购上市公司股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。

（4）上市公司之间换股吸收合并的，核查相关锁定期安排是否符合《重组办法》第五十条第二款相关规定

①基本情况

本次交易不涉及上市公司之间吸收合并。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及上市公司之间吸收合并。

（5）上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人发行股份购买资产，或者发行股份购买资产将导致上市公司实际控制权发生变更的，核查相关

锁定期安排是否符合《重组办法》第四十八条第二款相关规定

①基本情况

本次交易中，上市公司向间接控股股东华虹集团发行股份购买其持有的华力微 63.5443%股权。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易对方中华虹集团系上市公司间接控股股东，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更。

（6）分期发行股份支付购买资产对价的，核查特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，锁定期是否自首期发行结束之日起算

①基本情况

本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。

（7）核查配套募集资金的股份锁定期是否符合《再融资办法》第五十九条的相关规定；核查配套募集资金的可转债锁定期是否符合《再融资办法》第六十三条的相关规定

①基本情况

本次交易配套募集资金的锁定安排具体情况详见本报告“第五节 本次交易发行股份情况”之“二、本次募集配套资金安排”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了发行股份购买资产协议及其补充协议；核对了《再融资办法》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易募集配套资金的锁定安排符合《再融资办法》第五十九条的相关规定；本次配套募集资金不涉及发行可转债。

（8）适用《收购办法》第七十四条、第六十三条第一款第（三）项等规定的，核查锁定期是否符合相关规定

①基本情况

本次交易为上市公司发行股份购买标的公司股权，各交易对方的股份锁定期安排详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议；查阅了本次交易主体所出具的关于股份锁定期的承诺；核对了《上市公司收购管理办法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中相关交易对方所取得的股份锁定期安排符合《上市公司收购管理办法》第七十四条、第六十三条第一款第（三）项等相关规定。

10、过渡期损益安排

（1）拟购买资产以基于未来收益预期的估值方法作为主要评估方法的，过渡期损益安排是否符合《监管规则适用指引—上市类第 1 号》1-6 的规定

①基本情况

本次交易选取市场法、资产基础法对标的资产进行评估，不涉及以收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法作为主要评估方法的情形。

②核查情况

独立财务顾问审阅了发行股份购买资产协议及其补充协议、东洲评估出具的《资产评估报告》及相关评估说明；核对了《监管规则适用指引—上市类第 1 号》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易采用市场法、资产基础法对标的资产进行评估，不适用《监管规则适用指引——上市类第 1 号》1-6 的规定。

（2）标的资产以资产基础法等作为主要评估方法的，过渡期损益安排的合理性

①基本情况

本次交易选取市场法、资产基础法对标的资产进行评估。过渡期损益安排具体情况详见本报告“第五节 本次交易发行股份情况”之“一、（六）过渡期损益安排”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了发行股份购买资产协议及其补充协议、东洲评估出具的《资产评估报告》及相关评估说明；核对了《监管规则适用指引—上市类第 1 号》的相关规定。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易过渡期损益安排具有合理性。

11、收购少数股权（参股权）

（1）基本情况

本次交易标的为华力微 97.4988%股权，不属于收购少数股权（参股权）情形。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、股东大会决议、发行股份购买资产协议及其补充协议。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不属于收购少数股权（参股权）。

12、整合管控

（1）基本情况

上市公司和标的公司拟在业务、资产、财务、人员、机构等方面进行整合的具体举措如下：

① 业务整合

本次交易完成前，标的公司与上市公司存在竞争关系。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，标的公司的生产经营将由上市公司控制，相关生产经营安排将纳入上市公司的管理体系。上市公司与标的公司将在采购、生产、研发、销售等方面实现更全面的资源共享和优势互补，实现业务协同发展。

②资产整合

本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，其仍保留独立的法人地位，享有独立的法人财产权利，资产仍将保持独立。标的公司将依据自身产能规划需求制定重要资产的购买及处置规划，并履行上市公司相关审批程序。同时，上市公司依托自身管理水平及资本运作能力，结合标的公司市场发展前景及实际情况进一步优化资源配置，提高资产利用率，增强上市公司和标的公司的综合竞争力。

③财务整合

本次交易完成后，上市公司拟将标的公司并入上市公司的财务管理体系，上市公司将推动标的公司在财务管理系统、会计核算体系、内控管理制度等方面与上市公司保持一致，相关财务工作安排及财务流程审批等事项，将由上市公司进行统一审批管理，以确保标的公司能够有效执行符合上市公司要求的各项财务会计和内控管理制度。

④人员整合

一方面，为保证本次交易完成后标的公司原有团队的稳定性及竞争优势的持续性，上市公司将保持标的公司原有的业务团队；另一方面，为丰富和完善标的公司的业务团队和管理团队，满足标的公司的业务开拓需要，上市公司也将适时为标的公司引进优质人才。

⑤机构整合

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，日常运营和治理将严格按照《公司法》《证券法》、上市公司相关管理制度和内控制度体系《公司章程》及上交所和中国证监会的规定执行。

上市公司将在逐步统一管理机制的前提下，维持标的公司现有组织架构稳定，强化上市公司对标的公司在业务、财务、合规等方面的管理与控制，保证上市公司对标的公司重大事项的决策和控制权，降低标的公司内部控制风险，提高标的公司整体决策和规范运作水平。

本次交易后上市公司对于标的公司的管控措施如下：

①股东会

上市公司在本次交易完成后直接及间接持有标的公司 100%的股权，将享有100%的表决权作出股东决定，有权决定标的公司归属于股东会职权范围内的全部事项，能够在标的公司的经营方针、投资计划、财务预算和决算以及其他重大事项的决策中发挥主导作用。

②董事会

本次交易完成后，标的公司将改组董事会，改组后董事会成员将均由上市公司委派，在董事会层面控制标的公司，能够在标的公司的经营计划、投资方案、财务预算和决算、高级管理人员的任免、以及其他重大事项的决策中发挥主导作用

③高级管理人员

本次交易完成后，标的公司的日常业务经营由上市公司管理团队统一负责。标的公司高级管理人员对标的公司董事会负责。据此，上市公司可以通过董事会

对标的公司管理团队进行监督和管理。

④财务控制

本次交易完成后，上市公司将把标的公司并入公司财务管理体系。标的公司的相关财务工作安排及财务流程审批等事项，将由上市公司按照统一的内部制度进行统一审批管理，以确保标的公司能够有效执行符合上市公司要求的各项财务会计和内控管理制度。

（2）核查情况

独立财务顾问访谈上市公司、标的公司主要负责人，了解上市公司拟在收购完成后在发展战略、产品研发、客户资源、采购和生产等方面进行整合的具体举措，了解上市公司对于标的公司的管控措施。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司对拟购买资产的具体整合管控安排符合行业发展趋势和公司实际情况，相关安排可以实现上市公司对于拟购买资产的控制，具备合理性。

（二）关于合规性

1、产业政策

（1）本次交易是否符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

（2）涉及高耗能、高排放的，应根据相关规定充分核查。

①基本情况

本次交易有关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等的合规性参见本报告“第八节 独立财务顾问核查意见”之“二、本次交易的合规性分析”之“（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”。

②核查情况

独立财务顾问结合相关法律法规梳理了本次交易的相关要求，审阅了标的公司的合规证明、检索了相关主管部门网站。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次重组符合国家产业政策，在重大方面符合有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）款之规定；本次交易标的公司所属行业不属于高能耗、高污染行业，标的公司不存在违反国家环境保护相关法律和行政法规的情形。

2、需履行的前置审批或并联审批程序

本次交易已履行审批程序的完备性；尚未履行的审批程序，是否存在障碍以及对本次交易的影响

（1）基本情况

本次交易方案已履行和尚需履行的审批程序详见本报告“重大事项提示”之“五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序”。

（2）核查情况

独立财务顾问结合相关法律法规，梳理了本次重组所需履行的决策程序及报批程序；审阅了关于本次交易的相关决策、审批文件。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序；本次交易尚需履行的决策程序及报批程序及相关风险已在重组报告书中披露。

3、重组条件

（1）本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条相关规定

①基本情况

本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定的情况详见本报告“第八节 独立财务顾问核查意见”之“二”本次交易的合规性分析之“（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了标的公司的工商底稿、相关合规证明；审阅了本次交易的相关协议；审阅了本次交易的资产评估报告、审计报告、备考报告；审阅了上市公司的公司章程；审阅了本次交易相关方作出的重要承诺和说明。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条相关规定。

（2）本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条和第四十四条相关规定

①基本情况

本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条规定的情况详见本报告“第八节 独立财务顾问核查意见”之“二”本次交易的合规性分析之“（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定”和“（四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了本次交易的审计报告、备考报告和上市公司的最近一年审计报告；审阅了标的公司工商底档、政府主管部门出具的合规证明；审阅了上市公司现任董监高的无犯罪记录证明及承诺函。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《重组管理办法》第四十三条和第四十四条相关规定。

4、重组上市条件

（1）拟购买资产是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发管理办法》）第二节对于发行条件的要求；

（2）拟购买资产是否符合《首发管理办法》《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等规则对于板块定位的要求；

（3）拟购买资产是否符合《重组审核规则》第十条的要求；如拟购买资产为存在表决权差异安排的，核查拟购买资产是否符合《重组审核规则》第十一条的要求；

（4）标的资产是否符合《重组管理办法》第十三条关于上市公司、控股股东及实际控制人等的相关要求。

①基本情况

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

②核查情况

独立财务顾问审阅了本次交易方案及相关协议；查阅了上市公司历史沿革以及年度报告；测算了本次交易前后上市公司的控制权是否发生变化。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。

5、募集配套资金条件

（1）基本情况

本次募集配套资金的合规性披露情况详见本报告“第八节 独立财务顾问核查意见”之“二”本次交易的合规性分析之“（九）本次交易符合《发行注册管理办法》相关规定”。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅本次交易方案及相关协议；查阅《发行注册管理办法》，分析是否符合相关法规要求。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易募集配套资金符合《注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条至第五十八条的规定。

6、标的资产——行业准入及经营资质等

（1）涉及土地使用权、矿业权等资源类权利的，是否已取得土地使用权证书、采矿权证书，土地出让金、矿业权价款等费用的缴纳情况；采矿权证书的具体内容，相关矿产是否已具备相关开发或开采条件。

①基本情况

标的公司不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利。

②核查情况

独立财务顾问对标的公司相关人员进行访谈，了解标的公司的业务范围及运营情况；审阅标的公司相关经营许可及主要业务资质资料。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利。

（2）涉及立项、环保等有关报批事项的，是否已取得相应的许可证书或相关主管部门的批复文件，如未取得，未取得的原因及影响，上市公司是否按照《格式准则 26 号》第十八条进行特别提示。

①基本情况

本次交易标的资产为华力微股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

②核查情况

对标的公司相关人员进行访谈，了解标的公司的业务范围及运营情况。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及立项、环保等有关报批事项。

（3）涉及特许经营权的，特许经营权的取得情况、期限、费用标准，主要权利义务情况，以及对拟购买资产持续生产经营的影响。

①基本情况

标的公司不涉及特许经营权。

②核查情况

独立财务顾问对标的公司相关人员进行了访谈，了解标的公司的业务范围及运营情况；查阅了标的公司营业执照；查阅了标的公司所处行业的主要法律法规和政策。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司不涉及特许经营权。

7、标的资产——权属状况

（1）拟购买标的公司的权属是否清晰，是否存在对外担保，主要负债、或有负债情况，是否存在抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

①基本情况

标的公司自成立以来的股份变动情况、资金实缴到位情况详见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“二、标的公司历史沿革”。

标的公司对外担保、主要负债、或有负债情况，抵押、质押等权利限制情况详见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“五、标的公司主要资产权属状况、主要负债和对外担保情况”。

标的公司诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况详见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“五、标的公司主要资产权属状况、主要负债和对外担保情况”之“（五）标的资产其他情况”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了标的公司工商底档；通过查阅国家企业信用信息公示系统等平台核实标的公司历次股权变动情况；审阅了交易对方出具的标的资产权属情况的说明；审阅了标的公司出具的相关说明；获取标的公司专项信用报告；检索中国裁判文书网等网络平台。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，拟购买标

的公司的权属清晰，对外担保、主要负债、或有负债情况已在重组报告书中披露，本次交易标的公司股权不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）拟购买标的公司的主要资产，如核心专利、商标、技术、主要机器设备、土地厂房等对公司持续经营存在重大影响的资产，使用是否受限，权属是否清晰，是否存在对外担保，是否存在抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法保全、司法强制执行等重大争议

①基本情况

拟购买标的公司的主要资产详见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“五、标的公司主要资产权属状况、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了标的公司资产相关权属文件；审阅了《法律意见书》中关于诉讼或仲裁的相关内容；审阅了标的公司与银行签订的抵押合同及相关抵押登记文件；检索国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单查询系统以及其他网络平台。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，拟购买标的公司的主要资产权属清晰，除部分设备抵押借款外不存在查封、冻结等情形，相关情况已经在重组报告书中披露，标的公司不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议。

（3）拟购买非股权资产权属是否清晰，是否存在对外担保，是否存在抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

①基本情况

本次交易标的为股权，不涉及购买非股权资产。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议、股东大会决议。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及购买非股权资产。

（4）如主要资产、主要产品涉诉，应当审慎判断对标的资产持续经营能力或盈利能力产生的重大不利影响，并就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四十四条的规定审慎发表核查意见。

①基本情况

标的公司的主要资产、主要产品不涉及尚未了结的重大诉讼等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

②核查情况

独立财务顾问审阅了标的公司主要资产的权属证书；审阅了标的公司提供的关于诉讼及仲裁情况的说明；审阅了《法律意见书》中关于诉讼或仲裁的相关内容；检索了中国裁判文书网等网络平台。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司的主要资产、主要产品不涉及尚未了结的重大诉讼，本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十四条的规定。

（5）如败诉涉及赔偿，相关责任的承担主体、相关会计处理、或有负债计提是否充分、超过预计损失部分的补偿安排。

①基本情况

标的公司的主要资产、主要产品不涉及尚未了结的重大诉讼等重大争议情形。

②核查情况

独立财务顾问审阅了标的公司提供的关于诉讼及仲裁情况的说明；审阅了《法律意见书》中关于诉讼或仲裁的相关内容；检索了中国裁判文书网等网络平台。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司的主要资产、主要产品不涉及尚未了结的重大诉讼等重大争议情形。

8、标的资产——资金占用

（1）关联方非经营性资金占用的具体情况，包括形成背景和原因、时间、金额、用途、履行的决策程序、解决方式、清理进展；

（2）通过向股东分红方式解决资金占用的，标的公司是否符合分红条件，是否履行相关决策程序，分红款项是否缴纳个人所得税；

（3）是否已采取有效整改措施并清理完毕，是否对内控制度有效性构成重大不利影响，是否构成重大违法违规。

①基本情况

截至本独立财务顾问报告签署日，标的公司不存在股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形。参见重组报告书之“第十三节 其他重要事项”之“一、拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用”的相关内容。

②核查情况

独立财务顾问访谈标的公司管理层，**了解**标的公司防范非经营资金占用的相关内部控制；核查标的公司与关联方的关联交易和资金往来情况。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告签署日，标的公司不存在关联方非经营性资金占用的情形。

9、标的资产——VIE 协议控制架构

（1）基本情况

标的资产不涉及曾拆除 VIE 协议控制架构的情形。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了交易对方的工商登记资料；查阅了国家企业信用信息公示系统。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为标的资产不涉及曾拆除 VIE 协议控制架构的

情形。

10、标的资产——曾在新三板挂牌、前次 IPO 和重组被否或终止

（1）基本情况

截至本独立财务顾问报告签署日，标的公司不涉及在新三板挂牌、前次 IPO 和重组被否或终止的情况。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了交易对方的工商登记资料；查阅了国家企业信用信息公示系统。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告签署日，标的公司不涉及在新三板挂牌、前次 IPO 和重组被否或终止的情况。

11、交易对方——标的资产股东人数

（1）发行对象数量超过 200 人的，核查标的资产是否符合《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 4 号股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》（以下简称“《非公指引 4 号》”）的规定。

①基本情况

本次交易中发行股份购买资产的交易对方具体情况详见本报告“第三节 交易对方基本情况”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议；查阅了交易对方的工商资料；获取了交易对方出具的标的公司股东情况说明；检索了国家企业信用信息公示系统。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易发行对象数量不超过 200 人，发行对象不属于超 200 人非上市股份有限公司，不适用相关情形。

（2）发行对象为“200 人公司”的，参照《非公指引 4 号》的要求，核查“200 人公司”的合规性；“200 人公司”为标的资产控股股东、实际控制人，或者在交易完成后成为上市公司控股股东、实际控制人的，其是否按照《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，申请纳入监管范围。

①基本情况

本次交易中发行股份购买资产的交易对方具体情况详见本报告“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产的交易对方”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议；查阅了交易对方的工商资料；获取了交易对方出具的标的公司股东情况说明；检索了国家企业信用信息公示系统。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易发行对象数量不超过 200 人，发行对象不属于超 200 人非上市股份有限公司，不适用相关情形。

12、交易对方——涉及合伙企业、契约型私募基金、券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划、专门为本次交易设立的公司等

（1）涉及合伙企业的，核查各层合伙人取得相应权益的时间、出资方式、资金来源等；合伙企业是否专为本次交易设立，是否以持有标的资产为目的，是否存在其他投资，以及合伙协议约定的存续期限；合伙企业的委托人或合伙人之间是否存在分级收益等结构化安排；

（2）涉及交易对方为本次交易专门设立的，核查穿透到非为本次交易设立的主体持有交易对方的份额锁定期安排是否合规；

（3）涉及契约型私募基金的，是否完成私募基金备案，如未完成，是否已作出明确说明；

（4）如涉及合伙企业、契约型私募基金、券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划、专门为本次交易设立的公司

等情况的，该主体产品存续期，存续期安排是否与其锁定期安排匹配及合理性。

①基本情况

本次交易中发行股份购买资产的交易对方具体情况详见本报告“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份购买资产的交易对方”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司与本次交易相关的董事会决议；审阅了交易对方的工商资料、公司章程/合伙协议；审阅了交易对方出具的标的公司股东情况说明；审阅了交易对方出具的关于股份锁定期的承诺函；检索了国家企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会等网络平台。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的交易对方不存在为本次交易专门设立的情形，不涉及契约型私募基金、券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划；交易对方华虹集团为有限责任公司、上海集成电路基金及大基金二期均为股份有限公司，国投先导基金为合伙企业，交易对方穿透至各层股权/份额持有人的主体身份符合证监会关于上市公司股东的相关要求。

13、同业竞争

（1）本次交易是否导致新增重大不利影响的同业竞争，同业竞争的具体内容，相关各方就解决现实同业竞争作出的明确承诺和安排，包括但不限于解决同业竞争的具体措施、时限、进度与保障，该等承诺和措施的后续执行是否存在重大不确定性，是否损害上市公司和中小股东利益

①基本情况

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司直接及间接持有标的公司 100%的股权。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人变化。本次交易将解决上市公司首次公开发行股票并上市时的同业竞争，本次交易完成后，上市公司控股股东及其控制的其他企业将均不存在对上市公司构成重大不利影响的同业竞争。

②核查情况

核查本次交易前后上市公司与控股股东、实际控制人及其关联方企业之间的经营范围、业务、产品等，核查本次交易是否存在新增重大不利影响的同业竞争。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易完成后，上市公司不会因本次重组新增同业竞争。

（2）重组交易对方及其控股股东、实际控制人等是否已对避免潜在重大不利影响的同业竞争作出明确承诺，承诺内容是否明确可执行

①基本情况

为避免本次交易完成后与上市公司产生同业竞争情形，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，上市公司控股股东已作出明确承诺，详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

②核查情况

独立财务顾问查阅了上市公司控股股东出具的同业竞争承诺；审阅了《重组报告书》。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司控股股东已出具同业竞争承诺，且承诺内容明确可执行。

（3）结合交易完成后可能导致的现实或潜在重大不利影响的同业竞争情况，核查并论证本次交易是否符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定

①基本情况

本次交易完成后不存在可能导致重大不利影响的同业竞争的情况。

②核查情况

独立财务顾问审阅并核实交易方案；审阅交易对方出具的下属企业名单，并通过相关平台检索上述企业的经营范围是否存在疑似同业情况；审阅上市公司控股股东出具的《关于避免同业竞争的承诺函》。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定。

14、关联交易

（1）结合标的资产关联方认定、报告期内关联交易信息披露的完整性，核查并说明关联交易的原因和必要性

①基本情况

标的公司报告期内主要关联方及关联关系、关联交易详见重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”。

②核查情况

独立财务顾问获取标的公司管理层提供的关联方清单，核实其准确性及完整性，梳理关联方及关联交易情况；访谈标的公司管理层，了解关联交易形成的背景、原因、定价原则等，分析关联交易的必要性、定价合理性及公允性，以及本次交易前后上市公司关联交易变动情况；查阅上市公司相关制度，查阅相关方就关联交易事项出具的承诺。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司报告期内关联方认定及关联交易信息披露完整，关联交易具有必要性和合理性。

（2）结合标的资产关联交易的必要性，关联交易占标的资产收入、成本费用或利润总额的比例等，核查并说明是否严重影响独立性或者显失公平

①基本情况

报告期内，标的公司关联交易均系日常经营需要，具有必要性，标的公司关联交易具体情况详见重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”。

②核查情况

独立财务顾问查阅了标的公司的审计报告；获取报告期内标的关联交易的明

细表和主要关联交易协议；访谈标的公司财务负责人，了解关联交易的业务背景、定价方式及执行情况。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内，标的公司关联交易具有必要性和合理性，不存在严重影响独立性或者显失公平的情况。

（3）交易完成后上市公司关联交易的具体情况及未来变化趋势，上市公司为保证关联交易价格公允拟采取的具体措施及其有效性

①基本情况

本次交易对上市公司关联交易的影响和上市公司规范关联交易的措施详见重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”之“（四）本次交易前后上市公司关联交易的变化情况”和“（五）本次交易完成后规范关联交易的措施”。

②核查情况

独立财务顾问查阅了上市公司年度报告、半年度报告及备考审阅报告；查阅上市公司相关制度文件中就关联交易的决策权限和决策程序的规定；核查上市公司按照相关规定履行关联交易决策程序并及时进行信息披露的情况。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：交易完成后上市公司不会新增显失公平的关联交易，上市公司的制度文件中就关联交易决策权限和决策程序进行了规定。

（4）结合交易完成后新增关联交易金额及占比情况等，对本次交易是否符合《重组办法》第四十四条的相关规定审慎发表核查意见

①基本情况

本次交易对上市公司关联交易的影响和上市公司规范关联交易的措施详见重组报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”。

②核查情况

独立财务顾问查阅了上市公司年度报告、半年度报告；查阅安永会计师就本

次交易出具的备考审阅报告。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：交易完成后上市公司不会新增显失公平的关联交易，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定。

15、承诺事项及舆情情况

（1）上市公司、交易对方及有关各方是否按照《重组管理办法》《26 号格式准则》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之 1-7 等规定出具承诺

①基本情况

上市公司、交易对方及有关各方已按照《重组管理办法》《26 号格式准则》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之 1-7 等规定出具承诺，详见本报告“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

②核查情况

独立财务顾问审阅了上市公司、交易对方及有关各方按照《重组管理办法》《26 号格式准则》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之 1-7 等规定出具承诺。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司、交易对方及有关各方已按照《重组管理办法》《26 号格式准则》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之 1-7 等规定出具承诺。

（2）本次交易相关的舆情情况，相关事项是否影响重组条件和信息披露要求；对于涉及的重大舆情情况审慎核查并发表意见

①基本情况

截至本独立财务顾问报告签署日，公开渠道不存在对本次交易造成重大不利影响的重大舆情或媒体质疑。

②核查情况

独立财务顾问对本次交易在主流媒体的舆情情况进行了网络核查。

③核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具之日，本次交易不存在重大不利影响的重大舆情或媒体质疑。

（三）关于标的资产估值与作价

1、本次交易以资产评估结果或估值报告结果作为定价依据

（1）评估或估值的基本情况（包括账面价值、所采用的评估或估值方法、评估或估值结果、增减值幅度等），并结合不同评估或估值结果的差异情况、差异原因、业绩承诺及业绩补偿安排设置等因素，对本次最终确定评估或估值结论的原因及合理性进行审慎核查；如仅采用一种评估或估值方法，核查相关情况合理性、评估或估值方法的适用性、与标的资产相关特征的匹配性；

1）基本情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》，本次评估采用资产基础法和市场法对华力微股东全部权益价值进行评估，并以市场法结果作为本次评估结论。

本次评估的基本情况，不同评估结果的差异情况及原因、业绩承诺及业绩补偿安排设置等因素，本次最终确定评估结论的原因及合理性，详见本报告之“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“一、本次交易标的评估情况”、“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（二）评估合理性的分析”及“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、减值补偿协议”。

2）核查情况

①查阅本次交易重组报告书；

②复核东洲评估出具的《资产评估报告》。

③结合资产基础法和市场法评估结果差异情况、差异原因，分析市场法评估结果作为定价依据的合理性。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估实施了必要的评估程序，遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评

估方法，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结论具有公允性

（2）对评估或估值结论有重要影响的评估或估值假设合理性，如宏观和外部环境假设及根据交易标的自身情况所采用的特定假设等

1）基本情况

本次评估假设的合理性，详见本报告之“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“一、本次交易标的评估情况”之“（二）评估假设”，与“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（一）董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的意见”。

2）核查情况

①查阅本次交易重组报告书；

②复核东洲评估出具的《资产评估报告》。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵守了市场通行惯例，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（3）存在评估或估值特殊处理、对评估或估值结论有重大影响的事项，核查相关事项是否存在较大不确定性及其对评估或估值结论的影响，对评估或估值结论的审慎性发表明确意见

1）基本情况

本次评估中对于评估结论存在重大影响事项的说明及其对于评估结论的影响，详见本报告之“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“一、本次交易标的评估情况”之“（七）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的说明”。

2）核查情况

①查阅本次交易重组报告书；

②复核东洲评估出具的《资产评估报告》。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次对可能会对评估结论存在重大影响事项充分考虑，相关事项的评估处理合理、公允。

2、以收益法评估结果作为定价依据

（1）基本情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，评估机构采用资产基础法和市场法对标的资产股东全部权益价值进行评估，并以市场法结果作为本次评估结论。本次交易未以收益法评估结果作为定价依据。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易方案。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估以市场法评估结果作为最终评估结论，不涉及以收益法评估结果作为定价依据的情形。

3、以市场法评估结果作为定价依据

（1）基本情况

①市场法评估具体模型、价值比率的选取及理由

本次市场法评估具体模型、价值比率的选取及理由，详见本报告“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“一、本次交易标的评估情况”之“（四）市场法评估情况”相关内容。

②可比对象或可比案例的选取原则，具体包括：可比交易案例的选择标准、案例来源、可比交易的目的、交易时间、交易股权比例等

本次可比对象的选择原则等信息，详见本报告“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“一、本次交易标的评估情况”之“（四）市场法评估情况”相关内容。

③调整因素和流动性折扣的取值依据等

本次市场法评估过程中的调整因素和流动性折扣的取值依据等信息，详见本报告“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“一、本次交易标的评估情况”之“（四）市场法评估情况”相关内容。

（2）核查情况

①审阅重组报告书；

②了解华力微存续经营的相关法律情况，主要为有关章程、投资及出资协议、经营场所及经营能力等情况；

③了解华力微执行的会计制度、固定资产折旧政策、存货成本入账和存货发出核算方法等，执行的税率及纳税情况，近几年的债务、借款以及债务成本等情况；

④了解华力微业务类型、经营模式、历史经营业绩，包括主要经营业务的收入占比、主要客户分布，以及与关联企业之间的关联交易情况；

⑤获取近年经审计的资产负债表、损益表、现金流量表以及产品收入和成本费用明细表等财务信息数据；

⑥了解企业资产配置及实际利用情况，分析相关溢余资产和非经营性资产、负债情况，并与企业管理层取得一致意见；

⑦通过对被评估单位管理层访谈方式，了解企业的核心经营优势和劣势；主要经营业务收入和成本构成及其变化趋势等；

⑧与华力微主要供应商、销售客户进行访谈，了解其与被评估单位的业务合作情况、主要的合作基础条件、未来的合作意向等情况；

⑨了解与被评估单位属同一行业，或受相同经济因素影响的可比企业的数量及基本情况，结合可比公司情况核查可比公司的可比性。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估中市场法具体评估模型、市场价值比率的选取及取值依据具备合理性。本次可比对象、调整因素和流动性折扣的取值依据具备合理性，本次通过对同行业上市公司进行全面、合理的分析，挑选出与标的公司可比的上市公司，本次可比对象的选取具备合理性。

4、以资产基础法评估结果作为定价依据

（1）基本情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第 2446 号），以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，评估机构采用资产基础法和市场法对标的资产股东全部权益价值进行评估，并以市场法结果作为本次评估结论。本次交易未以资产基础法评估结果作为定价依据。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易方案。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估以市场法评估结果作为最终评估结论，不涉及以资产基础法评估结果作为定价依据的情形。

5、以其他方法评估结果或者估值报告结果作为定价依据

（1）基本情况

本次交易未以其他方法评估结果或者估值报告结果作为定价依据。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易方案。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易未以其他方法评估结果或者估值报告结果作为定价依据。

6、交易作价的公允性及合理性

（1）以列表形式披露标的资产最近三年内评估结果、估值结果或者交易价格、交易对方，与本次重组评估或估值情况的差异原因

1）基本情况

标的资产最近三年内股权转让或增资情况，请参见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（三）最近三年增减资、改制及评估情况”的相关内容。

2）核查情况

①审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易重组报告书；

②获取标的资产最近三年内股权转让或增资的原因和交易背景，转让或增资价格，对标的资产作价情况进行了解，并分析本次交易中评估作价与历史股权交易价格的差异原因。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中评估作价与历次股权转让或增资价格的差异原因具备合理性。

（2）结合本次交易市盈率、市净率、评估增值率等情况，对比同行业可比上市公司、可比交易情况，披露本次交易评估作价的合理性，并披露可比上市公司、可比交易的选择依据和可比性

1）基本情况

本次交易定价具体情况请参见本报告“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）定价公允性分析”的相关内容。

2）核查情况

①审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易重组报告书；

②了解与被评估单位属同一行业，或受相同经济因素影响的可比企业、可比市场交易案例的数量及基本情况，通过其价值倍数、评估增值率情况等进行分析比较。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估过程中，结合本次交易价值倍数、评估增值率等情况，以及标的资产运营模式、研发投入、业绩增长、同行业可比公司及可比交易定价情况等，本次交易评估作价具备合理性，可比上市公司、可比交易具备可比性。

（3）资产定价过程是否经过充分的市场博弈，交易价格是否显失公允。

1）基本情况

资产定价过程经过了充分的市场博弈，交易价格公允，具体情况请参见本报告“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）定价公允性分析”的相关内容。

2）核查情况

①审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易重组报告书；

②了解与被评估单位属同一行业，或受相同经济因素影响的可比企业、可比市场交易案例的数量及基本情况，通过其价值倍数、评估增值率情况等进行分析比较。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易定价的过程及交易作价具有公允性、合理性。

（4）评估或估值基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响

1）基本情况

本次评估基准日至重组报告书出具日之间未发生对评估结果有重大影响的相关事项。

2）核查情况

独立财务顾问审阅了东洲评估出具的资产评估报告及评估说明，以及本次交易重组报告书。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次评估基准日至重组报告书出具日之间未发生对评估结果有重大影响的相关事项。

7、商誉会计处理及减值风险

（1）基本情况

本次交易系构成同一控制下的企业合并，不产生商誉。

（2）核查情况

分析本次交易涉及商誉的会计处理及减值风险。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及商誉会计处理及减值风险。

（四）关于拟购买资产财务状况及经营成果

1、行业特点及竞争格局

（1）拟购买资产所属行业选取的合理性，相关产业政策、国际贸易政策等对行业发展的影响；与生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策的具体变化情况，相关趋势和变化对拟购买资产的具体影响；

1）基本情况

与标的公司行业相关的产业政策、国际贸易政策等对行业发展的影响以及与生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策的具体变化情况及对标的公司的影响详见本报告“第四节 交易标的基本情况”之“六、/（一）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”和“第九节 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”。

同时，关于相关产业政策、法律法规、国际贸易政策对标的公司的风险因素详见重组报告书“第十二节 因素风险”之“二、与标的资产相关的风险”。

2）核查情况

①通过公开渠道查询了标的公司所在行业的产业政策、国际贸易政策、法律法规，分析相关产业政策、国际贸易政策、法律法规的变化对行业发展的影响；

②访谈标的公司相关人员，了解标的公司业务范围及运营情况。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易拟购买资产所处的相关产业政策、国际贸易政策、法律法规对行业发展的影响以及相关风险已于重组报告书中披露。

（2）同行业可比公司的选取是否客观、全面、准确，是否具有可比性，前后是否一致；

1）基本情况

在进行财务分析时，上市公司选取华润微、士兰微、晶合集成、芯联集成、华虹公司、中芯国际作为标的公司同行业可比上市公司。

2）核查情况

①审阅重组报告书，访谈标的公司相关人员，了解同行业公司的选取是否合理；

②通过公开渠道查询标的公司同行业公司情况。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：同行业可比公司的选取客观、全面、准确，具有可比性。

（3）是否引用第三方数据，所引用数据的真实性及权威性。

1）基本情况

重组报告书引用了行业权威第三方数据来源包括 TechInsights、IC Insights、中商产业研究院、SIA、WSTS、电子信息产业网等。

2）核查情况

①审阅重组报告书；

②核对公开渠道第三方数据的资料来源，了解第三方数据的权威性。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：重组报告书引用了第三方数据，所引用的数

据具备真实性及权威性。

2、主要客户和供应商

（1）报告期各期拟购买资产前五大客户、供应商的基本情况，与前五大客户、供应商的交易内容、交易金额及占比情况，交易定价的公允性，与标的资产业务规模的匹配性；报告期各期前五大客户、供应商发生较大变化的，对同一客户、供应商交易金额存在重大变化的，核查变化的原因及合理性；

1）基本情况

① 前五大客户

报告期内，标的公司的前五大客户的基本情况如下：

客户名称	销售的产品
客户 A	芯片晶圆代工等
客户 B	芯片晶圆代工等
客户 C	芯片晶圆代工等
客户 D	芯片晶圆代工等
华虹集团	芯片晶圆代工、技术授权等
客户 F	芯片晶圆代工等

② 前五大供应商

报告期内，标的公司的前五大原材料及备品备件供应商的基本情况如下：

供应商名称	采购的产品
供应商 A	硅片、研磨液、光刻类化学品
供应商 B	硅片
供应商 C	光刻类化学品、研磨液、研磨垫和研磨盘
供应商 D	硅片
供应商 E	光刻类化学品、化学品等
供应商 F	备品备件

标的公司与上述主要客户、供应商的交易定价均为市场定价，具备公允性，且上述主要客户、供应商的业务规模与相关交易能够匹配。

标的公司与前五大客户、供应商的交易内容、交易金额及占比情况具体详见

本报告“第四节 交易标的基本情况”之“六、/（五）主要产品生产及销售情况”及“六、/（六）主要原材料、能源采购及供应情况”。

2）核查情况

①获取标的公司报告期内的收入明细表及采购明细表，对客户及供应商进行抽样，核查相关合同、订单等，确认标的公司与主要客户、供应商的交易内容、交易金额等情况。

②对报告期内主要客户及供应商进行走访并实施函证程序，了解客户、供应商基本情况，确认交易定价的公允性，与标的公司业务规模的匹配性。

③访谈标的公司管理层，了解报告期内主要客户、供应商存在变化的原因。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司的销售和采购业务模式稳定，相关交易定价公允，与客户及供应商的业务规模具有匹配性。

（2）报告期内拟购买资产涉及新增客户或供应商且金额较大的，核查基本情况、新增交易的原因及可持续性；涉及成立时间较短的客户或供应商且金额较大的，核查合作背景、原因及合理性；

1）基本情况

报告期内，标的公司新增前五大客户情况如下：

新增主要客户	新增交易原因及可持续性	首次建账时间
客户 D	根据客户需求进行交易，目前仍在持续销售中	2023 年 7 月

报告期内，标的公司不存在新增前五大供应商情况。

2）核查情况

①获取标的公司报告期内的销售及采购情况。

②获取标的公司报告期内销售及采购的合同、订单并审阅。

③通过公开信息及访谈所获取的资料，核查相关客户及供应商的背景信息。

④对标的公司管理层及客户和供应商的相关人员进行访谈，了解双方合作情况。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内标的公司与新增金额较大的客户及供应商之间的交易具有合理性。

（3）拟购买资产及其控股股东、实际控制人、董监高及其他核心人员与前五大客户、供应商是否存在关联关系；

1）基本情况

请参见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“六、标的公司主营业务情况”之 “（五）主要产品生产及销售情况”和“（六）主要原材料、能源采购及供应商情况”的相关内容。

2）核查情况

核查报告期内标的公司及其控股股东、实际控制人、董监高及其他核心人员与前五大客户、供应商是否存在关联关系。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内标的公司前五大客户中存在与其控股股东上海华虹（集团）有限公司有关联关系的企业，除上述情况外，报告期内标的公司及其控股股东、实际控制人、董监高及其他核心人员与前五大客户、供应商不存在关联关系。

（4）拟购买资产客户或供应商集中度较高的，核查相关情况的合理性，是否符合行业特征、与同行业可比公司的对比情况，业务的稳定性和可持续性，相关交易的定价原则及公允性，集中度较高是否对标的资产持续经营能力构成重大不利影响。

1）基本情况

报告期内，标的公司向前五大客户销售额占比与同行业可比公司对比如下：

证券代码	公司简称	2025 年度	2024 年度
688347	华虹公司	**34.18%**	30.09%
688249	晶合集成	**55.69%**	61.32%
688981	中芯国际	**35.80%**	36.00%

证券代码	公司简称	2025 年度	2024 年度
688396	华润微	**未披露**	12.28%
600460	士兰微	**未披露**	16.41%
688469	芯联集成	**未披露**	53.89%
可比公司平均		**41.89%**	35.00%
标的公司		**73.59%**	78.18%

标的公司不存在向单个客户销售比例超过总额 50%的情况，前五大客户销售额占**比高于**可比公司，系标的公司业务规模较小，导致销售集中程度较高，具有合理性。标的公司与客户之间的业务往来具有稳定性和可持续性,不存在客户集中度较高导致标的公司持续经营能力受到重大影响的情况。

标的公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%的情况,符合行业特征，与同行业可比公司情况基本一致。标的公司与供应商之间的业务往来具有稳定性和可持续性,不存在供应商集中度较高导致标的公司持续经营能力受到重大影响的情况。

2）核查情况

①统计分析报告期内标的公司主要客户、供应商占当期销售**及采购**总额的比例。

②查询同行业可比公司客户、供应商集中度等公开资料，与标的公司客户、供应商集中度情况进行比较。

③访谈标的公司管理层，了解相关交易的定价原则。

④与标的公司主要客户及供应商进行访谈，了解相关交易的公允性。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内标的公司不存在向单个客户销售的比例超过营业收入 50%的情况，前五大客户集中程度与可比公司晶合集成及芯联集成基本趋同，高于其他可比公司系业务规模较小导致销售集中程度较高，具有合理性。不存在向单个供应商采购的比例超过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。相关交易的定价公允，销售集中度较高对标的公司持续经营能力不构成重大不利影响。

3、财务状况

独立财务顾问应当对以下事项进行核查，并在《独立财务顾问报告》中发表明确核查意见：

（1）结合拟购买资产的行业特点、规模特征、销售模式等，核查拟购买资产财务状况的真实性、与业务模式的匹配性；

1）基本情况

标的公司的行业特点、规模特征详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析” 之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”；标的公司销售模式详见本报告“第四节 标的公司基本情况” 之“六、标的公司主营业务情况” 之“（四）主要经营模式、盈利模式和结算模式”；标的公司的资产财务状况详见重组报告书“第九节 管理层讨论与分析” 之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”。

2）核查情况

①查阅标的公司财务报表及模拟审计报告；

②结合标的公司的行业特点、规模特征、销售模式等，分析标的公司财务状况与业务模式的匹配性；

③结合走访、函证、盘点、分析性复核程序等对标的资产财务状况的真实性进行核查；

④通过走访、函证、核查大额银行流水等方式对收入、成本、费用的真实性进行了核查；

⑤对标的公司管理层进行访谈，了解标的公司的行业特点、规模特征等信息；对标的公司销售负责人进行访谈，了解标的公司销售模式、财务状况与业务模式匹配性等信息。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司财务状况具有真实性，其经营业绩与行业特点、规模特征以及销售模式等保持匹配。

（2）拟购买资产应收账款坏账准备计提政策的合理性，计提比例是否与同行业上市公司存在显著差异及具体原因；结合应收账款的主要构成、账龄结构、主要客户信用或财务状况、期后回款进度等因素，核查拟购买资产应收账款是否存在较大的可收回风险及坏账损失计提的充分性

1）基本情况

报告期内，标的公司应收账款的主要构成、账龄结构参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”的相关内容。

经查阅同行业可比公司年度报告等公开披露文件,标的公司应收账款坏账准备计提政策与同行业可比公司比较如下：

公司名称	坏账准备计提政策
华润微	考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失
士兰微	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失
晶合集成	通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。
芯联集成	参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备
华虹公司	考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以逾期账龄组合为基础评估预期信用损失，根据合同约定收款日计算逾期账龄，若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备
中芯国际	考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失，根据开票日期确定账龄，若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备

公司名称	坏账准备计提政策
标的公司	本公司利用逾期账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，逾期账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

注：**晶合集成、华虹公司及中芯国际**信息摘自 2025 年年报，**华润微、士兰微及芯联集成暂未披露 2025 年年报，故信息摘自 2025 年半年报。**

由上表可知，报告期内，标的公司应收坏账准备计提政策与同行业可比公司不存在重大差异。

经查阅同行业可比公司年度报告等公开披露文件，**报告期内，**标的公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司比较如下：

2025 年 12 月 31 日				
公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
华润微	逾期 0-2 个月以内（含 2 个月）5%；逾期 2-6 个月以内（含 6 个月）20%；逾期 6 个月—1 年（含 1 年）50%，逾期 1 年以上 100.00%			
士兰微	5%	10.00%	30.00%	100.00%
晶合集成	逾期 0-60 天（含 60 天）5%，逾期 61-180 天（含 180 天）10%，逾期 181 天-365 天（含 365 天）50%，逾期 365 天以上 100%			
芯联集成	6 个月以内（含 6 个月）0.10%；6 个月至 1 年（含 1 年）5%	-	-	-
华虹公司	信用期内 0.08%，逾期 90 天内 1.45%，逾期 90-180 天 27.80%，逾期 180 天以上 100%			
中芯国际	逾期 1 年以内 5.69%，逾期 1-2 年 9.86%，逾期 2-3 年 39.60%，逾期 3 年以上 100%			
标的公司	信用期内 1.14%；逾期 90 天内 7.71%，逾期 90 天-180 天 49.21%，逾期 180 天以上 100%			
2024 年 12 月 31 日				
公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
华润微	逾期 0-2 个月以内（含 2 个月）5%；逾期 2-6 个月以内（含 6 个月）20%；逾期 6 个月—1 年（含 1 年）50%，逾期 1 年以上 100.00%			
士兰微	5%	10.00%	30.00%	100.00%
晶合集成	逾期 0-60 天（含 60 天）5%，逾期 61-180 天（含 180 天）10%，逾期 181 天-365 天（含 365 天）50%，逾期 365 天以上 100%			
芯联集成	6 个月以内（含 6 个月）0.10%；6 个月至 1 年（含 1 年）5%	20%	50%	100%
华虹公司	信用期内 0.08%，逾期 90 天内 1.29%，逾期 90-180 天 27.80%，逾期 180 天以上 100%			

中芯国际	0.23%	16.26%	-	100%
标的公司	信用期内 0.45%；逾期 90 天内 3.44%，逾期 90 天-180 天 32.25%，逾期 180 天以上 100%			

注 1：截至目前华润微、士兰微及芯联集成暂未披露 2025 年年报，故 2025 年的计提比例数据摘自 2025 年半年报；

注 2：芯联集成 2025 年半年报未披露 1 年以上应收账款坏账准备计提比例；

注 3：中芯国际 2024 年年报未披露 2-3 年计提比例。

由上表可知，报告期内，标的公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司存在一定差异，标的公司与华润微、晶合集成及华虹公司均按照信用期账龄计提应收账款坏账准备。标的公司逾期 90 天以内应收账款预期信用损失率与同行业可比公司差异较小，而逾期超过 90 天应收账款预期信用损失率计提比例相较其他同行业可比公司更为谨慎，主要系标的公司相较同行业可比公司业务规模较小，财务管理相对谨慎。

标的公司应收账款主要为应收半导体设计企业款项，根据主要客户的期后回款情况、公开渠道信息核查客户信用或财务状况，无需进一步计提单项减值准备，相关坏账准备已充足计提。

2）核查情况

①查阅标的公司计提应收款项坏账准备相关的会计政策，复核其在报告期内的执行情况；

②查阅公开信息，获取同行业可比公司的应收账款坏账准备计提政策、计提比例；

③访谈标的公司财务负责人，了解应收账款的可回收情况、应收款项坏账准备计提是否充分；

④获取应收账款的科目明细表，对主要客户进行访谈、公开信息核查客户信用或财务状况。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司应收账款坏账准备计提政策与同行业上市公司不存在重大差异，坏账准备计提比例与同行业上市公司虽存在一定差异，但相较更为谨慎。标的公司应收账款主要为应收半导体设计企业款项，根据主要客户的期后回款情况、公开渠道信息核查客户信用或财务状况，无需进一步

计提单项减值准备，相关坏账准备已充足计提。

（3）拟购买资产的固定资产的使用状况，是否存在长期未使用或毁损的固定资产；重要固定资产折旧政策与同行业可比公司相比是否合理，折旧费用计提是否充分；固定资产可收回金额确定方法是否恰当，减值测试方法、关键假设及参数是否合理，资产减值相关会计处理是否准确

1）基本情况

①固定资产的使用状况及资产减值情况

报告期内，标的公司固定资产包括机器设备、厂务设施、工具器具、电脑及通讯设备、办公设备、运输设备等。标的公司的固定资产主要为正常生产经营活动所需的机器设备等。

对于固定资产，标的公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额并进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

由于上述资产中不存在长期未使用或毁损的固定资产，未发生减值的迹象，标的公司不存在需要计提固定资产减值准备的情况。

②重要固定资产折旧政策与同行业可比公司相比是否合理，折旧费用计提是否充分

标的公司主要固定资产折旧政策与同行业可比公司不存在显著差异，折旧费用计提充分，具体如下：

公司名称	固定资产折旧方法				
	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
华润微	房屋建筑物	年限平均法	25	5%	3.80%
	机器设备	年限平均法	8	2%	12.25%
	运输工具	年限平均法	5	0%	20.00%
	电子设备	年限平均法	3-5	0.00%-2.00%	19.60%-33.33%

公司名称	固定资产折旧方法				
	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
	信息系统	年限平均法	8	0%	12.50%
	办公设备及家具	年限平均法	5	0%	20.00%
	动力及基础设施	年限平均法	10	2%	9.80%
士兰微	房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5%	2.71%-3.17%
	通用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
	专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
	运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
晶合集成	房屋及建筑物	年限平均法	20-30	0%	3.33%-5.00%
	动力及基础设施	年限平均法	20-30	0%	3.33%-5.00%
	机器设备	年限平均法	5-10	0%	10.00%-20.00%
	运输设备	年限平均法	4	0%	25.00%
	电子设备及其他	年限平均法	3-5	0%	33.33%-20.00%
芯联集成	机器设备	年限平均法	5-10	0%	10.00%-20.00%
	办公设备及其他	年限平均法	3-5	0%	20.00%-33.33%
	房屋建筑物	年限平均法	25	0%	4.00%
	动力及基础设施	年限平均法	10	0%	10.00%
华虹公司	房屋及建筑物	年限平均法	25	5%	3.80%
	厂务设施	年限平均法	10	5%	9.50%
	机器设备	年限平均法	5-7	5%	13.60%-19.00%
	运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
	办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
中芯国际	房屋及建筑物	年限平均法	25	0%	4.00%
	机器设备	年限平均法	5-10	0%	10%-20%
	办公设备	年限平均法	3-5	0%	20%-33%
标的公司	厂务设施	年限平均法	10	5%	9.50%
	机器设备	年限平均法	7	5%	13.57%
	工具器具	年限平均法	5	5%	19.00%

公司名称	固定资产折旧方法				
	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
	电脑通讯设备	年限平均法	5	5%	19.00%
	办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
	运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

注：晶合集成、华虹公司及中芯国际信息摘自 2025 年年报，华润微、士兰微及芯联集成暂未披露 2025 年年报，故信息摘自 2025 年半年报。

由上表可知，标的公司与同行业可比公司均采用年限平均法计提固定资产折旧。标的公司固定资产的折旧年限处于同行业可比公司正常区间，不存在较大差异。

2）核查情况

①获取固定资产的科目明细表；

②对固定资产实施监盘，获取相关盘点记录文件，查看主要固定资产的使用状况，查看是否存在长期未使用或毁损的固定资产，分析是否存在减值迹象分析，判断标的公司会计处理是否符合企业会计准则的规定；

③访谈财务负责人，了解固定资产折旧政策、固定资产减值准备的政策，确认标的公司折旧政策是否符合相关企业会计准则的规定，与同行业公司是否存在重大差异。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期各期末，标的公司不存在涉及资产减值的长期闲置及损毁的固定资产；标的公司重要固定资产折旧政策与同行业可比公司不存在重大差异，具有合理性，固定资产折旧计提充分；标的公司固定资产可收回金额确定方法恰当，减值测试方法、关键假设及参数合理。

（4）结合拟购买资产各存货类别的库龄情况、产品的保质期、订单覆盖情况、单位产品结存成本与预计售价等因素核查存货跌价准备计提是否充分，对报告期存货实施的监盘程序、监盘范围、监盘比例及监盘结果

1）基本情况

报告期各期末，标的公司存货构成、库龄及相应的跌价准备计提情况如下：

单位：万元，%

项目	2025 年 12 月 31 日						
	账面余额	库龄 1 年以内		库龄 1 年以上		存货跌价准备	账面价值
		金额	占比	金额	占比		
原材料	**60,298.69**	**53,093.33**	**88.05**	**7,205.36**	**11.95**	**-**	**60,298.69**
在产品	**45,872.31**	**45,872.31**	**100.00**	**-**	**-**	**590.40**	**45,281.92**
产成品	**22,418.21**	**20,926.83**	**93.35**	**1,491.38**	**6.65**	**2,481.18**	**19,937.03**
合计	**128,589.21**	**119,892.47**	**93.24**	**8,696.74**	**6.76**	**3,071.58**	**125,517.63**
项目	**2024 年 12 月 31 日**						
	账面余额	**库龄 1 年以内**		**库龄 1 年以上**		**存货跌价准备**	**账面价值**
		金额	**占比**	**金额**	**占比**		
原材料	59,835.40	37,491.19	62.66	22,344.21	37.34	-	59,835.40
在产品	48,970.13	48,970.13	100.00	-	-	3,991.20	44,978.93
产成品	56,262.36	30,931.56	54.98	25,330.80	45.02	2,540.59	53,721.76
合计	**165,067.88**	**117,392.87**	**71.12**	**47,675.01**	**28.88**	**6,531.79**	**158,536.09**

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 158,536.09 万元和 **125,517.63** 万元，主要包括原材料、在产品和产成品。原材料主要为硅片、化学原料、石英、靶材以及备品备件等，在产品及产成品主要为各类晶圆半成品及成品，存货库龄以 1 年以内为主，整体存货库龄较短。

报告期各期末，标的公司的原材料均在质保期内，保存良好，库存周转率保持合理水平，原材料本身不存在减值迹象。受半导体行业周期性整体回暖影响，标的公司在报告期内扭亏为盈，预计未来盈利水平有望进一步提高，因此在正常排产的情况下，原材料部分尚无需计提跌价准备。

标的公司实行以销定产的生产模式，大部分产品按照客户下达的订单批量生产，同时进行少量备货式生产。标的公司以同类型产品估计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定在产品的可变现净值并计提存货跌价准备。对于存在毁损、呆滞的在产品，全额计提跌价准备。

对于库存商品，有销售合同/订单约定的库存商品，以合同/订单约定的售价减去估计的销售费用和相关税费，确定其可变现净值；无销售合同/订单约定的库存商品，按照接近资产负债表日公司销售该类产品的销售价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值并计提存货跌价准备。对于存在毁

损、呆滞的产成品，全额计提跌价准备。

2）核查情况

①了解并核查标的公司存货跌价准备的计提政策，重新计算标的公司对存货跌价准备的测算过程,确认存货跌价准备计提的准确性及是否符合企业会计准则的规定。

②获取标的公司各类存货的库龄表，结合存货监盘及存货库龄表，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，获取并复核标的公司于报告期各期末对存货可变现净值估计的相关依据是否充分合理。

③对标的公司报告期存货实施监盘程序，监盘情况如下：

A.监盘程序

获取标的公司盘点计划，评价标的公司盘点工作安排是否合理，盘点的存货地点是否完整；根据标的公司的盘点计划，安排相应的监盘人员，并编制相关的监盘计划；与标的公司管理层讨论盘点细节，包括盘点日期和时间安排、盘点范围、盘点人员分工、盘点方法、盘点人员分组等。

监盘中，实施观察和抽盘程序，观察盘点人员盘点过程中是否尽职，是否准确记录盘点结果。

执行存货双向抽盘，从存货盘点记录中随机抽查项目追查至存货实物，以测试存货的存在性；从存货实物中选取项目追查至存货盘点记录，以测试存货的完整性。

根据监盘计划的实施情况，以及监盘过程中发现的问题，对监盘结果进行评价，形成存货监盘小结。

根据盘点结果，复核盘点正推及倒推情况并与报告期各期末账面结存数量进行核对。

B.监盘结果

结合 2024 年度、**2025 年度**的存货进销存记录，倒推报告期**各期时点**的库存情况，并抽样检查存货出、入库单，对存货进销存记录的准确性进行检查，未见

重大不符情况。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司存货跌价准备计提充分，存货监盘结果不存在重大异常。

（5）如存在企业合并中识别并确认无形资产的情形，核查无形资产的确认和计量是否符合《企业会计准则》相关规定，是否存在减值风险

1）基本情况

报告期内，标的公司无形资产主要为软件、技术使用权及外购知识产权。标的公司的软件产品处于正常使用状态，标的公司不存在企业合并中识别并确认无形资产的情形。

2）核查情况

①查阅标的公司财务报表，访谈标的公司财务负责人，是否存在企业合并中识别并确认无形资产的情形；

②获取无形资产的科目明细表。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司不存在企业合并中识别并确认无形资产的情形。

（6）核查拟购买资产财务性投资的具体情况、可回收性以及对生产经营的影响。

1）基本情况

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》中的内容：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收

益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。 ”

截至报告期末，标的公司不存在财务性投资。

2）核查情况

①查阅标的公司财务报表和模拟审计报告；

②访谈华力微管理层，了解是否存在财务性投资以及具体情况。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：截至报告期末，标的公司不存在财务性投资。

4、经营成果

独立财务顾问应当对以下事项进行核查，并在《独立财务顾问报告》中发表明确核查意见：

（1）拟购买资产收入结构变动的原因，收入变动与同行业可比公司存在较大差异的，核查相关原因及合理性；拟购买资产收入季节性、境内外分布与同行业可比公司存在较大差异的，核查相关情况的合理性；

1）基本情况

标的公司收入结构变动，季节性、境内外分布情况，参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（二）、盈利能力分析”的相关内容。

2）核查情况

①查阅标的公司的财务明细账、会计凭证等资料。

②查阅公开信息，获取同行业可比公司的收入变动情况。

③访谈标的公司的主要客户，了解相关交易情况。

④查询同行业可比上市公司公开信息，了解同行业可比上市公司收入结构变动、收入季节性分布以及收入境内外分布等信息；比较分析标的公司上述信息与同行业可比上市公司情况。

⑤获取标的公司收入明细表，对标的公司收入结构变动、收入季节性分布、境内外分布情况进行分析。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内标的公司收入结构变动与客户的需求匹配，与同行业上市公司因各自特点不同差异具备合理性。标的公司收入的季节性波动符合同行业上市公司情况。境内外收入占比由于业务特点不同与上市公司存在差异具备合理性，标的公司收入相关情况具备合理性。

（2）拟购买资产具体收入确认政策，是否与合同约定及实际执行情况相匹配，是否与同行业可比公司存在较大差异，是否符合《企业会计准则》以及相关规则的规定；

1）基本情况

报告期内，标的公司收入确认原则和具体收入确认时点情况，参见本报告“第四节 标的公司基本情况”之“九、标的公司报告期会计政策及相关会计处理”之“（一）、收入的确认原则和计量方法”的相关内容。

标的公司具体收入确认政策与合同约定及实际执行情况相匹配。经查阅同行业可比公司年度报告、招股说明书等公开披露文件，标的公司收入确认原则和计量方法与同行业可比公司不存在重大差异，符合《企业会计准则》以及相关规则的规定。具体分析如下：

A.集成电路晶圆代工收入

标的公司集成电路晶圆代工业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品由客户签收或确认时商品的控制权转移，标的公司在该时点确认收入实现。

报告期内标的公司集成电路晶圆代工业务具体收入确认时点如下：

DDP	完税交付。指卖方在指定的目的地，将在交货运输工具上尚未卸下的货物交与买方，完成交货确认收入，卖方必须承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用。
DAP	目的地交货,指卖方已经用运输工具把货物运送到达买方指定的目的地后，将装在运输工具上的货物（不用卸载）交由买方处置，即完成交货确认收入。卖方不负责清关和缴纳关税。
FCA	货交承运人(指定地点)，是指卖方只要将货物在指定的地点交给买方指定的承运人或客户自行提货，并办理了出口清关手续，即完成交货确认收入。
EXW	工厂交货，指当卖方在其所在地或其他指定的地点(如工场、工厂或仓库)将货物交给买方处置时，即完成交货确认收入，卖方不办理出口清关手续或将货物装上任何运输工具。
FOB	卖方将货物放置于指定装运港由买方指定的船舶上即为交货并确认收入。
CIF	在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货确认收入
DDU	未完税交货，卖方在指定的目的地将货物交给买方处置，不办理进口手续，也不从交货的运输工具上将货物卸下，即完成交货并确认收入。

上述贸易条款与同行业可比公司贸易条款约定一致，不存在重大差异。

B.其他收入

主要包括测试服务以及技术转让收入。

测试服务在相关服务已完成时确认收入，技术转让业务根据合同条款约定，在客户签字确认技术转让成果或出具验收报告时确认收入。以上收入确认方法与同行业可比公司一致，不存在重大差异。

2）核查情况

①查阅同行业可比公司公开披露的资料，核查标的公司的收入确认会计政策是否与同行业可比公司存在较大的差异。

②核查标的公司收入确认原则、计量原则和具体的确认方法是否符合企业会计准则的相关规定。

3） 核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司具体收入确认政策与合同约定及实际执行情况相匹配，与同行业可比公司不存在较大差异，符合《企业会计准则》以及相关规则的规定。

（3）对拟购买资产收入核查的方法、过程、比例和结论，若存在多种销售模式、在多个国家地区开展业务等情形，请分别说明有关情况；对于报告期收入存在特殊情形的，如新增主要客户较多、收入增长显著异常于行业趋势等，独立

财务顾问是否采取了补充的收入真实性验证核查程序；

1）基本情况

标的公司收入情况参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（二）、盈利能力分析”的相关内容。

2）核查情况

①了解标的公司销售与收款循环的内部控制流程及关键控制点。获取标的公司与销售及收款相关的内部制度，对相关部门负责人进行了访谈，了解标的公司所处的行业特点、销售与收款内部控制流程以及各项关键控制点。

②了解标的公司收入确认政策，评价收入确认政策是否符合企业会计准则要求。获取标的公司主要客户的销售合同、协议或订单，结合关键条款内容，分析标的公司的收入确认政策是否符合会计准则规定。

③执行销售与收款循环测试。抽取报告期主要客户的订单、发票、签收单、物流记录、报关单、记账凭证及银行回款等资料，评价销售与收款内部控制流程实际执行情况与制度要求是否一致、关键控制点运行是否有效。

④对客户进行走访，了解客户的基本情况、与标的公司的业务合作情况、关联关系情况、交易情况、结算方式、是否存在其他资金往来等。客户走访的具体情况如下：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
营业收入总额	**5,101,146,295.54**	4,987,970,873.34
走访客户金额	**2,742,356,507.20**	3,453,513,831.80
走访客户比例	**53.76%**	69.24%

⑤对标的公司与客户的收入金额进行函证，客户函证的具体情况如下：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
营业收入发函金额 A	**4,264,034,509.87**	4,801,505,386.90
营业收入 B	**5,101,146,295.54**	4,987,970,873.34
发函比例 C=A/B	**83.59%**	96.26%
回函及替代测试可确认金额 D=E+F+G	**4,264,034,509.87**	4,801,505,386.90

项目	2025 年度	2024 年度
其中:回函相符可确认金额 E	**2,799,288,904.58**	3,547,197,440.11
回函不符调节后相符可确认金额 F	**1,464,745,605.29**	1,243,094,921.79
未回函替代测试可确认金额 G		11,213,025.00
回函及替代测试可确认比例 H=D/B	**83.59%**	96.26%

⑥实施分析程序，识别销售收入是否存在重大或异常波动，并查明波动原因。1）获取标的公司收入清单，按照产品类型、市场区域、终端应用市场、工艺节点以及季节性分布等维度，对不同维度收入变动情况及变动原因进行分析；2）获取同行业可比公司相关信息，对销售收入变动情况进行比较，对差异情况进行分析。

⑦对销售收入执行细节性测试。

⑧对收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的期间。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司报告期内营业收入真实、准确、完整，不存在特殊异常情形。

（4）拟购买资产收入变动及其与成本、费用等财务数据之间的配比关系是否合理；

1）基本情况

报告期内，标的公司收入变动及其成本、费用情况参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（二）、盈利能力分析”的相关内容。

2）核查情况

①查阅标的公司的审计报告；

②分析报告期内标的公司收入、成本、费用的波动趋势及波动原因。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：拟购买资产收入变动及其与成本、费用等财务数据之间的配比关系合理。

（5）拟购买资产成本归集方法、成本归集的准确性和完整性；成本构成与同行业可比公司存在较大差异的，核查相关原因及合理性

1）基本情况

标的公司采用标准成本法核算产品成本，产品生产过程需经过多道工序，公司根据不同产品的工艺及流程制定不同产品的标准成本 BOM 表，并每个季度维护和修订。产品成本包含料工费，各项成本归集如下：

A.原材料

公司采用月末一次加权平均计价法领用原材料，按照不同产品标准成本归集至各生产工单，并每月将实际原材料耗用与标准成本差额在结存和领用之间按金额分摊。

B.直接人工

公司根据与生产制造相关的直接部门人工薪酬归集计入直接人工，并每月将实际人工与标准人工差额在在产品和产成品入库之间分摊。

C.制造费用

制造费用主要包括折旧、摊销、能耗费、设备修理费和间接人工等。公司每月将实际发生的应由产品制造承担的，但不能直接计入产品成本的有关费用计入制造费用，并每月将实际制造费用与标准制造费用差额在在产品和产成品入库之间分摊。

上述成本归集完成后，公司每月将实际成本与标准成本之间的差额在产成品结存和销售出库之间按金额分摊。

2）核查情况

①了解标的公司成本归集的方法。

②选取测试样本，检查成本归集及分摊的准确性及完整性。

③查阅公开信息，获取同行业可比公司的成本归集方法及成本构成并分析比较差异原因。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司的成本归集方法符合会计准则，成本归集准确完整，成本构成与同行业可比公司不存在较大差异。

（6）拟购买资产主要产品毛利率波动的原因，相关产品毛利率与同行业可比公司存在较大差异的，核查相关原因及合理性；

1）基本情况

报告期内，标的公司主要产品毛利率波动原因及同行业比较情况参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、 标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（二）、盈利能力分析”的相关内容。

2）核查情况

①访谈标的公司管理层，了解影响产品毛利率变化的原因；

②查阅公开信息，获取同行业可比公司的毛利率情况并分析比较差异原因。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司毛利率波动原因具有合理性，标的公司相关产品毛利率与同行业可比公司因产品结构、产品工艺平台、业务模式等不同存在差异具备合理性。

（7)报告期内销售费用、管理费用或研发费用是否存在较大波动及其原因，相关费用占营业收入的比重与同行业可比公司是否存在较大差异及其合理性，销售费用以及市场推广活动的合法合规性，推广活动所涉各项费用的真实性和完整性

1）基本情况

报告期内，标的公司销售费用、管理费用、研发费用情况参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、 标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（二）、盈利能力分析”的相关内容。

2）核查情况

①获取标的公司报告期内的销售费用、管理费用及研发费用的明细表；

②分析标的公司报告期内销售费用、管理费用及研发费用变动趋势及原因；

③查阅公开信息，获取同行业可比公司相关费用占营业收入的比重，并分析比较差异原因。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司报告期内销售费用、管理费用或研发费用变动合理，相关费用占营业收入的比重与同行业可比公司的差异具有合理性，报告期内销售费用合法合规并且真实完整。

（8）拟购买资产经营活动现金净流量持续为负或者远低于净利润的，核查其原因及主要影响，并就其是否影响持续经营能力发表明确核查意见；

1）基本情况

报告期内，标的公司经营活动现金净流量情况参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、 标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“4、现金使用分析”的相关内容。

2）核查情况

①获取标的公司报告期内的现金流量表，并复核现金流量表编制的准确性。

②复核并分析经营活动现金净流量与利润的匹配关系。

3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内，标的公司不存在经营活动现金净流量持续为负或者远低于净利润的情形。

（9）对拟购买资产盈利能力连续性和稳定性的核查过程和核查结论。如拟购买资产未盈利，核查是否影响上市公司持续经营能力并设置中小投资者利益保护相关安排，是否有助于上市公司补链强链、提升关键技术水平。

（1）基本情况

报告期内，标的公司盈利能力情况参见重组报告书之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、 标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（二）、盈利能力分析”的相关内容。

（2）核查情况

①访谈华力微管理层；

②查阅标的公司上下游行业相关情况、同行业可比公司公开信息，分析标的公司盈利能力连续性和稳定性。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：标的公司盈利能力具备连续性，不存在未盈利的情形。

（五）其他

1、审核程序

不适用，本次交易不适用简易审核程序和快速审核程序。

2、信息披露要求及信息披露豁免

（1）基本情况

本次交易披露严格按照《格式准则 26 号》第四条、第五条、第六条以及《重组审核规则》第二十条等相关法律法规。

标的公司涉及集成电路行业，近年来受到较大国际政治经济形势影响，且上下游普遍有信息保密的要求。标的公司与客户、供应商通过销售合同或订单中的保密条款等安排严格明确了保密约定。此外，**标的公司法定财务报表、**华虹集团财务报表**及主要对外投资**、标的公司最近三年注册资本变化、标的公司最近三年增资情况及评估情况、标的公司部分关联方及关联交易等均涉及商业秘密，若公开披露上述信息，将会对上市公司及标的公司的经营带来不利影响，进而会严重损害上市公司及股东的权益。

因此，公司申请在申请文件中豁免披露客户及供应商名称、客户及供应商主营业务、**标的公司法定财务报表、**华虹集团财务报表**及主要对外投资**、标的公司最近三年注册资本变化、标的公司最近三年增资情况及评估情况、标的公司部分关联方及关联交易等相关内容。

（2）核查情况

①审阅上市公司、标的公司、交易对方关于本次交易的决策文件；

②审阅本次重组的《重组报告书》及相关文件；

③审阅本次重组披露的中介机构核查意见或文件。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次申请文件中的相关信息真实、准确、完整，包含对投资者作出投资决策有重大影响的信息，披露程度达到投资者作出投资决策所必需的水平。

本次交易所披露的信息一致、合理且具有内在逻辑性；简明易懂，便于一般投资者阅读和理解。本次交易披露严格按照《格式准则 26 号》第四条、第五条、第六条以及《重组审核规则》第二十条等相关法律法规，申请豁免披露的信息为涉及商业秘密的信息，不涉及对公司财务状况、研发状况、经营状况、持续经营能力的判断有重大影响的信息，不属于已公开信息，豁免披露不会对投资者决策判断构成重大障碍。

3、重组前业绩异常或拟置出资产

（1）基本情况

本次交易不构成重大资产重组，不涉及置出资产。

独立财务顾问、律师、会计师已经按照《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司披露事项进行专项核查、发表明确意见，并提交专项核查报告。

（2）核查情况

独立财务顾问审阅了重组报告书，并查阅了本次交易中介机构出具的核查意见或相关文件。

（3）核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重大资产重组，不涉及置出资产。独立财务顾问、律师、会计师已经按照《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司披露事项进行专项核查、发表明确意见，并提交专项核查报告。

第九节 独立财务顾问内核情况

一、独立财务顾问内部审核程序

（一）提出内部审核申请

根据相关法律、法规规定出具的财务顾问专业意见类型，项目小组提出内部审核申请并提交相应的申请资料。

（二）立项审核

国泰海通证券投资银行业务委员会设立了项目立项评审委员会，通过项目立项评审会议方式对并购重组项目进行立项评审，根据中国证监会和上交所的有关规定，对项目风险及申请材料进行审核。

立项申请经项目立项评审委员会审核通过后，项目小组应当根据有关规定将申报材料提交国泰海通内核委员会进行审核，同时国泰海通质量控制部验收底稿并向内核委员会提交质量控制报告。

（三）内核委员会审核

国泰海通证券设立了内核委员会作为投资银行类业务非常设内核机构以及内核风控部作为投资银行类业务常设内核机构，履行对并购重组项目的内核审议决策职责，对并购重组项目风险进行独立研判并发表意见。

内核风控部通过公司层面审核的形式对并购重组项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或者披露材料和文件的审核决策职责。内核委员会通过内核会议方式履行职责，对并购重组项目风险进行独立研判并发表意见，决定是否向证券监管部门提交、报送和出具独立财务顾问报告。

二、独立财务顾问的内核意见

国泰海通内核委员会于 2025 年 11 月 13 日召开了内核会议审议了华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目，会议共 7 名委员参与表决，经 2/3 以上参会内核委员表决同意，表决结果为通过，同意出具独立财务顾问报告。

第十节 独立财务顾问结论性意见

本独立财务顾问按照《公司法》《证券法》《重组办法》《指引第 6 号》《26 号准则》《财务顾问办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，通过尽职调查和对上市公司董事会编制的重组报告书等信息披露文件的审慎核查，并与上市公司、交易对方、本次交易的法律顾问、审计机构、评估机构等相关方经过充分沟通后认为：

1、本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的规定，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的情形；

2、本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条的规定；

3、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

4、本次交易根据资产评估结果定价，所选取的评估方法具有适当性，评估假设前提具有合理性，重要评估参数取值具有合理性，评估结论和评估定价具有公允性；本次交易拟购买资产定价具有合理性，发行股份购买资产的股份定价具有合理性；

5、本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、改善上市公司财务状况，本次交易有利于上市公司的持续发展，不存在损害股东合法权益的问题；

6、本次交易有利于上市公司提升市场地位和经营业绩，有利于增强上市公司的持续发展能力；

7、本次交易合同约定的资产交付安排不会导致上市公司在本次交易后无法及时获得标的资产的风险，标的资产交付安排相关的违约责任切实、有效；

8、本次重组构成关联交易，关联交易程序的履行符合相关规定，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形；

9、上市公司已在重组报告书中，就本次重组完成后可能出现即期回报被摊薄的情况，提出填补每股收益的具体措施，该等措施具有可行性、合理性；

10、标的资产符合科创板定位，所属行业与上市公司处于同行业；标的公司与上市公司具有协同效应。本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条的规定；

11、本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三方中介机构的行为。上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构、评估机构以外，还聘请了创升融资有限公司担任本次交易的中国香港独立财务顾问、聘请了 Herbert Smith Freehills Kramer（香港律所）担任本次交易的中国香港法律顾问、聘请大华国际（香港）会计师事务所有限公司担任本次交易标的公司港股审计机构、聘请了安永会计师事务所担任本次交易上市公司港股备考审阅机构以及聘请了北京向实启源管理咨询有限公司为上市公司提供申报文件制作、底稿电子化等服务，除此以外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》之签字盖章页）

法定代表人或授权代表：

郁伟君

内核负责人：

杨晓涛

部门负责人：

郁伟君

项目主办人：

李　淳　　聂绪雯

项目协办人：

陈是来　　肖翔云

乔宏图　　陈亚聪

国泰海通证券股份有限公司

年　　月　　日

上海华力微电子有限公司

审计报告

大华审字[2026]0011007164 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26GA68NDRN

上海华力微电子有限公司

审计报告及模拟财务报表

（2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）

目录 页次

一、 审计报告 1-4

二、 已审模拟财务报表

模拟资产负债表 1-2

模拟利润表 3

模拟现金流量表 4

模拟所有者权益变动表 5-7

模拟财务报表附注 1-65

三、 事务所及注册会计师执业资质证明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039]
电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2026]0011007164 号

华虹半导体有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微电子”）模拟财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟资产负债表，2025 年度、2024 年度的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。

我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注三所述编制基础编制，公允反映了华力微电子 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟财务状况以及 2025 年度、2024 年度的模拟经营成果和模拟现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华力微电子，适用了对公众利益实体财务报表审计的独立性要求，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

我们提醒模拟财务报表的使用者关注本报告模拟财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供模拟财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于任何其他目的。未经本所书面同意，不得披露、提及或引用本报告全部或部分内容。本段内容不影响已经发表的审计意见。

四、管理层和治理层对模拟财务报表的责任

华力微电子管理层负责按照模拟财务报表附注三所述编制基础编制模拟财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制模拟制财务报表时，华力微电子管理层负责评估华力微电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华力微电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华力微电子的财务报告过程。

五、注册会计师对模拟财务报表审计的责任

我们的目标是对模拟财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响模拟财务报表使用者依据模拟财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的模拟财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华力微电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意模拟财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华力微电子不能持续经营。

5．评价模拟财务报表的总体列报、结构和内容，并评价模拟财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的相关规定向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

（此页以下无正文）

（本页无正文，仅为大华审字[2026]0011007164 号上海华力微电子有限公司审计报告签字页）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

王胤

中国注册会计师：

李春姣

二〇二六年三月三十日

模拟资产负债表

编制单位：上海华力微电子有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注六	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释1	2,592,177,443.23	1,480,921,325.11
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释2		10,000,000.00
应收账款	注释3	655,883,867.03	635,910,459.14
应收款项融资			
预付款项	注释4	7,970,827.20	812,880.66
其他应收款	注释5	388,032.11	481,901.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货	注释6	1,255,176,285.00	1,585,360,902.23
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释7	13,028,672.74	
其他流动资产	注释8	17,525,606.86	107,055,811.19
流动资产合计		4,542,150,734.17	3,820,543,279.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释9	56,428,828.68	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释10	1,478,972,915.65	1,752,690,503.05
在建工程	注释11	75,031,245.02	34,385,712.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释12	352,640,909.52	437,486,209.57
无形资产	注释13	118,736,208.06	151,780,170.61
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	注释14	4,634,129.21	6,545,401.55
递延所得税资产			
其他非流动资产	注释15	4,137,751.93	55,461,328.56
非流动资产合计		2,090,581,988.07	2,438,349,325.93
资产总计		6,632,732,722.24	6,258,892,605.51

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟资产负债表（续）

编制单位：上海华力微电子有限公司

负债和所有者权益	附注六	2025年12月31日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释16	715,836,033.54	880,126,225.91
预收款项			
合同负债	注释17	105,719,438.04	119,942,554.96
应付职工薪酬	注释18	98,115,385.70	133,903,965.61
应交税费	注释19	3,784,635.47	10,551,635.57
其他应付款	注释20	78,886,893.21	106,388,258.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释21	563,083,249.52	887,226,243.44
其他流动负债	注释22	11,959,950.64	13,190,010.94
流动负债合计		1,577,385,586.12	2,151,328,894.96
非流动负债：			
长期借款	注释23	2,472,250,000.00	2,428,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释24	305,280,122.17	390,033,016.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释25	1,275,594.74	6,488,022.55
递延收益	注释26	16,110,000.00	16,110,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,794,915,716.91	2,840,631,038.78
负债合计		4,372,301,303.03	4,991,959,933.74
所有者权益：			
实收资本	注释27	2,036,192,198.06	1,873,648,154.85
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释28	55,720,098.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释29	1,969,388.66	
盈余公积			
未分配利润	注释30	166,549,734.48	-606,715,483.08
所有者权益合计		2,260,431,419.21	1,266,932,671.77
负债和所有者权益总计		6,632,732,722.24	6,258,892,605.51

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：秦健　主管会计工作负责人：王智　会计机构负责人：曹佳

模拟利润表

编制单位：上海华力微电子有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	2025年度	2024年度
一、营业收入	注释31	5,101,146,295.54	4,987,970,873.34
减：营业成本	注释31	3,892,573,410.04	4,164,602,166.09
税金及附加	注释32	4,239,812.15	11,655,339.66
销售费用	注释33	6,314,530.38	10,113,696.62
管理费用	注释34	129,076,942.08	143,111,383.36
研发费用	注释35	244,950,676.68	325,535,027.25
财务费用	注释36	62,077,355.00	-140,573,236.46
其中：利息费用		87,432,129.57	73,636,293.07
利息收入		-105,826,557.09	-167,424,685.98
加：其他收益	注释37	33,081,700.62	38,355,241.45
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释38	-23,952,871.51	20,194,794.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释39	-24,117,912.50	-10,072,198.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释40	25,805,159.80	361,706.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		772,729,645.62	522,366,041.56
加：营业外收入	注释41	1,449,453.14	4,654,467.41
减：营业外支出	注释42	913,881.20	5,496,475.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		773,265,217.56	521,524,033.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		773,265,217.56	521,524,033.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		773,265,217.56	521,524,033.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
六、综合收益总额		773,265,217.56	521,524,033.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟现金流量表

编制单位：上海华力微电子有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,367,565,782.74	5,436,480,775.04
收到的税费返还		176,215,437.66	52,542,057.56
收到其他与经营活动有关的现金	注释43	171,067,030.97	183,215,616.38
经营活动现金流入小计		5,714,848,251.37	5,672,238,448.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,295,405,362.34	2,868,787,310.36
支付给职工以及为职工支付的现金		628,356,668.50	585,452,805.44
支付的各项税费		10,338,715.44	61,112,044.96
支付其他与经营活动有关的现金	注释43	93,105,744.32	99,282,276.76
经营活动现金流出小计		4,027,206,490.60	3,614,634,437.52
经营活动产生的现金流量净额	注释44	1,687,641,760.77	2,057,604,011.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,054,808.60	30,467.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,054,808.60	30,467.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		232,058,420.85	54,104,458.07
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		232,058,420.85	54,104,458.07
投资活动产生的现金流量净额		-230,003,612.25	-54,073,991.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		218,264,141.22	3,001,617.22
取得借款收到的现金		917,550,000.00	1,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,135,814,141.22	1,063,001,617.22
偿还债务支付的现金		1,200,100,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,406,199.48	50,946,606.91
支付其他与筹资活动有关的现金	注释43	107,684,266.18	3,905,810,940.51
筹资活动现金流出小计		1,376,190,465.66	4,706,757,547.42
筹资活动产生的现金流量净额		-240,376,324.44	-3,643,755,930.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-72,711,933.33	52,986,593.96
五、现金及现金等价物净增加额		1,144,549,890.75	-1,587,239,315.85
加：期初现金及现金等价物余额		1,437,635,026.26	3,024,874,342.11
六、期末现金及现金等价物余额		2,582,184,917.01	1,437,635,026.26

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：秦健　　主管会计工作负责人：王智　　会计机构负责人：曹旎

模拟所有者权益变动表

编制单位：上海华力微电子有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2025年度									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1,873,648,154.85									-606,715,483.08	1,266,932,671.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	1,873,648,154.85									-606,715,483.08	1,266,932,671.77
三、本期增减变动金额	162,544,043.21				55,720,098.01			1,969,388.66		773,265,217.56	993,498,747.44
（一）综合收益总额										773,265,217.56	773,265,217.56
（二）所有者投入和减少资本	162,544,043.21				55,720,098.01						218,264,141.22
1．所有者投入的普通股	162,544,043.21				55,720,098.01						218,264,141.22
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增股本											
2．盈余公积转增股本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								1,969,388.66			1,969,388.66
1．本期提取								7,597,970.87			7,597,970.87
2．本期使用								-5,628,582.21			-5,628,582.21
（六）其他											
四、本期期末余额	2,036,192,198.06				55,720,098.01			1,969,388.66		166,549,734.48	2,260,431,419.21

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：秦健　　主管会计工作负责人：王智　　会计机构负责人：曹佳

模拟所有者权益变动表

编制单位：上海华力微电子有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2024年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	1,870,646,537.63									-1,128,239,516.34	742,407,021.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本期期初余额	1,870,646,537.63									-1,128,239,516.34	742,407,021.29
三、本期增减变动金额	3,001,617.22									521,524,033.26	524,525,650.48
（一）综合收益总额										521,524,033.26	521,524,033.26
（二）所有者投入和减少资本	3,001,617.22										3,001,617.22
1．所有者投入的普通股	3,001,617.22										3,001,617.22
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增股本											
2．盈余公积转增股本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取								6,723,166.18			6,723,166.18
2．本期使用								-6,723,166.18			-6,723,166.18
（六）其他											
四、本期期末余额	1,873,648,154.85									-606,715,483.08	1,266,932,671.77

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：秦健　　主管会计工作负责人：王智　　会计机构负责人：曹佳

上海华力微电子有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止前两个年度

模拟财务报表附注

一、公司基本情况

(一)历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

上海华力微电子有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原系由上海联和投资有限公司、上海华虹(集团)有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司共同于 2010 年 1 月 18 日在上海市注册成立的有限责任公司，初始注册资本为人民币 66 亿元。上海联和投资有限公司、上海华虹(集团)有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司注册资本的比例为 68.18%、10.61%、10.61%和 10.61%。

2010 年 12 月 1 日，根据股东会决议、增资协议和修改后章程，由上海联和投资有限公司对本公司新增注册资本人民币 13 亿元，全部以现金形式投入。增资后，本公司注册资本为人民币 79 亿元。上海联和投资有限公司、上海华虹(集团)有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司注册资本的比例为 73.42%、8.86%、8.86%和 8.86%。

2013 年 1 月，原投资方上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司新设合并为上海华虹宏力半导体制造有限公司。变更后，上海联和投资有限公司、上海华虹(集团)有限公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司分别占本公司注册资本的比例为 73.42%、8.86%和 17.72%。

2016 年 12 月 14 日，根据股东会决议、增资协议和修改后章程，由上海联和投资有限公司和上海集成电路产业投资基金股份有限公司分别对本公司新增注册资本人民币 52 亿元及人民币 88 亿元。增资后，本公司注册资本为人民币 219 亿元。上海联和投资有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、上海华虹(集团)有限公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司分别占本公司注册资本的比例为 50.23%、40.18%、3.20%及 6.39%。

2019 年 12 月 25 日，上海联和投资有限公司将所持有的本公司 50.23%的股权转让给上海华虹(集团)有限公司。同时，上海华虹(集团)有限公司以人民币 1.8 亿元对本公司进行增资。变更后，本公司注册资本为人民币 22,072,397,279.95 元。上海华虹(集团)有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司分别占本公司注册资本的比例为 53.79%、39.87%及 6.34%。

2023 年 11 月 28 日，根据股东会决议、增资协议和修改后章程，由上海华虹（集团）有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司对本公司增加注册资本。增资后，上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司分别占本公司注册资本的比例为 53.85%、30.98%、10.24%和 4.93%。

2025 年 4 月 30 日，根据股东会决议、增资协议和修改后章程，由上海华虹（集团）有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司对本公司增加注册资本。增资后，上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）和上海华虹宏力半导体制造有限公司分别占本公司注册资本的比例为 63.54%、15.72%、10.25%、7.98%和 2.50%。

2025 年 8 月 21 日，根据股东会决议、分立协议和修改后章程，本公司采取存续分立的形式，将公司分立为上海华力微电子有限公司及新设公司（以下简称“公司 A”）。分立后，本公司的注册资本变更为 2,036,192,198.06 元，公司各股东持股比例与分立前保持一致。

公司母公司为上海华虹（集团）有限公司，最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会。

公司现持有统一社会信用代码为 913100005500570876 的营业执照。

本公司经批准的经营期限为 2010 年 1 月 18 日至 2060 年 1 月 17 日。

法定代表人：秦健。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号。

本公司经批准的经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。

二、重大资产重组方案及交易标的相关情况

（一）重大资产重组方案

2025 年 8 月 29 日，华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”）2025 年第六次董事会会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，华虹公司以通过发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的本公司 97.4988%股权并募集配套资金。2026 年 2 月 10 日，华虹公司召开 2026 年第一次临时股东大会，会议决议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案等若干议案。

(二)交易标的相关情况

2025 年 6 月 26 日，根据沪华力微股（2025）第 4 号股东会决议，全体股东一致同意公司存续分立的方案，采取存续分立的形式，将公司分立为上海华力微电子有限公司（存续公司，以下简称“分立后的华力微”）及新设公司。分立后的华力微继续运营位于中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号的 12 英寸晶圆厂晶圆代工等相关的业务，并承继与之相关的资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务，新设公司承继长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务。分立后的华力微与新设公司保持业务、资产、人员、财务、机构等方面的相互独立。公司于 2025 年 8 月 21 日完成了本次分立行为。分立后的华力微注册资本与新设公司的注册资本之和等于本次分立前华力微的注册资本。各股东在分立后的华力微与新设公司的持股比例，与本次分立前在华力微的持股比例一致。分立后的华力微为本次重组拟注入华虹公司的标的资产。

三、模拟财务报表的编制基础

(一)模拟财务报表的编制基础

除下述事项外，本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的规定，编制模拟财务报表。

1、模拟华力微电子在本报告期内均已完成存续分立。华力微电子于 2025 年 8 月 21 日完成存续分立，华力微电子（分立前主体）分立为分立后的华力微（现存续主体）和新设公司。本公司对 2025 年 8 月 21 日之前的报告期财务报表数据按照分立拆分原则，进行模拟拆分：即假设华力微电子于报告期初即已完成了存续分立，按照分立协议约定分立拆分原则完成财务数据的拆分。

2、本公司模拟于报告期期初即已执行华虹公司的会计估计及会计政策，并已作了追溯调整。

(二)持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三)记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

四、重要会计政策、会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的模拟财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟财务状况，2025 年度、2024 年度的模拟经营成果和模拟现金流量等有关信息。

(二)会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

(三)营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的在建工程	本期增加额超过人民币 1,500 万元
重要的应付账款/合同负债/其他应付款	单项应付账款/合同负债/其他应付款占应付账款/合同负债/其他应付款总额的 10%以上
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上

(六)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七)外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生折算后的汇兑记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(八)金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1．金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和一年内到期的非流动资

产等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符

合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2．金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3．金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4．金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当

视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6．金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据和应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的长期应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内

预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险特征组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7．金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（九）应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

（十）应收账款

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险特征组合	本组合以应收款项的逾期账龄作为信用风险特征	本公司利用逾期账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，逾期账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款逾期账龄按合同约定收款日进行计算。

(十一)其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

(十二)存货

1．存货类别、发出计价方法、盘存制度

（1）存货类别

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、合同履约成本等。

（2）存货发出计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

2．存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(十三)长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（八）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

(十四)固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2．固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3．固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
厂务设施	年限平均法	10	5.00	9.50
机器设备	年限平均法	7	5.00	13.57
工具器具	年限平均法	5	5.00	19.00
电脑通讯设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产的减值

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（十九）长期资产减值。

（4）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五)在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资

产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（十九）长期资产减值。

（十六）借款费用

1．借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2．借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4．借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定

可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.本公司发生的初始直接费用；

4.本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注（十九）长期资产减值。

（十八）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、技术使用权和外购知识产权。

1．无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2．无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	预计可使用年限
技术使用权	3-10	相关合同所载有效期或预计可使用年限
外购知识产权	5	预计可使用年限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见本附注（十九）长期资产减值。

3．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力

使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

（十九）长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

（二十）长期待摊费用

1．摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2．摊销年限

类别	摊销年限（年）
装修费	5
实施服务费	5

（二十一）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1．短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2．离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3．辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

4．其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(二十三)预计负债

1．预计负债的确认标准

当与亏损合同或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

2．预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十四）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1．扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2．取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3．在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4．在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5．根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）收入

本公司的收入主要来源于销售商品及提供服务。

1．收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某

一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度/投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2．收入确认的具体方法

（1）销售商品

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品由客户签收或确认时商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

（2）提供服务

本公司向客户提供的服务主要为测试服务等，在服务已完成，客户取得相关服务控制权时确认收入。

(二十六)合同成本

1．合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2．合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3．合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4．合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十七）政府补助

1．类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3．会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费

用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1．确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2．确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延

所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十九）租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1．租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2．租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3．本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（十七）和（二十四）。

4．本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（三十）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专

项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、税项

(一)公司主要税种和税率

税种	计税依据/收入类型	税率（%）	备注
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务	13	本附注（二）、1
	不动产租赁服务	9	
	其他应税销售服务行为	6	
	简易计税方法	3	
	销售除油气外的出口货物；跨境应税销售服务行为	0	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5	
企业所得税	应纳税所得额	0	本附注（二）、2

(二)税收优惠政策及依据

1. 根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。本公司适用上述增值税加计抵减政策。

2．据国务院颁布的《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）和财政部、税务总局、发展改革委及工业和信息化部颁布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告[2020]45 号）的相关规定，本公司为集成电路线宽小于 65 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业，按照税法相关规定可以自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司进入税务获利年度第一年。

根据《财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告2023年第44号），集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的220%在税前摊销。

六、模拟财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
库存现金	38,454.10	39,991.08
银行存款	2,582,146,462.91	1,437,595,035.18
其他货币资金	1,600.00	1,012,000.00
未到期应收利息	9,990,926.22	42,274,298.85
合计	2,592,177,443.23	1,480,921,325.11

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
信用卡保证金		1,000,000.00
ETC 保证金	1,600.00	12,000.00
合计	1,600.00	1,012,000.00

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		10,000,000.00

本公司经评估后认为报告期内所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他承兑人违约而产生重大损失。

2. 本报告期公司无已质押的应收票据

3. 本报告期公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	687,006,134.91	644,156,578.05
1-2 年	13,492,777.53	5,752,928.50
2-3 年	5,120,603.93	46,609,215.71
3 年以上	34,825,485.29	
小计	740,445,001.66	696,518,722.26
减：坏账准备	84,561,134.63	60,608,263.12
合计	655,883,867.03	635,910,459.14

2．按坏账计提方法分类披露

类别	2025 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	740,445,001.66	100.00	84,561,134.63	11.42	655,883,867.03
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	740,445,001.66	100.00	84,561,134.63	11.42	655,883,867.03
合计	740,445,001.66	100.00	84,561,134.63		655,883,867.03

续：

类别	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	696,518,722.26	100.00	60,608,263.12	8.70	635,910,459.14
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	696,518,722.26	100.00	60,608,263.12	8.70	635,910,459.14
合计	696,518,722.26	100.00	60,608,263.12		635,910,459.14

按组合计提坏账准备

（1）信用风险特征组合

信用期	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用期内	640,536,390.22	7,281,860.78	1.14
逾期 90 天内	20,577,659.04	1,585,848.73	7.71
逾期 90 天-180 天	7,162,579.73	3,525,052.45	49.21
逾期 180 天以上	72,168,372.67	72,168,372.67	100.00
合计	740,445,001.66	84,561,134.63	

续：

信用期	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用期内	608,845,380.33	2,713,353.17	0.45
逾期 90 天内	21,530,425.84	740,364.79	3.44
逾期 90 天-180 天	13,267,525.88	4,279,154.95	32.25
逾期 180 天以上	52,875,390.21	52,875,390.21	100.00
合计	696,518,722.26	60,608,263.12	

3．本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2023 年 12 月 31 日	本期变动情况				2024 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	80,803,057.91	-20,194,794.79				60,608,263.12
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	80,803,057.91	-20,194,794.79				60,608,263.12
合计	80,803,057.91	-20,194,794.79				60,608,263.12

续：

类别	2024 年 12 月 31 日	本期变动情况				2025 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	60,608,263.12	23,952,871.51				84,561,134.63
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备	60,608,263.12	23,952,871.51				84,561,134.63
合计	60,608,263.12	23,952,871.51				84,561,134.63

4．本报告期无实际核销的应收账款

5．按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

期末余额前五名应收账款汇总	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	已计提应收账款坏账准备余额
2025 年 12 月 31 日	565,919,083.05	76.43	38,651,127.01
2024 年 12 月 31 日	570,080,136.87	81.85	32,688,023.73

注释4．预付款项

1．预付款项按账龄列示

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,970,827.20	100.00	812,880.66	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
合计	7,970,827.20	100.00	812,880.66	100.00

2．本报告期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

时点	期末余额前五名预付款项合计	占预付款项期末余额的比例(%)
2025 年 12 月 31 日	7,888,785.54	98.97
2024 年 12 月 31 日	754,813.81	92.86

注释5．其他应收款

1．按账龄披露

账龄	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	133,632.11	4,174.00
1-2 年		442,302.00
2-3 年	254,400.00	
3 年以上		35,425.25
小计	388,032.11	481,901.25
减：坏账准备		
合计	388,032.11	481,901.25

2．按款项性质分类情况

款项性质	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
押金及保证金	370,054.97	477,727.25
其他	17,977.14	4,174.00
小计	388,032.11	481,901.25
减：坏账准备		
合计	388,032.11	481,901.25

3．本报告期无计提、收回或转回的坏账准备的情况

4．报告期无实际核销的其他应收款

5．按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款

单位名称	款项性质	2025 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海张投国业科技发展有限公司	押金及保证金	317,416.51	1-3 年	81.80	

续：

单位名称	款项性质	2024 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海张投国业科技发展有限公司	押金及保证金	254,400.00	1-2 年	52.79	
环瑀企业管理咨询(上海)有限公司	押金及保证金	187,902.00	1-2 年	38.99	
合计		442,302.00		91.78	

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	602,986,862.54		602,986,862.54
在产品	458,723,144.04	5,903,984.92	452,819,159.12
产成品	224,182,058.84	24,811,795.50	199,370,263.34
合计	1,285,892,065.42	30,715,780.42	1,255,176,285.00

续：

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	598,353,960.89		598,353,960.89
在产品	489,701,280.76	39,911,987.94	449,789,292.82
产成品	562,623,560.03	25,405,911.51	537,217,648.52
合计	1,650,678,801.68	65,317,899.45	1,585,360,902.23

2. 存货跌价准备

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额			2024 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
在产品	93,084,876.74	35,362,736.48			88,535,625.28		39,911,987.94
产成品	91,899,843.25			25,290,538.48	41,203,393.26		25,405,911.51
合计	184,984,719.99	35,362,736.48		25,290,538.48	129,739,018.54		65,317,899.45

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额			2025 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
在产品	39,911,987.94	5,670,116.43			39,678,119.45		5,903,984.92
产成品	25,405,911.51	18,447,796.07			19,041,912.08		24,811,795.50
合计	65,317,899.45	24,117,912.50			58,720,031.53		30,715,780.42

注释7. 一年内到期的非流动资产

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	13,028,672.74	

注释8. 其他流动资产

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	17,525,606.86	107,055,811.19
合计	17,525,606.86	107,055,811.19

注释9. 长期应收款

款项性质	2025 年 12 月 31 日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	76,317,439.20		76,317,439.20	2.44%
减：未实现融资收益	6,859,937.78		6,859,937.78	
减：一年内到期的长期应收款	13,028,672.74		13,028,672.74	
合计	56,428,828.68		56,428,828.68	

1. 本报告期无计提、收回或转回的坏账准备的情况

2. 本报告期无实际核销的长期应收款

3. 应收融资租赁款

剩余租赁年限	2025 年 12 月 31 日
1 年以内	14,352,902.07
1-2 年	7,631,743.74
2-3 年	7,631,743.74
3-4 年	7,631,743.74
4-5 年	7,631,743.74
5 年以上	31,437,562.17
应收租赁收款额总额小计	76,317,439.20
减：未确认融资收益	6,859,937.78
应收租赁收款额现值小计	69,457,501.42
减：一年内到期的租赁款	13,028,672.74
合计	56,428,828.68

注释10．固定资产

1．固定资产情况

项目	厂务设施	机器设备	工具器具	电脑通讯设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值							
1．2024 年 1 月 1 日	1,244,501,720.76	13,929,406,549.32	11,080,825.80	204,517,234.96	1,217,991.52	8,368,357.82	15,399,092,680.18
2．本期增加	5,893,175.77	43,286,363.58		113,716.81			49,293,256.16
在建工程转入	5,893,175.77	43,286,363.58		113,716.81			49,293,256.16
3．本期减少金额		5,057,000.00	119,658.12	1,564,362.45	13,675.22	4,356,350.00	11,111,045.79
处置或报废			119,658.12	1,564,362.45	13,675.22	4,356,350.00	6,054,045.79
政府补助抵减		5,057,000.00					5,057,000.00
4．2024 年 12 月 31 日	1,250,394,896.53	13,967,635,912.90	10,961,167.68	203,066,589.32	1,204,316.30	4,012,007.82	15,437,274,890.55
二、累计折旧							
1．2024 年 1 月 1 日	1,145,453,013.59	11,850,264,467.48	8,617,381.16	183,686,489.83	862,139.02	7,473,608.47	13,196,357,099.55
2．本期增加	36,810,305.74	641,288,405.84	669,885.96	5,576,705.00	104,074.44	137,420.88	684,586,797.86
本期计提	36,810,305.74	641,288,405.84	669,885.96	5,576,705.00	104,074.44	137,420.88	684,586,797.86
3．本期减少	832,944.19	188,017,921.35	114,539.21	3,242,581.20	12,991.46	4,138,532.50	196,359,509.91
处置或报废			113,675.21	1,486,143.87	12,991.46	4,138,532.50	5,751,343.04
政府补助抵减	832,944.19	188,017,921.35	864.00	1,756,437.33			190,608,166.87
4．2024 年 12 月 31 日	1,181,430,375.14	12,303,534,951.97	9,172,727.91	186,020,613.63	953,222.00	3,472,496.85	13,684,584,387.50
三、减值准备							
1．2024 年 1 月 1 日							
2．本期增加							
3．本期减少							

项目	厂务设施	机器设备	工具器具	电脑通讯设备	办公设备	运输设备	合计
4．2024 年 12 月 31 日							
四、账面价值							
1．2024 年 12 月 31 日	68,964,521.39	1,664,100,960.93	1,788,439.77	17,045,975.69	251,094.30	539,510.97	1,752,690,503.05
2．2024 年 1 月 1 日	99,048,707.17	2,079,142,081.84	2,463,444.64	20,830,745.13	355,852.50	894,749.35	2,202,735,580.63

项目	厂务设施	机器设备	工具器具	电脑通讯设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值							
1．2024 年 12 月 31 日	1,250,394,896.53	13,967,635,912.90	10,961,167.68	203,066,589.32	1,204,316.30	4,012,007.82	15,437,274,890.55
2．本期增加	14,514,171.29	118,721,243.28	1,154,640.09	2,827,380.52			137,217,435.18
在建工程转入	14,514,171.29	118,721,243.28	1,154,640.09	2,827,380.52			137,217,435.18
3．本期减少		117,233,175.73	47,776.93	3,821,627.20	264,359.71	3,288,740.00	124,655,679.57
处置或报废		5,447,650.65	47,776.93	3,821,627.20	264,359.71	3,288,740.00	12,870,154.49
融资租出		111,785,525.08					111,785,525.08
政府补助抵减							
4．2025 年 12 月 31 日	1,264,909,067.82	13,969,123,980.45	12,068,030.84	202,072,342.64	939,956.59	723,267.82	15,449,836,646.16
二、累计折旧							
1．2024 年 12 月 31 日	1,181,430,375.14	12,303,534,951.97	9,172,727.91	186,020,613.63	953,222.00	3,472,496.85	13,684,584,387.50
2．本期增加	8,932,814.59	501,146,495.34	572,180.62	3,258,069.35	68,847.18	137,420.90	514,115,827.98
本期计提	8,932,814.59	501,146,495.34	572,180.62	3,258,069.35	68,847.18	137,420.90	514,115,827.98
3．本期减少	244,482.65	220,554,475.24	46,252.09	3,630,547.82	236,424.17	3,124,303.00	227,836,484.97
处置或报废		5,175,268.15	45,388.09	3,630,547.82	236,424.17	3,124,303.00	12,211,931.23
融资租出		76,493,386.07					76,493,386.07
政府补助抵减	244,482.65	138,885,821.02	864.00				139,131,167.67
4．2025 年 12 月 31 日	1,190,118,707.08	12,584,126,972.07	9,698,656.44	185,648,135.16	785,645.01	485,614.75	13,970,863,730.51

项目	厂务设施	机器设备	工具器具	电脑通讯设备	办公设备	运输设备	合计
三、减值准备							
1．2024 年 12 月 31 日							
2．本期增加							
3．本期减少							
4．2025 年 12 月 31 日							
四、账面价值							
1．2025 年 12 月 31 日	74,790,360.74	1,384,997,008.38	2,369,374.40	16,424,207.48	154,311.58	237,653.07	1,478,972,915.65
2．2024 年 12 月 31 日	68,964,521.39	1,664,100,960.93	1,788,439.77	17,045,975.69	251,094.30	539,510.97	1,752,690,503.05

注释11．在建工程

1．在建工程情况

项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	66,319,759.12		66,319,759.12
工具器具	7,123.90		7,123.90
电脑通讯设备	46,017.70		46,017.70
无形资产	8,658,344.30		8,658,344.30
合计	75,031,245.02		75,031,245.02

续：

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	25,850,543.04		25,850,543.04
工具器具	10,690.27		10,690.27
电脑通讯设备	385,001.77		385,001.77
无形资产	8,139,477.51		8,139,477.51
合计	34,385,712.59		34,385,712.59

2．在建工程项目本报告期变动情况

工程项目名称	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期转入固定资产	本期转入无形资产	本期其他减少	2024 年 12 月 31 日
厂务设施	1,117,930.23	4,775,245.54	5,893,175.77			
机器设备	36,199,980.01	34,695,608.61	43,286,363.58		1,758,682.00	25,850,543.04
工具器具		10,690.27				10,690.27
电脑通讯设备		498,718.58	113,716.81			385,001.77
无形资产	8,314,547.15	37,088,759.21		37,263,828.85		8,139,477.51
合计	45,632,457.39	77,069,022.21	49,293,256.16	37,263,828.85	1,758,682.00	34,385,712.59

续：

工程项目名称	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产	本期转入无形资产	本期其他减少	2025 年 12 月 31 日
厂务设施		14,514,171.29	14,514,171.29			
机器设备	25,850,543.04	164,795,605.42	118,721,243.28		5,605,146.06	66,319,759.12
工具器具	10,690.27	1,151,073.72	1,154,640.09			7,123.90
电脑通讯设备	385,001.77	2,488,396.45	2,827,380.52			46,017.70
无形资产	8,139,477.51	2,487,778.08		1,968,911.29		8,658,344.30
合计	34,385,712.59	185,437,024.96	137,217,435.18	1,968,911.29	5,605,146.06	75,031,245.02

3．本报告期无计提在建工程减值准备情况

注释12．使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1．2024 年 1 月 1 日	767,642,146.94
2．本期增加	1,136,643.66
重估调整	1,136,643.66
3．本期减少	132,561.18
租赁到期	132,561.18
4．2024 年 12 月 31 日	768,646,229.42
二、累计折旧	
1．2024 年 1 月 1 日	245,780,243.14
2．本期增加	85,512,337.89
本期计提	85,512,337.89
3．本期减少	132,561.18
租赁到期	132,561.18
4．2024 年 12 月 31 日	331,160,019.85
三、减值准备	
1．2024 年 1 月 1 日	
2．本期增加	
3．本期减少	
4．2024 年 12 月 31 日	
四、账面价值	
1．2024 年 12 月 31 日	437,486,209.57
2．2024 年 1 月 1 日	521,861,903.80

续：

项目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1．2024 年 12 月 31 日	768,646,229.42
2．本期增加	786,033.11
重估调整	786,033.11
3．本期减少	
4．2025 年 12 月 31 日	769,432,262.53
二、累计折旧	
1．2024 年 12 月 31 日	331,160,019.85
2．本期增加	85,631,333.16
本期计提	85,631,333.16
3．本期减少	

项目	房屋及建筑物
4．2025 年 12 月 31 日	416,791,353.01
三、减值准备	
1．2024 年 12 月 31 日	
2．本期增加	
3．本期减少	
4．2025 年 12 月 31 日	
四、账面价值	
1．2025 年 12 月 31 日	352,640,909.52
2．2024 年 12 月 31 日	437,486,209.57

注释13．无形资产

1．无形资产情况

项目	软件	技术使用权	外购知识产权	合计
一、账面原值				
1．2024 年 1 月 1 日	24,081,390.07	422,677,181.75	175,884,548.80	622,643,120.62
2．本期增加		35,929,494.85	1,334,334.00	37,263,828.85
在建工程转入		35,929,494.85	1,334,334.00	37,263,828.85
3．本期减少	1,113,923.87	149,156,230.52		150,270,154.39
处置	1,113,923.87	147,958,373.37		149,072,297.24
政府补助抵减		1,197,857.15		1,197,857.15
4．2024 年 12 月 31 日	22,967,466.20	309,450,446.08	177,218,882.80	509,636,795.08
二、累计摊销				
1．2024 年 1 月 1 日	23,872,258.92	286,010,766.09	154,532,954.03	464,415,979.04
2．本期增加	92,349.57	29,119,022.48	22,555,182.27	51,766,554.32
本期计提	92,349.57	29,119,022.48	22,555,182.27	51,766,554.32
3．本期减少	1,113,923.87	149,016,272.15	8,195,712.87	158,325,908.89
处置	1,113,923.87	147,958,373.37		149,072,297.24
政府补助抵减		1,057,898.78	8,195,712.87	9,253,611.65
4．2024 年 12 月 31 日	22,850,684.62	166,113,516.42	168,892,423.43	357,856,624.47
三、减值准备				
1．2024 年 1 月 1 日				
2．本期增加				
3．本期减少				
4．2024 年 12 月 31 日				
四、账面价值				
1．2024 年 12 月 31 日	116,781.58	143,336,929.66	8,326,459.37	151,780,170.61
2．2024 年 1 月 1 日	209,131.15	136,666,415.66	21,351,594.77	158,227,141.58

续：

项目	软件	技术使用权	外购知识产权	合计
一、账面原值				
1．2024 年 12 月 31 日	22,967,466.20	309,450,446.08	177,218,882.80	509,636,795.08
2．本期增加		1,398,500.42	570,410.87	1,968,911.29
在建工程转入		1,398,500.42	570,410.87	1,968,911.29
3．本期减少	41,430.91	2,002,468.44		2,043,899.35
处置	41,430.91	2,002,468.44		2,043,899.35
政府补助抵减				
4．2025 年 12 月 31 日	22,926,035.29	308,846,478.06	177,789,293.67	509,561,807.02
二、累计摊销				
1．2024 年 12 月 31 日	22,850,684.62	166,113,516.42	168,892,423.43	357,856,624.47
2．本期增加	32,162.18	29,564,978.65	11,524,137.80	41,121,278.63
本期计提	32,162.18	29,564,978.65	11,524,137.80	41,121,278.63
3．本期减少	41,430.91	2,337,701.91	5,773,171.32	8,152,304.14
处置	41,430.91	2,002,468.44		2,043,899.35
政府补助抵减		335,233.47	5,773,171.32	6,108,404.79
4．2025 年 12 月 31 日	22,841,415.89	193,340,793.16	174,643,389.91	390,825,598.96
三、减值准备				
1．2024 年 12 月 31 日				
2．本期增加				
3．本期减少				
4．2025 年 12 月 31 日				
四、账面价值				
1．2025 年 12 月 31 日	84,619.40	115,505,684.90	3,145,903.76	118,736,208.06
2．2024 年 12 月 31 日	116,781.58	143,336,929.66	8,326,459.37	151,780,170.61

注释14．长期待摊费用

项目	2024年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2024年12月31日
装修费	7,875,021.86		1,807,937.90		6,067,083.96
实施服务费	676,242.11		197,924.52		478,317.59
合计	8,551,263.97		2,005,862.42		6,545,401.55

续：

项目	2024年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2025年12月31日
装修费	6,067,083.96		1,713,347.82		4,353,736.14
实施服务费	478,317.59		197,924.52		280,393.07
合计	6,545,401.55		1,911,272.34		4,634,129.21

注释15．其他非流动资产

类别及内容	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
预付设备使用费		51,585,101.89
预付租赁款	3,498,229.31	3,876,226.67
预付设备款	639,522.62	
合计	4,137,751.93	55,461,328.56

注释16．应付账款

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付材料款	314,345,384.42	458,599,160.60
应付费用其他类	401,490,649.12	421,527,065.31
合计	715,836,033.54	880,126,225.91

注释17．合同负债

1．合同负债情况

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
预收货款	105,719,438.04	119,942,554.96

2．本报告期末无账龄超过一年且金额重要的合同负债

注释18．应付职工薪酬

1．应付职工薪酬列示

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
短期薪酬	94,926,166.14	571,458,323.49	537,267,369.98	129,117,119.65
离职后福利-设定提存计划	5,101,670.84	57,757,683.00	58,072,507.88	4,786,845.96
辞退福利		147,168.00	147,168.00	
合计	100,027,836.98	629,363,174.49	595,487,045.86	133,903,965.61

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
短期薪酬	129,117,119.65	550,322,613.05	585,224,318.24	94,215,414.46
离职后福利-设定提存计划	4,786,845.96	52,086,775.70	52,973,650.42	3,899,971.24
合计	133,903,965.61	602,409,388.75	638,197,968.66	98,115,385.70

2．短期薪酬列示

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	91,695,726.33	494,677,056.26	459,996,712.42	126,376,070.17
职工福利费		13,470,753.31	13,470,753.31	
社会保险费	3,230,439.81	33,666,576.47	34,155,966.80	2,741,049.48

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
其中：医疗及生育保险费	3,091,921.72	32,097,832.12	32,578,746.95	2,611,006.89
工伤保险费	138,518.09	1,568,744.35	1,577,219.85	130,042.59
住房公积金		24,186,565.00	24,186,565.00	
工会经费和职工教育经费		5,457,372.45	5,457,372.45	
合计	94,926,166.14	571,458,323.49	537,267,369.98	129,117,119.65

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	126,376,070.17	478,515,791.72	512,936,067.13	91,955,794.76
职工福利费		14,478,757.82	14,478,757.82	
社会保险费	2,741,049.48	30,179,234.59	30,660,664.37	2,259,619.70
其中：医疗及生育保险费	2,611,006.89	28,410,979.93	28,894,729.78	2,127,257.04
工伤保险费	130,042.59	1,768,254.66	1,765,934.59	132,362.66
住房公积金		21,965,733.00	21,965,733.00	
工会经费和职工教育经费		5,183,095.92	5,183,095.92	
合计	129,117,119.65	550,322,613.05	585,224,318.24	94,215,414.46

3．设定提存计划列示

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
基本养老保险	4,947,074.75	56,007,433.05	56,312,717.78	4,641,790.02
失业保险费	154,596.09	1,750,249.95	1,759,790.10	145,055.94
合计	5,101,670.84	57,757,683.00	58,072,507.88	4,786,845.96

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
基本养老保险	4,641,790.02	50,508,380.50	51,368,380.23	3,781,790.29
失业保险费	145,055.94	1,578,395.20	1,605,270.19	118,180.95
合计	4,786,845.96	52,086,775.70	52,973,650.42	3,899,971.24

注释19．应交税费

税费项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
个人所得税	1,584,659.11	2,229,734.42
车船使用税		480.00
印花税	2,185,725.56	8,275,311.60
环境保护税	14,250.80	21,795.14
其他		24,314.41
合计	3,784,635.47	10,551,635.57

注释20．其他应付款

1．按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付设备及工程等相关款	59,975,644.91	83,064,107.07
代收代付款项	5,190,001.00	4,932,601.00
应付费用	7,885,228.29	12,941,948.51
代扣代缴个人社保	2,481,800.01	3,046,175.89
其他	3,354,219.00	2,403,426.06
合计	78,886,893.21	106,388,258.53

注释21．一年内到期的非流动负债

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	476,918,367.74	803,743,438.89
一年内到期的租赁负债	86,164,881.78	83,482,804.55
合计	563,083,249.52	887,226,243.44

注释22．其他流动负债

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
待转销项税额	11,959,950.64	13,190,010.94

注释23．长期借款

借款类别	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
质押借款		1,500,000,000.00
抵押借款	1,760,000,000.00	960,000,000.00
信用借款	1,187,450,000.00	770,000,000.00
未到期应付利息	1,718,367.74	1,743,438.89
减：一年内到期的长期借款	476,918,367.74	803,743,438.89
合计	2,472,250,000.00	2,428,000,000.00

长期借款说明：

2025 年度长期借款的利率为 0.00%-3.00%（2024 年度：1.20%-3.00%）

注释24．租赁负债

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
租赁付款额	426,298,054.67	527,854,213.04
减：未确认融资费用	34,853,050.72	54,338,392.26
租赁负债合计	391,445,003.95	473,515,820.78
减：一年内到期的租赁负债	86,164,881.78	83,482,804.55
合计	305,280,122.17	390,033,016.23

2025 年度确认租赁负债利息费 19,539,504.90 元（2024 年度：23,443,132.30 元）。

注释25. 预计负债

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	形成原因
退租复原成本	1,275,386.97	1,214,520.59	租赁合同约定
待执行的亏损合同	207.77	5,273,501.96	订单亏损
合计	1,275,594.74	6,488,022.55	

注释26. 递延收益

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
与资产相关政府补助	4,537,000.00	1,270,000.00	5,807,000.00	
与收益相关政府补助	19,043,000.00	9,990,000.00	12,923,000.00	16,110,000.00
合计	23,580,000.00	11,260,000.00	18,730,000.00	16,110,000.00

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
与资产相关政府补助				
与收益相关政府补助	16,110,000.00	24,180,000.00	24,180,000.00	16,110,000.00
合计	16,110,000.00	24,180,000.00	24,180,000.00	16,110,000.00

注释27. 实收资本

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
上海华虹(集团)有限公司	1,290,881,154.42	3,001,617.22		1,293,882,771.64
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	320,120,740.45			320,120,740.45
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	208,716,343.14			208,716,343.14
上海华虹宏力半导体制造有限公司	50,928,299.62			50,928,299.62
合计	1,870,646,537.63	3,001,617.22		1,873,648,154.85

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
上海华虹(集团)有限公司	1,293,882,771.64			1,293,882,771.64
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	320,120,740.45			320,120,740.45
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	208,716,343.14			208,716,343.14
上海华虹宏力半导体制造有限公司	50,928,299.62			50,928,299.62
上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）		162,544,043.21		162,544,043.21
合计	1,873,648,154.85	162,544,043.21		2,036,192,198.06

注释28．资本公积

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）		55,720,098.01		55,720,098.01

注释29．专项储备

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2024 年 12 月 31 日
安全生产费		6,723,166.18	6,723,166.18	

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
安全生产费		7,597,970.87	5,628,582.21	1,969,388.66

注释30．未分配利润

项目	2025 年度	2024 年度
期初未分配利润	-606,715,483.08	-1,128,239,516.34
加：本期归属于所有者的净利润	773,265,217.56	521,524,033.26
期末未分配利润	166,549,734.48	-606,715,483.08

注释31．营业收入和营业成本

1．营业收入和营业成本情况

项目	2025 年度		2024 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,061,887,664.07	3,875,034,593.64	4,479,124,586.40	4,151,926,935.02
其他业务	39,258,631.47	17,538,816.40	508,846,286.94	12,675,231.07
合计	5,101,146,295.54	3,892,573,410.04	4,987,970,873.34	4,164,602,166.09

2．营业收入分解信息

项目	2025 年度	2024 年度
一、商品类型		
集成电路晶圆代工	4,866,168,732.69	4,272,268,221.16
其他	234,977,562.85	715,702,652.18
合计	5,101,146,295.54	4,987,970,873.34
二、商品转让的时间		
在某一时点转让	5,080,558,960.79	4,959,568,536.51
在某一时段内转让	20,587,334.75	28,402,336.83
合计	5,101,146,295.54	4,987,970,873.34
三、经营地区		
中国境内	2,608,124,947.66	2,723,398,037.35
中国境外	2,493,021,347.88	2,264,572,835.99
合计	5,101,146,295.54	4,987,970,873.34

3．营业成本分解信息

项目	2025 年度	2024 年度
一、 商品类型		
集成电路晶圆代工	3,717,830,430.76	3,970,198,938.54
其他	174,742,979.28	194,403,227.55
合计	3,892,573,410.04	4,164,602,166.09
二、 商品转让的时间		
在某一时点转让	3,888,865,161.49	4,156,748,392.70
在某一时段内转让	3,708,248.55	7,853,773.39
合计	3,892,573,410.04	4,164,602,166.09

4．履约义务

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	提供的质量保证类型及相关义务
商品销售	以客户取得相关商品控制权的时点	合同价款通常在交付商品后 30-45 天内到期，不存在重大融资成分	晶圆及相关产品	是	保证类质保

确认的收入来源于：

项目	2025 年度	2024 年度
合同负债期/年初账面价值	118,454,493.60	57,234,051.11

注释32．税金及附加

项目	2025 年度	2024 年度
印花税	4,134,126.86	11,574,075.42
车船使用税	6,960.00	8,580.00
环境保护税	98,725.29	72,684.24
合计	4,239,812.15	11,655,339.66

注释33．销售费用

项目	2025 年度	2024 年度
职工薪酬	4,874,307.66	8,537,604.08
其他	1,440,222.72	1,576,092.54
合计	6,314,530.38	10,113,696.62

注释34．管理费用

项目	2025 年度	2024 年度
职工薪酬	50,728,553.75	68,011,660.10
专业服务费	16,176,904.15	15,821,084.37
使用权资产折旧费	18,478,951.08	16,806,752.52
折旧费用	4,642,335.66	5,328,714.25
摊销费用	32,162.18	73,546.15

项目	2025 年度	2024 年度
日常运营费用	12,906,377.17	13,965,677.76
保险费	6,205,959.45	6,568,884.24
办公费	3,313,280.16	3,423,601.99
环境保护费	2,786,239.48	2,255,407.55
安保费	2,259,809.01	2,238,371.93
修理费	2,060,604.76	2,374,858.55
其他	9,485,765.23	6,242,823.95
合计	129,076,942.08	143,111,383.36

注释35．研发费用

项目	2025 年度	2024 年度
职工薪酬	116,895,531.85	131,683,596.78
研究测试费用	55,912,215.90	89,554,158.60
折旧费用	33,441,463.55	51,792,170.05
摊销费用	20,642,809.77	28,178,522.50
维修维护费	24,392,279.29	25,562,931.76
燃料动力及水电费	7,647,372.54	11,686,647.57
政府补助抵减研发费用	-13,980,996.22	-12,923,000.01
合计	244,950,676.68	325,535,027.25

注释36．财务费用

项目	2025 年度	2024 年度
利息支出	87,432,129.57	73,636,293.07
减：利息收入	105,826,557.09	167,424,685.98
汇兑损益	80,393,431.89	-46,939,322.27
银行手续费	78,350.63	154,478.72
合计	62,077,355.00	-140,573,236.46

注释37．其他收益

1．其他收益明细情况

产生其他收益的来源	2025 年度	2024 年度
政府补助	829,900.00	1,263,226.00
增值税加计抵减	31,456,063.43	36,018,343.71
三代手续费返还	795,737.19	1,073,671.74
合计	33,081,700.62	38,355,241.45

2．计入其他收益的政府补助

本公司政府补助详见附注八、政府补助（三）计入当期损益的政府补助。

注释38．信用减值损失

项目	2025 年度	2024 年度
应收账款坏账损失	-23,952,871.51	20,194,794.79

上表中，损失以“－”号填列。

注释39．资产减值损失

项目	2025 年度	2024 年度
存货跌价损失	-24,117,912.50	-10,072,198.00

上表中，损失以“－”号填列。

注释40．资产处置收益

项目	2025 年度	2024 年度
固定资产处置利得或损失	25,805,159.80	361,706.50

注释41．营业外收入

项目	2025 年度	2024 年度
违约赔偿收入	266,000.00	651,569.00
无需支付款项	1,152,000.00	4,002,898.41
非流动资产报废利得	31,453.14	
合计	1,449,453.14	4,654,467.41

1．计入各期非经常性损益的金额

项目	2025 年度	2024 年度
违约赔偿收入	266,000.00	651,569.00
无需支付款项	1,152,000.00	4,002,898.41
非流动资产报废利得	31,453.14	
合计	1,449,453.14	4,654,467.41

注释42．营业外支出

项目	2025 年度	2024 年度
非流动资产毁损报废损失	500,353.33	40,178.17
待执行的亏损合同	207.77	5,273,501.96
其他	413,320.10	182,795.58
合计	913,881.20	5,496,475.71

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2025 年度	2024 年度
非流动资产毁损报废损失	500,353.33	40,178.17
待执行的亏损合同	207.77	5,273,501.96
其他	413,320.10	182,795.58
合计	913,881.20	5,496,475.71

注释43．现金流量表附注

1．与经营活动有关的现金

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	2025 年度	2024 年度
利息收入	138,035,470.51	152,875,024.75
政府补助收入	25,009,900.00	12,523,226.00
个税手续费返还	843,481.42	1,138,092.04
营业外收入	266,000.00	651,569.00
代收款项	5,790,000.00	13,582,460.23
其他	1,122,179.04	2,445,244.36
合计	171,067,030.97	183,215,616.38

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	2025 年度	2024 年度
银行手续费	66,661.09	150,335.69
代付款项	5,412,600.00	1,361,700.00
支付的各项费用	87,165,438.71	97,629,895.07
营业外支出	461,044.52	140,346.00
合计	93,105,744.32	99,282,276.76

2．与筹资活动有关的现金

（1）支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2025 年度	2024 年度
模拟预留资金		3,799,042,686.32
租赁支出	107,684,266.18	106,768,254.19
合计	107,684,266.18	3,905,810,940.51

（2）筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	2024 年 1 月 1 日	本期增加		本期减少		2024 年 12 月 31 日
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款	3,785,909,617.22		13,133,069.10	3,799,042,686.32		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	550,465,965.65		29,998,416.88	106,768,254.19	180,307.56	473,515,820.78
合计	4,336,375,582.87		43,131,485.98	3,905,810,940.51	180,307.56	473,515,820.78

续：

项目	2024 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2025 年 12 月 31 日
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	473,515,820.78		25,667,612.71	107,684,266.18	54,163.36	391,445,003.95

注释44. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2025 年度	2024 年度
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	773,265,217.56	521,524,033.26
加：信用减值损失	23,952,871.51	-20,194,794.79
资产减值准备	24,117,912.50	10,072,198.00
固定资产折旧	374,984,660.31	493,978,630.99
使用权资产折旧	85,631,333.16	85,512,337.89
无形资产摊销	35,012,873.84	42,512,942.67
长期待摊费用摊销	1,911,272.34	2,005,862.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-25,805,159.80	-361,706.50
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	468,900.19	40,178.17
财务费用（收益以“一”号填列）	160,144,062.90	20,649,699.11
存货的减少（增加以“一”号填列）	306,066,704.73	545,960,412.70
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	157,357,499.78	-14,447,962.87
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-231,435,776.91	370,352,180.41
其他	1,969,388.66	
经营活动产生的现金流量净额	1,687,641,760.77	2,057,604,011.46
（2）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,582,184,917.01	1,437,635,026.26
减：现金的期初余额	1,437,635,026.26	3,024,874,342.11
现金及现金等价物净增加额	1,144,549,890.75	-1,587,239,315.85

2. 与租赁相关的总现金流出

2025 年度与租赁相关的总现金流出为人民币 107,684,266.18 元（2024 年度：人民币 106,768,254.19 元）。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	2025 年度	2024 年度
（1）现金	2,582,184,917.01	1,437,635,026.26
其中：库存现金	38,454.10	39,991.08
可随时用于支付的银行存款	2,582,146,462.91	1,437,595,035.18
（2）期末现金及现金等价物余额	2,582,184,917.01	1,437,635,026.26

注释45．所有权或使用权受到限制的资产

2025 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	1,600.00	1,600.00	ETC 保证金
固定资产	7,860,966,253.88	878,253,771.12	抵押取得长期借款
合计	7,860,967,853.88	878,255,371.12	

续：

2024 年 12 月 31 日			
项目	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	1,012,000.00	1,012,000.00	ETC 保证金、信用卡保证金
固定资产	326,279,888.10	106,024,967.89	抵押取得长期借款
合计	327,291,888.10	107,036,967.89	

其他说明：

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司以固定资产为抵押分别取得国家开发银行上海市分行人民币 500,000,000.00 元长期借款，期限为 2015 年 11 月 24 日至 2030 年 11 月 23 日；国家开发银行上海市分行人民币 300,000,000.00 元长期借款，期限为 2016 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日；国家开发银行上海市分行、交通银行股份有限公司上海新区支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行和上海银行股份有限公司徐汇支行人民币 960,000,000.00 元长期借款，期限为 2023 年 2 月 27 日至 2031 年 2 月 26 日，详见附注六、注释 23。

注释46. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			2,274,702,449.21			4,107,599,274.55
其中：美元	323,620,936.48	7.0288	2,274,666,838.33	571,415,611.41	7.1884	4,107,563,981.06
欧元	1,498.18	8.2355	12,338.26	1,498.18	7.5257	11,274.85
日元	519,513.00	0.044797	23,272.62	519,513.00	0.046233	24,018.64
应收账款			358,530,856.15			350,106,515.52
其中：美元	51,008,828.84	7.0288	358,530,856.15	48,704,373.09	7.1884	350,106,515.52
其他应收款						34,425.25
其中：美元				4,789.00	7.1884	34,425.25
应付账款			130,121,767.56			259,782,070.60
其中：美元	14,127,845.53	7.0288	99,301,800.66	30,239,145.91	7.1884	217,371,076.46
欧元	380,027.47	8.2355	3,129,716.23	476,490.18	7.5257	3,585,922.15
日元	618,127,345.00	0.044797	27,690,250.67	839,769,688.00	0.046233	38,825,071.99
其他应付款			34,411,987.43			61,356,020.30
其中：美元	4,451,834.63	7.0288	31,291,055.25	5,882,381.03	7.1884	42,284,907.80
欧元	23,000.00	8.2355	189,416.50			
日元	65,440,000.00	0.044797	2,931,515.68	412,500,000.00	0.046233	19,071,112.50

注释47．租赁

(一)作为承租人的披露

本公司使用权资产、租赁负债和与租赁相关的总现金流出情况详见注释 12、注释 24 和注释 44。本公司作为承租人，计入损益情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度
租赁负债的利息	19,539,504.90	23,443,132.30
转租使用权资产取得的收入	561,369.03	571,066.86

(二)作为出租人的披露

1．与经营租赁有关的信息

与经营租赁相关的收益如下：

2025 年度		
项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
洁净厂房租赁	561,369.03	

续：

2024 年度		
项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
洁净厂房租赁	571,066.86	

2．与融资租赁有关的信息

（1）租赁活动

本公司作为出租人与承租人签订了设备租赁合同，租赁期 120 个月，租赁期自 2025 年 2 月至 2035 年 2 月，该合同不包含续约或终止租赁选择权。

融资租赁收款额的收款情况和未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节如下：

项目	每年未折现租赁收款额	
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产负债表日后第 1 年	14,352,902.07	
资产负债表日后第 2 年	7,631,743.74	
资产负债表日后第 3 年	7,631,743.74	
资产负债表日后第 4 年	7,631,743.74	
资产负债表日后第 5 年	7,631,743.74	
以后年度	31,437,562.17	
未折现租赁收款额合计	76,317,439.20	
加：未担保余值		
租赁投资总额	76,317,439.20	
减：未实现融资收益	6,859,937.78	
租赁投资净额	69,457,501.42	

与融资租赁相关的收益如下：

2025 年度			
项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
设备租赁		1,384,633.42	

七、研发支出

(一)按费用性质列示

详见附注六、注释 35。

八、政府补助

(一)报告期末按应收金额确认的政府补助

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司应收政府补助款项 0.00 元。

(二)涉及政府补助的负债项目

详见附注六、注释 26。

(三)计入当期损益的政府补助

会计科目	2025 年度	2024 年度	与资产相关/与收益相关
其他收益	829,900.00	1,263,226.00	与收益相关

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、长期借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

(一)金融工具产生的各类风险

1．信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用逾期账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款涉及大量客户，逾期账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，计算预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，对于预期信用损失进行合理评估。

本报告期末公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	减值准备
应收票据		
应收账款	740,445,001.66	84,561,134.63
其他应收款	388,032.11	
长期应收款（含一年内到期的款项）	69,457,501.42	
合计	810,290,535.19	84,561,134.63

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司未对外提供财务担保。

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。信用风险按照客户进行管理。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 76.43%（2024 年 12 月 31 日：81.85%）源于余额前五名客户。

2．流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司下属财务部门基于企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 477,000.00 万元，其中：已使用授信金额为 194,888.94 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	2025 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债					
应付账款	715,836,033.54				715,836,033.54
其他应付款	78,886,893.21				78,886,893.21
一年内到期的非流动负债	631,432,397.55				631,432,397.55
长期借款		403,027,085.72	1,967,089,884.97	212,355,333.33	2,582,472,304.02
租赁负债		101,432,970.47	223,289,028.79		324,721,999.26
非衍生金融负债小计	1,426,155,324.30	504,460,056.19	2,190,378,913.76	212,355,333.33	4,333,349,627.58
合计	1,426,155,324.30	504,460,056.19	2,190,378,913.76	212,355,333.33	4,333,349,627.58

3．市场风险

（1）汇率风险

本公司的主要经营业务位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

1）截至 2025 年 12 月 31 日止，公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2025 年 12 月 31 日			
	美元项目	欧元项目	日元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	2,274,666,838.33	12,338.26	23,272.62	2,274,702,449.21
应收账款	358,530,856.15			358,530,856.15
小计	2,633,197,694.48	12,338.26	23,272.62	2,633,233,305.36
外币金融负债：				
应付账款	99,301,800.66	3,129,716.23	27,690,250.67	130,121,767.56
其他应付款	31,291,055.25	189,416.50	2,931,515.68	34,411,987.43
小计	130,592,855.91	3,319,132.73	30,621,766.35	164,533,754.99

2）敏感性分析：

截至 2025 年 12 月 31 日止，对于本公司各类美元、欧元及日元金融资产和美元、欧元及日元金融负债，如果人民币对美元、欧元及日元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 246,869,955.04 元（2024 年度约 413,660,212.44元）。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。

1）截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,049,900,000.00 元。

3）敏感性分析：

截至 2025 年 12 月 31 日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 5,249,500.00 元（2024 年度约 3,850,000.00 元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司无以公允价值计量的金融工具。

（二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十一、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
上海华虹（集团）有限公司	上海市	对企业进行股权投资	1,604,355.9005	63.5443	63.5443

本公司最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

(二)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海华力集成电路制造有限公司	同受华虹集团控制
公司 B	同受华虹集团控制
上海华虹宏力半导体制造有限公司	参股股东，同受华虹集团控制
上海华虹虹日电子有限公司	同受华虹集团控制
上海华虹挚芯电子科技有限公司	同受华虹集团控制
挚芯电子（上海）有限公司	同受华虹集团控制
华海清科股份有限公司	华虹集团原董事于报告期内担任董事兼总经理的公司（2024 年 12 月 2 日辞任）
上海复旦微电子集团股份有限公司	华虹集团董事于报告期内担任董事兼总经理的公司（2025 年 6 月 18 日委任-2025 年 9 月 13 日辞任）

(三)关联方交易

1．购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
上海华力集成电路制造有限公司	采购货物	289,556,083.80	278,582,785.84
公司 B	采购货物	5,486,901.00	128,310.00
上海华虹虹日电子有限公司	采购货物	14,318,999.29	38,475,798.67
上海华虹挚芯电子科技有限公司	采购货物	1,008,159.93	1,621,553.57
挚芯电子（上海）有限公司	采购货物	541,987.00	13,562.00
华海清科股份有限公司	采购货物	10,620.46	120,786.15
小计		310,922,751.48	318,942,796.23
上海华力集成电路制造有限公司	接受服务	66,214,382.51	31,562,775.64
公司 B	接受服务	33,311.01	71,904.03
小计		66,247,693.52	31,634,679.67
合计		377,170,445.00	350,577,475.90

2．销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
上海华力集成电路制造有限公司	销售货物	206,495,606.97	271,167,801.10
公司 B	销售货物	2,098,652.82	
挚芯电子（上海）有限公司	销售货物		628,432.00
上海复旦微电子集团股份有限公司	销售货物	70,211,820.00	54,346,165.00
小计		278,806,079.79	326,142,398.10
上海华力集成电路制造有限公司	提供服务	16,698,951.01	22,721,820.09
公司 B	提供服务	5,267,828.48	5,678,354.79
挚芯电子（上海）有限公司	提供服务		71,798.00
上海复旦微电子集团股份有限公司	提供服务	5,719,318.40	8,008,543.00

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
小计		27,686,097.89	36,480,515.88
公司 B	技术开发		471,000,000.00
小计			471,000,000.00
合计		306,492,177.68	833,622,913.98

3．关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度确认的租赁收入	2024 年度确认的租赁收入
上海华力集成电路制造有限公司	房屋及建筑物	561,369.03	571,066.86
公司 B	设备	1,384,633.42	
合计		1,946,002.45	571,066.86

（2）本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力半导体制造有限公司	房屋及建筑物	99,595,621.28	19,470,211.16	786,033.11

续：

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力半导体制造有限公司	房屋及建筑物	97,846,263.60	23,249,978.04	1,136,643.66

4．关联方委托贷款

委托人	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
上海华虹(集团)有限公司		137,550,000.00		137,550,000.00

5．关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
公司 B	融资租出设备	59,292,984.00	

6．关键管理人员薪酬

项目	2025 年度	2024 年度
关键管理人员薪酬	16,212,816.78	36,527,033.43

7．其他关联交易

交易类型	关联方名称	2025 年度	2024 年度
由关联方代收代付水电物业费	上海华虹宏力半导体制造有限公司	203,724,693.70	203,582,910.27

8．关联方应收应付款项

（1）应收账款

关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
上海华力集成电路制造有限公司	75,067,747.91	7,018,929.69	33,886,020.36	3,994,350.68
公司 B	374,771.65	114,695.31	1,191,472.39	5,309.86
上海复旦微电子集团股份有限公司	440,146.30	5,017.67	2,997,737.45	13,359.58
合计	75,882,665.86	7,138,642.67	38,075,230.20	4,013,020.12

（2）其他应收款

关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
上海华力集成电路制造有限公司	12,240.05		4,174.00	

（3）长期应收款（含一年内到期的非流动资产）

关联方名称	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
公司 B	69,457,501.42			

（4）其他非流动资产

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力半导体制造有限公司	3,498,229.31	3,876,226.67
上海华力集成电路制造有限公司		51,585,101.89
合计	3,498,229.31	55,461,328.56

（5）应付账款

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华力集成电路制造有限公司	86,965,487.00	85,795,520.74
公司 B		128,310.00
上海华虹宏力半导体制造有限公司	46,759,356.11	62,806,966.77
上海华虹虹日电子有限公司	319,712.80	15,474,109.26
上海华虹挚芯电子科技有限公司	212,470.00	476,905.12
挚芯电子（上海）有限公司	334,915.00	13,562.00
华海清科股份有限公司	105.00	2,049.04
合计	134,592,045.91	164,697,422.93

（6）其他应付款

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华力集成电路制造有限公司	2,151,177.48	7,022,838.92
公司 B	1,137.48	33,234.90
上海华虹宏力半导体制造有限公司	5,738,944.95	4,173,815.32
合计	7,891,259.91	11,229,889.14

（7）租赁负债（含一年内到期的非流动负债）

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力半导体制造有限公司	391,445,003.95	470,784,380.79

十二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

除本附注六、注释 45 所述事项外，截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

1．开出保函、信用证

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司银行保函业务担保余额为人民币 10,000,000.00 元，最后一笔将于 2026 年 2 月 10 日到期。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额美元 1,220,250.00（等值人民币 8,576,893.20 元）折算人民币总金额为 8,576,893.20 元，最后一笔将于 2026 年 5 月 7 日到期。

除存在上述或有事项外，截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项说明

（一）前期会计差错

1．追溯重述法

本期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2．未来适用法

本期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

十五、补充资料

(一)非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

项目	2025 年度	2024 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	25,336,259.61	321,528.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	31,543,825.45	22,445,071.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,004,472.13	-801,830.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目		471,000,000.00
减：所得税影响额		
合计	57,884,557.19	492,964,770.12

2. 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的项目如下：

项目	涉及金额	原因
技术授权	471,000,000.00	未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入

企业法定代表人：秦健　　主管会计工作负责人：王智　　会计机构负责人：曹佳

上海华力微电子有限公司

（公章）

二〇二六年三月三十日

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

（副 本）(7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　杨晨辉

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　1360万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2026 年 01 月 08 日

仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0022858

会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：1101014[illegible]

批准执业文号：京财会许可[illegible]2011[illegible]0143号

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关北京市财政局

2025 年 11 月 3 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名
Full name　王胤

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of birth　1985-06-17

工作单位
Working unit　大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码
Identity card No.　320322198506177316

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
1100000063553

证书编号：No. of Certificate　110101489948

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　上海市注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance　2014 年/y 03 月/m 25 日/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王胤(110101489948)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年/y　月/m　日/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王胤(110101489948)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年/y　月/m　日/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王胤年检二维码

年/y　月/m　日/d

证书编号：
No. of Certificate

110101481223

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2023 年 /y 02 月 /m 15 日 /d

中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 李春姣

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1990-02-04

工作单位 Working unit 大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No. 310104199002043645

上海市通力律师事务所

关于

华虹半导体有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书

二〇二六年三月

目 录

一. 本次交易各方的主体资格 6
二. 本次交易涉及之方案、相关协议及安排 23
三. 本次交易涉及之授权与批准 34
四. 本次交易涉及之标的资产 39
五. 本次交易涉及的债权债务和员工安置的处理 58
六. 本次交易的信息披露 59
七. 本次交易的相关实质性条件 61
八. 同业竞争与关联交易 69
九. 本次交易涉及的证券服务机构及其资格 72
十. 关于上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况以及股票买卖自查情况 73
十一. 结论意见 76
附件一：标的公司拥有的主要知识产权 77
附件二：标的公司报告期内关联交易情况 281

LINKS Law Offices
通力律师事务所

上 海
上海市银城中路68号
时代金融中心19楼
邮编: 200120
电话: +86 21 3135 8666
传真: +86 21 3135 8600
master@llinkslaw.com

SHANGHAI
19F, ONE LUJIAZUI
68 Yin Cheng Road Middle
Shanghai 200120 P.R.China
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600
www.llinkslaw.com

上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

致：华虹半导体有限公司

敬启者：

上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》和中国境内有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现时有效的法律、法规以及规范性文件等有关规定（以下简称“法律、法规以及规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。

（引　言）

根据华虹半导体有限公司（以下简称“华虹半导体”或“上市公司”）的委托，本所指派陈军律师、夏青律师（以下合称“本所律师”）作为华虹半导体本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，就本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据本所律师对我国现行法律、法规以及规范性文件的理解出具法律意见。

本所出具的法律意见书仅对出具日以前已经发生或存在的且与本次交易有关的重要法律问题发表法律意见，并不对其他问题以及会计、审计、资产评估等专业事项发表

意见，也不具备适当资格对其他国家或地区法律管辖范围内的事项发表意见。本所律师并不具备对本法律意见书中所引用的有关会计、审计、资产评估等专业文件之内容进行核查和判断的专业资格，本法律意见书对该等专业文件及其内容的引用并不意味着本所律师对该等专业文件以及所引用内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证；本法律意见书提及其他国家或地区法律意见书、法律审阅报告或其内容，均系指援引、参考该等发行人可依赖的境外法律意见书、法律审阅报告或其内容。

本所已得到本次交易相关各方的确认，其提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符，提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于与出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、前述各方或其他单位出具的证明文件或相关专业报告发表法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供华虹半导体为本次交易之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为华虹半导体申请进行本次交易必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。本所律师同意华虹半导体在本次交易重组报告书及其摘要中自行引用或按监管机构审核要求引用本法律意见书的部分或全部内容，但华虹半导体作上述引用时不得因引用而导致法律上的歧义和曲解。

（正　文）

为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的涵义：

1.	华虹半导体、上市公司	指华虹半导体有限公司。
2.	华虹 NEC	指上海华虹 NEC 电子有限公司。
3.	华虹集团	指上海华虹（集团）有限公司。
4.	华虹国际	指 Shanghai Hua Hong International，Inc.（上海华虹国际公司），系一家根据开曼群岛法律注册成立且合法存续的公司。
5.	张江集团	指上海张江（集团）有限公司。
6.	NEC	指日本电气株式会社。
7.	香港海华	指香港海华有限公司。
8.	Newport	指 Newport Fab LLC。
9.	中国日电	指日电（中国）有限公司。
10.	上海贝岭	指上海贝岭股份有限公司。
11.	上海华虹宏力	指上海华虹宏力半导体制造有限公司。
12.	上海集成电路基金	指上海集成电路产业投资基金股份有限公司。
13.	大基金二期	指国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

14. 国投先导基金	指上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
15. 资产出售方、交易对方	指华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。
16. 标的公司、华力微	指上海华力微电子有限公司。
17. 标的资产	指资产出售方所持华力微 97.4988%的股权。
18. 华力集	指上海华力集成电路制造有限公司。
19. 本次交易	指华虹半导体向资产出售方发行股份购买华力微 97.4988%股权并募集配套资金暨关联交易。
20. 本次发行股份购买资产	指华虹半导体向资产出售方发行股份购买华力微 97.4988%股权。
21. 本次募集配套资金	指华虹半导体向合计不超过 35 名的特定投资者发行股份募集配套资金的行为。
22. 《购买资产协议》	指华虹半导体与交易对方于 2025 年 8 月 29 日签署之《发行股份及支付现金购买资产协议》。
23. 《购买资产协议之补充协议》	指华虹半导体与交易对方于 2025 年 12 月 31 日签署之《发行股份购买资产协议之补充协议》。
24. 《减值补偿协议》	指华虹半导体与华虹集团于 2025 年 12 月 31 日签署之《减值补偿协议》。

25. 国泰海通	指国泰海通证券股份有限责任公司。
26. 大华会计师	指大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
27. 东洲评估	指上海东洲资产评估有限公司。
28. 《重组报告书》	指《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
29. 《审计报告》	指大华会计师于 2026 年 3 月 30 日出具的大华审字[2026]0011007164 号《审计报告》。
30. 《资产评估报告》	指东洲评估以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日对华力微股东全部权益进行评估并出具的东洲评报字【2025】第 2446 号《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
31. 报告期	指 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
32. 中国证监会	指中国证券监督管理委员会。
33. 上交所	指上海证券交易所。
34. 上海市国资委	指上海市国有资产监督管理委员会。
35. 《证券法》	指《中华人民共和国证券法》。
36. 《重组办法》	指《上市公司重大资产重组管理办法》。

37. 《发行办法》	指《上市公司证券发行注册管理办法》。
38. 法律、法规以及规范性文件	指已公开颁布、生效并现行有效的中华人民共和国境内法律、行政法规、行政规章、有权监管机构的有关规定等法律、法规以及规范性文件。为本法律意见书之目的，本法律意见书所述的“法律、法规以及规范性文件”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律、法规以及规范性文件。
39. 香港联交所	指香港联合交易所有限公司。
40. 《公司条例》	指不时修订的中国香港特别行政区《公司条例》。
41. 《香港法律审阅报告》	指上市公司香港法律顾问 Herbert Smith Freehills Kramer 为上市公司本次交易事宜于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 2 月 10 日及 2026 年 3 月 26 日出具的 Hong Kong Legal Review Report。
42. 元	如无特别指明，指人民币元。

一. 本次交易各方的主体资格

(一) 资产购买方华虹半导体

1. 基本情况

经本所律师核查，根据华虹半导体提供的文件资料及《香港法律审阅报告》，华虹半导体系于 2005 年 1 月 21 日依据《公司条例》设立的

公司，于 2014 年 10 月 15 日于香港联交所上市，并于 2023 年 8 月 7 日于上交所科创板上市。

经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》，截至《香港法律审阅报告》出具之日，华虹半导体系依据香港法律适当设立且有效存续。

2. 股本沿革

经本所律师核查，根据华虹半导体提供的文件资料，华虹半导体历次主要股本变动情况如下：

(1) 华虹半导体的设立及收购华虹 NEC

经本所律师核查，经国务院于2004年12月批示同意，为华虹NEC重组上市目的，华虹NEC中方股东华虹集团、张江集团、上海贝岭拟将其持有的华虹NEC股权划转到境外，并与华虹NEC外方股东合资设立拟上市公司，自行选择有利时机，到境外发行股票并在香港上市。

2005年1月21日，华虹半导体在中国香港依据《公司条例》注册，设立时公司名称为“华虹半导体有限公司（Hua Hong Semiconductor Limited）”，设立时已发行股份数为1股，每股面值为0.01美元，该等已发行股份由Harefield Limited持有。

2005年3月3日，华虹NEC相关股东、华虹半导体签订股权转让相关协议，约定华虹NEC当时全体注册于境内的股东分别将其持有的华虹NEC股权划转、转让予相关境外主体，并由华虹半导体向前述划转或转让完成后的华虹NEC全体股东发行股份购买其合计持有的华虹NEC100%股权，前述事宜的具体情况如下表所示：

单位：万美元

华虹 NEC 原股东情况			第一步：华虹 NEC 境内股东将股权划转、转让予境外主体			第二步：华虹半导体发行股份购买华虹 NEC 全部股权		
股东名称	出资额	持股比例（%）	划入方/受让方	出资额	持股比例（%）	出售方	出售比例（%）	对价股份（股）
华虹集团	50,000	55.92	华虹国际	50,000	55.92	华虹国际（注 1）	61.42	350,401,100（注 2）
华虹国际	4,480	5.01	—	—	—			
张江集团（注 1）	437	0.49	华虹国际（注 1）	437	0.49			
中国日电	7,000	7.83	NEC	7,000	7.83	NEC	17.36	99,038,800
NEC	8,520	9.53	—	—	—			
上海贝岭	10,030	11.22	香港海华	10,030	11.22	香港海华	11.22	64,010,100
Newport	8,941	10	—	—	—	Newport	10	57,050,000
合计	**89,408**	**100**	—	**89,408**	**100**	—	**100**	**570,500,000**

注 1：经本所律师核查，根据华虹集团、华虹国际与张江集团等于 2005 年 3 月 3 日签订的境外信托契据及华虹集团、华虹国际与张江集团于 2005 年 3 月 3 日签订的股权托管及划转协议，张江集团将华虹 NEC 0.49%股权（即“华虹 NEC 权益”）委托华虹集团代管并划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹 NEC 权益置换为华虹半导体 0.49%股权（对应华虹半导体 2,795,450 股，即“华虹半导体权益”）；股权置换后，由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理华虹半导体权益，并代表张江集团行使华虹半导体权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江集团根据协议约定保留华虹半导体权益项下的处分权、收益权等股东权利，并承担相应义务。

注 2：其中华虹国际所持有的华虹半导体 1 股股份系自 Harefield Limited 处以 0.01 美元的价格受让取得。

经本所律师核查，国务院国有资产监督管理委员会于2005年2月4日出具国资产权[2005]150号《关于对上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹NEC中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。

经本所律师核查，中华人民共和国商务部分别于2005年3月31日、2005年4月30日、2005年7月28日核发商合批[2005]178号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540号《商务部关于同意上海华虹NEC电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，中华人民共和国国家发展和改革委员会于2005年5月8日核发发改外资[2005]730号《国家发展改革委关于上海华虹NEC电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，华虹国际、NEC、香港海华及Newport已于2005年6月1日被登记为华虹半导体股东，华虹NEC之股权已于2005年10月9日变更登记至华虹半导体名下。

上述华虹NEC收购完成后，华虹半导体的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100	61.42

		（其中 2,795,450 股系为张江集团托管）	
2.	NEC	99,038,800	17.36
3.	香港海华	64,010,100	11.22
4.	Newport	57,050,000	10
合计		**570,500,000**	**100**

(2) 2014 年 10 月华虹半导体在香港联交所首次公开发行股票并上市

经本所律师核查，华虹半导体股东大会于2014年9月20日作出决议，同意华虹半导体公开发行股票，同时批准董事行使华虹半导体配发、发行及处置股份的一切权力（包括作出要约、订立协议、或授出将会或可能须配发及发行股份的证券的权力）。

经本所律师核查，根据华虹半导体公开披露的相关信息，华虹半导体于2014年10月以11.25港币/股的价格公开发行合计228,696,000股股份；本次发行完成后，华虹半导体已发行股份总数增至1,033,871,656股。2014年10月15日，华虹半导体在香港联交所主板挂牌上市。

(3) 2015 年 9 月第一期股票期权激励计划及授予

经本所律师核查，华虹半导体股东特别大会于2015年9月1日作出决议，同意采纳股票期权计划，并授权董事会自计划批准日7年内任何时间决定授予参与者按行权价认购一定数量华虹半导体股票的权利；该股票期权计划项下拟授出的所有期权及华虹半导体任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数，合计不得超过当时的已发行股本总数的10%，

且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过华虹半导体总股本的3%。

经本所律师核查，上海市国资委已于2015年8月14日出具沪国资委分配〔2015〕278号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》，原则同意上述期权激励计划。

经本所律师核查，根据华虹半导体股东大会的上述授权，华虹半导体董事会于2015年9月4日作出决议，同意于2015年9月4日向董事及雇员授出股票期权。华虹半导体本次授出30,250,000份期权，前述期权可按行权价6.912港元认购合计最多30,250,000股股票，本次期权分三期归属，并将于2022年9月3日失效。

(4) 2018 年 11 月增资

经本所律师核查，华虹半导体于2018年1月3日与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订《认购协议》，约定国家集成电路产业投资基金股份有限公司（无论是通过其自身或是通过其指定人士）认购华虹半导体242,398,925股股份，认购价为每股12.9002港元；华虹半导体股东特别大会于2018年2月14日作出决议，同意前述股份认购事宜。国家集成电路产业投资基金股份有限公司指定的主体鑫芯（香港）投资有限公司已于2018年11月7日完成前述股份认购。

经本所律师核查，华虹集团于2017年12月15日召开一届五十三次党委会，同意鑫芯（香港）投资有限公司入股华虹半导体；大基金已于2017年12月15日召开第二十次董事会审议通过鑫芯（香港）投资有限公司入股华虹半导体事宜，并就前述事宜于2017年12月

15日出具了《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》。本次增资完成后，华虹半导体已发行股份总数增至1,283,750,891股。

(5) 2018年12月第二期股票期权计划第一次授予

经本所律师核查，华虹半导体董事会于2018年12月18日作出决议，同意于2018年12月24日及2019年12月23日向若干雇员和/或董事配发股票期权，但该等期权计划的实施须根据国资监管部门的要求以取得华虹半导体股东大会的批准为前提。华虹半导体于2018年12月24日向华虹半导体若干员工及当时的董事授出34,500,000份期权（该等期权须经华虹半导体股东大会批准后方可生效）。前述期权可按行权价15.056港元认购合计最多34,500,000股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员（连同董事）而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属；前述期权已于2025年12月23日失效。

经本所律师核查，上海市国资委于2019年3月12日出具沪国资委分配（2019）44号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划（二期）的批复》，原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划（二期）方案》，并应按有关规定提交华虹半导体股东大会审议。

经本所律师核查，华虹半导体股东特别大会于2019年3月28日作出决议，同意根据华虹半导体于2015年9月1日采纳的股票期权计划于2018年12月24日授出34,500,000份股票期权，并同意于2019年12月23日或前后进一步授出4,000,000份股票期权。

(6) 2019 年 3 月第二期股票期权计划第二次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及华虹半导体股东大会的授权，华虹半导体董事会于2019年3月28日作出决议，同意于2019年3月29日向唐均君授出500,000份期权，前述期权可按行权价18.40港元认购合计最多500,000股股票；本次期权分四期归属，并将于2026年3月28日失效。

(7) 2019 年 12 月第二期股票期权计划第三次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及华虹半导体股东大会的授权，华虹半导体董事会于2019年11月12日作出决议，同意于2019年12月23日向华虹半导体（无锡）有限公司具有重要技术专长及/或担任核心管理职位的101名员工授予2,482,000份期权。前述期权可按行权价17.952港元认购合计最多2,482,000股股票，其中，就副总裁及以上级别的职员而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属。前述期权将于2026年12月22日失效。

(8) 2021 年 11 月华虹半导体股票期权计划调整

经本所律师核查，华虹半导体股东特别大会于2021年11月26日作出决议，为使华虹半导体能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励，同意将华虹半导体股票期权计划授出限额调整为130,047,036股股票。

(9) 2023 年 8 月华虹半导体在上交所首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2023]1228号《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，华虹半导体向社会公开发行人民币普通股40,775万股，每股发行价格52元。经上交所同意，华虹半导体境内发行股票总数为40,775万股，其中10,397.4252万股于2023年8月7日起在上交所科创板上市交易。

3. 控股股东及实际控制人

经本所律师核查，根据华虹半导体提供的股东名册并经华虹半导体确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华虹国际持有华虹半导体 347,605,650 股境外上市外资股股份，占华虹半导体于 2025 年 12 月 31 日已发行股份总数的 20.00%，为华虹半导体的直接控股股东；华虹集团持有华虹国际 100%的股权，并直接持有华虹半导体 1,198,517 股 A 股股份，为华虹半导体的间接控股股东；截至 2025 年 12 月 31 日，上海市国资委直接持有华虹集团 51.74%的股权，系华虹半导体的实际控制人。

基于上述核查，并根据《香港法律审阅报告》，本所律师认为，华虹半导体系依据香港法律适当设立且有效存续的公司，具备参与本次交易的主体资格。

(二) 资产出售方

1. 华虹集团

经本所律师核查，根据华虹集团的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，华虹集团的基本情况如下：

企业名称	上海华虹（集团）有限公司
统一社会信用代码	91310000132263312B
法定代表人	秦健
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号
注册资本	1,352,148.449311 万元
成立日期	1996 年 4 月 9 日
营业期限	1996 年 4 月 9 日至 2046 年 4 月 8 日
企业类型	有限责任公司
经营范围	组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业，咨询服务，资产管理，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师核查，根据华虹集团提供的章程等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，华虹集团的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1.	上海市国资委	699,642.264137	51.74%
2.	上海国际集团有限公司	206,680.669833	15.29%
3.	上海国盛（集团）有限公司	206,680.669833	15.29%
4.	上海仪电（集团）有限公司	131,556.483529	9.73%
5.	上海临港经济发展（集团）有限公司	107,588.361979	7.96%

合计	1,352,148.449311	100.00%（注）

注：合计数与各部分数直接相加之和如存在尾数差异，系由四舍五入原因造成，下同。

2. 上海集成电路基金

经本所律师核查，根据上海集成电路基金的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，上海集成电路基金的基本情况如下：

企业名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL3AW02
法定代表人	李鑫
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 1201 室 A 单元
注册资本	2,480,000 万元
成立日期	2016 年 12 月 7 日
营业期限	2016 年 12 月 7 日至 2029 年 3 月 31 日
企业类型	股份有限公司
经营范围	股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师核查，根据上海集成电路基金提供的章程等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至 2025 年 12 月 31 日，上海集成电路基金的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1.	上海科技创业投资（集团）有限公司	761,403.34	30.70%
2.	中国人寿资产管理有限公司（代表“中国人寿-沪发 1 号股权投资计划”）	750,526.16	30.26%
3.	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	261,052.69	10.53%
4.	上海浦东新兴产业投资有限公司	174,035.25	7.02%
5.	上海国际信托有限公司	156,631.54	6.32%
6.	中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	131,544.95	5.30%
7.	中保投齐芯（嘉兴）集成电路产业投资有限责任公司	104,421.15	4.21%
8.	中国中信金融资产管理股份有限公司	96,876.20	3.91%
9.	上海嘉定创业投资管理有限公司	43,508.72	1.75%
合计		**2,480,000**	**100.00%**

经本所律师核查，上海集成电路基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SEJ523。上海集成电路基金的基金管理人上海集成电路产业投资基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1068675。

3. 大基金二期

经本所律师核查，根据大基金二期的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至2025年12月31日，大基金二期的基本情况如下：

企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
法定代表人	张新
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
注册资本	20,415,000万元
成立日期	2019年10月22日
营业期限	2019年10月22日至2029年10月21日
企业类型	股份有限公司
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经本所律师核查，根据大基金二期提供的章程等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，

截至 2025 年 12 月 31 日，大基金二期的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1.	中华人民共和国财政部	2,250,000	11.02%
2.	国开金融有限责任公司	2,200,000	10.78%
3.	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000	7.35%
4.	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000	7.35%
5.	成都天府国集投资有限公司	1,500,000	7.35%
6.	中国烟草总公司	1,500,000	7.35%
7.	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000	7.35%
8.	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,400,000	6.86%
9.	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000	4.90%
10.	中移资本控股有限责任公司	1,000,000	4.90%
11.	北京国谊医院有限公司	1,000,000	4.90%
12.	江苏聿泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000	4.90%
13.	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000	3.67%
14.	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000	3.67%
15.	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000	1.47%

16.	深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	300,000	1.47%
17.	广州产业投资基金管理有限公司	300,000	1.47%
18.	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000	0.98%
19.	中国电信集团有限公司	150,000	0.73%
20.	联通资本投资控股有限公司	100,000	0.49%
21.	广西投资引导基金有限责任公司	100,000	0.49%
22.	中电金投控股有限公司	50,000	0.24%
23.	华芯投资管理有限责任公司	15,000	0.07%
24.	福建三安集团有限公司	10,000	0.05%
25.	协鑫资本管理有限公司	10,000	0.05%
26.	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000	0.05%
27.	北京建广资产管理有限公司	10,000	0.05%
28.	上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000	0.05%
合计		**20,415,000**	**100.00%**

经本所律师核查，大基金二期系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SJU890。大基金二期的基金管理人华芯投资管理有限责任公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1009674。

4. 国投先导基金

经本所律师核查，根据国投先导基金的《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至2025年12月31日，国投先导基金的基本情况如下：

企业名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MADTAPYB6E
执行事务合伙人	上海国投先导私募基金管理有限公司
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区中科路1699号28层02单元
认缴出资额	4,500,100万元
成立日期	2024年7月22日
营业期限	2024年7月22日至无固定期限
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经本所律师核查，根据国投先导基金提供的合伙协议等文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，截至2025年12月31日，国投先导基金的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例

1.	上海国投先导私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.0022%
2.	上海国经投资发展有限公司	有限合伙人	2,000,000	44.44%
3.	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	有限合伙人	1,000,000	22.22%
4.	上海国有资本投资有限公司	有限合伙人	600,000	13.33%
5.	上海汽车工业（集团）有限公司	有限合伙人	250,000	5.56%
6.	上海国际集团有限公司	有限合伙人	250,000	5.56%
7.	上海国盛（集团）有限公司	有限合伙人	200,000	4.44%
8.	海通创新证券投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
9.	国泰君安证裕投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
10.	上海申能诚毅股权投资有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
11.	上海国际信托有限公司	有限合伙人	50,000	1.11%
合计			**4,500,100**	**100.00%**

经本所律师核查，国投先导基金系《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规范的私募投资基金，已进行私募基金备案，基金编号为 SAMQ44。

国投先导基金的基金管理人上海国投先导私募基金管理有限公司已进行私募基金管理人登记，登记编号为 P1074817。

基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上述四名资产出售方均有效存续，具备参与本次交易的主体资格。

二. 本次交易涉及之方案、相关协议及安排

（一） 本次交易方案概述

经本所律师核查，根据华虹半导体 2025 年第六次董事会决议、2025 年第九次董事会决议、2026 年第一次临时股东大会决议、2026 年第三次董事会决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《减值补偿协议》及《重组报告书》，本次交易系华虹半导体通过发行股份的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金合计持有的华力微 97.4988%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。根据东洲评估出具的《资产评估报告》，标的公司股东全部权益评估价值为 848,000 万元，华虹半导体与交易对方在此基础上协商确定标的资产的交易价格为 826,790.215326 万元。本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。本次交易的具体内容如下：

1. 发行股份购买资产

华虹半导体拟通过发行股份的方式购买华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名交易对方持有的华力微 97.4988%股权。本次交易拟购买资产华力微 97.4988%股权的交易价格为

826,790.215326 万元。本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司。

(1) 交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。

(2) 标的资产的交易对价和支付方式

本次交易中，上市公司聘请东洲评估以2025年8月31日为评估基准日对标的资产进行了评估。根据东洲评估出具的《资产评估报告》，华力微全部权益的评估值为848,000万元。基于前述评估值并经交易各方充分协商，标的资产交易对价为826,790.215326万元，各交易对方的交易对价如下表所示：

交易对方	出售华力微股权比例	交易对价（万元）
华虹集团	63.5443%	538,855.119569
上海集成电路基金	15.7215%	133,318.646521
大基金二期	10.2503%	86,922.766501
国投先导基金	7.9827%	67,693.682735
合计	**97.4988%**	**826,790.215326**

本次交易的交易对价由上市公司通过发行股份方式进行支付，不足一股的部分由上市公司以现金补足。如经有权国资监管机构备案的评估结果与上述华力微股东全部权益评估结果不一致的，各方将经内部有权机构批准后基于经备案的评估结果重新确定本

次交易的交易对价，并就此另行签署补充协议。

(3) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产中所发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），该等股票无面值，上市地点为上海证券交易所。

(4) 发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。

(5) 发行股份的定价方式和价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为华虹半导体审议本次交易的首次董事会决议公告之日。根据《重组办法》相关规定，华虹半导体发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日华虹半导体股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日华虹半导体股票交易总额/决议公告日前若干个交易日华虹半导体股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次发行股份的发行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日华虹半导体股票均价的80%，符合《重组办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中

国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

(6) 发行数量

上市公司本次发行股份的数量将根据交易对价和发行价格确定，具体计算方式为：向各发行对象发行股份数量=向各发行对象购买标的资产对应的交易对价/发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。依据该公式计算的发行股份数量精确至股，不足一股的部分由上市公司以现金补足。

根据标的资产的交易总对价及股份对价情况，本次发行股份的数量为190,768,392股，各交易对方在本次交易中将分别获得上市公司本次发行股份的数量如下：

交易对方	股份对价（万元）	获得股份的数量（股）
华虹集团	538,855.119569	124,332,053
上海集成电路基金	133,318.646521	30,761,109
大基金二期	86,922.766501	20,056,014
国投先导基金	67,693.682735	15,619,216
合计	**826,790.215326**	**190,768,392**

本次发行股份购买资产中的最终股份发行数量应以经上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也

随之进行调整。

(7) 锁定期安排

交易对方因本次发行股份购买资产取得的华虹半导体股份的锁定期安排分别如下：

A. 华虹集团本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。本次交易完成后 6 个月内如华虹半导体股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则华虹集团通过本次交易取得的前述华虹半导体股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。

B. 上海集成电路基金本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。如果上海集成电路基金符合《重组办法》第四十七条第三款第（一）项规定，则其本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 6 个月内不得进行转让。

C. 大基金二期、国投先导基金本次交易中以华力微股权认购取得的华虹半导体股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让；如其取得前述华虹半导体股份时，对于用于认购华虹半导体股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的华虹半导体股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。

股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份及因华虹半导体送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。

若上述限售期安排与届时有效的法律、法规、部门规章及规范性文件的规定不相符或与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关规定或监管意见相应调整。

(8) 减值补偿安排

根据《资产评估报告》，本次交易标的公司华力微系采用市场法确定最终评估价值，上市公司将与减值补偿主体华虹集团签署《减值补偿协议》，就本次交易涉及的减值测试资产、减值测试期间及补偿方法、减值补偿的执行等事宜进行约定。

(9) 过渡期损益安排

本次交易以市场法作为主要评估方法，未以基于未来收益预期的估值方法作为主要评估方法，本次交易过渡期（自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当日）止）期间，标的资产的盈利、亏损由上市公司享有或承担。

(10) 滚存未分配利润安排

华虹半导体在本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份购买资产完成后华虹半导体的新老股东共同享有。

2. 募集配套资金

本次交易中，华虹半导体拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 755,628.60 万元。

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金中所发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），该等股票无面值，上市地点为上交所。

(2) 发行方式及发行对象

本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行，发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）的特定投资者。

最终发行对象将由华虹半导体股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会注册同意文件后，与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

(3) 发行股份的定价方式和价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日华虹半导体股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及

董事会授权人士根据股东大会的授权与本次交易的主承销商根据竞价结果协商确定。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(4) 发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过755,628.60万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金项下发行股份数量=募集配套资金总额÷发行价格，且不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。按照前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。最终发行规模及发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照《发行办法》等的相关规定最终确定。

在本次募集配套资金定价基准日至发行日期间，华虹半导体如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

(5) 股份锁定期

本次募集配套资金的认购方所认购的华虹半导体股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于华虹半导体送股、转增股本等原因增持的华虹半导体股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

(6) 募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于华力微技术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用，其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。具体用途如下：

项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	占募集配套资金比例
华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
合计	**755,628.60**	**100.00%**

如果本次募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由上市公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前，华虹半导体若根据实际情况自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

(7) 滚存未分配利润安排

华虹半导体在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后华虹半导体的新老股东共同享有。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易方案符合法律、法规以及规范性文件的规定，方案内容不存在侵害华虹半导体及其股东合法利益的情形。

（二） 本次交易涉及之相关协议

1. 《购买资产协议》及其补充协议

经本所律师核查，华虹半导体与华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方于 2025 年 8 月 29 日签署了附生效条件的《购买资产协议》，对本次发行股份购买资产事项进行了具体约定，主要包括标的资产内容、发行方式及发行股票的种类和面值、发行价格、锁定期、协议生效、资产交割、保证及承诺、违约责任、税费分担、协议的终止及解除、通知、保密、不可抗力、法律适用及争议解决、其它等条款。

经本所律师核查，华虹半导体与华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方于 2025 年 12 月 31 日签署了附生效条件的《购买资产协议之补充协议》，就标的资产的交易对价及对价支付、过渡期损益安排予以约定。

2. 《减值补偿协议》

经本所律师核查，华虹半导体与华虹集团于 2025 年 12 月 31 日签署了附生效条件的《减值补偿协议》，对华虹半导体拟通过发行股份的方

式购买标的资产有关减值测试及减值补偿事项进行了具体约定，主要包括减值测试资产、减值测试期间及补偿方法、减值补偿的执行、法律适用及争议解决、违约责任、协议的生效、变更及终止、其它等条款。

经本所律师对前述协议条款和条件的核查，该等协议不存在违反法律以及行政法规强制性规定的情形，待其各自约定之生效条件获得满足后即成为对协议当事人具有约束力的法律文件。

（三） 本次交易不构成重大资产重组

经本所律师核查，根据本次交易作价情况、《审计报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70013197_B01 号《审计报告》，并依据《重组办法》第十二条的规定，根据华力微 2025 年度经审计的财务数据与华虹半导体 2025 年度经审计的财务数据，标的公司相关财务指标占比计算结果如下：

项目	资产总额与交易金额孰高（万元）	资产净额与交易金额孰高（万元）	营业收入（万元）
标的公司	826,790.22	826,790.22	510,114.63
华虹半导体财务指标	10,012,329.13	4,516,029.04	1,729,145.07
财务指标占比	8.26%	18.31%	29.50%

根据上述测算，标的公司相关财务指标占华虹半导体同期经审计的合并财务报告对应财务指标的比例均未达到 50%以上。据此，本所律师认为，本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组。

（四） 本次交易不构成重组上市

经本所律师核查，并根据华虹半导体的确认，本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委。据此，本所律师认为，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。

三. 本次交易涉及之授权与批准

（一） 本次交易已取得的批准与授权

1. 华虹半导体为本次交易召开之董事会

经本所律师核查，华虹半导体 2025 年第六次董事会于 2025 年 8 月 29 日作出决议，同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈华虹半导体集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议

案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》等与本次交易相关的议案。华虹半导体独立董事已对本次交易相关事宜发表独立意见。

经本所律师核查，华虹半导体 2025 年第九次董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附生效条件的<减值补偿协议>的议案》《关于本次交易构成关联（连）交易的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何

上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》《关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案》《关于提请提请股东大会批准特别交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于提请召开股东大会的议案》等与本次交易相关的议案。华虹半导体独立董事已对本次交易相关事宜发表独立意见。

经本所律师核查，华虹半导体 2026 年第三次董事会于 2026 年 3 月 30 日作出决议，同意《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。华虹半导体独立董事已对本次交易相关事宜发表独立意见。

2. 华虹半导体为本次交易召开之股东大会

经本所律师核查，华虹半导体于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于签署附生效条件的<减值补偿协议>的议案》《关于本次交易构成关联（连）交易的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》《关于提请提请股东大会批准特别交易的议案》《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案》等与本次交易相关的议案。

3. 经本所律师核查，根据交易对方提供的文件资料，本次交易的交易对方已取得其内部有权决策机构现阶段应当履行的关于参与本次交易的批准和授权。

4. 经本所律师核查，上海市国资委已于 2026 年 1 月 12 日出具了《上海市国有资产评估项目备案表》，对本次交易中标的公司华力微的评估值予以备案。

5. 经本所律师核查，上海市国资委已于 2026 年 2 月 7 日出具沪国资委产权[2026]31 号《市国资委关于华虹半导体有限公司资产重组有关事项的批复》，原则同意本次交易方案。

6. 经本所律师核查，并根据《香港法律审阅报告》，本次交易已获得香港证券及期货事务监察委员会就本次交易向华虹集团授出的清洗豁免及就特别交易事宜给予的同意。

（二） 本次交易尚须取得的批准与授权

经本所律师核查，并根据《香港法律审阅报告》，截至本法律意见书出具之日，本次交易尚需取得的批准与授权如下：

1. 就本次交易取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2. 相关法律法规所要求的其他必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。

（三） 基于上述核查，并根据《香港法律审阅报告》，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除尚须取得的上述批准与授权外，本次交易已依其进行阶段取得了法律、法规以及规范性文件所要求的相关批准及授权。

四. 本次交易涉及之标的资产

经本所律师核查，本次交易的标的资产为华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金合计持有的华力微 97.4988%股权，其具体情况如下：

（一） 华力微的基本情况

经本所律师核查，根据上海市市场监督管理局核发之《营业执照》及本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询，华力微的基本情况如下：

企业名称	上海华力微电子有限公司
统一社会信用代码	91310000550057087 6
法定代表人	秦健
住所	中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号
注册资本	203,619.2198 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 1 月 18 日
经营范围	开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经本所律师核查，根据华力微提供之公司章程、本所律师于国家企业信用

信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询并经华力微确认，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	华虹集团	129,388.277164	129,388.277164	63.5443
2.	上海集成电路基金	32,012.074045	32,012.074045	15.7215
3.	大基金二期	20,871.634314	20,871.634314	10.2503
4.	国投先导基金	16,254.404321	16,254.404321	7.9827
5.	上海华虹宏力	5,092.829962	5,092.829962	2.5012
合计		203,619.219806	203,619.219806	100.0000

（二） 华力微的设立及股本沿革

1. 2010 年 1 月设立

华力微系由上海联和投资有限公司、华虹集团、华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司共同出资于 2010 年 1 月 18 日设立，设立时的注册资本为 660,000 万元，其中，上海联和投资有限公司出资 450,000 万元，持有华力微 68.1817%的股权；华虹集团出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；华虹 NEC 出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权；上海宏力半导体制造有限公司出资 70,000 万元，持有华力微 10.6061%的股权。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 13 日出具的中瑞岳华沪验字[2010]第 004 号《验资报告》，截至 2010 年 1 月 13 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的首期注册资本

200,000 万元。

2010 年 1 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

华力微设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2.	华虹集团	70,000	0	10.61
3.	华虹 NEC	70,000	0	10.61
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	0	10.61
合计		**660,000**	**200,000**	**100.00**

2. 2010 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 15 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1010 号《验资报告》，截至 2010 年 4 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第二期注册资本 35,000 万元。

2010 年 4 月 29 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	450,000	200,000	68.18
2.	华虹集团	70,000	0	10.61
3.	华虹 NEC	70,000	0	10.61
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		**660,000**	**235,000**	**100.00**

3. 2010 年 10 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 8 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1035 号《验资报告》，截至 2010 年 9 月 30 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第三期注册资本 100,000 万元。

2010 年 10 月 13 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	450,000	300,000	68.18

2.	华虹集团	70,000	0	10.61
3.	华虹 NEC	70,000	0	10.61
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	10.61
合计		**660,000**	**335,000**	**100.00**

4. 2010 年 12 月第一次增资

2010 年 11 月 20 日，华力微股东会作出决议，同意华力微注册资本由 660,000 万元增至 790,000 万元，新增注册资本 130,000 万元由上海联和投资有限公司以 130,000 万元的价格认缴。

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 26 日出具的沪立信佳诚验字（2010）第 1039 号《验资报告》，截至 2010 年 11 月 25 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第四期注册资本 58,083 万元。

2010 年 12 月 1 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	358,083	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86

3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**393,083**	**100.00**

5. 2011 年 4 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 28 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1011 号《验资报告》，截至 2011 年 4 月 28 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第五期注册资本 127,550 万元。

2011 年 4 月 28 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	485,633	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**520,633**	**100.00**

6. 2011 年 8 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 2 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1020 号《验资报告》，截至 2011 年 8 月 2 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第六期注册资本 71,917 万元。

2011 年 8 月 5 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	557,550	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**592,550**	**100.00**

7. 2011 年 11 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2011）第 1030 号《验资报告》，截至 2011 年 11 月 14 日，华力微已收到上海联和投资有限公司以货币缴纳的第七期注册资本 22,450 万元。

2011 年 11 月 18 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	华虹集团	70,000	0	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	0	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**615,000**	**100.00**

8. 2012 年 1 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 16 日出具的沪立信佳诚验字（2012）第 1002 号《验资报告》，截至 2012 年 1 月 16 日，华力微已收到华虹集团和华虹 NEC 以货币缴纳的第八期注册资本 140,000 万元。

2012 年 1 月 17 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	华虹集团	70,000	70,000	8.86
3.	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	35,000	8.86
合计		**790,000**	**755,000**	**100.00**

9. 2014 年 2 月实收资本变更

根据上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2014 年 2 月 14 日出具的沪立信佳诚验字（2014）第 1001 号《验资报告》，截至 2014 年 2 月 13 日，华力微已收到上海宏力半导体制造有限公司以货币缴纳的第九期注册资本 35,000 万元。

2014 年 2 月 19 日，华力微取得上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000000098113 的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	华虹集团	70,000	70,000	8.86

3.	华虹 NEC	70,000	70,000	8.86
4.	上海宏力半导体制造有限公司	70,000	70,000	8.86
合计		**790,000**	**790,000**	**100.00**

10. 2016 年 4 月股东变更

根据华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司于 2012 年 4 月 23 日签订的《上海华虹 NEC 电子有限公司与上海宏力半导体制造有限公司合并协议》，双方以新设合并方式设立公司，名称为“上海华虹宏力半导体制造有限公司”，合并后，华虹 NEC 与上海宏力半导体制造有限公司解散，其债权、债务全部由上海华虹宏力承继。据此，华虹 NEC 及上海宏力半导体制造有限公司持有的华力微股权均变更为由合并后的上海华虹宏力持有。

2016 年 4 月 7 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次股东变更完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	580,000	580,000	73.42
2.	上海华虹宏力	140,000	140,000	17.72
3.	华虹集团	70,000	70,000	8.86

合计	**790,000**	**790,000**	**100.00**

11. 2016 年 12 月第二次增资

2016 年 11 月 18 日，华力微股东会作出《关于同意上海华力微电子有限公司增资的决议》，同意华力微注册资本由 790,000 万元增至 2,190,000 万元，其中上海联和投资有限公司以 520,000 万元的价格认缴新增注册资本 520,000 万元，上海集成电路基金以 880,000 万元的价格认缴新增注册资本 880,000 万元。

2016 年 12 月 14 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000055005708 76 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	上海联和投资有限公司	1,100,000	1,100,000	50.23
2.	上海集成电路基金	880,000	880,000	40.18
3.	上海华虹宏力	140,000	140,000	6.39
4.	华虹集团	70,000	70,000	3.20
合　计		**2,190,000**	**2,190,000**	**100.00**

12. 2019 年 12 月第一次股权转让及第三次增资

2019 年 12 月 13 日，华力微股东会作出《关于上海华力微电子有限公

司股权变更和增资的决议》，同意上海联和投资有限公司将其所持有的华力微 50.2283%股权（对应注册资本 1,100,000 万元）以 1,148,510 万元的价格转让给华虹集团；同意华力微注册资本由 2,190,000 万元增至 2,207,239.727995 万元，新增 17,239.727995 万元注册资本由华虹集团以 18,000 万元的价格进行认缴。

2019 年 12 月 25 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	华虹集团	1,187,239.727995	1,187,239.727995	53.79
2.	上海集成电路基金	880,000	880,000	39.87
3.	上海华虹宏力	140,000	140,000	6.34
合计		**2,207,239.727995**	**2,207,239.727995**	**100.00**

13. 2023 年 11 月第四次增资

2023 年 11 月 18 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团及大基金二期。

2023 年 11 月 28 日，华力微取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执

照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例（%）
1.	华虹集团	53.85
2.	上海集成电路基金	30.98
3.	大基金二期	10.24
4.	上海华虹宏力	4.93
合计		**100.00**

14. 2025 年 4 月第五次增资

2025 年 3 月 28 日，华力微股东会作出决议，同意华力微增资，增资方为华虹集团、国投先导基金及大基金二期。

2025 年 4 月 30 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次增资完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	股权比例（%）
1.	华虹集团	63.54
2.	上海集成电路基金	15.72
3.	大基金二期	10.25
4.	国投先导基金	7.98
5.	上海华虹宏力	2.50

合计	100.00

15. 2025 年 8 月分立

2025 年 6 月 26 日，华力微股东会作出《关于公司分立的决议》，同意华力微进行分立，分立基准日为 2024 年 11 月 30 日，分立后华力微继续存续，同时将华力微的长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定权利义务依法分出给新设公司；分立后，华力微的注册资本为 203,619.219806 万元，分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致，分立前的债务由分立后的华力微及新设公司承担连带责任。前述分立决议作出后，华力微于报纸发布了关于华力微分立事宜的公告，并向相关债权人发出了《债权人通知书》。

2025 年 8 月 21 日，华力微取得上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91310000550057087 6 的《营业执照》。

本次分立完成后，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1.	华虹集团	129,388.277164	129,388.277164	63.54
2.	上海集成电路基金	32,012.074045	32,012.074045	15.72
3.	大基金二期	20,871.634314	20,871.634314	10.25
4.	国投先导基金	16,254.404321	16,254.404321	7.98

5.	上海华虹宏力	5,092.829962	5,092.829962	2.50
合计		**203,619.219806**	**203,619.219806**	**100.00**

（三） 标的资产权利负担情况

经本所律师核查，根据华力微提供的市场监督管理部门登记档案等文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）的查询以及华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方出具的承诺，资产出售方各自持有的华力微的股权不存在纠纷，未设置有质押等担保权利，也未遭受查封、冻结或其他权利限制。

基于上述核查，本所律师认为，华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等 4 名资产出售方各自合法持有华力微的相应股权，标的资产产权清晰，不存在涉及重大纠纷的情况。

（四） 华力微的主要资产

经本所律师核查，并根据华力微的确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微主要资产的具体情况如下：

1. 主要租赁物业

经本所律师核查，并根据华力微的确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微承租的主要经营性租赁物业情况如下：

序号	出租方	租赁地址	租赁面积	租赁期限	用途
1.	上海华虹宏力	上海市浦东新区张江高科技园区13街坊2丘厂房	91,563.11平方米	2010年3月1日至2030年2月28日	厂房
2.			化学品仓库、动力厂房和生产厂房	自验收合格交付之日起20年	
3.			192平方米	2021年6月1日至2026年12月31日	厂房

基于上述核查，本所律师认为，华力微以租赁方式使用上述房屋不违反法律、行政法规的强制性规定。

2. 主要专利

(1) 主要境内已授权专利

经本所律师核查，根据华力微提供的专利证书等文件资料、本所律师于国家知识产权局网站的公开查询并经华力微确认，截至2025年12月31日，华力微拥有的分立后拟保留在其名下的主要境内已授权专利共计1933项，具体情况详见本法律意见书附件一表1。

基于上述核查，本所律师认为，华力微系自行申请取得上述专利

权，华力微已取得的上述专利权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

(2) 主要境外已授权专利

经本所律师核查，根据华力微提供的专利证书等文件资料、上海浦一知识产权代理有限公司出具的《关于上海华力微电子有限公司境外专利的说明》，截至2025年12月31日，华力微拥有的分立后拟保留在其名下的主要境外已授权专利共计148项，具体情况详见本法律意见书附件一表2。

经本所律师核查，根据上海浦一知识产权代理有限公司出具的《关于上海华力微电子有限公司境外专利的说明》并经华力微确认，华力微依法有效拥有上述专利的权利，并均已按照注册地法律法规的规定依法缴纳了相关费用，该等专利处于合法有效的状态；该等专利权属清晰，不存在争议或纠纷，或潜在争议或纠纷，或抵押、质押等权利瑕疵或限制的情形。

3. 主要集成电路布图设计专有权

经本所律师核查，根据华力微提供的文件资料并经华力微确认，截至2025 年 12 月 31 日，华力微拥有的主要集成电路布图设计专有权共 10 项，具体情况详见本法律意见书附件一表 3。

基于上述核查，本所律师认为，华力微系自行申请取得上述集成电路布图设计专有权，华力微已取得的上述集成电路布图设计专有权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

4. 主要 IP 授权

经本所律师核查，根据华力微提供的文件资料并经华力微确认，华力微通过与第三方 IP 供应商的合作，为客户提供不同种类的标准单元库、存储器编译器和其他 IP 类型。截至 2025 年 12 月 31 日，华力微获得的 IP 授权主要类型包括标准单元库、可编程存储类 IP、嵌入式非易失性存储 IP 及模拟、接口 IP 等。

（五） 华力微的业务开展及业务许可

经本所律师核查，华力微的经营范围为“开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。根据华力微的确认，华力微的主营业务为集成电路晶圆代工业务。

经本所律师核查，并根据华力微的确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微拥有的主要资质及许可如下：

1. 华力微已办理进出口货物收发货人备案，所在地海关为浦东海关，海关备案编码为3122211409，备案日期为2010年3月5日。

2. 华力微持有上海市浦东新区生态环境局于2022年12月9日核发的《排污许可证》，证书编号为91310000550057087600lV，行业类别为集成电路制造、锅炉，有效期限自2022年12月9日至2027年12月8日。

（六） 华力微的税务情况

1. 税种、税率及税收优惠情况

经本所律师核查，根据大华会计师出具的《审计报告》以及华力微的确认，华力微目前适用的主要税种、税率情况如下：

公司名称	主要税种	税率
华力微	企业所得税	0%（注 1）
	增值税	13、9、6、3、0%（注 2）

注 1：根据国务院颁布的《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8 号）和财政部、税务总局、发展改革委及工业和信息化部颁布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告[2020]45 号）的相关规定，华力微为集成电路线宽小于 65 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业，按照税法相关规定可以自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。截至 2025 年 12 月 31 日止，华力微进入税务获利年度第一年。

注 2：根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。据此，华力微适用上述增值税加计抵减政策。

2. 税务合规情况

经本所律师核查，根据上海市公共信用信息服务中心于 2026 年 3 月 17 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，就华力微，在 2021 年 2 月 25 日（含）至 2026 年 2 月 25 日（含）的查

询时间范围内，在税务领域“未查见信息主体的违法记录信息”。

（七） 华力微的合规经营情况

经本所律师核查，根据上海市公共信用信息服务中心于 2026 年 3 月 17 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，就华力微，在 2021 年 2 月 25 日（含）至 2026 年 2 月 25 日（含）的查询时间范围内，在发展改革、商务、生态环境、安全生产、消防、市场监管、税务、人力资源社会保障、公积金管理等领域“未查见信息主体的违法记录信息”。

（八） 华力微的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

经本所律师核查，根据华力微提供的相关文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）、信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）等公开网络信息的查询并经华力微确认，截至 2025 年 12 月 31 日，华力微不存在尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。

五. 本次交易涉及的债权债务和员工安置的处理

经本所律师核查，根据本次交易方案，本次交易实施完毕后，华力微涉及之原有债权债务将仍由华力微自行承担，不涉及债权、债务的转让。本次交易实施完毕后，华虹半导体将成为华力微的控股股东，并以其在华力微认缴的出资额为限对华力微承担责任。

经本所律师核查，本次交易实施完毕后，华力微的独立法人主体地位未发生变化，其应继续依法履行其与员工的劳动合同。

六. 本次交易的信息披露

（一） 经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体就本次交易履行信息披露义务的具体情况如下：

1. 2025年8月18日，华虹半导体发布《华虹半导体有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-019），华虹半导体A股股票自2025年8月18日开市起停牌。

2. 2025年8月25日，华虹半导体发布《华虹半导体有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-020）。

3. 2025年8月29日，华虹半导体2025年第六次董事会作出决议，同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于2025年9月1日发布《华虹半导体有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-025），华虹半导体股票自2025年9月1日开市起复牌。

4. 2025年9月30日、2025年10月31日、2025年11月29日、2025年12月29日，华虹半导体分别发布了关于本次交易事项的进展公告。

5. 2025年12月31日，华虹半导体2025年第九次董事会作出决议，同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》等与本次交易相关的议案；2026年1月22日，华虹半导体发出了关于本次交易的股东大会通知。

6. 2026年2月10日，华虹半导体公告了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告。同日，华虹半导体召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案》《关于〈华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

7. 2026年3月30日，华虹半导体2026年第三次董事会作出决议，同意《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

（二） 基于上述核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体就本次交易已根据相关法律、法规以及规范性文件的规定，履行了必要的信息披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；华虹半导体尚须根据本次交易进展情况，按照《重组办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关信息披露义务。

七. 本次交易的相关实质性条件

（一） 本次交易符合《重组办法》规定的相关条件

1. 经本所律师核查，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组办法》第十一条第（一）项之规定，具体如下：

(1) 经本所律师核查，根据华力微提供的相关文件资料及其确认，华力微主要从事集成电路晶圆代工业务。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，华力微所从事的业务不属于限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策。

(2) 经本所律师核查，本次交易的标的资产为华力微 97.4988%的股权，根据上海市公共信用信息服务中心于 2026 年 3 月 17 日出具的《专用信用报告（替代有无违法记录证明专用版）》，报告期内华力微不存在因违反环境保护、土地管理相关法律法规而受到行政处罚的情形。

(3) 经本所律师核查，本次交易中，参与集中的上市公司、标的公司上一年度营业额已达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》所规定的申报经营者集中的营业额标准；但本次交易前华虹集团直接持有标的公司 63.5443%的股权，本次交易后标的公司将成为上市公司的全资子公司，由于华虹集团仍系上市公司的间接控股股东，华虹集团将通过上市公司间接控制标的公司，因此本次交易未导致标的公司最终控制权发生变更。

本所律师已于2025年9月通过经营者集中反垄断业务系统提交《华虹半导体有限公司收购上海华力微电子有限公司97.4988%股权经营者集中申报事宜商谈申请报告》，并提出本次交易是否触发经营者集中审查的商谈问题。上海市市场监督管理局（国家市场监督管理总局授权的华东地区行政监管单位）负责本次交易商谈申请的审查人员已在商谈过程中答复标的公司控制权未发生变更的情形下，无需履行经营者集中申报程序。

(4) 经本所律师核查，上市公司系注册于中国香港特别行政区的红筹企业，交易对方及标的公司均为内资企业；本次交易后，上市公司将直接持有标的公司 97.4988%的股权。本次交易涉及外商投资事宜、不涉及对外投资，需就外商投资事宜履行外商投资信息报告程序，上市公司将根据有关规定及本次交易时间进度办理相关手续。

2. 经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，华虹半导体的股份总数为 173,761.4193 万股。根据本次交易方案之发行股份上限计算（包括发行股份购买资产和募集配套资金），本次交易完成后，社会公众股股东持有的股份不低于华虹半导体股本总额的 10%，华虹半导体仍然符合上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 经本所律师核查，本次交易购买的标的资产的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构确认的评估结果为基础确定；华虹半导体董事会和独立董事均已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估价值的公允性发表肯定性意见；本次交易的交易各方已按照或将按照相关法律、法规以及规范性文件及

内部管理制度的要求履行相应的内部授权与批准程序。本次发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日（即华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议公告日）前 120 个交易日华虹半导体股票交易均价的 80%。据此，本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害华虹半导体和其股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项之规定。

4. 经本所律师核查，根据交易对方和华力微提供的相关文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）等公开网络信息的查询及资产出售方出具的相关承诺，华虹半导体本次交易购买的标的资产权属清晰，交易对方合法拥有标的资产的所有权，标的资产不存在被质押、查封、冻结等限制转让的情形，标的资产的过户和转移不存在法律障碍。

经本所律师核查，根据本次交易方案及相关协议，本次交易不涉及债权、债务的转移或处置，标的公司的债权债务仍将由其享有和承担。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，本次交易符合《重组办法》第十一条第（四）项之规定。

5. 经本所律师核查，根据《重组报告书》以及华虹半导体的确认，本次交易有利于华虹半导体增强持续经营能力，不存在可能导致华虹半导体在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 经本所律师核查，根据《重组报告书》以及华虹半导体提供的相关文件资料及其确认，本次交易前，华虹半导体已经按照有关法律、法规以及规范性文件的规定建立了法人治理结构和独立运营的公司管理体系，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于实际控制人及其关联人。本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司，华虹半导体的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于其实际控制人及其关联人。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（六）项之规定。

7. 经本所律师核查，华虹半导体已经按照《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。华虹半导体上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，华虹半导体仍将保持其健全有效的法人治理结构。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（七）项之规定。

8. 经本所律师核查，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70013197_B01 号《审计报告》，华虹半导体不存在最近一年财务会计报告被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

9. 经本所律师核查，根据华虹半导体及其董事、高级管理人员出具的承诺、相关政府主管部门出具的证明以及本所律师于信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）、中国证监会网站（http://www.csrc.gov.cn）等公开网络信息的查询，华虹半导体及

其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及华虹半导体的确认，本次交易有利于提高华虹半导体的资产质量、增强华虹半导体的持续经营能力，不会导致华虹半导体财务状况发生重大不利变化，本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经本所律师核查，根据本次交易的相关协议、资产出售方出具的相关承诺，华虹半导体本次交易购买的标的资产权属清晰，不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷或者妨碍权属转移的其他情况，标的资产的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍；交易对方合法持有标的资产，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持标的资产的情形，标的资产未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形；交易对方对标的公司的出资不存在未缴纳出资、虚报或抽逃注册资本的情形。据此，本所律师认为，本次交易购买的标的资产权属清晰，如相关法律程序和先决条件得到适当履行，资产出售方持有之华力微股权在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。

据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十四条之规定。

11. 经本所律师核查，根据《重组报告书》以及本次交易方案，本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，

且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%；本次募集配套资金拟用于华力微技术升级改造项目、华力微特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。据此，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》第四十五条及《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之规定。

12. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议、2025 年第九次董事会会议决议、2026 年第一次临时股东大会决议及 2026 年第三次董事会会议决议，华虹半导体本次发行股份购买资产的发行价格为 43.34 元/股，不低于定价基准日（即华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议公告日）前 120 个交易日华虹半导体股票交易均价的 80%。据此，本所律师认为，本次发行股份购买资产的发行价格符合《重组办法》第四十六条之规定。

13. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、华虹半导体 2025 年第六次董事会会议决议、2025 年第九次董事会会议决议、2026 年第一次临时股东大会决议、2026 年第三次董事会会议决议以及交易对方出具的承诺函，交易对方已就在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期作出承诺（交易对方锁定期承诺的具体情况详见本法律意见书第二（一）1（7）项）。据此，本所律师认为，本次交易中有关股份限售安排符合《重组办法》第四十七条、第四十八条第二款之规定。

（二） 本次交易符合《发行办法》规定的相关条件

1. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、华虹半导体及其董事、高级

管理人员的出具的相关承诺并经华虹半导体确认，截至本法律意见书出具之日，华虹半导体不存在《发行办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形：

(1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

(2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

(3) 现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，华虹半导体本次募集配套资金拟用于华力微技术升级改造项目、华力微特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。

据此，本所律师认为，本次募集配套资金的用途符合《发行办法》第十二条之规定。

3. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，最终发行对象将由华虹半导体股东大会授权董事会在取得中国证监会注册同意文件后，与本次交易的主承销商根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。据此，本所律师认为，本次募集配套资金的发行对象符合《发行办法》第五十五条之规定。

4. 经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日华虹半导体股票交易均价的 80%，最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次交易的主承销商根据竞价结果协商确定。据此，本所律师认为，本次募集配套资金的定价基准日、发行价格符合《发行办法》第五十六条、第五十七条之规定。

5. 经本所律师核查，根据《重组报告书》、本次交易方案，根据本次发行方案，本次发行的发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。据此，本所律师认为，本次募集配套资金的股份限售安排符合《发行办法》第五十九条之规定。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易符合《重组办法》和《发行办法》规定的各项实质条件。

八. 同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

1. 经本所律师核查，根据华虹半导体的年度报告等公开披露文件及其确认，华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。本次交易前，华虹半导体间接控股股东华虹集团控制的华力微与上市公司均从事 65/55nm、40nm 晶圆代工业务，双方的同类业务为相同工艺节点下的重合工艺平台的代工业务。上市公司和华力微的工艺技术存在一定的差异，但双方基于各自的工艺技术提供的代工服务不存在实质性差异，双方存在不构成重大不利影响的同业竞争。

2. 经本所律师核查，根据本次交易方案、华虹集团出具的相关承诺及华虹半导体的确认，本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司，华虹集团及其控股子公司（华虹半导体及其控股子公司除外）所从事之业务与华虹半导体及其控股子公司从事之主营业务不存在构成重大不利影响的同业竞争。

3. 关于避免同业竞争的措施

经本所律师核查，为充分保护华虹半导体及投资者的利益，华虹半导体的直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 截至承诺函签署之日，其及其控制的除华虹半导体及其控股子公

司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”），与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。

(2) 本次交易完成后，其及其控制的其他企业与华虹半导体及其控股子公司不存在构成重大不利影响的同业竞争，其及其控制的其他企业将采取有效措施避免新增与华虹半导体及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争的业务或活动。

(3) 其如违反上述承诺的，愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给华虹半导体及其控股子公司造成的所有直接和间接损失。

(4) 上述承诺在其作为华虹半导体控股股东/间接控股股东期间有效。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易不会导致华虹半导体新增构成重大不利影响的同业竞争；同时，华虹国际及华虹集团已就避免与华虹半导体之间的同业竞争出具了有效承诺，有助于保护华虹半导体及其中小股东的利益。

(二) 关联交易

1. 本次交易构成关联交易

经本所律师核查，根据《重组报告书》及本次交易方案，本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

2. 标的公司报告期内关联交易情况

经本所律师核查，根据大华会计师出具的《审计报告》以及华力微提供的相关文件资料，报告期内，标的公司与其主要关联方之间发生的主要关联交易的具体情况详见本法律意见书附件二。

3. 规范关联交易的措施

经本所律师核查，为减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护华虹半导体及其中小股东的合法权益，华虹半导体的直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

(1) 本次交易完成后，其及其控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；

(2) 其将严格遵守相关法律法规和上市公司章程等文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向其提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。

(3) 其违反上述承诺的，其愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易完成后，华力微将成为华虹半导体的全资子公司，华虹半导体因标的资产注入将新增部分关联交易，该等关联交易是标的公司基于自身业务需求所作出的经营决策，未对其经营独立性产生重大不利影响。此外，华虹半导体的直接及间接控股股东已出具《关于规范关联交易的承诺》，该等承诺不存在违反法律、法规以及规范性文件规定的情形，有利于保障华虹半导体及其中小股东的利益。

九. 本次交易涉及的证券服务机构及其资格

经本所律师核查，本次交易涉及的主要证券服务机构情况如下：

（一） 独立财务顾问

经本所律师核查，本次交易的独立财务顾问为国泰海通，国泰海通持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

（二） 审计机构

经本所律师核查，本次交易针对标的资产的审计机构为大华会计师，大华会计师持有北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》，并办理了从事证券服务业务会计师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

（三） 资产评估机构

经本所律师核查，本次交易针对标的资产的资产评估机构为东洲评估，东洲评估已于上海市财政局办理评估机构备案并公告，并办理了从事证券服务业务资产评估机构备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

（四） 备考审阅机构

经本所律师核查，本次交易的备考审阅机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）持有中华人民共和国财政部核发的《会计师事务所执业证书》，并办理了从事证券服务业务会计师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

（五） 法律顾问

经本所律师核查，本次交易的法律顾问为本所，本所持有上海市司法局核发的《律师事务所执业许可证》，并已完成证券法律业务律师事务所备案，具有为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

基于上述核查，本所律师认为，为本次交易提供服务的证券服务机构均具备为本次交易提供相关证券服务的执业资格。

十. 关于上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况以及股票买卖自查情况

（一） 内幕信息知情人登记制度的制定情况

经本所律师核查，华虹半导体已制定《内幕信息知情人登记管理制度》等公司制度。

（二） 内幕信息知情人登记制度的执行情况

经本所律师核查，根据华虹半导体董事会出具的相关说明，华虹半导体已按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在本次交易期间，采取了如下保密措施：

1. 华虹半导体在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2. 华虹半导体及华虹半导体相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

3. 华虹半导体严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上交所。

4. 华虹半导体多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。在华虹半导体召开审议有关本次交易的董事会之前，华虹半导体严格遵守了保密义务。

5. 华虹半导体与交易对方签署《保密协议》，且华虹半导体与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。华虹半导体与为本次交易聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。

6. 筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成华虹半导体股价异常波动，经华虹半导体向上交所申请，华虹半导体股票自 2025 年 8 月 18 日开市起停牌。

基于上述核查，本所律师认为，华虹半导体在本次交易中按照《内幕信息知情人登记制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公司制度的规定。

（三） 相关人员买卖上市公司股票情况

经本所律师核查，根据《重组办法》等法律法规的规定，华虹半导体应对本次交易申请股票停牌前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（以下简称“核查期间”），华虹半导体及其董事、高级管理人员，华虹半导体控股股东，交易对方及其主要负责人、有关知情人员，标的公司及其董事、高级管理人员、有关知情人员，相关中介机构及其经办人员、其他有关知情人员，以及前述人员的直系亲属等主体（以下简称“相关人员”）买卖华虹半导体股票的情况进行自查。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及相关人员出具的自查报告、承诺函等文件资料，本所已就内幕信息知情人核查期间买卖上市公司股票的情况出具了《上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》。

十一. 结论意见

综上所述，本所律师认为，华虹半导体有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易各方均具备参与本次交易的主体资格；本次交易方案的内容符合法律、法规以及规范性文件的要求；本次交易符合《重组办法》和《发行办法》规定的各项实质条件；本次交易在取得本法律意见书所述必要的批准、授权后，其实施不存在法律障碍。

本法律意见书正本一式六份。

上海市通力律师事务所

事务所负责人

韩　炯　律师

经办律师

陈　军　律师

夏　青　律师

二〇二六 年 三 月三十日

附件一：标的公司拥有的主要知识产权

表 1：标的公司拥有的分立后拟保留在其名下的主要境内已授权专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	期限	取得方式
1.	去除等离子体反应腔体内的刻蚀残留物的方法	发明	ZL202410693041.7	2024-05-30	申请日起二十年	原始取得
2.	基于承载台的套刻精度修正方法	发明	ZL202310580502.5	2023-05-22	申请日起二十年	原始取得
3.	一种接触层 OPC 方法	发明	ZL202310487630.5	2023-04-28	申请日起二十年	原始取得
4.	缺陷源检测方法	发明	ZL202310465632.4	2023-04-26	申请日起二十年	原始取得
5.	CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL202310465646.6	2023-04-26	申请日起二十年	原始取得
6.	透射电子显微镜样品的制备方法	发明	ZL202310341087.8	2023-03-31	申请日起二十年	原始取得
7.	一种晶圆失效原因的诊断方法	发明	ZL202310345544.0	2023-03-31	申请日起二十年	原始取得
8.	一种失效定位方法及电子设备	发明	ZL202310176980.X	2023-02-24	申请日起二十年	原始取得
9.	一种半导体测试结构、失效定位方法及电子设备	发明	ZL202310171806.6	2023-02-24	申请日起二十年	原始取得
10.	版图图形边缘分割方法	发明	ZL202211390612.7	2022-11-08	申请日起二十年	原始取得

11.	OPC 修正方法	发明	ZL202211343909.8	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
12.	目标版图优化方法	发明	ZL202211343908.3	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
13.	基于派工规则的自适应铜化学机械抛光设备智能排程控制方法	发明	ZL202211343857.4	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
14.	静电消除装置及晶圆表面静电的消除方法	发明	ZL202211343831.X	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
15.	调节器件电学参数的方法	发明	ZL202211343837.7	2022-10-31	申请日起二十年	原始取得
16.	CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL202211192978.3	2022-09-28	申请日起二十年	原始取得
17.	晶圆缺陷检测方法	发明	ZL202211129030.3	2022-09-16	申请日起二十年	原始取得
18.	目标基准结构的选择及基于其制备半导体结构的方法	发明	ZL202211128817.8	2022-09-16	申请日起二十年	原始取得
19.	一种涡轮分子泵用定子防尘组件	发明	ZL202211058220.0	2022-08-31	申请日起二十年	原始取得
20.	一种 CMP LK 机台清洗端漏液检测装置及检测方法	发明	ZL202211056056.X	2022-08-31	申请日起二十年	原始取得
21.	一种缺陷检测方法	发明	ZL202211053151.4	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
22.	一种电容测试结构及测试方法	发明	ZL202211042217.X	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得
23.	产品版图的评估系统及评估方法	发明	ZL202211053139.3	2022-08-29	申请日起二十年	原始取得

24.	一种数模混合的高精度建立保持时间测量电路及其实现方法	发明	ZL202210963404.5	2022-08-11	申请日起二十年	原始取得
25.	一种闪存器件及其制备方法	发明	ZL202210906188.0	2022-07-29	申请日起二十年	原始取得
26.	像素结构、图像传感器及终端	发明	ZL202210899224.5	2022-07-28	申请日起二十年	原始取得
27.	高压器件的制造方法	发明	ZL202210761842.3	2022-06-29	申请日起二十年	原始取得
28.	缺陷监控方法及缺陷监控系统	发明	ZL202210744426.2	2022-06-27	申请日起二十年	原始取得
29.	样品载体保存装置	发明	ZL202210743865.1	2022-06-27	申请日起二十年	原始取得
30.	晶圆校准方法	发明	ZL202210629214.X	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
31.	WAT 测试装置的检测方法及系统	发明	ZL202210602433.9	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
32.	SONOS 存储器的光刻返工方法	发明	ZL202210614756.X	2022-05-30	申请日起二十年	原始取得
33.	缺陷样品的制备方法及互连结构缺陷的失效分析方法	发明	ZL202210438345.X	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
34.	版图的局部图形密度分析方法	发明	ZL202210420874.7	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
35.	图像传感器的制作方法	发明	ZL202210419104.0	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
36.	半导体结构及其制造方法	发明	ZL202210418472.3	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
37.	半导体制程量测数据的预测方法	发明	ZL202210419129.0	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得

38.	一种用于带走工艺腔室内残污的工艺方法	发明	ZL202210420937.9	2022-04-20	申请日起二十年	原始取得
39.	取卡装置	发明	ZL202210287643.3	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
40.	冲洗装置及半导体制造设备	发明	ZL202210304776.7	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
41.	抽气阀门、抽气阀门开闭方法及负压腔体组件	发明	ZL202210289042.6	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
42.	图像传感器的制造方法	发明	ZL202210287629.3	2022-03-22	申请日起二十年	原始取得
43.	一种双端口 SRAM 控制电路及其控制方法	发明	ZL202210190775.4	2022-02-28	申请日起二十年	原始取得
44.	一种晶圆生产线智能获取派工 WPH 的控制系统和方法	发明	ZL202210108131.6	2022-01-28	申请日起二十年	原始取得
45.	一种 PVD 机台	发明	ZL202210102716.7	2022-01-27	申请日起二十年	原始取得
46.	缺陷自分类方法及系统	发明	ZL202111681769.0	2021-12-30	申请日起二十年	原始取得
47.	监测晶圆杂质的方法	发明	ZL202111656770.8	2021-12-30	申请日起二十年	原始取得
48.	MOS 晶体管	发明	ZL202111626376.X	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
49.	一种 NOR 闪存的制备方法	发明	ZL202111681229.2	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得

50.	基于 Q-time 容时区间站点断线的智能调控方法及系统	发明	ZL202111626368.5	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
51.	一种干泵尾管和离子注入机	发明	ZL202111626346.9	2021-12-28	申请日起二十年	原始取得
52.	一种增强特殊分布缺陷检测的方法	发明	ZL202111433602.2	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
53.	一种集成电路版图可制造性的分析方法	发明	ZL202111437319.7	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
54.	SRAM 及其版图设计方法	发明	ZL202111437296.X	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
55.	一种晶圆缺陷扫描方法及系统	发明	ZL202111448042.8	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
56.	一种检查光刻工艺微小失焦的方法	发明	ZL202111437342.6	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
57.	承载台边缘位置平坦度的监控方法	发明	ZL202111437339.4	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
58.	一种阈值电压的测量方法及其系统	发明	ZL202111436114.7	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
59.	一种深度加速集成电路版图光刻工艺热点检查的方法	发明	ZL202111436108.1	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得

60.	一种全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL202111436051.5	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
61.	一种横向扩散金属氧化物半导体的子电路模型构建方法	发明	ZL202111433629.1	2021-11-29	申请日起二十年	原始取得
62.	一种高压器件的栅氧层及其制造方法	发明	ZL202111276185.5	2021-10-29	申请日起二十年	原始取得
63.	图像传感器的制造方法	发明	ZL202111276184.0	2021-10-29	申请日起二十年	原始取得
64.	浅沟槽隔离及通孔刻蚀工艺刻蚀窗口的方法	发明	ZL202111266553.8	2021-10-28	申请日起二十年	原始取得
65.	基于整数规划的产品生产计划的制定方法	发明	ZL202111153447.9	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
66.	PMOS 管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111151124.6	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
67.	NMOS 管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111153440.7	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
68.	PMOS 管触发双向硅控整流器	发明	ZL202111151126.5	2021-09-29	申请日起二十年	原始取得
69.	机台联动性的监控方法及监控系统	发明	ZL202111006801.5	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
70.	一种半导体反应设备及其位置校准方法	发明	ZL202111005062.8	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得

71.	FINFET 多输入标准单元版图结构及半导体器件	发明	ZL202111005046.9	2021-08-30	申请日起二十年	原始取得
72.	缺陷忽视区域的自计算方法及装置	发明	ZL202110865251.6	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
73.	一种垂直栅半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865250.1	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
74.	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865223.4	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
75.	显影方法及显影装置	发明	ZL202110865198.X	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
76.	OPC 热点的修补方法	发明	ZL202110865191.8	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
77.	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110865147.7	2021-07-29	申请日起二十年	原始取得
78.	测试结构及测试方法	发明	ZL202110748238.2	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
79.	自动物料传输系统及自动化物料传输方法	发明	ZL202110748236.3	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
80.	浅沟槽隔离能力测试结构及其测试方法	发明	ZL202110728159.5	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
81.	通孔层的 OPC 热点的修补方法	发明	ZL202110728158.0	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得

82.	计算机存储介质、禁跑货物预警系统及方法	发明	ZL202110728140.0	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
83.	MOSFET 本征电压的模拟计算方法	发明	ZL202110728116.7	2021-06-29	申请日起二十年	原始取得
84.	图像传感器及其制造方法	发明	ZL202110607036.6	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
85.	TEM 样品的制备方法	发明	ZL202110593171.X	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
86.	与非型闪存器件的接触孔制造方法	发明	ZL202110593161.6	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
87.	半导体器件	发明	ZL202110593143.8	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
88.	在制品数量的预测方法及预测系统	发明	ZL202110591292.0	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
89.	掩模板及监控遮光板位置的方法	发明	ZL202110591286.5	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
90.	闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110591283.1	2021-05-28	申请日起二十年	原始取得
91.	一种 SONOS 器件的制作方法	发明	ZL202110469842.1	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
92.	测试结构及测试方法	发明	ZL202110469820.5	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
93.	晶圆背面清洁装置、浸没式光刻机及晶圆背面清洁方法	发明	ZL202110469812.0	2021-04-28	申请日起二十年	原始取得
94.	电阻失配模型及提取方法	发明	ZL202110354884.0	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得

95.	版图结构及芯片的测试方法	发明	ZL202110354882.1	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
96.	一种图像传感器的制作方法	发明	ZL202110343076.4	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
97.	监控特殊形貌颗粒缺陷的方法	发明	ZL202110343035.5	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
98.	MOS 器件闪烁噪声模型及提取方法	发明	ZL202110343014.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
99.	光掩模结构和光刻设备	发明	ZL202110342840.6	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
100.	三维结构的天线效应的判断方法	发明	ZL202110342820.9	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
101.	半导体器件的制备方法	发明	ZL202110342807.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
102.	化学机械研磨工艺模型的预测方法	发明	ZL202110340990.3	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
103.	晶边缺陷自动对焦系统及方法和计算机存储介质	发明	ZL202110340985.2	2021-03-30	申请日起二十年	原始取得
104.	半导体生产制造中 lot 实时追踪及分析方法及系统	发明	ZL202110278683.7	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
105.	针对 SRAM 图形 OPC 一致性检测的方法	发明	ZL202110278678.6	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得

106.	带失效分析标尺的电迁移测试结构	发明	ZL202110278611.2	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
107.	一种固定宽度的单位方块电阻建模方法	发明	ZL202110274611.5	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
108.	一种晶圆切割方法	发明	ZL202110274604.5	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
109.	一种查询中断晶圆批次 LOT 的方法及系统	发明	ZL202110274242.X	2021-03-15	申请日起二十年	原始取得
110.	一种栅约束 NPN 三极管型 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL202110209885.6	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
111.	或非型闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110209863.X	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
112.	NOR FLASH 的形成方法	发明	ZL202110209862.5	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
113.	一种缺陷检测方法	发明	ZL202110209860.6	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
114.	NOR FLASH 的形成方法	发明	ZL202110209856.X	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
115.	一种栅约束 NPN 三极管型 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL202110209122.1	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
116.	一种闪存存储器字线驱动电路	发明	ZL202110209114.7	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得

117.	一种具有数据保持功能的低功耗静态随机存取存储器电路	发明	ZL202110209113.2	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
118.	或非型闪存器件及其制造方法	发明	ZL202110209103.9	2021-02-24	申请日起二十年	原始取得
119.	基于神经网络的存储器地址的测试方法及测试装置	发明	ZL202110167504.2	2021-02-07	申请日起二十年	原始取得
120.	芯片的图形密度的分析方法、装置及电子设备	发明	ZL202110119198.5	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
121.	一种光阻供应系统	发明	ZL202110117648.7	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
122.	一种基于 WCF 的分布式报表系统	发明	ZL202110117638.3	2021-01-28	申请日起二十年	原始取得
123.	一种异常检测方法及装置	发明	ZL202110105541.0	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
124.	半导体结构分析方法	发明	ZL202110105536.X	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
125.	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL202110103680.X	2021-01-26	申请日起二十年	原始取得
126.	推挽结构输出电路	发明	ZL202011563490.8	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
127.	用于 SAR-ADC 中差分输出共模电压可控的 DAC 电路及其控制方法	发明	ZL202011563240.4	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
128.	一种版图 DRC 违例的对比和定位方法	发明	ZL202011563235.3	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得

129.	efuse 单元结构、efuse 单元的双列结构及 efuse 单元结构的应用电路	发明	ZL202011562191.2	2020-12-25	申请日起二十年	原始取得
130.	涂胶显影设备的稳压装置以及涂胶显影设备	发明	ZL202011486095.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
131.	掩模版及其制备方法、光刻机	发明	ZL202011486091.6	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
132.	炉管工艺的派工优化方法	发明	ZL202011486070.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
133.	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011486015.5	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
134.	分裂栅闪存单元	发明	ZL202011483368.X	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
135.	光罩位置匹配装置及其匹配方法、光刻机	发明	ZL202011483312.4	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
136.	晶圆缺陷扫描系统及扫描方法和计算机存储介质	发明	ZL202011483296.9	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
137.	图像传感器的制备方法	发明	ZL202011483214.0	2020-12-16	申请日起二十年	原始取得
138.	一种浅沟槽隔离的制备方法	发明	ZL202011377953.1	2020-11-30	申请日起二十年	原始取得
139.	一种具有线性对数输出的 CIS 传感器	发明	ZL202011363476.3	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得

140.	半导体芯片缺陷定位方法和定位模块	发明	ZL202011362183.3	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
141.	用于表征 PN 结耗尽区特征的 WAT 测试结构和方法	发明	ZL202011355641.0	2020-11-27	申请日起二十年	原始取得
142.	阻变存储器及其制造方法	发明	ZL202011353688.3	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
143.	CMOS 图像传感器的像素结构及像素结构的形成方法	发明	ZL202011353401.7	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
144.	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011353399.3	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
145.	SPICE 寿命模型的建模方法、调参方法及建模系统	发明	ZL202011347826.7	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
146.	DFM 综合评分方法	发明	ZL202011347795.5	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
147.	存储器阈值电压均匀性的电性测试方法	发明	ZL202011347770.5	2020-11-26	申请日起二十年	原始取得
148.	SPICE 模型仿真系统及仿真方法	发明	ZL202011265291.9	2020-11-13	申请日起二十年	原始取得
149.	一种通过 STI 刻蚀工艺改善 HDP 填充缺陷的方法	发明	ZL202011252721.3	2020-11-11	申请日起二十年	原始取得

150.	光刻工艺热点的光学邻近修正的方法	发明	ZL202011199811.0	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
151.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL202011196327.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
152.	测试结构、测试结构版图及其形成方法和测试方法	发明	ZL202011192438.6	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
153.	VT-BS 模型的先进工艺控制方法、系统及半导体设备	发明	ZL202011191797.X	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
154.	栅极氧化层的形成方法	发明	ZL202011191792.7	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
155.	改善顶层金属互联层表面缺陷的工艺方法	发明	ZL202011191791.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
156.	半导体结构的刻蚀方法	发明	ZL202011187636.3	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
157.	光学邻近修正方法	发明	ZL202011187204.2	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
158.	半导体结构及其制备方法	发明	ZL202011187190.4	2020-10-30	申请日起二十年	原始取得
159.	一种用于检测曝光机台透镜眩光程度的光掩膜版及方法	发明	ZL202011125663.8	2020-10-20	申请日起二十年	原始取得
160.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202011095029.4	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得

161.	基于自对准双重图形的产品良率在线评估系统及评估方法	发明	ZL202011094785.5	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
162.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202011094759.2	2020-10-14	申请日起二十年	原始取得
163.	监测光刻机漏光情况的方法	发明	ZL202011026687.8	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
164.	一种栅约束硅控整流器及其实现方法	发明	ZL202011026662.8	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
165.	像素图形的预处理方法	发明	ZL202011026644.X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
166.	晶圆缺陷的监控方法	发明	ZL202011026627.6	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
167.	提高版图边缘格点的预测准确率的方法	发明	ZL202011024116.0	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
168.	一种栅约束硅控整流器及其实现方法	发明	ZL202011024063.2	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
169.	一种栅约束硅控整流器及其实现方法	发明	ZL202011024051.X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
170.	CMOS 图像传感器的制作方法	发明	ZL202011024012.X	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
171.	晶圆缺陷的验证方法	发明	ZL202011024000.7	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得

172.	改善栅极刻蚀形貌稳定性的方法和刻蚀设备	发明	ZL202011023983.2	2020-09-25	申请日起二十年	原始取得
173.	双重图形氧化硅芯轴制备方法	发明	ZL202010894940.5	2020-08-31	申请日起二十年	原始取得
174.	接触孔光刻工艺热点的光学邻近修正方法	发明	ZL202010891829.0	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
175.	快速热退火设备	发明	ZL202010884966.1	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
176.	提升静电吸盘使用寿命的方法	发明	ZL202010884946.4	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
177.	一种高精度温度模型校准方法及系统	发明	ZL202010884907.4	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
178.	增强二维图形 OPC 模型精度的方法	发明	ZL202010884893.6	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
179.	半导体结构的制备方法	发明	ZL202010884286.X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
180.	改善通孔刻蚀残留的方法	发明	ZL202010884276.6	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
181.	退火设备的温度监控方法	发明	ZL202010884274.7	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
182.	金属层光刻工艺热点的修复方法	发明	ZL202010884271.3	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
183.	一种高利用率的电阻并联结构	发明	ZL202010884261.X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得

184.	判断研磨头的胶膜是否扭曲的方法	发明	ZL202010884254.X	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
185.	闪存存储器及其制造方法	发明	ZL202010884241.2	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
186.	优化冗余图形的方法	发明	ZL202010884240.8	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
187.	MOSFET 阈值电压的 SPICE 子电路模型建模方法	发明	ZL202010884236.1	2020-08-28	申请日起二十年	原始取得
188.	非挥发性存储器的读参考电流自动调节电路	发明	ZL202010831332.X	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
189.	CMOS 图像传感器转移管垂直栅极深度检测方法	发明	ZL202010831333.4	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
190.	全局快门 CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL202010832325.1	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
191.	刻蚀工艺的切换方法	发明	ZL202010840249.9	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
192.	掩膜版及其制备方法	发明	ZL202010833559.8	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
193.	提高金属层和通孔层之间的覆盖率的 OPC 处理方法	发明	ZL202010833535.2	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
194.	版图的特征图形的识别方法	发明	ZL202010832188.1	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得

195.	深沟槽隔离结构的制备方法及半导体结构	发明	ZL202010832187.7	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
196.	绿色版图的认证方法及预警点的风险性的判断方法	发明	ZL202010832185.8	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
197.	光刻标记、对准标记及对准方法	发明	ZL202010832174.X	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
198.	图像传感器金属栅格版图的生成方法及金属栅格光罩图形	发明	ZL202010832168.4	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
199.	提高 OPC 修正效率的方法	发明	ZL202010832140.0	2020-08-18	申请日起二十年	原始取得
200.	栅氧化层测试结构及其制造方法、栅氧化层测试基板	发明	ZL202010811326.8	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
201.	一种集成电路数字后端设计的方法和系统	发明	ZL202010803517.X	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
202.	只读存储器阵列结构、电子设备、扩展方法及编码方法	发明	ZL202010802417.5	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
203.	版图图形密度的分析方法	发明	ZL202010802392.9	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
204.	判断扫描电子显微镜机台是否倾斜的方法	发明	ZL202010802383.X	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得

205.	一种优化光学邻近效应修正中曝光辅助图形的方法	发明	ZL202010802375.5	2020-08-11	申请日起二十年	原始取得
206.	电可编程熔丝系统及其编程方法、读取方法	发明	ZL202010762700.X	2020-07-31	申请日起二十年	原始取得
207.	可编程电路及其编程方法、读取方法	发明	ZL202010760424.3	2020-07-31	申请日起二十年	原始取得
208.	一种深沟槽隔离栅格结构的制造方法	发明	ZL202010745346.X	2020-07-29	申请日起二十年	原始取得
209.	晶片传送装置及 PVD 机台	发明	ZL202010717946.5	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
210.	温度控制电路、装置、芯片封装测试系统	发明	ZL202010717932.3	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
211.	半导体结构的形成方法	发明	ZL202010717830.1	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
212.	一种压控振荡器结构及锁相环	发明	ZL202010717303.0	2020-07-23	申请日起二十年	原始取得
213.	一种 SONOS 存储器及其制造方法	发明	ZL202010698851.3	2020-07-20	申请日起二十年	原始取得
214.	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL202010695542.0	2020-07-16	申请日起二十年	原始取得
215.	提升高压集成电路防负电流闩锁能力的保护环及实现方法	发明	ZL202010694335.3	2020-07-17	申请日起二十年	原始取得

216.	提升高压集成电路防负电流闩锁能力的保护环及实现方法	发明	ZL202010693328.1	2020-07-17	申请日起二十年	原始取得
217.	电迁移测试结构	发明	ZL202010611427.0	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
218.	MOSFET 器件的全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL202010611393.5	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
219.	电迁移测试结构	发明	ZL202010611392.0	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
220.	MPW 多产品联测的数据处理方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010609717.1	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
221.	版图分析管控标准的计算方法及版图分析的管控方法	发明	ZL202010609716.7	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
222.	转移管的垂直栅及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL202010609712.9	2020-06-29	申请日起二十年	原始取得
223.	晶圆缺陷检测方法及系统	发明	ZL202010577852.2	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
224.	下字线驱动读辅助电路和版图设计	发明	ZL202010577071.3	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
225.	晶背缺陷图检索及预警方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010577051.6	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得

226.	OPC 修正通孔的选择方法	发明	ZL202010576117.X	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
227.	时钟信号调节电路和方法以及模拟电路	发明	ZL202010576116.5	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
228.	失效数据修复电路和方法、非挥发性存储器、可读存储介质	发明	ZL202010576095.7	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
229.	一种网格图形统一尺寸的方法、存储介质及计算机设备	发明	ZL202010576089.1	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
230.	版图图形精准匹配的检查方法	发明	ZL202010576088.7	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
231.	金属线版图设计规则检查方法	发明	ZL202010576086.8	2020-06-22	申请日起二十年	原始取得
232.	冗余图形的检测方法	发明	ZL202010479608.2	2020-05-29	申请日起二十年	原始取得
233.	源极跟随管及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL202010478077.5	2020-05-29	申请日起二十年	原始取得
234.	晶圆缺陷监控系统及其监控方法	发明	ZL202010414919.0	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
235.	一种通用的芯片测试系统、测试方法及存储介质	发明	ZL202010414915.2	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
236.	RRAM 阻变结构的形成方法	发明	ZL202010413713.6	2020-05-15	申请日起二十年	原始取得
237.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202010350856.7	2020-04-28	申请日起二十年	原始取得

238.	一种硅控整流器及其制造方法	发明	ZL202010350852.9	2020-04-28	申请日起二十年	原始取得
239.	NMOS 器件的制备方法	发明	ZL202010345511.2	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
240.	NMOS 晶体管器件速度的补偿方法	发明	ZL202010344615.1	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
241.	金属线自对准二次成型工艺方法	发明	ZL202010344600.5	2020-04-27	申请日起二十年	原始取得
242.	SONOS 存储器及其制作方法	发明	ZL202010231443.7	2020-03-27	申请日起二十年	原始取得
243.	一种双向硅控整流器及其制备方法	发明	ZL202010231324.1	2020-03-27	申请日起二十年	原始取得
244.	一种堆叠电容、闪存器件及其制造方法	发明	ZL202010224926.4	2020-03-26	申请日起二十年	原始取得
245.	晶圆边缘缺陷检测系统及方法	发明	ZL202010183596.9	2020-03-16	申请日起二十年	原始取得
246.	一种设置研磨时间上限和研磨时间下限的方法及装置	发明	ZL202010183587.X	2020-03-16	申请日起二十年	原始取得
247.	一次性可编程器件的制造方法及一次性可编程器件	发明	ZL202010164411.X	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
248.	一种检测晶圆缺陷的方法及装置	发明	ZL202010159765.5	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
249.	存储器的形成方法	发明	ZL202010159638.5	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
250.	SONOS 器件的制作方法	发明	ZL202010159625.8	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得

251.	半导体的形成方法	发明	ZL202010159624.3	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
252.	改善光刻机对准的方法	发明	ZL202010159622.4	2020-03-10	申请日起二十年	原始取得
253.	过曝图形漏报错的检查方法、计算机设备及存储介质	发明	ZL202010104683.0	2020-02-20	申请日起二十年	原始取得
254.	一种单元标记及其设计方法	发明	ZL202010104156.X	2020-02-20	申请日起二十年	原始取得
255.	一种 efuse 熔丝的版图结构	发明	ZL202010063863.9	2020-01-20	申请日起二十年	原始取得
256.	一种并行冗余修正电路	发明	ZL202010053416.5	2020-01-17	申请日起二十年	原始取得
257.	检测闪存位线之间漏电结构的制造方法及漏电检测方法	发明	ZL201911360934.5	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
258.	缺陷监控方法	发明	ZL201911360930.7	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
259.	减小关键尺寸漂移的方法	发明	ZL201911360926.0	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
260.	写入辅助电路、存储器及写入操作方法	发明	ZL201911359172.7	2019-12-25	申请日起二十年	原始取得
261.	冗余结构及其形成方法	发明	ZL201911334713.0	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
262.	浮栅型闪存的制作方法	发明	ZL201911334533.2	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
263.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201911334529.6	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
264.	对准方法及校准方法	发明	ZL201911334523.9	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得

265.	光罩组件以及光刻方法	发明	ZL201911334500.8	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
266.	标准单元库的测试方法	发明	ZL201911334496.5	2019-12-23	申请日起二十年	原始取得
267.	用于形成空气间隔的存储器制造方法	发明	ZL201911291112.6	2019-12-16	申请日起二十年	原始取得
268.	闪存的制造方法及闪存	发明	ZL201911261707.7	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
269.	半导体测试结构及测试方法	发明	ZL201911261700.5	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
270.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201911260210.3	2019-12-10	申请日起二十年	原始取得
271.	阻变存储器及其制造方法	发明	ZL201911255220.8	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
272.	测试方法	发明	ZL201911255219.5	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
273.	半导体结构、晶体管、可变电容及元器件	发明	ZL201911252048.0	2019-12-09	申请日起二十年	原始取得
274.	芯轴图形的形成方法	发明	ZL201911204018.2	2019-11-29	申请日起二十年	原始取得
275.	闪存器件的形成方法	发明	ZL201911204016.3	2019-11-29	申请日起二十年	原始取得
276.	跳线装置	发明	ZL201911194919.8	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
277.	版图优化方法	发明	ZL201911193288.8	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
278.	检测晶片上下层叠对的方法和设备	发明	ZL201911186817.1	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得

279.	改善铝焊盘结晶缺陷的方法	发明	ZL201911186786.X	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
280.	硅控整流器及其制造方法	发明	ZL201911186720.0	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
281.	硅控整流器及其制造方法	发明	ZL201911186693.7	2019-11-28	申请日起二十年	原始取得
282.	进样密封装置、气相色谱-质谱联用仪及色谱柱更换方法	发明	ZL201911185508.2	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
283.	测试结构、失效分析定位方法及失效分析方法	发明	ZL201911183955.4	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
284.	改善 2D-NAND 侧墙倾斜的方法	发明	ZL201911183942.7	2019-11-27	申请日起二十年	原始取得
285.	电平转换电路	发明	ZL201911173830.3	2019-11-26	申请日起二十年	原始取得
286.	占空比 50%的连续整数分频器及包括其的锁相环电路	发明	ZL201911162944.8	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
287.	掩膜版和标准片及对准图形误差补偿方法	发明	ZL201911162936.3	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
288.	金属硬质掩模一体化刻蚀方法及其控制系统	发明	ZL201911162919.X	2019-11-25	申请日起二十年	原始取得
289.	光刻层掩膜版的制备方法、离子注入方法	发明	ZL201911147979.4	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得

290.	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201911137379.X	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
291.	MOS 器件的制造方法	发明	ZL201911136246.0	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
292.	去胶设备、顶针监控方法和去胶工艺	发明	ZL201911136237.1	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
293.	一种缺陷观测机台及其的图像分析补偿方法	发明	ZL201911133518.1	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
294.	TechLEF 文件验证方法及其验证系统	发明	ZL201911133493.5	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
295.	存储器读取速度调节电路	发明	ZL201911133050.6	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
296.	n 倍驱动两输入与非门标准单元及其版图	发明	ZL201911133036.6	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
297.	一种垂直栅 CMOS 图像传感器及制造方法	发明	ZL201911133006.5	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
298.	一种改善小像素 CMOS 图像传感器性能的结构和工艺方法	发明	ZL201911132999.4	2019-11-19	申请日起二十年	原始取得
299.	字线制作方法	发明	ZL201911095517.2	2019-11-11	申请日起二十年	原始取得

300.	产品关键层的平均相似度计算方法及产品良率预测方法	发明	ZL201911090135.0	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
301.	确定合适的 OPC 修正程序的方法及装置、掩膜版及优化方法	发明	ZL201911089066.1	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
302.	晶背扫描仪、晶背扫描方法和晶圆扫描方法	发明	ZL201911089034.1	2019-11-08	申请日起二十年	原始取得
303.	浅沟槽隔离结构及其形成方法、半导体器件的制作方法	发明	ZL201911046453.7	2019-10-30	申请日起二十年	原始取得
304.	水循环装置及水循环系统	发明	ZL201911025742.9	2019-10-25	申请日起二十年	原始取得
305.	刻蚀方法以及半导体器件的制造方法	发明	ZL201911024501.2	2019-10-25	申请日起二十年	原始取得
306.	一种内嵌硅控整流器的 PMOS 器件及其实现方法	发明	ZL201910969259.X	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
307.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201910969256.6	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
308.	基于 FDSOI 结构的电平转换单元电路及版图设计方法	发明	ZL201910969246.2	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得

309.	一种提取用于透射电子显微镜的待测样品的方法	发明	ZL201910968721.4	2019-10-12	申请日起二十年	原始取得
310.	RRAM 阻变结构下电极的工艺方法	发明	ZL201910914898.6	2019-09-26	申请日起二十年	原始取得
311.	原子层沉积法形成氮化物膜的方法	发明	ZL201910912457.2	2019-09-25	申请日起二十年	原始取得
312.	版图图形密度的分析方法	发明	ZL201910906283.9	2019-09-24	申请日起二十年	原始取得
313.	Flash 器件耐久性能测试方法	发明	ZL201910898039.2	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
314.	改善刻蚀腔体缺陷的方法	发明	ZL201910897996.3	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
315.	一种评估 CIS 产品不同机台白色像素差异的方法	发明	ZL201910897871.0	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
316.	电迁移可靠性测试结构及电迁移可靠性测试方法	发明	ZL201910897833.5	2019-09-23	申请日起二十年	原始取得
317.	一种应用于锁相环的基于频率比较的锁定指示电路及方法	发明	ZL201910891665.9	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
318.	聚合物的去除方法	发明	ZL201910891638.1	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
319.	光源优化方法、光源优化装置、光刻系统及光刻方法	发明	ZL201910891431.4	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得

320.	浸没式光刻工艺中晶圆表面残水缺陷的改善方法	发明	ZL201910891416.X	2019-09-20	申请日起二十年	原始取得
321.	浅沟道隔离结构中的孔洞缺陷的检测方法	发明	ZL201910849214.9	2019-09-09	申请日起二十年	原始取得
322.	套刻精度修正方法	发明	ZL201910818292.2	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
323.	金属互连线填充方法	发明	ZL201910818279.7	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
324.	CMOS 传感器及 CMOS 传感器的形成方法	发明	ZL201910816560.7	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
325.	改善栅极氧化层的方法及半导体器件的制造方法	发明	ZL201910816556.0	2019-08-30	申请日起二十年	原始取得
326.	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809929.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
327.	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809608.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
328.	缺陷扫描机台间高匹配度扫描程式的快速建立方法	发明	ZL201910809109.2	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
329.	版图修正方法	发明	ZL201910809085.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得

330.	一种化学机械研磨机台缺陷检测方法	发明	ZL201910809015.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
331.	一种栅约束硅控整流器 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910809013.6	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
332.	阻变存储器的制备方法	发明	ZL201910808942.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
333.	一种新型栅控 P-i-N 二极管 ESD 器件及其实现方法	发明	ZL201910808934.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
334.	金属填充缺陷的检测结构及其方法	发明	ZL201910808932.1	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
335.	栅约束硅控整流器 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201910808916.2	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
336.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910808827.8	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
337.	一种内嵌硅控整流器的 PMOS 器件及其实现方法	发明	ZL201910808797.0	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
338.	标准晶片及其制造方法	发明	ZL201910808692.5	2019-08-29	申请日起二十年	原始取得
339.	振荡器	发明	ZL201910777059.4	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
340.	晶圆表面电荷消除装置及方法	发明	ZL201910777052.2	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得

341.	一种建立晶圆背面图形数据库的方法	发明	ZL201910777051.8	2019-08-22	申请日起二十年	原始取得
342.	一种栅控 P-i-N 二极管及其制造方法	发明	ZL201910763000.X	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
343.	一种截取锥清洗装置及使用方法	发明	ZL201910762887.0	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
344.	一种晶圆表面超小尺寸缺陷检测方法	发明	ZL201910762878.1	2019-08-19	申请日起二十年	原始取得
345.	一种晶圆缺陷标记装置及晶圆缺陷标记方法	发明	ZL201910698776.8	2019-07-31	申请日起二十年	原始取得
346.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910698753.7	2019-07-31	申请日起二十年	原始取得
347.	套准标记及其形成方法	发明	ZL201910678518.3	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
348.	OPC 修正程序的 MRC 取值方法	发明	ZL201910678510.7	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
349.	电迁移测试结构及方法	发明	ZL201910677450.7	2019-07-25	申请日起二十年	原始取得
350.	一种具备修正功能的 antifuse 电路	发明	ZL201910670124.3	2019-07-24	申请日起二十年	原始取得
351.	闪存的分裂栅极的制造方法	发明	ZL201910659098.4	2019-07-22	申请日起二十年	原始取得

352.	触点单元结构及其构成的矩阵探针卡	发明	ZL201910643613.X	2019-07-17	申请日起二十年	原始取得
353.	离线量产产品工艺参数调整方法及其调整系统	发明	ZL201910571300.8	2019-06-28	申请日起二十年	原始取得
354.	闪存的制造方法、闪存储器及光罩掩膜版	发明	ZL201910541255.1	2019-06-21	申请日起二十年	原始取得
355.	色谱柱辅助安装工具及色谱柱安装方法	发明	ZL201910538137.5	2019-06-20	申请日起二十年	原始取得
356.	芯片拼接方法	发明	ZL201910529990.0	2019-06-19	申请日起二十年	原始取得
357.	锁存器	发明	ZL201910476094.2	2019-06-03	申请日起二十年	原始取得
358.	半导体器件隔离侧墙厚度计算方法及其计算系统	发明	ZL201910476089.1	2019-06-03	申请日起二十年	原始取得
359.	CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL201910452540.6	2019-05-28	申请日起二十年	原始取得
360.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201910450593.4	2019-05-28	申请日起二十年	原始取得
361.	MOS_D 晶体管及其构成的 ESD 保护电路	发明	ZL201910432616.9	2019-05-23	申请日起二十年	原始取得

362.	一种缺陷检测系统、检测方法及电子束扫描机台	发明	ZL201910386157.5	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
363.	OPC 修正方法及 OPC 修正系统	发明	ZL201910385297.0	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
364.	全局快门 CMOS 图像传感器	发明	ZL201910382534.8	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
365.	基于 FinFET 结构的高速标准单元库版图设计方法	发明	ZL201910382478.8	2019-05-09	申请日起二十年	原始取得
366.	一种分离栅闪存单元的半导体结构及其制造方法	发明	ZL201910362571.2	2019-04-30	申请日起二十年	原始取得
367.	CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL201910358958.0	2019-04-29	申请日起二十年	原始取得
368.	一种自对准双层图形的形成方法	发明	ZL201910313973.3	2019-04-18	申请日起二十年	原始取得
369.	一种半导体结构及其制造方法	发明	ZL201910265516.1	2019-04-03	申请日起二十年	原始取得
370.	一种防止 ONO 刻蚀造成衬底损伤的方法	发明	ZL201910244692.7	2019-03-28	申请日起二十年	原始取得
371.	一种辅助对准方法及系统	发明	ZL201910234065.5	2019-03-26	申请日起二十年	原始取得
372.	一种用于改善硅片翘曲度并提高套刻精度的方法	发明	ZL201910177307.1	2019-03-08	申请日起二十年	原始取得
373.	一种侧墙结构的形成方法	发明	ZL201910173445.2	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得

374.	一种晶圆清洗干燥装置、方法及化学机械研磨机台	发明	ZL201910173003.8	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
375.	掩膜版、闪存器件及其制造方法	发明	ZL201910172994.8	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
376.	闪存器件及其制造方法	发明	ZL201910172992.9	2019-03-07	申请日起二十年	原始取得
377.	一种形成随机存储器层的方法	发明	ZL201910157174.1	2019-03-01	申请日起二十年	原始取得
378.	一种探针卡的针尖的智能检测及处理方法	发明	ZL201910157146.X	2019-03-01	申请日起二十年	原始取得
379.	一种分析半导体晶圆的方法及装置	发明	ZL201811636763.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
380.	NOR FLASH 器件结构及其制造方法	发明	ZL201811632627.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
381.	晶圆的晶边缺陷的监控方法	发明	ZL201811632588.7	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
382.	STI 的填充方法	发明	ZL201811632345.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
383.	SOI 二极管	发明	ZL201811632266.2	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
384.	晶圆制造中在线产品批次跑货状态的分析预测方法	发明	ZL201811630469.8	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得

385.	拼接产品的测试光罩及其组合方法	发明	ZL201811630468.3	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
386.	分栅闪存的制造方法	发明	ZL201811630467.9	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
387.	NOR 闪存及其制造方法	发明	ZL201811630391.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
388.	分栅闪存的测试结构及其制造方法	发明	ZL201811630384.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
389.	缺陷监控分析系统及方法	发明	ZL201811630264.X	2018-12-29	申请日起二十年	原始取得
390.	台阶状 ONO 薄膜的刻蚀方法	发明	ZL201811607216.9	2018-12-27	申请日起二十年	原始取得
391.	电子束扫描机台电子束孔径动态调整结构及测试方法	发明	ZL201811607200.8	2018-12-27	申请日起二十年	原始取得
392.	一种自动扫描缺陷的方法	发明	ZL201811595214.2	2018-12-25	申请日起二十年	原始取得
393.	晶圆刻蚀系统及晶圆刻蚀方法	发明	ZL201811580776.X	2018-12-24	申请日起二十年	原始取得
394.	一种提高混合刻蚀工艺稳定性的方法	发明	ZL201811557616.3	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
395.	一种提高刻蚀腔电流稳定性的方法	发明	ZL201811557608.9	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得
396.	分离栅 flash 器件的工艺方法	发明	ZL201811553752.5	2018-12-19	申请日起二十年	原始取得

397.	去除侧壁 ONO 结构中阻挡氧化层残留的工艺方法	发明	ZL201811516115.0	2018-12-12	申请日起二十年	原始取得
398.	晶体管电性测试结构及测试方法	发明	ZL201811477002.4	2018-12-05	申请日起二十年	原始取得
399.	一种处理半导体晶圆的方法	发明	ZL201811471840.0	2018-12-04	申请日起二十年	原始取得
400.	一种晶圆转速监控装置及监控方法	发明	ZL201811467391.2	2018-12-03	申请日起二十年	原始取得
401.	气体注入装置及高温炉管	发明	ZL201811460120.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
402.	源漏极离子注入方法及注入系统	发明	ZL201811460106.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
403.	一种改善衬底缺陷处的图形刻蚀的方法	发明	ZL201811458598.3	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
404.	SRAM 测试结构	发明	ZL201811458597.9	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
405.	半导体器件的缺陷检测结构、装置及其检测方法	发明	ZL201811458596.4	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
406.	半导体结构的制备方法	发明	ZL201811458583.7	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
407.	一种双大马士革结构的形成方法	发明	ZL201811458561.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
408.	一种 MOS 晶体管栅极小信号电容测试方法及系统	发明	ZL201811458548.5	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得

409.	电阻模型的建立方法	发明	ZL201811458546.6	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
410.	酸槽式湿法刻蚀工艺	发明	ZL201811458540.9	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
411.	一种自对准双层图形的形成方法	发明	ZL201811458523.5	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
412.	一种 LOD 应力效应 SPICE 建模的方法	发明	ZL201811458514.6	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
413.	改善自对准像素单元满阱容量的 CMOS 图像传感器	发明	ZL201811458508.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
414.	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201811458489.1	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
415.	一种 MRC 冲突协同优化算法	发明	ZL201811458473.0	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
416.	一种晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201811458460.3	2018-11-30	申请日起二十年	原始取得
417.	一种 SONOS 存储结构及其制造方法	发明	ZL201811444528.2	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
418.	一种刻蚀方法及半导体器件	发明	ZL201811432033.8	2018-11-28	申请日起二十年	原始取得
419.	一种验证设计规则检查脚本的方法	发明	ZL201811408981.8	2018-11-23	申请日起二十年	原始取得
420.	Interconnect 电容值 SPICE 建模方法	发明	ZL201811396797.6	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得

421.	半导体产品良率上限分析方法	发明	ZL201811396608.5	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
422.	SONOS 器件的制造方法	发明	ZL201811396604.7	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
423.	栅极结构的制造方法	发明	ZL201811396595.1	2018-11-22	申请日起二十年	原始取得
424.	一种晶粒缺陷监控方法	发明	ZL201811369312.4	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
425.	一种检测机台的派工方法	发明	ZL201811368312.2	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
426.	一种离子注入的方法及设备	发明	ZL201811344422.5	2018-11-13	申请日起二十年	原始取得
427.	一种缺陷抽检方法	发明	ZL201811340879.9	2018-11-12	申请日起二十年	原始取得
428.	一种通过光阻膜厚监控涂胶显影机台涂胶槽水平程度的方法	发明	ZL201811302702.X	2018-11-02	申请日起二十年	原始取得
429.	一种优化通孔层连接性能的光学邻近修正方法	发明	ZL201811289318.0	2018-10-31	申请日起二十年	原始取得
430.	闪存的制造方法	发明	ZL201811281931.8	2018-10-31	申请日起二十年	原始取得
431.	一种优化势垒区像素离子注入改善串扰的方法	发明	ZL201811246105.X	2018-10-24	申请日起二十年	原始取得
432.	改善分栅结构闪存多步多晶硅刻蚀损伤的工艺集成方法	发明	ZL201811217631.3	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得

433.	一种改善 SONOS 存储器之多晶硅薄膜沉积特性的方法	发明	ZL201811217621.X	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
434.	闪存器件的制造方法	发明	ZL201811216570.9	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
435.	一种膜质监控方法及装置	发明	ZL201811216561.X	2018-10-18	申请日起二十年	原始取得
436.	一种光学临近修正前的预处理方法	发明	ZL201811204210.7	2018-10-16	申请日起二十年	原始取得
437.	一种阈值可调式高压金属氧化物半导体器件及其制备方法	发明	ZL201811198257.7	2018-10-15	申请日起二十年	原始取得
438.	一种样品去层次方法	发明	ZL201811198243.5	2018-10-15	申请日起二十年	原始取得
439.	一种图形密度的分析方法	发明	ZL201811154697.2	2018-09-30	申请日起二十年	原始取得
440.	闪存结构及其控制方法	发明	ZL201811134024.0	2018-09-27	申请日起二十年	原始取得
441.	闪存结构及对应的编程、擦除和读取方法	发明	ZL201811132953.8	2018-09-27	申请日起二十年	原始取得
442.	一种涂布机构以及在硅片上涂布 HMDS 的方法	发明	ZL201811064491.0	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得
443.	应用于高压电路防静电保护的无回滞效应硅控整流器	发明	ZL201811064488.9	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得

444.	缺陷过滤系统及过滤方法和计算机存储介质	发明	ZL201811063793.6	2018-09-12	申请日起二十年	原始取得
445.	一种刻蚀副产物智能自清洁方法	发明	ZL201811026563.2	2018-09-04	申请日起二十年	原始取得
446.	一种形成金属扩散阻挡层的方法	发明	ZL201811015325.1	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
447.	晶圆缺陷检测系统及检测方法和计算机存储介质	发明	ZL201811014892.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
448.	一种锁存电路	发明	ZL201811014888.9	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
449.	故障设备识别系统及识别方法和计算机存储介质	发明	ZL201811014880.2	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
450.	一种冗余图形添加方法	发明	ZL201811014864.3	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
451.	一种像素结构及其制造方法	发明	ZL201811013688.1	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
452.	晶圆清洗装置	发明	ZL201811013483.3	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
453.	一种多晶层光刻工艺热点查找方法	发明	ZL201811012246.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
454.	一种校正及监测铜电镀中洗边位置的方法	发明	ZL201811012214.5	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
455.	一种一体化刻蚀方法	发明	ZL201811011770.0	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得

456.	一种掩模版的制备方法	发明	ZL201811011755.6	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
457.	控片及其制造方法和化学机械研磨缺陷的监测方法	发明	ZL201811011719.X	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
458.	一种 CMOS 图像传感器的形成方法	发明	ZL201811011675.0	2018-08-31	申请日起二十年	原始取得
459.	一种形成具有高深宽比图形的结构的方法	发明	ZL201810941652.3	2018-08-17	申请日起二十年	原始取得
460.	改善高深宽比图形不一致和提高光刻胶形貌陡度的方法	发明	ZL201810927353.4	2018-08-15	申请日起二十年	原始取得
461.	去除光刻胶层的方法	发明	ZL201810898935.4	2018-08-08	申请日起二十年	原始取得
462.	改善闪存单元擦除相关失效的工艺集成方法	发明	ZL201810840312.1	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
463.	改善 N 型 SONOS 器件阈值电压均一性的方法	发明	ZL201810840290.9	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
464.	基于 BSIM4 模型的 MOS 器件子电路温度模型及建模方法	发明	ZL201810840264.6	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得
465.	滤除图形匹配度误报错的方法	发明	ZL201810840252.3	2018-07-27	申请日起二十年	原始取得

466.	一种 MOSFET 栅氧化层电容校准结构	发明	ZL201810800725.7	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
467.	一种改善双重图形刻蚀芯模顶端圆角的工艺方法	发明	ZL201810800712.X	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
468.	一种浅沟槽隔离结构的形成方法及浅沟槽隔离结构	发明	ZL201810800695.X	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
469.	一种光刻工艺热点的检查方法	发明	ZL201810800585.3	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
470.	一种应用于干法去胶工艺的匹配验证方法	发明	ZL201810800573.0	2018-07-20	申请日起二十年	原始取得
471.	一种晶圆制程工艺参数的反馈方法	发明	ZL201810759253.5	2018-07-11	申请日起二十年	原始取得
472.	一种半导体器件及其制造方法	发明	ZL201810714188.4	2018-06-29	申请日起二十年	原始取得
473.	一种工艺控制方法	发明	ZL201810706079.8	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
474.	检测晶圆工作台平坦度的方法	发明	ZL201810672956.4	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
475.	快速热退火工艺能力的监控方法	发明	ZL201810672950.7	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得
476.	化学机械研磨设备工艺能力的监控方法	发明	ZL201810672949.4	2018-06-26	申请日起二十年	原始取得

477.	一种分裂栅结构下的浮栅隔离刻蚀工艺	发明	ZL201810632298.6	2018-06-19	申请日起二十年	原始取得
478.	一种分裂栅结构下的侧墙栅极隔离刻蚀膜层工艺	发明	ZL201810632297.1	2018-06-19	申请日起二十年	原始取得
479.	一种双大马士革结构的制作方法	发明	ZL201810604625.7	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
480.	一种等离子体刻蚀的方法	发明	ZL201810604623.8	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
481.	栅极区域的 OPC 验证方法	发明	ZL201810604622.3	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
482.	一种存储单元模型的阈值电压调节方法和系统	发明	ZL201810604592.6	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
483.	一种改善等离子体刻蚀工艺中首片效应的方法	发明	ZL201810604582.2	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
484.	探针卡	发明	ZL201810604560.6	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
485.	一种 SONOS 存储器及其制造方法	发明	ZL201810604556.X	2018-06-13	申请日起二十年	原始取得
486.	一种划片区内的监控图形的排布方法	发明	ZL201810565129.5	2018-06-04	申请日起二十年	原始取得
487.	金属离子监控方法	发明	ZL201810504049.9	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得

488.	一种应用于 SRAM 的可调节 WLUD 读写辅助电路	发明	ZL201810504047.X	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
489.	一种化学气相淀积机台及处理机台报警的方法	发明	ZL201810503740.5	2018-05-23	申请日起二十年	原始取得
490.	一种闪存单元结构的制备方法	发明	ZL201810428572.8	2018-05-07	申请日起二十年	原始取得
491.	E-FUSE 存储阵列、E-FUSE 以及 E-FUSE 操作方法	发明	ZL201810388020.9	2018-04-26	申请日起二十年	原始取得
492.	一种静电吸附盘的温度监控方法	发明	ZL201810387262.6	2018-04-26	申请日起二十年	原始取得
493.	一种检测站的来料负荷控制方法	发明	ZL201810362521.X	2018-04-20	申请日起二十年	原始取得
494.	一种调试关键尺寸均匀性的方法	发明	ZL201810360659.6	2018-04-20	申请日起二十年	原始取得
495.	一种晶圆的测试方法	发明	ZL201810355979.2	2018-04-19	申请日起二十年	原始取得
496.	一种铜金属互连电迁移测试结构及其测试方法	发明	ZL201810316625.7	2018-04-10	申请日起二十年	原始取得
497.	一种芯片测试装置、测试方法及测试板	发明	ZL201810298527.5	2018-04-03	申请日起二十年	原始取得
498.	无回滞效应栅接地 NMOS 静电防护半导体器件及其实现方法	发明	ZL201810277913.6	2018-03-30	申请日起二十年	原始取得

499.	一种改进型的多样品并行去封装方法	发明	ZL201810252902.2	2018-03-26	申请日起二十年	原始取得
500.	获取晶圆晶背刮伤来源的方法	发明	ZL201810157691.4	2018-02-24	申请日起二十年	原始取得
501.	芯片的测试方法	发明	ZL201810157468.X	2018-02-24	申请日起二十年	原始取得
502.	一种检测晶圆上介质层孔道连通性的方法	发明	ZL201810153103.X	2018-02-11	申请日起二十年	原始取得
503.	射频晶体管射频参数模型建立方法	发明	ZL201810114825.4	2018-02-06	申请日起二十年	原始取得
504.	一种独立控温的用于可靠性测试的测试结构及其测试方法	发明	ZL201810096981.2	2018-01-31	申请日起二十年	原始取得
505.	闪存的制造方法	发明	ZL201810084833.9	2018-01-29	申请日起二十年	原始取得
506.	一种光刻胶回刻蚀工艺中改善晶圆表面颗粒缺陷的方法	发明	ZL201810069436.4	2018-01-24	申请日起二十年	原始取得
507.	闪存	发明	ZL201810063032.4	2018-01-23	申请日起二十年	原始取得
508.	闪存及其制造方法	发明	ZL201810063024.X	2018-01-23	申请日起二十年	原始取得
509.	光刻胶去除方法	发明	ZL201810058404.4	2018-01-22	申请日起二十年	原始取得
510.	闪存阵列的制作方法及闪存阵列	发明	ZL201711466172.8	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得

511.	一种电迁移加速测试方法	发明	ZL201711465933.8	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
512.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201711464516.1	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
513.	无回滞效应硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201711464508.7	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
514.	一种闪烁噪声统计模型的建模方法及其提取方法	发明	ZL201711464504.9	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
515.	OPC 建模中次分辨率辅助图形确定的方法	发明	ZL201711464502.X	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
516.	适用于离子注入工艺套刻精度的评估方法	发明	ZL201711461652.5	2017-12-28	申请日起二十年	原始取得
517.	一种带 SONOS 结构的晶体管及其制造方法	发明	ZL201711430506.6	2017-12-26	申请日起二十年	原始取得
518.	改善 HTO 厚度稳定性的方法	发明	ZL201711419332.3	2017-12-25	申请日起二十年	原始取得
519.	一种对插塞缺陷进行检测的方法	发明	ZL201711394241.9	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
520.	一种版图重复单元匹配性检查方法及系统	发明	ZL201711394189.7	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得

521.	一种压控振荡器电路	发明	ZL201711394141.6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
522.	一种高可靠性读出电路	发明	ZL201711394120.4	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
523.	去除斜边凸起的方法	发明	ZL201711394075.2	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
524.	一种降低连接孔层程式运行时间的 OPC 修正方法	发明	ZL201711394054.0	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
525.	一种 SPICE 集中模型的建模方法及系统	发明	ZL201711393123.6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
526.	一种电子束扫描程式参数自调整方法	发明	ZL201711393038.X	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
527.	晶圆侧边去光阻方法	发明	ZL201711392379.5	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
528.	一种 MOSFET 器件之全局工艺角模型的建模方法	发明	ZL201711392362.X	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
529.	一种电感版图之辅助层及器件参数抽取的方法	发明	ZL201711392318.9	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
530.	适用于随机存储器自动测试的高速电路结构及其测试方法	发明	ZL201711392308.5	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
531.	SONOS 存储器的 ONO 刻蚀方法	发明	ZL201711392296.6	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得

532.	一种改善长寿命钽靶材后期使用的腔体套件结构	发明	ZL201711392270.1	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
533.	具有侧墙型选择栅的非易失存储器及其制造方法	发明	ZL201711389221.2	2017-12-21	申请日起二十年	原始取得
534.	一种检测多晶硅是否出现短路的检测方法	发明	ZL201711387149.X	2017-12-20	申请日起二十年	原始取得
535.	一种通过增加热处理过程改善CIS 白色像素点的方法	发明	ZL201711387099.5	2017-12-20	申请日起二十年	原始取得
536.	一种带沟槽结构的双极型晶体管及其制作方法	发明	ZL201711374117.6	2017-12-19	申请日起二十年	原始取得
537.	提高通孔层 OPC 精度的方法	发明	ZL201711345445.3	2017-12-15	申请日起二十年	原始取得
538.	预调金属导线尺寸的方法	发明	ZL201711312299.4	2017-12-11	申请日起二十年	原始取得
539.	优化不同透光率下浅槽隔离刻蚀形貌的方法	发明	ZL201711281769.5	2017-12-07	申请日起二十年	原始取得
540.	改善金属层腐蚀缺陷方法	发明	ZL201711279353.X	2017-12-06	申请日起二十年	原始取得
541.	监控 3D 栅极氧化层工艺的方法及结构	发明	ZL201711244384.1	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得

542.	金属互连结构及其制作方法	发明	ZL201711243083.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
543.	避免控制栅形成中刻蚀返工导致无定型碳膜剥落的方法	发明	ZL201711242834.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
544.	浅沟槽隔离的制造方法	发明	ZL201711241074.4	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
545.	一种亮场缺陷检测设备自动优化光强条件的方法及系统	发明	ZL201711240724.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
546.	一种金属连线恒温电迁移测试结构	发明	ZL201711240650.3	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
547.	一种存储单元及其存储阵列结构、操作方法	发明	ZL201711240646.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
548.	刻蚀腔体部件的检测方法	发明	ZL201711239742.X	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
549.	提高注入机生产效率的方法	发明	ZL201711237469.7	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
550.	改善闪存中高压器件栅极氧化层可靠性的工艺集成方法	发明	ZL201711237456.X	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
551.	小样品的去层方法	发明	ZL201711234859.9	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
552.	一种金属层光阻顶部缺失工艺热点的版图处理方法	发明	ZL201711227505.1	2017-11-29	申请日起二十年	原始取得

553.	根据电路设计图形设置扫描阈值的方法	发明	ZL201711220974.0	2017-11-29	申请日起二十年	原始取得
554.	一种自动监控产品跑货状况的方法	发明	ZL201711219188.9	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
555.	一种基于光学临近效应修正减少栅极波动的方法	发明	ZL201711219183.6	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
556.	一种形成不同深度接触孔的刻蚀方法	发明	ZL201711219182.1	2017-11-28	申请日起二十年	原始取得
557.	单端转差分电路及其构成的缓冲器电路和采样保持电路	发明	ZL201711201528.5	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
558.	一种一键式激活数据收集项目的方法	发明	ZL201711192842.1	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
559.	一种改善锗硅源漏极形貌的制备方法	发明	ZL201711191234.9	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
560.	一种化学机械研磨垫磨损的检测装置及工作方法	发明	ZL201711189823.3	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得

561.	一种改善层间介质研磨工艺厚度稳定性的方法	发明	ZL201711189813.X	2017-11-24	申请日起二十年	原始取得
562.	一种模拟内部版图图形的边缘冗余图形生成方法	发明	ZL201711183763.4	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
563.	半导体器件的 SAB 工艺方法	发明	ZL201711178355.X	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
564.	提高离子注入区的深宽比的制造方法	发明	ZL201711178339.0	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
565.	槽式湿法清洗机台	发明	ZL201711178278.8	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
566.	去除光刻胶显影后残留缺陷的方法	发明	ZL201711178203.X	2017-11-23	申请日起二十年	原始取得
567.	一种监测离子注入设备性能的方法	发明	ZL201711177123.2	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
568.	一种晶圆的重测方法	发明	ZL201711177120.9	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
569.	一种用于尺寸缩减 NORFlash 单元工艺集成方法	发明	ZL201711176780.5	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
570.	一种高可靠性三态输出电路	发明	ZL201711176777.3	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得

571.	一种改善一体化刻蚀聚集残留缺陷的方法	发明	ZL201711172098.9	2017-11-22	申请日起二十年	原始取得
572.	SONOS 器件的形成方法	发明	ZL201711168493.X	2017-11-21	申请日起二十年	原始取得
573.	一种精确控制浅沟槽隔离的整体形貌和性能的方法	发明	ZL201711167683.X	2017-11-21	申请日起二十年	原始取得
574.	一种嵌入式闪存工艺集成方法	发明	ZL201711160947.9	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
575.	一种具备故障诊断的系统级芯片生产方法	发明	ZL201711160758.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
576.	一种建立全局调节模型进行优化快速热退火的方法	发明	ZL201711160733.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
577.	一种改善 HCD 氮化硅沉积工艺过程缺陷状况的装置	发明	ZL201711160388.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
578.	一种对芯片表面进行分区域对比扫描的检测方法及设备	发明	ZL201711160370.1	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得
579.	一种基于缺陷贡献度的缺陷检测机台自动派工系统和方法	发明	ZL201711159860.X	2017-11-20	申请日起二十年	原始取得

580.	一种接触孔底部钨栓缺陷的检测结构及检测方法	发明	ZL201711140573.4	2017-11-16	申请日起二十年	原始取得
581.	闪存的工艺集成结构和方法	发明	ZL201711138163.6	2017-11-16	申请日起二十年	原始取得
582.	一种检测接触孔底部钨栓缺失缺陷的方法	发明	ZL201711132944.4	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
583.	一种消除湿法刻蚀金属硅化物阻挡层底切缺陷的工艺方法	发明	ZL201711131180.7	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
584.	PVD 设备的工艺腔的工艺调节结构和方法	发明	ZL201711127897.4	2017-11-15	申请日起二十年	原始取得
585.	一种改善的套刻精度量测方法	发明	ZL201711125009.5	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
586.	一种存储器件中形成控制栅的工艺流程方法	发明	ZL201711123938.2	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
587.	有源区顶部圆滑度的模拟检测方法	发明	ZL201711121971.1	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
588.	镍金属硅化物的 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201711121958.6	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
589.	闪存单元结构及其制造方法	发明	ZL201711121845.6	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得

590.	刻蚀腔体的聚合物清洁方法	发明	ZL201711121422.4	2017-11-14	申请日起二十年	原始取得
591.	基于规则的 OPC 方法	发明	ZL201711112632.7	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
592.	一种改善光刻填充材料平坦度的方法	发明	ZL201711106966.3	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
593.	接触孔的金属连接结构及其制造方法	发明	ZL201711102829.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
594.	光刻套刻精度量测准确性的评估方法	发明	ZL201711102811.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
595.	用于化学机械研磨工艺模型建模的测试图形	发明	ZL201711102787.2	2017-11-10	申请日起二十年	原始取得
596.	一种边缘保护圈结构、反应室和化学气相沉积设备	发明	ZL201711100107.3	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
597.	一种提高离子注入层抗前层反射的 OPC 修正方法	发明	ZL201711100020.6	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
598.	一种分布式存储区块访问电路	发明	ZL201711100003.2	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
599.	一种改善闪存单元的工艺集成方法	发明	ZL201711099991.3	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得

600.	一种带误码消除功能的锁定指示器电路	发明	ZL201711099120.1	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
601.	一种提高监控图形监控精度的方法	发明	ZL201711099108.0	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
602.	一种省去 CLDD 光罩的 NorFlash 器件集成工艺方法	发明	ZL201711098208.1	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
603.	OPC 修正方法	发明	ZL201711097082.6	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
604.	刻蚀工艺方法	发明	ZL201711097030.9	2017-11-09	申请日起二十年	原始取得
605.	一种高效的缺陷抽检方法及系统	发明	ZL201711092655.6	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
606.	一种制备西格玛凹槽的方法	发明	ZL201711092654.1	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
607.	一种根据射频时数改善一体化刻蚀工艺面内均匀性的方法	发明	ZL201711091683.6	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
608.	一种检测静电吸盘表面颗粒污染物的方法	发明	ZL201711091677.0	2017-11-08	申请日起二十年	原始取得
609.	一种检测及校正晶圆与腔体载物台偏移的装置及方法	发明	ZL201711073025.4	2017-11-03	申请日起二十年	原始取得
610.	一种闪存晶圆的制作方法	发明	ZL201711057785.6	2017-10-23	申请日起二十年	原始取得

611.	一种减小 WPE 效应的标准单元库版图设计方法	发明	ZL201711050885.6	2017-10-31	申请日起二十年	原始取得
612.	一种完善光刻模型数据对测试图形覆盖范围的方法	发明	ZL201710987039.0	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
613.	浅沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201710987035.2	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
614.	重复性缺陷的筛选方法	发明	ZL201710987031.4	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
615.	一种高性能输出驱动电路	发明	ZL201710986287.3	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
616.	一种自适应闪存写入操作控制方法及电路	发明	ZL201710986267.6	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
617.	一种多晶硅层桥接断路的解决方法	发明	ZL201710985194.9	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
618.	一种套刻精度点检方法	发明	ZL201710985188.3	2017-10-20	申请日起二十年	原始取得
619.	一种光刻辅助图形的设计方法	发明	ZL201710928912.9	2017-10-09	申请日起二十年	原始取得
620.	一种校正全局金属层工艺热点的方法	发明	ZL201710924604.9	2017-09-30	申请日起二十年	原始取得
621.	一种分裂栅的栅极形成方法	发明	ZL201710884971.0	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得

622.	源/漏的形成方法以及半导体器件的形成方法	发明	ZL201710882857.4	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得
623.	一种锗硅源漏极及其制备方法	发明	ZL201710882787.2	2017-09-26	申请日起二十年	原始取得
624.	一种光罩的校正方法	发明	ZL201710861813.3	2017-09-21	申请日起二十年	原始取得
625.	一种温度的测量方法及电迁移的测试方法	发明	ZL201710822916.9	2017-09-13	申请日起二十年	原始取得
626.	一种 MIP 平板电容结构及其形成方法	发明	ZL201710801609.2	2017-09-07	申请日起二十年	原始取得
627.	一种针对产品量测区域缺陷监控的方法	发明	ZL201710797272.2	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
628.	一种线宽量测和问题评估的方法	发明	ZL201710797215.4	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
629.	一种离子注入机钨金属污染的监控方法	发明	ZL201710796722.6	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
630.	一种套刻误差量测和问题评估的方法	发明	ZL201710796702.9	2017-09-06	申请日起二十年	原始取得
631.	基于计算机辅助设计的晶圆激光标识工艺实现方法及系统	发明	ZL201710758627.7	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得

632.	适用于 TDDB 的原位侦测热点方法	发明	ZL201710757942.8	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
633.	光刻工艺热点的整合方法	发明	ZL201710757929.2	2017-08-29	申请日起二十年	原始取得
634.	一种晶圆检测方法	发明	ZL201710750267.6	2017-08-28	申请日起二十年	原始取得
635.	一种新型硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710731685.0	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
636.	一种新型硅控整流器型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710731223.9	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
637.	一种改善浮栅极并联电容稳定性的方法	发明	ZL201710730505.7	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
638.	一种多晶硅上接触孔粘结层异常缺陷检测方法	发明	ZL201710730497.6	2017-08-23	申请日起二十年	原始取得
639.	一种改善 CMOS 图像传感器刻蚀腔体金属污染的方法	发明	ZL201710702567.7	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
640.	一种通孔的形成方法	发明	ZL201710702565.8	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得
641.	一种掩膜板微尘影响评估方法和系统	发明	ZL201710701067.1	2017-08-16	申请日起二十年	原始取得

642.	一种光学临近修正工艺的预处理方法	发明	ZL201710670732.5	2017-08-08	申请日起二十年	原始取得
643.	一种确定离子注入机注入角度偏差的方法	发明	ZL201710642794.5	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
644.	一种降低存储器擦写功耗的电荷泵电路	发明	ZL201710642793.0	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
645.	一种双时域动态变频测试方法	发明	ZL201710641641.9	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
646.	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710640089.1	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
647.	一种图形转角的 OPC 修正方法	发明	ZL201710636987.X	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
648.	一种浅离子注入层的 OPC 修正方法	发明	ZL201710636973.8	2017-07-31	申请日起二十年	原始取得
649.	一种自适应定义缺陷扫描方程式扫描区域的方法	发明	ZL201710613874.8	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
650.	电阻模型及其修正方法	发明	ZL201710612356.4	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得
651.	一种用于闪存电路中的变容二极管结构及其制造方法	发明	ZL201710609969.2	2017-07-25	申请日起二十年	原始取得

652.	一种基于改进的带隙基准结构的上电复位电路	发明	ZL201710567419.9	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
653.	刻蚀管控系统及其管控方法和刻蚀机台	发明	ZL201710567416.5	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
654.	一种用于聚焦离子束机台提取样品的方法	发明	ZL201710567411.2	2017-07-12	申请日起二十年	原始取得
655.	一种熔断器及其制造方法	发明	ZL201710561178.7	2017-07-11	申请日起二十年	原始取得
656.	图像传感器的制备方法	发明	ZL201710494748.5	2017-06-26	申请日起二十年	原始取得
657.	一种高能离子注入工艺中形成高深宽比隔离的方法	发明	ZL201710471715.9	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
658.	一种模拟离子注入光阻穿透深度的模型及其建模方法	发明	ZL201710471713.X	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
659.	静电释放装置及制造方法、聚焦离子束设备及使用方法	发明	ZL201710470999.X	2017-06-20	申请日起二十年	原始取得
660.	提高套刻精度的方法	发明	ZL201710458343.6	2017-06-16	申请日起二十年	原始取得
661.	一种检测晶圆表面氮化硅残留的方法	发明	ZL201710429161.6	2017-06-08	申请日起二十年	原始取得

662.	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710420095.6	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
663.	一种新型 ESD 保护结构及其实现方法	发明	ZL201710420086.7	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
664.	一种电平转换与非电路	发明	ZL201710419522.9	2017-06-06	申请日起二十年	原始取得
665.	一种减小 STI-CMP 过程中碟型凹陷的方法	发明	ZL201710401452.4	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
666.	晶圆退火的热量补偿方法	发明	ZL201710401289.1	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
667.	半导体芯片老化测试装置及方法	发明	ZL201710400323.3	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
668.	一种晶圆颗粒检测系统及方法	发明	ZL201710399666.2	2017-05-31	申请日起二十年	原始取得
669.	一种驱动力可配置的电荷泵电路	发明	ZL201710370115.3	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
670.	一种光刻胶供应装置	发明	ZL201710370114.9	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
671.	一种在氧化硅湿法刻蚀中降低硅损伤的方法	发明	ZL201710370095.X	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
672.	一种器件建模中最优器件的自动选择方法及系统	发明	ZL201710368792.1	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得

673.	一种通孔中光刻胶栓刻蚀量的自动调节方法	发明	ZL201710368784.7	2017-05-23	申请日起二十年	原始取得
674.	晶圆缺陷的检测方法	发明	ZL201710353548.8	2017-05-18	申请日起二十年	原始取得
675.	一种金属互连结构的制备方法	发明	ZL201710329424.6	2017-05-11	申请日起二十年	原始取得
676.	光学邻近校正前的图形预处理方法	发明	ZL201710318782.7	2017-05-08	申请日起二十年	原始取得
677.	计算版图中线宽固定节距不同的线条的分布的方法	发明	ZL201710318781.2	2017-05-08	申请日起二十年	原始取得
678.	一种采用电流编程的电子可编程熔丝电路结构	发明	ZL201710312461.6	2017-05-05	申请日起二十年	原始取得
679.	一种通过预补值来快速建立光刻工艺条件的方法	发明	ZL201710276130.1	2017-04-25	申请日起二十年	原始取得
680.	一种电荷捕获型非易失存储器及其制作方法	发明	ZL201710272690.X	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
681.	一种降低闪存源端导通电阻的方法	发明	ZL201710272670.2	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得

682.	一种结合耐高压晶体管的电荷捕获型非易失存储器制作方法	发明	ZL201710272223.7	2017-04-24	申请日起二十年	原始取得
683.	一种层间电容的控制方法及控制系统	发明	ZL201710229267.1	2017-04-10	申请日起二十年	原始取得
684.	一种嵌入式存储器自适应工作参数调整方法	发明	ZL201710228681.0	2017-04-10	申请日起二十年	原始取得
685.	图形光罩连接孔缺陷检查测试结构及方法	发明	ZL201710225567.2	2017-04-07	申请日起二十年	原始取得
686.	接触孔制作工艺缺陷的检查方法	发明	ZL201710225130.9	2017-04-07	申请日起二十年	原始取得
687.	实现更小线宽的光刻工艺	发明	ZL201710190157.9	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
688.	一种大尺寸拼接产品曝光方法	发明	ZL201710190123.X	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
689.	一种钳位电压电路	发明	ZL201710189260.1	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
690.	减缓晶圆边缘散焦的光刻方法	发明	ZL201710188876.7	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
691.	套刻精度补正的优化方法及系统	发明	ZL201710187899.6	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
692.	一种 EFUSE 烧写方法及烧写电路	发明	ZL201710187627.6	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得
693.	一种浪涌电流控制模块及其方法	发明	ZL201710187522.0	2017-03-27	申请日起二十年	原始取得

694.	版图重复单元光学邻近效应修正一致性检查方法	发明	ZL201710170707.0	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
695.	补偿由光刻镜头散射光导致曝光误差的方法	发明	ZL201710170252.2	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
696.	一种上电复位电路	发明	ZL201710169793.3	2017-03-21	申请日起二十年	原始取得
697.	一种监控 Ge 离子注入质量的方法	发明	ZL201710146467.0	2017-03-13	申请日起二十年	原始取得
698.	一种时钟分布网络结构及其生成方法	发明	ZL201710146090.9	2017-03-13	申请日起二十年	原始取得
699.	一种提高芯片同测数的方法	发明	ZL201710141184.7	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
700.	一种增强型 CMOS 施密特电路	发明	ZL201710141051.X	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
701.	一种光罩颗粒尺寸的评估方法	发明	ZL201710140908.6	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
702.	一种提高 SONOS 器件读取电流的方法	发明	ZL201710140796.4	2017-03-10	申请日起二十年	原始取得
703.	一种刻蚀方法	发明	ZL201710033545.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
704.	图形光罩接触孔缺陷检测方法	发明	ZL201611089543.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
705.	测试结构及测试方法	发明	ZL201611087779.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得

706.	一种基于频率比较的锁定指示器	发明	ZL201611086921.X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
707.	一种基于前层图形判别的离子注入层边界的光学临近修正方法	发明	ZL201611085965.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
708.	WAT 机台报警引起的 lot 异常处理优化方法及系统	发明	ZL201611085624.3	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
709.	一种半导体晶圆的测试结构	发明	ZL201611077582.9	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
710.	一种降低热载流子劣化的电平转换电路	发明	ZL201611077581.4	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
711.	一种改善高深宽比光刻胶形貌的结构和方法	发明	ZL201611077084.4	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
712.	防止研磨头与研磨垫修整器相撞的装置、方法及研磨设备	发明	ZL201611076614.3	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
713.	一种监控 CIS 像素单元相关电容的电路及方法	发明	ZL201611076611.X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
714.	一种用于优化晶圆边缘缺陷的晶圆传送方法	发明	ZL201611076590.1	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
715.	一种电源箝位 ESD 保护电路结构	发明	ZL201611076587.X	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得

716.	一种优化低功耗产品漏电流的方法	发明	ZL201611076529.7	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
717.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201611075479.0	2016-11-30	申请日起二十年	原始取得
718.	一种考虑版图环境的电阻模型提取方法及系统	发明	ZL201611061474.2	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
719.	一种应用于 PLL 的高性能 VCO 电路	发明	ZL201611061473.8	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
720.	一种电阻闪烁噪声模型的建立方法及系统	发明	ZL201611061346.8	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
721.	一种炉管尾气处理管道	发明	ZL201611059866.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
722.	一种通用版图临近效应表征模型及其提取方法	发明	ZL201611053506.4	2016-11-25	申请日起二十年	原始取得
723.	一种电阻子电路噪声模型结构及其建模方法	发明	ZL201611048937.1	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
724.	一种增强 OPC 处理精度的方法	发明	ZL201611047406.0	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
725.	一种用于产生二维 OPC 测试图形的方法	发明	ZL201611042085.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得

726.	一种自校准可扩展性 SRAM 延时测试电路	发明	ZL201611041043.X	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
727.	改善有源区点状腐蚀缺陷的方法	发明	ZL201611040507.5	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
728.	芯片内部动作时间的检测系统及方法	发明	ZL201611040490.3	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
729.	一种基于理想电阻的可熔断电阻验证系统及方法	发明	ZL201611037379.9	2016-11-23	申请日起二十年	原始取得
730.	一种 WAT 阈值电压测试方法及系统	发明	ZL201611031129.4	2016-11-22	申请日起二十年	原始取得
731.	一种改善非对称性静电吸盘刻蚀腔体边缘缺陷的方法	发明	ZL201611028534.0	2016-11-18	申请日起二十年	原始取得
732.	一种多步骤干法刻蚀机台颗粒监测的方法	发明	ZL201611027701.X	2016-11-01	申请日起二十年	原始取得
733.	一种 NISSIN 离子注入机台的自动化程式正确性管理方法及装置	发明	ZL201611018094.0	2016-11-18	申请日起二十年	原始取得
734.	PMOS 器件及其集成工艺方法	发明	ZL201611017984.X	2016-11-17	申请日起二十年	原始取得
735.	电迁移测试结构	发明	ZL201611010913.7	2016-11-17	申请日起二十年	原始取得

736.	一种动态调整安全研磨时间限的方法	发明	ZL201610993680.0	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
737.	一种上电复位电路	发明	ZL201610986873.3	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
738.	一种可探知晶圆滑动的机械臂装置	发明	ZL201610986671.9	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
739.	提高前照式 CMOS 图像传感器红光量子效率的方法及结构	发明	ZL201610985910.9	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
740.	一种集成 5 伏器件和 SONOS 存储器的制造方法	发明	ZL201610985902.4	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
741.	一种晶圆化学机械抛光保持环的清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610985516.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
742.	一种集成离子刻蚀划片槽和密封环的制造方法	发明	ZL201610985505.7	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
743.	用于钨沉积前的接触孔表面的处理方法	发明	ZL201610985481.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
744.	半导体器件及其制备方法	发明	ZL201610984921.5	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得

745.	消除前金属层内部缺陷导致的短路漏电的方法	发明	ZL201610984912.6	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
746.	一种炉管的氮气冷却系统及晶圆和晶舟的冷却方法	发明	ZL201610983199.3	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
747.	一种延长刻蚀腔体开腔保养时间间隔的保养方法	发明	ZL201610983032.7	2016-11-09	申请日起二十年	原始取得
748.	一种快速收集阈值电压分布的方法	发明	ZL201610971021.7	2016-11-01	申请日起二十年	原始取得
749.	一种化学机械研磨机台研磨压力补偿方法	发明	ZL201610957345.5	2016-10-27	申请日起二十年	原始取得
750.	恒温电迁移测试中的电流加速因子评估方法	发明	ZL201610950150.8	2016-10-26	申请日起二十年	原始取得
751.	用于封装级可靠性测试的静电防护电路和测试安装方法	发明	ZL201610949909.0	2016-10-26	申请日起二十年	原始取得
752.	一种基于 systemverilog 的 AHB 核随机验证方法	发明	ZL201610936104.2	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得

753.	药液槽承载晶圆的底座及提高槽式湿法刻蚀均匀性的方法	发明	ZL201610926005.6	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
754.	一种嵌入式闪存及其电流比较读出电路	发明	ZL201610925994.7	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
755.	一种晶圆边缘清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610925966.5	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
756.	一种优化晶圆环状缺陷的方法	发明	ZL201610924726.3	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
757.	自校准式恒温电迁移测试中的金属活化能评估方法	发明	ZL201610924546.5	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
758.	一种减少曝光焦距误差的方法	发明	ZL201610924503.7	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
759.	一种 CIS 器件及优化后段光通道工艺来降低 CIS 暗电流的方法	发明	ZL201610924437.3	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
760.	抗电磁干扰的晶振谐振回路电路	发明	ZL201610924231.0	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
761.	一种用于无电容型 LDO 的补偿电路	发明	ZL201610901016.9	2016-10-17	申请日起二十年	原始取得
762.	一种改善应力记忆工艺效果的方法	发明	ZL201610885707.4	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得

763.	一种连接孔图形光罩缺点的检测方法	发明	ZL201610884418.2	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
764.	一种降低背照式 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201610884399.3	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
765.	一种剥离嵌入式闪存的逻辑及 SRAM 区中浮栅结构的方法	发明	ZL201610884377.7	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
766.	一种金属线层小尺寸冗余图形的添加和处理方法	发明	ZL201610884323.0	2016-10-10	申请日起二十年	原始取得
767.	一种双向 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201610875594.X	2016-09-30	申请日起二十年	原始取得
768.	一种用于缺陷检测机台的实时侦测光阻损伤的方法	发明	ZL201610857461.X	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
769.	一种用作 ESD 保护的 GGNMOS 器件及其制作方法	发明	ZL201610854759.5	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
770.	一种栅氧层的制备方法	发明	ZL201610854700.6	2016-09-27	申请日起二十年	原始取得
771.	一种上电复位电路	发明	ZL201610852610.3	2016-09-26	申请日起二十年	原始取得
772.	一种 ESD 器件及其制作方法	发明	ZL201610850755.X	2016-09-26	申请日起二十年	原始取得

773.	降低化学机械抛光工艺热点检测漏报率的方法	发明	ZL201610828347.4	2016-09-18	申请日起二十年	原始取得
774.	一种突破外观缺陷机台检测极限的方法	发明	ZL201610795422.1	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
775.	适用于各类周期性测试算法的存储器内建自测试电路	发明	ZL201610795123.8	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
776.	一种测试有源区顶部圆滑度的方法	发明	ZL201610790820.4	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
777.	一种形成 MIS 结构的方法	发明	ZL201610790816.8	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
778.	降低离子注入层光刻胶剥离风险的方法	发明	ZL201610790803.0	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
779.	一种优化 CMOS 图像传感器晶圆边缘缺陷的方法	发明	ZL201610790785.6	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
780.	提高良率提升缺陷监测效率的方法	发明	ZL201610790782.2	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得
781.	电化学镀铜洗边装置以及电化学镀铜洗边方法	发明	ZL201610790760.6	2016-08-31	申请日起二十年	原始取得

782.	保形沉积的薄膜厚度预测模型建立及应用方法	发明	ZL201610777684.5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
783.	刻蚀设备以及用于去除晶背边缘薄膜的晶背边缘刻蚀方法	发明	ZL201610776793.5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
784.	一种监控侧墙刻蚀后残留的方法	发明	ZL201610770418.X	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
785.	一种炉管的进气装置	发明	ZL201610770371.7	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
786.	一种降低变容器最小电容的方法	发明	ZL201610766363.5	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
787.	可制造性检测分析方法	发明	ZL201610766345.7	2016-08-30	申请日起二十年	原始取得
788.	一种检测浅沟槽隔离区空洞缺陷的方法	发明	ZL201610704834.X	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
789.	一种锗硅 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610704833.5	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
790.	一种非易失存储器结构及其制作方法	发明	ZL201610704806.8	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
791.	改善有源区边界处的栅极拐角的方法	发明	ZL201610704771.8	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
792.	一种嵌入式闪存的电荷泵控制电路结构	发明	ZL201610704743.6	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得

793.	一种在接触孔中制备薄膜的方法	发明	ZL201610704710.1	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
794.	一种晶圆研磨头清洗装置及清洗方法	发明	ZL201610703066.6	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
795.	一种适用于低电容密度电容测试结构的版图布局方法	发明	ZL201610703053.9	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
796.	一种可调控制栅增加 ILD 填充窗口的工艺方法	发明	ZL201610703052.4	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
797.	防止重掺杂的硅衬底边缘的离子析出的方法	发明	ZL201610703032.7	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
798.	一种避免电子束扫描过程中产生电弧放电的缺陷检测方法	发明	ZL201610703019.1	2016-08-22	申请日起二十年	原始取得
799.	半浮栅晶体管工艺方法	发明	ZL201610696009.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
800.	改善 OPC 版图处理不一致的方法	发明	ZL201610695909.2	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
801.	透射电子显微镜样品结染色的方法	发明	ZL201610694441.5	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
802.	针对多晶硅氧化物栅极缺失的电子束扫描检测方法	发明	ZL201610694386.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得

803.	多产品共晶圆流片中的几何信息提取方法	发明	ZL201610694146.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
804.	降低金属硬质掩模大马士革一体化刻蚀缺陷生长的方法	发明	ZL201610694050.3	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
805.	制备透射电子显微镜样品的方法	发明	ZL201610692334.9	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
806.	透射电子显微镜样品结染色的方法	发明	ZL201610692332.X	2016-08-19	申请日起二十年	原始取得
807.	自加热电迁移测试结构以及晶圆级自加热电迁移测试方法	发明	ZL201610608746.X	2016-07-29	申请日起二十年	原始取得
808.	离子注入设备及监控方法	发明	ZL201610608697.X	2016-07-29	申请日起二十年	原始取得
809.	一种化学机械研磨模拟方法	发明	ZL201610606958.4	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
810.	一种单位格点几何信息提取方法	发明	ZL201610606945.7	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
811.	一种基于图形密度的工艺模型建模与修正方法	发明	ZL201610606942.3	2016-07-28	申请日起二十年	原始取得
812.	SEN 离子注入机台的自动化程式正确性管理方法及装置	发明	ZL201610585587.6	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
813.	用于执行版图 OPC 处理的方法	发明	ZL201610585550.3	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得

814.	具有双外延层结构的 CMOS 图像传感器及其制造方法	发明	ZL201610585056.7	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
815.	一种用于共源架构嵌入式闪存的字线驱动电路及其方法	发明	ZL201610584970.X	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
816.	一种改善圆晶片内膜厚均匀性的方法	发明	ZL201610584924.X	2016-07-22	申请日起二十年	原始取得
817.	改善闪存阵列区垫氧层刻蚀过程中硅衬底完整性的方法	发明	ZL201610510527.8	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
818.	一种降低 ESD 风险的版图处理方法	发明	ZL201610510504.7	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
819.	一种离子注入工艺的精确控制方法	发明	ZL201610498922.9	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
820.	一种快速降低热板温度的方法	发明	ZL201610498921.4	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
821.	一种量测工序的智能抽样方法及系统	发明	ZL201610498899.3	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
822.	调节衬底表面反射率的结构及方法、光刻方法	发明	ZL201610498878.1	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得

823.	一种离子注入层图形线宽尺寸的形成方法	发明	ZL201610498312.9	2016-06-30	申请日起二十年	原始取得
824.	一种优化 OPC 验证的方法	发明	ZL201610421103.4	2016-06-14	申请日起二十年	原始取得
825.	一种电化学镀铜洗边宽度的自动调节装置和自动调节方法	发明	ZL201610415928.5	2016-06-14	申请日起二十年	原始取得
826.	用于 CMP 设备上的研磨垫安装夹具装置及使用方法	发明	ZL201610370175.0	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
827.	一种光刻机的晶圆承载吸附压力优化方法	发明	ZL201610370135.6	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
828.	一种曝光条件检测方法及系统	发明	ZL201610370132.2	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
829.	一种自对准 STI 的制备方法	发明	ZL201610367958.3	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
830.	一种铜研磨方法及系统	发明	ZL201610367935.2	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
831.	一种提高 OPC 修正精度的方法	发明	ZL201610367932.9	2016-05-30	申请日起二十年	原始取得
832.	改善闪存浅槽嵌壁工艺缺陷的双光刻处理方法	发明	ZL201610357144.1	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
833.	防止有形貌晶圆表面刻蚀损伤的光刻刻蚀方法	发明	ZL201610357141.8	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得

834.	一种暗场缺陷检测设备自对准工艺窗口的校正方法	发明	ZL201610357127.8	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
835.	局部曝光异常缺陷自动检测方法	发明	ZL201610356816.7	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
836.	一种亮场扫描设备自动定义扫描区域的检测方法	发明	ZL201610355214.X	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
837.	一种优化 CMOS 图像传感器晶圆边缘缺陷的方法	发明	ZL201610355204.6	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
838.	一种金属层膜厚堆叠模型校准的方法及系统	发明	ZL201610355194.6	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
839.	一种离子注入机的智能工艺互锁控制方法及系统	发明	ZL201610355192.7	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
840.	一种靶材边缘之铝熔射层的检测方法	发明	ZL201610353584.X	2016-05-25	申请日起二十年	原始取得
841.	函括格点边缘区域图形数据的版图特征参数提取方法	发明	ZL201610327932.6	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
842.	超浅结退火方法	发明	ZL201610327931.1	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
843.	一种平面 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610327914.8	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得

844.	化学机械研磨工艺模型校准验证流程中薄膜厚度引入方法	发明	ZL201610327878.5	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
845.	实现多晶硅栅极平坦化的方法	发明	ZL201610327876.6	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
846.	版图设计中的权重线宽的提取方法	发明	ZL201610326227.4	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
847.	基于掩模板规则限制优化光学临近修正结果的方法	发明	ZL201610326182.0	2016-05-17	申请日起二十年	原始取得
848.	一种减少光刻胶中毒的方法	发明	ZL201610323439.7	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
849.	用于预防半导体芯片版图的天线效应的方法	发明	ZL201610320945.0	2016-05-13	申请日起二十年	原始取得
850.	一种离子注入层阴影效应分析结构的形成方法	发明	ZL201610319144.2	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
851.	一种 3D 集成电路结构及其制造方法	发明	ZL201610319141.9	2016-05-16	申请日起二十年	原始取得
852.	一种加速 WAT 测试的系统和方法	发明	ZL201610280121.5	2016-04-29	申请日起二十年	原始取得
853.	离子注入层版图的光学修正方法	发明	ZL201610280103.7	2016-04-29	申请日起二十年	原始取得

854.	一种使电荷泵输出电压具有多种温度系数的电路	发明	ZL201610250583.2	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
855.	一种基于 MEEF 的 OPC 验证方法	发明	ZL201610250573.9	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
856.	一种用于小电容失配检测及绝对值测量的电路及方法	发明	ZL201610250571.X	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
857.	阻挡介质层的刻蚀方法	发明	ZL201610250432.7	2016-04-21	申请日起二十年	原始取得
858.	MOS 管阈值电压分布的测量系统及测量方法	发明	ZL201610219022.6	2016-04-11	申请日起二十年	原始取得
859.	一种通过改变 SAB 膜质降低 CIS 器件噪声的方法	发明	ZL201610218970.8	2016-04-11	申请日起二十年	原始取得
860.	离子注入设备的冷却单元	发明	ZL201610212943.X	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
861.	梯度压力模式改善膜厚均一性的方法	发明	ZL201610212828.2	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
862.	测试金属线的电迁移结构	发明	ZL201610212826.3	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
863.	一种平衡存储单元区填充与逻辑区栅氧完整性的工艺方法	发明	ZL201610212604.1	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得

864.	利用曝光辅助图形来减少基底反射影响的方法	发明	ZL201610212558.5	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
865.	一种确定 OPC 模型焦平面的方法	发明	ZL201610212556.6	2016-04-07	申请日起二十年	原始取得
866.	一种改善晶圆翘曲度的方法	发明	ZL201610186873.5	2016-03-29	申请日起二十年	原始取得
867.	一种改善炉管晶舟支撑脚颗粒状况的装置及方法	发明	ZL201610185803.8	2016-03-29	申请日起二十年	原始取得
868.	控制多晶硅栅极关键尺寸均匀性的方法	发明	ZL201610173911.3	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
869.	高电流注入机台监控方法	发明	ZL201610173716.0	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
870.	炉管、晶片冷却方法以及自动晶舟清洁方法	发明	ZL201610173685.9	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
871.	自动晶圆校准方法	发明	ZL201610173682.5	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
872.	一种消除闪光退火机台首十枚效应的方法	发明	ZL201610173408.8	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
873.	阻挡 CMOS 图像传感器 HDP 浅沟槽填充过程中金属污染的方法	发明	ZL201610173365.3	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得

874.	针对版图设计数据改版的光刻工艺的友善性检查方法	发明	ZL201610173339.0	2016-03-24	申请日起二十年	原始取得
875.	一种 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201610164426.X	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
876.	一种 MOSFET BSIM4 子电路器件模型及其建模方法	发明	ZL201610163792.3	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
877.	一种改善深亚微米级闪存器件耦合率的沟槽氧化物的刻蚀方法	发明	ZL201610163759.0	2016-03-22	申请日起二十年	原始取得
878.	一种校正电子显微镜电子束与晶圆位置偏差的方法	发明	ZL201610114691.7	2016-03-01	申请日起二十年	原始取得
879.	一种解决 HDP PSG 制程厚度均一性持续跳高的方法	发明	ZL201610109837.9	2016-02-29	申请日起二十年	原始取得
880.	降低 CMOS 图像传感器的无金属硅化物区域接触电阻的方法	发明	ZL201610107865.7	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
881.	一种兼容不同规格之探针的探针卡	发明	ZL201610107841.1	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
882.	改善静电吸附盘树脂保护环损伤的结构及方法	发明	ZL201610107752.7	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得

883.	改善闪存产品多晶硅表面缺陷检测灵敏度的方法及结构	发明	ZL201610107730.0	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
884.	双结构接触孔同步刻蚀工艺	发明	ZL201610107729.8	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
885.	一种提升经时击穿测试有效性的方法	发明	ZL201610107358.3	2016-02-26	申请日起二十年	原始取得
886.	栅氧化层厚度实时监控方法	发明	ZL201610088975.3	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
887.	一种用于槽型湿法设备的干燥装置及干燥方法	发明	ZL201610088128.7	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
888.	一种验证快闪存储器隧穿氧化层可靠性的方法	发明	ZL201610088127.2	2016-02-17	申请日起二十年	原始取得
889.	消除比较器延迟的振荡电路	发明	ZL201510724253.8	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
890.	一种 CMOS 图像传感器的结构及其制备方法	发明	ZL201510719251.X	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
891.	一种 H3PO4 槽小换酸的控制方法	发明	ZL201510719240.1	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
892.	一种检测光刻机焦距偏移量的方法	发明	ZL201510719205.X	2015-10-29	申请日起二十年	原始取得
893.	一种排除电性噪声干扰的方法	发明	ZL201510716961.7	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得

894.	一种改善低介电质膜厚稳定性的方法	发明	ZL201510716951.3	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
895.	一种改善低介电质薄膜厚度稳定性的方法	发明	ZL201510716938.8	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
896.	形成源漏区外延锗硅均匀轮廓的方法	发明	ZL201510716917.6	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
897.	一种降低颗粒产生的方法	发明	ZL201510716894.9	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
898.	一种针对多晶硅层光刻版图的工艺热点检查方法	发明	ZL201510715852.3	2015-10-28	申请日起二十年	原始取得
899.	一种降低接触式图像传感器工作区金属污染的方法	发明	ZL201510708400.2	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
900.	一种降低接触式图像传感器工作区金属污染的方法	发明	ZL201510708385.1	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
901.	一种 MOS 可变电容的仿真模型建立方法和仿真方法	发明	ZL201510707912.7	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
902.	嵌入式外延锗硅层的盖帽层的制作方法	发明	ZL201510707870.7	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得

903.	嵌入式外延锗硅层的盖帽层的制作方法	发明	ZL201510707673.5	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
904.	研磨液供给及研磨垫整理装置、研磨机台	发明	ZL201510707376.0	2015-10-27	申请日起二十年	原始取得
905.	一种研磨垫及其更换方法	发明	ZL201510703868.2	2015-10-26	申请日起二十年	原始取得
906.	一种保持研磨机台研磨率平衡的方法	发明	ZL201510703181.9	2015-10-26	申请日起二十年	原始取得
907.	用于化学机械研磨机台的固定环	发明	ZL201510683995.0	2015-10-20	申请日起二十年	原始取得
908.	一种 TEM 芯片样品的标记方法	发明	ZL201510680560.0	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
909.	一种 CIS 器件的制造方法	发明	ZL201510680467.X	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
910.	MIM 电容器的测试结构和测试方法	发明	ZL201510680458.0	2015-10-19	申请日起二十年	原始取得
911.	抑制浅沟槽隔离结构深度负载效应的方法	发明	ZL201510663204.8	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
912.	一种侦测锗硅残留的方法	发明	ZL201510663115.3	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
913.	无深度负载效应的浅沟槽隔离结构的制备方法	发明	ZL201510663074.8	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得

914.	一种 SRAM 单元建模方法	发明	ZL201510663043.2	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
915.	一种晶圆验收测试机台加压校准方法	发明	ZL201510662809.5	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
916.	一种半导体器件电性测试方法	发明	ZL201510662806.1	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
917.	对准精度测量的图形结构	发明	ZL201510662782.X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
918.	一种利用信息码识别的探针卡及方法	发明	ZL201510662503.X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
919.	一种避免浅沟槽隔离结构出现深度负载效应的方法	发明	ZL201510662464.3	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
920.	一种 AL 刻蚀机台热量再利用的装置及方法	发明	ZL201510662415.X	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
921.	离子注入阻挡层的制作方法	发明	ZL201510662096.2	2015-10-14	申请日起二十年	原始取得
922.	一种存储器测试装置及一种存储器芯片测试方法	发明	ZL201510655029.8	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
923.	一种消除比较器延迟和失配的振荡电路	发明	ZL201510626725.6	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
924.	一种光刻套准补正的方法	发明	ZL201510626687.4	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得

925.	一种金属沟槽刻蚀方法	发明	ZL201510626669.6	2015-09-28	申请日起二十年	原始取得
926.	一种偏置电压显性相关的失配模型及其提取方法	发明	ZL201510624152.3	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
927.	U 形栅极的形成方法	发明	ZL201510624106.3	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
928.	一种通用失配模型及其提取方法	发明	ZL201510623395.5	2015-09-27	申请日起二十年	原始取得
929.	一种降低 CMOS 图像传感器白像素的集成工艺	发明	ZL201510621256.9	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
930.	通过多晶硅吸杂降低 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201510621245.0	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
931.	通过 C 离子注入降低 CMOS 图像传感器白像素的方法	发明	ZL201510621209.4	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
932.	通过 F 离子注入降低 CMOS 图像传感器暗电流的方法	发明	ZL201510621207.5	2015-09-25	申请日起二十年	原始取得
933.	一种改善晶圆形变的曝光载片台	发明	ZL201510608938.6	2015-09-22	申请日起二十年	原始取得
934.	一种漏电流的测试版图、检测结构及其检测方法	发明	ZL201510592962.5	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得

935.	一种改善晶圆边缘产品良率的方法	发明	ZL201510591788.2	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
936.	一种栅极阵列图形的双重曝光制作方法	发明	ZL201510591374.X	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
937.	一种光学邻近效应修正离焦模型的校准方法	发明	ZL201510591365.0	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
938.	一种制作 Sigma 型锗硅沟槽的方法	发明	ZL201510591355.7	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
939.	一种提高器件性能均一性的方法	发明	ZL201510591338.3	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
940.	一种扫描程式运用阈值修正进行晶圆检测的方法	发明	ZL201510591333.0	2015-09-17	申请日起二十年	原始取得
941.	一种防止 TEM 芯片样品破裂的方法	发明	ZL201510578320.X	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得
942.	用于 CMOS 器件离子注入光学修正的测试结构及方法	发明	ZL201510578319.7	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得
943.	解决高能量下连续片晶圆孤立线宽下降的方法	发明	ZL201510578270.5	2015-09-11	申请日起二十年	原始取得

944.	一种 SONOS 器件中 ONO 结构的制造方法	发明	ZL201510547787.8	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
945.	一种晶圆边缘产品良率的改善方法	发明	ZL201510547779.3	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
946.	常压炉管生长的薄膜厚度的控制方法	发明	ZL201510546241.0	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
947.	高深宽比结构的光刻胶填充方法	发明	ZL201510546180.8	2015-08-31	申请日起二十年	原始取得
948.	一种制备 TEM 芯片样品的方法	发明	ZL201510532705.2	2015-08-26	申请日起二十年	原始取得
949.	电迁移测试结构及测试方法	发明	ZL201510532704.8	2015-08-26	申请日起二十年	原始取得
950.	用于减少高浓度外延工艺中的位错缺陷的方法和系统	发明	ZL201510524163.4	2015-08-24	申请日起二十年	原始取得
951.	一种互连寄生电阻电容校准结构	发明	ZL201510514462.X	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
952.	CMOS 器件工艺中锗硅外延层的制备方法	发明	ZL201510514447.5	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
953.	一种集成电路分析中透射电镜平面样品的制备方法	发明	ZL201510514446.0	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得

954.	一种双位 SONOS 存储器及其编译、擦除和读取方法	发明	ZL201510514435.2	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
955.	一种 N 沟道非易失性闪存器件及其编译、擦除和读取方法	发明	ZL201510514392.8	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
956.	一种栅氧化层缺陷的分析方法	发明	ZL201510514373.5	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
957.	一种防止 I/O 电路不确定态的上电检测电路	发明	ZL201510514279.X	2015-08-20	申请日起二十年	原始取得
958.	预估 MEEF 较大图形的方法及系统	发明	ZL201510497384.7	2015-08-13	申请日起二十年	原始取得
959.	多管路液体气化反应成膜设备气流控制方法	发明	ZL201510494546.1	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
960.	一种Σ型结构的半浮栅器件的制造方法	发明	ZL201510494525.X	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
961.	光刻生产控制方法	发明	ZL201510493961.5	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
962.	一种 TEM 样品制备方法	发明	ZL201510493945.6	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得
963.	一种引线键合去除的方法	发明	ZL201510493865.0	2015-08-12	申请日起二十年	原始取得

964.	金属硬掩模一体化刻蚀中桥接位置的检测方法	发明	ZL201510489081.0	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
965.	弯折探针及其治具	发明	ZL201510489059.6	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
966.	栅极硬掩模层的去除方法	发明	ZL201510489041.6	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
967.	一种避免光刻机镜头过热的方法	发明	ZL201510489028.0	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
968.	抑制反短沟道效应的方法及 NMOS 器件制备方法	发明	ZL201510488879.3	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
969.	一种基于多曝光程序的多硅片循环运动方法	发明	ZL201510488878.9	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
970.	一种平面 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201510487953.X	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
971.	超薄栅氧的制备方法	发明	ZL201510487665.4	2015-08-11	申请日起二十年	原始取得
972.	一种引入套刻误差的光刻工艺规则检查方法	发明	ZL201510460417.0	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
973.	一种自动放行 WAT PM 探针卡的系统及方法	发明	ZL201510460280.9	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
974.	一种双浅沟槽隔离形成方法	发明	ZL201510460278.1	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
975.	一种栅介质层的制备方法	发明	ZL201510460277.7	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得

976.	一种晶圆支撑件的清洗装置及清洗方法	发明	ZL201510460195.2	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
977.	一种重复单元结构 TEM 样品的定位方法	发明	ZL201510460194.8	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
978.	一种在线测试半导体器件衬底	发明	ZL201510459334.X	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
979.	一种避免在形成金属硅化物工艺中接触孔尺寸偏移的方法	发明	ZL201510459314.2	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
980.	一种集成电路芯片反向工程的定位方法	发明	ZL201510459284.5	2015-07-30	申请日起二十年	原始取得
981.	栅极区域的光学临近修正验证方法	发明	ZL201510456589.0	2015-07-29	申请日起二十年	原始取得
982.	离子注入层光刻胶膜厚的优化方法	发明	ZL201510456455.9	2015-07-29	申请日起二十年	原始取得
983.	针对特定重复图形的光学临近效应修正方法	发明	ZL201510435966.2	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
984.	一种同时形成一维和二维光刻胶图形的方法	发明	ZL201510435960.5	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得

985.	通过优化电荷释放步骤工艺条件改善球状缺陷的方法	发明	ZL201510435956.9	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
986.	一种测试 SRAM 共享接触孔与多晶硅接触电阻的结构	发明	ZL201510435944.6	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
987.	一种晶圆反应腔室及晶圆反应腔室之晶圆保护方法	发明	ZL201510435942.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
988.	一种测试 SRAM 共享接触孔与有源区接触电阻的结构	发明	ZL201510435916.4	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
989.	金属电迁移测试结构以及金属电迁移测试方法	发明	ZL201510435910.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
990.	进出气装置、具有进出气装置之热处理机台及进出气方法	发明	ZL201510435906.0	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
991.	形成不同深度沟槽的集成电路制造方法	发明	ZL201510435897.5	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
992.	晶圆测试管理系统及方法	发明	ZL201510435476.2	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
993.	一种同时形成一维和二维光刻胶图形的方法	发明	ZL201510435445.7	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得

994.	一种 SPC 策略自动更新方法及 SPC 自动策略系统	发明	ZL201510435372.1	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
995.	一种半导体工艺生产线的派工方法及系统	发明	ZL201510435344.X	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
996.	掩模板表面微尘去除装置及除尘方法	发明	ZL201510435342.0	2015-07-22	申请日起二十年	原始取得
997.	一种节省光罩的 CMOS 阱形成方法	发明	ZL201510430138.X	2015-07-21	申请日起二十年	原始取得
998.	一种双位无结闪存存储器及其编程、擦除和读取方法	发明	ZL201510422547.5	2015-07-17	申请日起二十年	原始取得
999.	金属氧化物金属电容器制作方法	发明	ZL201510375658.5	2015-06-30	申请日起二十年	原始取得
1000.	针对晶圆晶边的化学气相沉积工艺腔及化学气相沉积方法	发明	ZL201510375630.1	2015-06-30	申请日起二十年	原始取得
1001.	刻蚀映射关系模型和控制浅槽隔离刻蚀关键尺寸的方法	发明	ZL201510369469.7	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1002.	侧墙的形成方法	发明	ZL201510369468.2	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得

1003.	改善磷硅玻璃中磷分布均匀性的方法	发明	ZL201510369420.1	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1004.	双层套刻精度控制层次管理的方法、校准标记及测量系统	发明	ZL201510369337.4	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1005.	一种镍硅化物的形成方法	发明	ZL201510369145.3	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1006.	一种探针卡	发明	ZL201510367325.8	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1007.	一种掩膜板及孤立孔寻址图形在测量中的应用方法	发明	ZL201510367319.2	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1008.	一种制作镍硅化物的方法	发明	ZL201510367130.3	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1009.	一种镍硅化物的优化方法	发明	ZL201510367108.9	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1010.	一种镍硅化物的制作方法	发明	ZL201510367094.0	2015-06-29	申请日起二十年	原始取得
1011.	一种跨导恒定的差分对输入电路	发明	ZL201510309771.3	2015-06-08	申请日起二十年	原始取得
1012.	一种控制静电吸盘吸力的方法	发明	ZL201510277990.8	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1013.	一种基于动态电压衬度分析的样品制备方法	发明	ZL201510277921.7	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1014.	一种用于器件建模的标准单元选择方法	发明	ZL201510277904.3	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得

1015.	一种金属硬质掩模一体化刻蚀通孔过刻蚀量的检测方法	发明	ZL201510277903.9	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1016.	一种降低图像传感器暗电流的方法	发明	ZL201510277901.X	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1017.	一种晶圆曝光顺序的优化方法	发明	ZL201510277863.8	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1018.	探针针痕位置的检测系统及方法	发明	ZL201510277862.3	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1019.	一种混合晶向无结 CMOS 结构	发明	ZL201510276547.9	2015-05-27	申请日起二十年	原始取得
1020.	光刻抗反射层的离线监控方法	发明	ZL201510272206.4	2015-05-25	申请日起二十年	原始取得
1021.	通过工艺集成优化减小半导体器件性能调试难度的方法	发明	ZL201510249105.5	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
1022.	一种改善不同晶片之间有源区关键尺寸差异的方法	发明	ZL201510249102.1	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
1023.	一种提高芯片去层次时均匀度的方法	发明	ZL201510248913.X	2015-05-15	申请日起二十年	原始取得
1024.	减少聚合物产生的光刻化学品喷涂系统及控制方法	发明	ZL201510225370.X	2015-05-04	申请日起二十年	原始取得
1025.	一种离子注入机的剂量匹配方法	发明	ZL201510216741.8	2015-04-30	申请日起二十年	原始取得

1026.	一种刻蚀反应腔体的清洁方法	发明	ZL201510213483.8	2015-04-29	申请日起二十年	原始取得
1027.	一种嵌入式锗硅结构的制作方法	发明	ZL201510213373.1	2015-04-29	申请日起二十年	原始取得
1028.	一种监控光刻机台稳定性的方法及系统	发明	ZL201510199044.6	2015-04-23	申请日起二十年	原始取得
1029.	一种透射电镜样品的制备方法及定位方法	发明	ZL201510199043.1	2015-04-23	申请日起二十年	原始取得
1030.	一种铜互连的制备方法	发明	ZL201510198901.0	2015-04-22	申请日起二十年	原始取得
1031.	一种 SONOS 双栅闪存器件及其编译方法	发明	ZL201510198895.9	2015-04-22	申请日起二十年	原始取得
1032.	用于使用保形填充层改善器件表面均匀性的方法和系统	发明	ZL201510189718.4	2015-04-20	申请日起二十年	原始取得
1033.	等离子体刻蚀装置及提高硅钴镍刻蚀效率的方法	发明	ZL201510174002.7	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1034.	一种 Flash 产品的 ONO 薄膜缺陷的失效分析方法	发明	ZL201510174001.2	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1035.	降低多孔 low-k 材料的 k 值的互连工艺	发明	ZL201510173995.6	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得

1036.	钴阻挡层的形成方法和金属互连工艺	发明	ZL201510173198.8	2015-04-13	申请日起二十年	原始取得
1037.	光刻对准标记结构及其制造方法	发明	ZL201510149621.0	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1038.	一种气体喷嘴	发明	ZL201510149062.3	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1039.	一种掩膜版装载盒	发明	ZL201510149035.6	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1040.	改善 ArF 光阻在硅片表面上的黏附性的方法	发明	ZL201510149034.1	2015-03-31	申请日起二十年	原始取得
1041.	晶片刻蚀腔室的清洗方法	发明	ZL201510145288.6	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1042.	集成目标图形优化与光学邻近修正的方法	发明	ZL201510144598.6	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1043.	接触孔的形成方法	发明	ZL201510144276.1	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1044.	一种解决光罩图形单元 ESD 现象的处理方法	发明	ZL201510144260.0	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1045.	检测刻蚀负载效应的方法	发明	ZL201510144256.4	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1046.	一种基于模型的离子析出缺陷改善方法	发明	ZL201510144225.9	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1047.	一种晶圆边缘缺陷的检测方法	发明	ZL201510144223.X	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得

1048.	根据集成电路制程能力指数自动调整抽检频率的量测方法	发明	ZL201510144222.5	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1049.	一种 TEM 样品制备方法	发明	ZL201510144200.9	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1050.	一种提高二维图形解析度的工艺方法	发明	ZL201510144159.5	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1051.	栅氧层缺陷检测方法及器件漏电检测方法	发明	ZL201510144158.0	2015-03-30	申请日起二十年	原始取得
1052.	一种通过显微镜法实现纳米级套刻精度的方法	发明	ZL201510133717.8	2015-03-25	申请日起二十年	原始取得
1053.	一种浮栅闪存器件及其编译方法	发明	ZL201510128242.3	2015-03-23	申请日起二十年	原始取得
1054.	晶圆可接受性测试机台内部环境的监测方法和监测装置	发明	ZL201510128230.0	2015-03-23	申请日起二十年	原始取得
1055.	一种监控电子显微镜真空腔体洁净度的方法	发明	ZL201510126619.1	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1056.	一种检测接触孔过度刻蚀的方法	发明	ZL201510126618.7	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1057.	相邻两个同电位通孔的光学临近修正方法	发明	ZL201510126616.8	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得

1058.	一种侦测图形底部光刻胶残留的缺陷检测方法	发明	ZL201510126604.5	2015-03-20	申请日起二十年	原始取得
1059.	具有用于嵌入锗材料的成形腔的半导体器件及其双沟槽制造工艺	发明	ZL201510079521.5	2015-02-13	申请日起二十年	原始取得
1060.	具有用于嵌入锗材料的成形腔的半导体器件及其制造工艺	发明	ZL201510079513.0	2015-02-13	申请日起二十年	原始取得
1061.	嵌入式 SiGe 外延测试块的设计	发明	ZL201510050661.X	2015-01-30	申请日起二十年	原始取得
1062.	用于改善 SiGe 厚度的均匀性的方法和系统	发明	ZL201510035496.0	2015-01-23	申请日起二十年	原始取得
1063.	一种 UV 处理机台工艺性能的日常检查方法	发明	ZL201410714988.8	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1064.	一种接触孔刻蚀装置及刻蚀方法	发明	ZL201410714909.3	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1065.	ONO 介质层的制备方法	发明	ZL201410714893.6	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1066.	消除多晶硅刻蚀工艺中多晶硅残余的方法	发明	ZL201410714842.3	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1067.	一种光刻工艺热点的自动修复方法	发明	ZL201410714799.0	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得

1068.	一种改善金属硅化物的方法	发明	ZL201410714798.6	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1069.	一种测定薄膜研磨速率的方法	发明	ZL201410710267.X	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1070.	一种改善金属硅化物的方法	发明	ZL201410710161.X	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1071.	一种离子注入机的预处理方法	发明	ZL201410710134.2	2014-11-28	申请日起二十年	原始取得
1072.	嵌入式碳化硅的制备方法	发明	ZL201410697561.1	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1073.	改善 SiGe CMOS 工艺中 PMOS 器件的电学性能的方法	发明	ZL201410697473.1	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1074.	一种采用存储器监测器件制程余量的方法	发明	ZL201410697305.2	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1075.	嵌入式锗硅器件的制作方法	发明	ZL201410693124.2	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1076.	一种 TEM 样品的制备方法	发明	ZL201410692996.7	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1077.	DC-DC 转换电路	发明	ZL201410692975.5	2014-11-26	申请日起二十年	原始取得
1078.	NMOS 器件的硅衬底表面的处理方法及 NMOS 器件的制作方法	发明	ZL201410664725.0	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1079.	改善浅沟槽隔离边缘 SiC 应力性能的方法	发明	ZL201410664592.7	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得
1080.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201410664315.6	2014-11-19	申请日起二十年	原始取得

1081.	晶圆净化装置、刻蚀机台及大马士革刻蚀方法	发明	ZL201410654598.6	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1082.	一种闪存器件及其编程方法	发明	ZL201410654597.1	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1083.	一种 SONOS 闪存器件的编译方法	发明	ZL201410654584.4	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1084.	一种浮栅闪存器件及其编程方法	发明	ZL201410654582.5	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1085.	一种 SONOS 闪存器件及其编译方法	发明	ZL201410654511.5	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1086.	一种降低源极和漏极电阻的方法	发明	ZL201410654365.6	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1087.	降低源极和漏极电阻的结构和方法	发明	ZL201410654361.8	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1088.	一种静电吸盘性能的监测方法	发明	ZL201410652825.1	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1089.	一种接触孔关键尺寸的控制方法	发明	ZL201410652823.2	2014-11-17	申请日起二十年	原始取得
1090.	根据特殊电路结构脱落缺陷确定可疑工艺步骤的方法	发明	ZL201410629236.1	2014-11-10	申请日起二十年	原始取得
1091.	后段铜互连工艺中降低通孔间介质材料的 K 值的方法	发明	ZL201410625362.X	2014-11-07	申请日起二十年	原始取得

1092.	改善浅沟槽隔离边缘 SiC 应力性能的方法	发明	ZL201410619982.2	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1093.	SiGe 源漏 MOS 器件制造方法	发明	ZL201410619373.7	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1094.	半导体器件的形成方法	发明	ZL201410618097.2	2014-11-05	申请日起二十年	原始取得
1095.	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	发明	ZL201410597402.4	2014-10-29	申请日起二十年	原始取得
1096.	背面探测式光子辐射显微镜装置及测试方法	发明	ZL201410597388.8	2014-10-29	申请日起二十年	原始取得
1097.	一种调节高压器件电性的多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201410522341.5	2014-09-30	申请日起二十年	原始取得
1098.	改善 HCD 氮化硅沉积工艺的应力缺陷的方法	发明	ZL201410520740.8	2014-09-30	申请日起二十年	原始取得
1099.	浅沟槽隔离的制造方法	发明	ZL201410491604.0	2014-09-24	申请日起二十年	原始取得
1100.	一种探针卡清针装置	发明	ZL201410491591.7	2014-09-24	申请日起二十年	原始取得
1101.	铜互连的扩散阻挡层、半导体器件及其制造方法	发明	ZL201410487739.X	2014-09-23	申请日起二十年	原始取得
1102.	一种用于制备等离子氮化栅极介质层的方法	发明	ZL201410443794.9	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得

1103.	高深宽比沟槽刻蚀残留缺陷的检测方法	发明	ZL201410443792.X	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1104.	改善亮场机台缺陷扫描精度的方法	发明	ZL201410443791.5	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1105.	消息中间件的监控系统	发明	ZL201410443404.8	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1106.	一种接触孔可靠性测试装置	发明	ZL201410443389.7	2014-09-02	申请日起二十年	原始取得
1107.	一种对图形结构刻蚀能力的检测方法	发明	ZL201410441474.X	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1108.	一种用于缺陷分类的光学检测方法	发明	ZL201410441473.5	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1109.	一种检测离子阱注入形貌对器件性能影响的方法	发明	ZL201410441471.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1110.	一种清洗设备颗粒监控的方法	发明	ZL201410441448.7	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1111.	预防机台偏移对产品造成机械刮伤的方法	发明	ZL201410441418.6	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1112.	一种提高外延机台产能的装置与方法	发明	ZL201410440501.1	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得

1113.	一种刻蚀装置与方法	发明	ZL201410440490.7	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1114.	改善晶圆边缘缺陷的装置	发明	ZL201410440477.1	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1115.	样品座	发明	ZL201410440457.4	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1116.	一种检测图形尺寸对离子阱形貌影响的方法	发明	ZL201410440456.X	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1117.	一种检测扫描机台的性能方法	发明	ZL201410440447.0	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1118.	一种光罩图形缺陷检测系统及方法	发明	ZL201410440440.9	2014-09-01	申请日起二十年	原始取得
1119.	减少修正迭代次数的 OPC 方法	发明	ZL201410428712.3	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1120.	n 沟道 SONOS 器件及其编译方法	发明	ZL201410428695.3	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1121.	一种双接触孔刻蚀停止层的制作方法	发明	ZL201410428687.9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1122.	用于镍硅合金化工艺的阻挡层的制备方法	发明	ZL201410428597.X	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1123.	改善激光退火热分布的方法	发明	ZL201410428585.7	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1124.	一种光罩自动派工控制方法及控制系统	发明	ZL201410428244.X	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得

1125.	n 沟道非易失性存储元件及其编译方法	发明	ZL201410427477.8	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1126.	SONOS 闪存器件及其编译方法	发明	ZL201410427471.0	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1127.	闪存器件的编程方法	发明	ZL201410427436.9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1128.	一种提高钴阻挡层沉积选择比的方法	发明	ZL201410427394.9	2014-08-27	申请日起二十年	原始取得
1129.	电子束缺陷扫描装置及方法	发明	ZL201410414994.1	2014-08-21	申请日起二十年	原始取得
1130.	晶圆缺陷扫描方法	发明	ZL201410414597.4	2014-08-21	申请日起二十年	原始取得
1131.	梯度式干法去胶方法	发明	ZL201410412283.0	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1132.	静态存储器的检测设备及检测方法	发明	ZL201410411989.5	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1133.	一种修复超低介质常数薄膜侧壁损伤的方法	发明	ZL201410411975.3	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1134.	一种减少超低介质常数薄膜侧壁损伤的方法	发明	ZL201410411972.X	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1135.	一种防止化学机械研磨时微观刮伤的研磨方法	发明	ZL201410411838.X	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得

1136.	形成浅沟槽隔离结构的方法	发明	ZL201410410384.4	2014-08-20	申请日起二十年	原始取得
1137.	末端射程损伤的检测以及修复方法	发明	ZL201410403765.X	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1138.	图形预处理方法以及测量图形密度的方法	发明	ZL201410403759.4	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1139.	改善 PMOS 器件性能的离子注入方法	发明	ZL201410403757.5	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1140.	用于多孔低介电常数材料的紫外光固化工艺方法	发明	ZL201410403729.3	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1141.	改善多孔低介电常数材料垂直均匀性的方法	发明	ZL201410403327.3	2014-08-15	申请日起二十年	原始取得
1142.	半导体制造过程的监控方法及半导体生产方法	发明	ZL201410390822.5	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1143.	根据图形特征对自动聚焦光强进行补偿的缺陷检测方法	发明	ZL201410390806.6	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1144.	湿法清洗工艺设备颗粒监控方法	发明	ZL201410390799.X	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得

1145.	一种提高同测数的新型测试开发方法	发明	ZL201410390798.5	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1146.	通过刻蚀不足缺陷检测多晶硅与连接孔对准度的方法	发明	ZL201410390797.0	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1147.	一种浅沟槽隔离结构的制造方法	发明	ZL201410390784.3	2014-08-08	申请日起二十年	原始取得
1148.	通过栅氧的双氧化提高栅氧均匀性的方法	发明	ZL201410390774.X	2014-09-18	申请日起二十年	原始取得
1149.	一种产品通孔刻蚀缺陷的检测方法	发明	ZL201410377465.9	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1150.	半导体器件缺陷的光学检测方法	发明	ZL201410377459.3	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1151.	晶圆缺陷监控方法	发明	ZL201410377374.5	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1152.	静态存储器的在线失效分析方法及在线电子束检测设备	发明	ZL201410377359.0	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1153.	量测群组设备及量测方法	发明	ZL201410377345.9	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得
1154.	一种对缺陷进行选择性检测的方法	发明	ZL201410377341.0	2014-08-01	申请日起二十年	原始取得

1155.	一种具有凸面栅极结构的 B4-Flash	发明	ZL201410375182.0	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1156.	一种有效验证探针卡异常的方法	发明	ZL201410374767.0	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1157.	气体过滤方法	发明	ZL201410374698.3	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1158.	一种具有凸面栅极结构的 B4-Flash	发明	ZL201410374646.6	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1159.	一种无结晶体管	发明	ZL201410374634.3	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1160.	用于制作嵌入式锗硅的方法	发明	ZL201410374256.9	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1161.	曝光辅助图形的优化方法	发明	ZL201410371051.5	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1162.	一种透射电镜样品的制备方法	发明	ZL201410370914.7	2014-07-31	申请日起二十年	原始取得
1163.	测试结构及其测试方法	发明	ZL201410369986.X	2014-07-30	申请日起二十年	原始取得
1164.	浅沟槽隔离的工艺方法	发明	ZL201410359893.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1165.	CMOS 中 P 型源漏离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357338.2	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1166.	P 型轻掺杂离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357335.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得

1167.	N 型轻掺杂离子注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357285.4	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1168.	利用同型结监控 N 型源漏离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357283.5	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1169.	恒温测试系统及温度监测方法	发明	ZL201410357245.X	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1170.	一种通孔刻蚀不足的检测方法	发明	ZL201410357244.5	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1171.	利用同型结监控 N 型轻掺杂离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357242.6	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1172.	一种改善通孔刻蚀后晶圆表面微环境的方法	发明	ZL201410357201.7	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1173.	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201410357183.2	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1174.	CMOS 中 N 型源漏注入对准度的监控结构及方法	发明	ZL201410357182.8	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1175.	利用同型结监控 P 型轻掺杂离子注入对准度的结构及方法	发明	ZL201410357174.3	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1176.	负偏压温度不稳定性评估方法	发明	ZL201410357130.0	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1177.	一种通孔刻蚀不足的检测方法	发明	ZL201410357129.8	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得

1178.	形成浅沟槽隔离结构的方法	发明	ZL201410357127.9	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1179.	一种消除连接孔刻蚀副产物凝结缺陷的晶圆净化设备	发明	ZL201410357115.6	2014-07-25	申请日起二十年	原始取得
1180.	炉管清洗工艺	发明	ZL201410356934.9	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1181.	监控图形晶片栅极氧化层表面的方法	发明	ZL201410356924.5	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1182.	监控图形晶片栅极氧化层表面的方法	发明	ZL201410356373.2	2014-07-24	申请日起二十年	原始取得
1183.	减少自对准硅化镍尖峰缺陷和管道缺陷的方法	发明	ZL201410331759.8	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1184.	半导体制造的多平行动态流程控制方法	发明	ZL201410331742.2	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1185.	晶圆边缘非晶碳薄膜清除装置及方法	发明	ZL201410331729.7	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1186.	测试结构的断路定位方法	发明	ZL201410331726.3	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得
1187.	OPC 修正方法	发明	ZL201410331704.7	2014-07-11	申请日起二十年	原始取得

1188.	消除晶圆曝光失焦缺陷的吸盘及方法	发明	ZL201410321501.X	2014-07-08	申请日起二十年	原始取得
1189.	半导体工艺方法以及半导体结构	发明	ZL201410315127.2	2014-07-03	申请日起二十年	原始取得
1190.	并行测试系统及其测试方法	发明	ZL201410307559.9	2014-06-30	申请日起二十年	原始取得
1191.	干氧扩散过程中氧在硅基片中扩散系数的确定方法	发明	ZL201410306975.7	2014-06-30	申请日起二十年	原始取得
1192.	一种解决 TEOS 机台保养后颗粒跳高的方法	发明	ZL201410286826.9	2014-06-24	申请日起二十年	原始取得
1193.	浸没式光刻工艺方法	发明	ZL201410276008.0	2014-06-19	申请日起二十年	原始取得
1194.	掩膜板图形的形成方法和光刻及刻蚀方法	发明	ZL201410275987.8	2014-06-19	申请日起二十年	原始取得
1195.	电击穿测试结构	发明	ZL201410274268.4	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1196.	半导体器件的制备方法	发明	ZL201410273962.4	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1197.	半导体生产约束管控方法	发明	ZL201410273947.X	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1198.	SONOS B4-flash 存储器	发明	ZL201410273620.2	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1199.	一种提高图形搜索准确率的方法	发明	ZL201410273618.5	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1200.	一种晶圆横向水平对准的方法	发明	ZL201410273408.6	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得

1201.	一种晶圆边缘找平的方法	发明	ZL201410273168.X	2014-06-18	申请日起二十年	原始取得
1202.	光刻机对准性能的检测方法	发明	ZL201410261079.3	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1203.	一种在线确定光刻工艺窗口的方法	发明	ZL201410261076.X	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1204.	铝刻蚀工艺用聚焦环、铝刻蚀工艺	发明	ZL201410260820.4	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1205.	晶圆曝光布局的优化方法	发明	ZL201410260817.2	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1206.	一种用于光刻胶厚度摆动曲线测试的硅片及制作方法	发明	ZL201410260816.8	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1207.	离子注入层图形线宽尺寸的优化方法	发明	ZL201410260767.8	2014-06-12	申请日起二十年	原始取得
1208.	机台之机械手臂偏移的检测装置及其检测方法	发明	ZL201410258529.3	2014-06-11	申请日起二十年	原始取得
1209.	小尺寸样品层次去除方法	发明	ZL201410254088.X	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1210.	一种低功耗高稳定性的复位电路	发明	ZL201410254082.2	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1211.	一种采用双侧墙工艺形成超低尺寸图形的方法	发明	ZL201410253948.8	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得

1212.	SRAM 版图的生成方法	发明	ZL201410253555.7	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1213.	利用氮注入改善锗硅选择性外延的侧墙淀积问题的方法	发明	ZL201410253551.9	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1214.	PMOS 器件漏电测量方法	发明	ZL201410253237.0	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1215.	一种采用双侧墙工艺形成超低尺寸图形的方法	发明	ZL201410253213.5	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1216.	通孔链结构的失效分析方法	发明	ZL201410253207.X	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1217.	半导体芯片失效分析的方法	发明	ZL201410253203.1	2014-06-09	申请日起二十年	原始取得
1218.	一种化学机械研磨后的清洗装置	发明	ZL201410228259.1	2014-05-27	申请日起二十年	原始取得
1219.	铜互连大马士革工艺方法	发明	ZL201410217938.9	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1220.	金属互连结构及其制造方法	发明	ZL201410217927.0	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1221.	一次性可编程器件的制造方法	发明	ZL201410217798.5	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1222.	侧墙结构、侧墙结构的制备方法、CMOS 器件	发明	ZL201410217721.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1223.	辅助图形的设计方法、测试版图的制作方法、光刻方法	发明	ZL201410217697.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得

1224.	一种优化离子注入区域形貌的方法	发明	ZL201410217696.3	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1225.	锁存比较器	发明	ZL201410217637.6	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1226.	一种内介电层的制备方法	发明	ZL201410217636.1	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1227.	一种监控电子显微镜化学油污污染的方法	发明	ZL201410216685.3	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1228.	应用晶边扫描预防线状分布缺陷发生的方法	发明	ZL201410216683.4	2014-05-21	申请日起二十年	原始取得
1229.	一种消除晶边颗粒残留的铝刻蚀前置工艺方法	发明	ZL201410215840.X	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1230.	离子注入设备及离子注入方法	发明	ZL201410215837.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1231.	一种改善晶圆尖峰退火均一性的校准方法	发明	ZL201410215824.0	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1232.	单电容振荡器	发明	ZL201410215811.3	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1233.	高粘度光刻胶的涂布方法、光刻方法	发明	ZL201410215788.8	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得

1234.	一种探针卡探针的颗粒物清洁控制方法	发明	ZL201410215781.6	2014-05-20	申请日起二十年	原始取得
1235.	金属互连线拼接版图结构	发明	ZL201410193170.6	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1236.	一种低介电常数薄膜的成膜方法	发明	ZL201410193144.3	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1237.	一种形成低介电常数薄膜及其缓冲层的成膜方法	发明	ZL201410193143.9	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1238.	氧化硅薄膜制备方法	发明	ZL201410192908.7	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1239.	硅通孔绝缘层制备方法	发明	ZL201410192894.9	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1240.	金属硬掩膜结构、制造方法及铜互连结构制造方法	发明	ZL201410192846.X	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1241.	一种用于硅通孔形貌修正的 SiCoNi 蚀刻方法	发明	ZL201410192806.5	2014-05-08	申请日起二十年	原始取得
1242.	测试结构及其版图生成方法	发明	ZL201410182131.6	2014-04-30	申请日起二十年	原始取得
1243.	一种传输晶体管结构	发明	ZL201410174842.9	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1244.	一种浅沟槽氧化物空洞和浮栅极多晶硅凹点的消除方法	发明	ZL201410174759.1	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1245.	一种有源区制备方法	发明	ZL201410174736.0	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得

1246.	一种用于光阻喷嘴的清洗槽体结构及其应用	发明	ZL201410174612.2	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1247.	一种栅极侧墙减薄工艺	发明	ZL201410174441.3	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1248.	一个光罩内的单元芯片存在不同图像条件的缺陷扫描方法	发明	ZL201410173942.X	2014-04-28	申请日起二十年	原始取得
1249.	晶圆回收方法	发明	ZL201410164593.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1250.	一种半导体炉管的晶舟	发明	ZL201410164143.6	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1251.	一种缺陷检测和观察设备的位置同步方法	发明	ZL201410164124.3	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1252.	用于预防封装时测试结构短路的保护环和封装测试方法	发明	ZL201410164122.4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1253.	一种新的芯片测试结构	发明	ZL201410164090.8	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1254.	一种消除有源区损伤的多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201410164086.1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1255.	一种离子注入倾角的日常监控方法	发明	ZL201410164080.4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

1256.	一种采用温度模型进行曲线拟合的方法	发明	ZL201410164079.1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1257.	一种快速退火装置的监控方法	发明	ZL201410164077.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1258.	一种闪存的存储单元栅极制备方法	发明	ZL201410164074.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1259.	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201410164057.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1260.	一种套刻精度测量的图像结构及其套刻精度测量方法	发明	ZL201410164035.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1261.	一种管理设备状态转换关系的方法	发明	ZL201410163886.1	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1262.	一种提高光刻工艺窗口的版图处理方法	发明	ZL201410163857.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1263.	一种研磨盘装置	发明	ZL201410163591.4	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1264.	一种集成电路缺陷的分析方法	发明	ZL201410163560.9	2014-07-28	申请日起二十年	原始取得
1265.	降低多晶硅栅极与活化区镍硅化物厚度比的方法	发明	ZL201410163504.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1266.	晶圆测试结果图标记修改方法	发明	ZL201410163495.X	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

1267.	电流检测电路及包括该电流检测电路的电流环控制电路	发明	ZL201410163453.6	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1268.	一种降低在线 WAT 测试对铜互连可靠性影响的方法	发明	ZL201410163450.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1269.	链式通孔结构样品处理方法及失效测试方法	发明	ZL201410163436.2	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1270.	降低多晶硅栅极与活化区镍硅化物厚度比的方法	发明	ZL201410162899.7	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1271.	改善器件负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201410162847.X	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1272.	用于监控炉管无氧氛围的监控片、制造方法及其监控方法	发明	ZL201410162818.3	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1273.	降低手机时间管理模块漏电的工艺改进方法	发明	ZL201410162700.0	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1274.	一种多晶硅上小尺寸图形结构的制备方法	发明	ZL201410161318.8	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1275.	一种激光脉冲退火方法	发明	ZL201410161316.9	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得

1276.	一种底部无负载的自对准双层图形的制作方法	发明	ZL201410161257.5	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1277.	一种监控离子注入机稳定性和均匀性的方法	发明	ZL201410161246.7	2014-04-22	申请日起二十年	原始取得
1278.	围栅型纳米线晶体管	发明	ZL201410145600.7	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1279.	离子注入浓度的校准方法	发明	ZL201410141310.5	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1280.	延长超低介电常数材料的工艺等待时间的方法	发明	ZL201410138998.1	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1281.	一种改进接触孔线宽均一性的刻蚀方法	发明	ZL201410138996.2	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1282.	闪存存储器	发明	ZL201410138977.X	2014-04-08	申请日起二十年	原始取得
1283.	浸润式光刻机浸润部件的自动清洗装置和清洗方法	发明	ZL201410127033.2	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1284.	等离子体刻蚀装置的腔体清洗方法	发明	ZL201410127005.0	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1285.	离线机台利用率计算系统及计算方法	发明	ZL201410126994.1	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得

1286.	透射电镜样品的制备方法	发明	ZL201410126975.9	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1287.	PMOS 制造工艺中减少 e-SiGe 晶格缺陷的方法	发明	ZL201410125554.4	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1288.	用于清洗半导体晶圆的清洗槽	发明	ZL201410125553.X	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1289.	一种添加冗余图形的方法	发明	ZL201410125546.X	2014-03-31	申请日起二十年	原始取得
1290.	原子力显微镜探针装置	发明	ZL201410118223.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1291.	晶圆良率监测方法	发明	ZL201410118221.9	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1292.	原子力显微镜探针装置	发明	ZL201410118215.3	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1293.	一种半导体制造试验工艺流程的建立方法	发明	ZL201410118200.7	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1294.	一种多晶硅层器件辅助图形的绘制方法	发明	ZL201410118199.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1295.	一种双栅氧的制备方法	发明	ZL201410118197.9	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1296.	一种智能探针卡针压控制系统及控制方法	发明	ZL201410118188.X	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1297.	多晶硅残留监测结构	发明	ZL201410117788.4	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1298.	PMOS 器件的制造方法	发明	ZL201410117766.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得

1299.	一种与激光退火工艺问题相关的排除硅片质量因素的方法	发明	ZL201410117759.8	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1300.	一种多通道管控工艺流程的设计方法	发明	ZL201410117735.2	2014-03-27	申请日起二十年	原始取得
1301.	一种智能化选择性目标尺寸调整方法	发明	ZL201410111322.3	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1302.	用于 NDC 薄膜的离线监控方法	发明	ZL201410111309.8	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1303.	一种 NAND 闪存器件及其制造方法	发明	ZL201410111308.3	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1304.	探针卡识别芯片安装方法	发明	ZL201410111293.0	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1305.	晶圆后段电容电性测试结构	发明	ZL201410111285.6	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1306.	层间介质层性能的测试结构和测试方法	发明	ZL201410110743.4	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1307.	双层栅介质层结构及其制备方法	发明	ZL201410110065.1	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1308.	对准图形及晶圆	发明	ZL201410110062.8	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1309.	P 型沟道闪存器件及其制造方法	发明	ZL201410110060.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1310.	用于 WAT 测试的半导体结构	发明	ZL201410110056.2	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得

1311.	监测方法	发明	ZL201410109846.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1312.	离子注入层的光学临近效应修正方法	发明	ZL201410109835.0	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1313.	监测氧化硅沉积工艺中硅损耗的方法	发明	ZL201410109834.6	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1314.	减少互补式金氧半导体影像传感器白像素的方法	发明	ZL201410109814.9	2014-03-24	申请日起二十年	原始取得
1315.	一种优化浅槽隔离刻蚀线宽的方法	发明	ZL201410106820.9	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1316.	一种浅沟槽填充方法	发明	ZL201410106819.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1317.	一种监测低温离子注入的方法	发明	ZL201410106663.1	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1318.	一种防止研磨垫刮伤晶圆的系统	发明	ZL201410106660.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1319.	读取非易失性存储器电流的方法及获取电流分布状态的方法	发明	ZL201410106658.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1320.	一种针对光刻版图接触孔热点的检查方法	发明	ZL201410106641.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得

1321.	一种验证缺陷检测程序灵敏度的方法	发明	ZL201410106633.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1322.	一种稳定 MIM 电容光刻线宽的方法	发明	ZL201410106627.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1323.	一种提高栅氧化层质量的方法	发明	ZL201410106618.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1324.	一种提高 B4-Flash 器件耐久性的方法	发明	ZL201410106616.7	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1325.	一种用于氮掺杂碳化硅薄膜的离线监控方法	发明	ZL201410106607.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1326.	采用电容衬度测试结构检测多晶硅底部桥连缺陷的方法	发明	ZL201410106602.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1327.	一种测试样品的制备方法	发明	ZL201410106589.3	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1328.	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201410106568.1	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1329.	一种用于锁相环电路的锁定检测电路	发明	ZL201410106552.0	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1330.	对没有重复分界的存储区域进行扫描的方法	发明	ZL201410106540.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得

1331.	一种降低镍管道缺陷的方法	发明	ZL201410106537.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1332.	控制栅极刻蚀方法	发明	ZL201410106533.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1333.	一种降低源漏外延生长缺陷的方法	发明	ZL201410106521.5	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1334.	一种金属电迁移结构	发明	ZL201410106505.6	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1335.	一种减少 OPC 修正后验证误报错的方法	发明	ZL201410106502.2	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1336.	探针卡	发明	ZL201410106479.7	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1337.	一种优化等离子体均匀性的压力控制阀门及方法	发明	ZL201410106477.8	2014-03-20	申请日起二十年	原始取得
1338.	离子注入段问题机台的判定方法	发明	ZL201410060668.5	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1339.	芯片分区采集最佳光线偏振信号的缺陷程式建立方法	发明	ZL201410060660.9	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1340.	一种晶圆可接受测试方法	发明	ZL201410060659.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1341.	具有毛刺抑制能力的电流舵型数模转换电路	发明	ZL201410060641.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1342.	用于湿法刻蚀工艺的酸槽	发明	ZL201410060590.7	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得

1343.	采用电容测试结构检测多晶硅栅极刻蚀缺陷的方法	发明	ZL201410060338.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1344.	一种检测多晶硅残留的测试结构	发明	ZL201410060317.4	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1345.	一种 WAT 测试的备份结构及备份方法	发明	ZL201410060309.X	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1346.	采用小窗口图形测试结构检测多晶硅底部桥连缺陷的方法	发明	ZL201410060130.4	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1347.	一种高压晶体管制备工艺	发明	ZL201410060105.6	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1348.	一种晶圆可接受性测试的探针卡自动更换方法	发明	ZL201410059971.3	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1349.	采用离子击穿检测多晶硅底部刻蚀不足缺陷的方法	发明	ZL201410059958.8	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1350.	一种通用型针座及其使用方法	发明	ZL201410059942.7	2014-02-21	申请日起二十年	原始取得
1351.	制备嵌入式锗硅外延前的表面处理方法	发明	ZL201410042486.5	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1352.	用于激光退火机的监控方法	发明	ZL201410042474.2	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得

1353.	改善工艺窗口的光学临近修正方法	发明	ZL201410042455.X	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1354.	自动扩展缺陷图形库的方法	发明	ZL201410042444.1	2014-01-29	申请日起二十年	原始取得
1355.	一种制备空气间隙铜互连结构的方法	发明	ZL201310637734.6	2013-12-02	申请日起二十年	原始取得
1356.	一种利用高深宽比工艺的器件隔离方法	发明	ZL201310632125.1	2013-12-02	申请日起二十年	原始取得
1357.	晶圆多次测试数据的整合方法	发明	ZL201310631845.6	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1358.	多层薄膜层间粘附性能表征及其试样制备方法	发明	ZL201310631772.0	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1359.	浮栅晶体管阵列及其制备方法	发明	ZL201310631488.3	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1360.	电流舵数模转换器电流源阵列的版图结构	发明	ZL201310631462.9	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1361.	通孔或接触孔的形成方法	发明	ZL201310631359.4	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1362.	双大马士革结构的制造方法	发明	ZL201310631357.5	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1363.	控制多晶硅栅极关键尺寸的方法	发明	ZL201310630338.0	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1364.	离子注入角度监控方法	发明	ZL201310630276.3	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得

1365.	干法工艺稳定性和匹配性的判断方法	发明	ZL201310630263.6	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1366.	CMOS 器件栅氧化层的制造方法	发明	ZL201310630240.5	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1367.	双大马士革结构的制造方法	发明	ZL201310630206.8	2013-11-29	申请日起二十年	原始取得
1368.	改善 HDP PSG 工艺的方法及金属沉积前的介电质层制造方法	发明	ZL201310625737.8	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1369.	基于规则图形过滤的版图设计光刻工艺友善性检查方法	发明	ZL201310625726.X	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1370.	CMOS 感光器件接触孔刻蚀方法及 CMOS 感光器件制造方法	发明	ZL201310625589.X	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1371.	TEM 样品的制作方法及其 TEM 样品	发明	ZL201310625537.2	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1372.	一种晶圆可接受性测试系统及方法	发明	ZL201310625206.9	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1373.	一种铝衬垫制备方法	发明	ZL201310625197.3	2013-11-28	申请日起二十年	原始取得
1374.	栅极侧墙图形化的方法	发明	ZL201310616217.0	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1375.	一种 WAT 测试头的布置方法	发明	ZL201310612743.X	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得

1376.	一种低介电常数薄膜的紫外线处理方法	发明	ZL201310612730.2	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
1377.	十字型探针卡	发明	ZL201310565733.5	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1378.	三维容错性自寻路径交叉开关矩阵设备	发明	ZL201310565679.4	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1379.	一种浅沟槽隔离结构的形成方法	发明	ZL201310565677.5	2013-11-13	申请日起二十年	原始取得
1380.	一种炉管设备的组批派工系统和方法	发明	ZL201310554674.1	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1381.	DRC 文件的坐标数据对比方法	发明	ZL201310554644.0	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1382.	一种软启动电路及包括该软启动电路的 DC-DC 电路	发明	ZL201310554631.3	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1383.	开关装置及具有该开关装置的多通道耦合选择器	发明	ZL201310554295.2	2013-11-08	申请日起二十年	原始取得
1384.	浅沟槽隔离结构制备方法	发明	ZL201310530767.0	2013-10-30	申请日起二十年	原始取得
1385.	曝光机文件自动检查系统	发明	ZL201310506771.3	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1386.	SECS/GEM 消息交换设备和方法	发明	ZL201310505310.4	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得

1387.	一种形成多层复合式接触孔刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201310505137.8	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1388.	多种类硅化物掩膜层的形成方法	发明	ZL201310505099.6	2013-10-23	申请日起二十年	原始取得
1389.	一种 CMOS 图像传感器有源像素的结构及其制造方法	发明	ZL201310495735.1	2013-10-21	申请日起二十年	原始取得
1390.	减小负偏压温度不稳定性的 CMOS 器件制作方法	发明	ZL201310492053.5	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1391.	一种金属硬掩膜层及铜互连结构的制备方法	发明	ZL201310491799.4	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1392.	一种光刻胶填充式金属互连结构及其制造方法	发明	ZL201310491613.5	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1393.	嵌入式锗硅工艺中静态随机存储器及写入冗余度改善方法	发明	ZL201310491611.6	2013-10-18	申请日起二十年	原始取得
1394.	一种用于非晶碳沉积工艺中的清洗方法	发明	ZL201310461217.8	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
1395.	一种在芯片失效分析过程中去除层次的方法	发明	ZL201310460450.4	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得

1396.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310449849.2	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1397.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432459.4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1398.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432456.0	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1399.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432448.6	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1400.	制作栅极线条的方法	发明	ZL201310432435.9	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1401.	制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432414.7	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1402.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310432385.4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1403.	能简化极小线宽栅极线条的制作工艺的栅极线条制作方法	发明	ZL201310432087.5	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1404.	一种可按照离子注入区域分类的电子束缺陷检测方法	发明	ZL201310432063.X	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1405.	解决氮化硅和镍硅化物界面剥落问题的工艺方法	发明	ZL201310432018.4	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得
1406.	提高源漏接触和氮化硅薄膜黏附力的方法	发明	ZL201310432014.6	2013-09-22	申请日起二十年	原始取得

1407.	一种金属硬掩膜层及铜互连结构的制备方法	发明	ZL201310380002.3	2013-08-27	申请日起二十年	原始取得
1408.	应用于栅极线尾切割的双重图形成型方法	发明	ZL201310360830.0	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1409.	栅极 LELE 双重图形成型方法	发明	ZL201310360404.7	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1410.	基于 DARC 掩膜结构的栅极 LELE 双重图形成型方法	发明	ZL201310360385.8	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1411.	基于 DARC 掩膜结构的双重图形成型方法	发明	ZL201310360384.3	2013-08-16	申请日起二十年	原始取得
1412.	双深度浅沟道隔离槽的刻蚀工艺	发明	ZL201310354785.8	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1413.	多晶硅炉管生长厚度监测方法	发明	ZL201310354782.4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1414.	高压 ESD 器件版图结构以及包含该版图结构的芯片	发明	ZL201310354719.0	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1415.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354689.3	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1416.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354686.X	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得

1417.	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201310354616.4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1418.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354609.4	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1419.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354608.X	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1420.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354606.0	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1421.	双重曝光制作高均匀度栅极线条的方法	发明	ZL201310354604.1	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1422.	接触孔的刻蚀方法	发明	ZL201310354603.7	2013-08-14	申请日起二十年	原始取得
1423.	改善有源区损伤的方法	发明	ZL201310337067.X	2013-08-02	申请日起二十年	原始取得
1424.	SRAM 失配晶体管检测方法	发明	ZL201310317737.1	2013-07-25	申请日起二十年	原始取得
1425.	用于测试 MIM 电容的半导体结构	发明	ZL201310312455.2	2013-07-23	申请日起二十年	原始取得
1426.	SONOS 器件中 ONO 结构的制造方法	发明	ZL201310302913.4	2013-07-18	申请日起二十年	原始取得
1427.	高压 NPN 器件及其版图结构	发明	ZL201310286451.1	2013-07-09	申请日起二十年	原始取得

1428.	检测通孔蚀刻不足和通孔缺失缺陷的方法	发明	ZL201310286389.6	2013-07-09	申请日起二十年	原始取得
1429.	改善电容器件击穿电压的方法	发明	ZL201310265059.9	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1430.	一种可按照工艺晶圆数量负载动态调整的缺陷抽检方法	发明	ZL201310264843.8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1431.	增强光刻工艺能力的装置及利用该装置进行的光刻工艺	发明	ZL201310264730.8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1432.	检测多晶硅栅极与接触孔对准度的方法	发明	ZL201310264726.1	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1433.	双结构接触孔同步刻蚀工艺	发明	ZL201310264711.5	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1434.	改善栅氧有源区缺陷的方法	发明	ZL201310264408.5	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1435.	检测接触孔与多晶硅栅极对准度的方法	发明	ZL201310262927.8	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1436.	抗反射涂层填充式超低介电常数之铜互连制造方法	发明	ZL201310262907.0	2013-06-27	申请日起二十年	原始取得
1437.	版图数据的处理方法	发明	ZL201310258304.3	2013-06-26	申请日起二十年	原始取得
1438.	栅极的形成方法	发明	ZL201310258301.X	2013-06-26	申请日起二十年	原始取得

1439.	测算接触孔与多晶硅栅极对准偏差值的方法	发明	ZL201310256841.4	2013-06-25	申请日起二十年	原始取得
1440.	测算接触孔与多晶硅栅极对准偏差值的方法	发明	ZL201310256206.6	2013-06-25	申请日起二十年	原始取得
1441.	保护浅沟槽隔离区的方法	发明	ZL201310253617.X	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1442.	改善硅片背面金属污染的方法	发明	ZL201310253594.2	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1443.	改善 GP CMOS 器件的电性参数均一性的方法	发明	ZL201310253193.7	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1444.	一种多功能半导体样品夹具	发明	ZL201310253153.2	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1445.	改善半导体器件电性参数的方法	发明	ZL201310253134.X	2013-06-24	申请日起二十年	原始取得
1446.	光学临近效应修正方法	发明	ZL201310229404.3	2013-06-08	申请日起二十年	原始取得
1447.	改善半导体器件良率的方法	发明	ZL201310222267.0	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1448.	一种制备铜种子层的方法	发明	ZL201310221366.7	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1449.	改善 CMOS 图像传感器性能的方法	发明	ZL201310221336.6	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1450.	一种快速高效的晶背缺陷识别方法	发明	ZL201310220498.8	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得

1451.	flash 抗编程串扰的优化方法	发明	ZL201310220497.3	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1452.	一种缺陷扫描结果控制制程机台的派工方法	发明	ZL201310220485.0	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1453.	改善半导体器件负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201310220483.1	2013-06-04	申请日起二十年	原始取得
1454.	Σ形凹槽的制作方法	发明	ZL201310217267.1	2013-06-03	申请日起二十年	原始取得
1455.	化学气相沉积室的清洁方法	发明	ZL201310213637.4	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1456.	一种提高叠对测量精度的方法	发明	ZL201310213617.7	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1457.	采用双极曝光方式的光刻装置、通光单元及光刻方法	发明	ZL201310211966.5	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1458.	具有环形透光光圈的光刻装置、通光单元及光刻方法	发明	ZL201310211954.2	2013-05-31	申请日起二十年	原始取得
1459.	一种磷酸硅玻璃薄膜的等离子体化学气相沉积方法	发明	ZL201310196276.7	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1460.	降低冗余金属耦合电容的通孔优先双大马士革铜互连方法	发明	ZL201310196254.0	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得

1461.	光刻胶的处理方法以及半导体器件的制备方法	发明	ZL201310195621.5	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1462.	降低冗余金属耦合电容的通孔优先双大马士革铜互连方法	发明	ZL201310195572.5	2013-05-23	申请日起二十年	原始取得
1463.	双栅氧器件的制造方法	发明	ZL201310177577.5	2013-05-14	申请日起二十年	原始取得
1464.	膜厚量测机台中颗粒的监控方法及控片	发明	ZL201310166041.3	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1465.	CMOS 带隙基准源电路	发明	ZL201310166026.9	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1466.	监控制程稳定性的测试模块和方法	发明	ZL201310165992.9	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1467.	CMOS 电荷泵电路	发明	ZL201310165971.7	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1468.	TEM 样品的制备方法	发明	ZL201310165226.2	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1469.	提高高压器件浅沟槽隔离性能的方法	发明	ZL201310165188.0	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得
1470.	一种在 SiGe BiCMOS 工艺中寄生的 PNP 管及其制造方法	发明	ZL201310164260.8	2013-05-07	申请日起二十年	原始取得

1471.	一种双层浅沟槽隔离结构、制备方法及横向扩散 MOS 管	发明	ZL201310157307.8	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1472.	晶体管及其沟道长度的形成方法	发明	ZL201310157253.5	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1473.	一种控制晶圆温度的等离子体刻蚀腔室及其方法	发明	ZL201310157252.0	2013-05-02	申请日起二十年	原始取得
1474.	Σ形凹槽的制作方法	发明	ZL201310156183.1	2013-04-28	申请日起二十年	原始取得
1475.	半导体芯片的版图图层设计方法及其掩膜板	发明	ZL201310153678.9	2013-04-28	申请日起二十年	原始取得
1476.	半导体器件的制造方法	发明	ZL201310122105.X	2013-04-09	申请日起二十年	原始取得
1477.	一种制备栅极氧化层的方法	发明	ZL201310120029.9	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1478.	浅沟槽隔离工艺	发明	ZL201310119905.6	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1479.	一种形成超浅结面的方法	发明	ZL201310119895.6	2013-04-08	申请日起二十年	原始取得
1480.	一种栅氧化层的制备方法	发明	ZL201310085199.8	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1481.	金属沟槽的刻蚀方法	发明	ZL201310085181.8	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1482.	实现浅沟道隔离的工艺方法	发明	ZL201310085158.9	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1483.	金属硬质掩模结构的修复方法	发明	ZL201310084505.6	2013-03-15	申请日起二十年	原始取得
1484.	一种Σ型硅沟槽的制造方法	发明	ZL201310082117.4	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得

1485.	TEM 样品的制备方法	发明	ZL201310082083.9	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1486.	掩膜版的自动化管理系统及方法	发明	ZL201310082060.8	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1487.	检测研磨工艺负载效应的方法	发明	ZL201310082029.4	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1488.	一种形成硅化物阻挡层的方法	发明	ZL201310081989.9	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1489.	一种 U 型沟槽的制造方法	发明	ZL201310081961.5	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1490.	一种二氧化硅金属阻挡层的淀积方法	发明	ZL201310081930.X	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1491.	一组应用于双大马士革金属互连工艺的光掩模	发明	ZL201310081912.1	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1492.	提高 PMOS 栅氧负偏压温度不稳定性的方法	发明	ZL201310081898.5	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1493.	去除 BPSG 薄膜中散射状颗粒的方法	发明	ZL201310081872.0	2013-03-14	申请日起二十年	原始取得
1494.	涂布装置及其涂布方法	发明	ZL201310062544.6	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1495.	实现浅沟槽隔离的工艺方法	发明	ZL201310062525.3	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得
1496.	互连电迁移的测试结构	发明	ZL201310062231.0	2013-02-27	申请日起二十年	原始取得

1497.	一种氧化反应炉及利用该反应炉进行氧化反应的方法	发明	ZL201310055077.4	2013-02-20	申请日起二十年	原始取得
1498.	一种侦测硅片平坦度的装置及方法	发明	ZL201210501282.4	2012-11-30	申请日起二十年	原始取得
1499.	优化浅槽隔离刻蚀工艺的方法	发明	ZL201210501020.8	2012-11-29	申请日起二十年	原始取得
1500.	浅沟槽隔离之边角圆化的方法	发明	ZL201210496571.X	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1501.	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210496254.8	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1502.	湿法刻蚀装置及其刻蚀方法	发明	ZL201210496197.3	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1503.	一种研磨垫及利用该研磨垫进行研磨时的损耗检测方法	发明	ZL201210493978.7	2012-11-28	申请日起二十年	原始取得
1504.	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210451889.6	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1505.	双应力薄膜的制造方法以及半导体器件	发明	ZL201210451699.4	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1506.	接触孔的制作方法	发明	ZL201210451655.1	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1507.	接触孔的制作方法	发明	ZL201210451318.2	2012-11-12	申请日起二十年	原始取得
1508.	一种 B4-flash 器件及其制作方法	发明	ZL201210432508.X	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得

1509.	一种监控设备运行状态的系统及方法	发明	ZL201210432475.9	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1510.	一种铜互联线的制作工艺	发明	ZL201210432401.5	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1511.	一种磁阻存储器的环状存储单元的制作方法	发明	ZL201210432398.7	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1512.	一种检测半导体圆形接触孔圆度的方法	发明	ZL201210432250.3	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1513.	一种介电常数可调整的金属互连层及其制作方法	发明	ZL201210432249.0	2012-11-02	申请日起二十年	原始取得
1514.	铜金属覆盖层的制备方法	发明	ZL201210389028.X	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1515.	检测光刻机对图形模糊成像控制能力的方法	发明	ZL201210389026.0	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1516.	机台传送部件自清洗方法以及机台传送部件	发明	ZL201210388933.3	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1517.	通孔优先铜互连制作方法	发明	ZL201210388834.5	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1518.	多晶硅栅极刻蚀方法	发明	ZL201210388740.8	2012-10-12	申请日起二十年	原始取得
1519.	一种提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210380938.1	2012-10-09	申请日起二十年	原始取得

1520.	提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210380920.1	2012-10-09	申请日起二十年	原始取得
1521.	一种形成双深度隔离沟槽的方法	发明	ZL201210375753.1	2012-10-08	申请日起二十年	原始取得
1522.	一种简化存储器中字线介电质膜刻蚀成型工艺的方法	发明	ZL201210375725.X	2012-10-08	申请日起二十年	原始取得
1523.	炉管挡片结构制造方法	发明	ZL201210352952.0	2012-09-19	申请日起二十年	原始取得
1524.	一种增大 MOM 电容密度的制造工艺方法	发明	ZL201210345797.X	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1525.	一种形成磁阻存储器环状存储单元的方法	发明	ZL201210343578.8	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1526.	一种具有多孔结构的双大马士革结构	发明	ZL201210343547.2	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1527.	一种对 40/45 纳米工艺金属硬光罩结构的缺陷解决方案	发明	ZL201210343527.5	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1528.	改善掺杂与非掺杂多晶硅栅极刻蚀形貌差异的方法	发明	ZL201210343505.9	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1529.	一种对 40/45 纳米工艺金属硬光罩结构的缺陷解决方案	发明	ZL201210343463.9	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得

1530.	一种带有空气间隙的大马士革工艺	发明	ZL201210341832.0	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1531.	一种提高 Cu CMP 效率的方法	发明	ZL201210341662.6	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1532.	一种制备顶层金属互联工艺刻蚀中间停止层的方法	发明	ZL201210341630.6	2012-09-17	申请日起二十年	原始取得
1533.	双大马士革结构中底部抗反射涂层的刻蚀方法	发明	ZL201210335545.9	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1534.	提高 MOM 电容密度的方法	发明	ZL201210335529.X	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1535.	一种铜互联线的制作工艺	发明	ZL201210333872.0	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1536.	一种双位 NROM 存储器及提高其电子注入效率的方法和结构	发明	ZL201210333706.0	2012-09-11	申请日起二十年	原始取得
1537.	提高通孔图形性能表现的方法	发明	ZL201210293369.7	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1538.	改善刻蚀形貌并提升可靠性的铜互连制备方法	发明	ZL201210292646.2	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1539.	半导体器件的制造方法	发明	ZL201210292632.0	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得
1540.	改善可靠性的铜互连层制备方法及半导体器件	发明	ZL201210292621.2	2012-08-16	申请日起二十年	原始取得

1541.	通孔优先铜互连制作方法	发明	ZL201210264541.6	2012-07-27	申请日起二十年	原始取得
1542.	一种消除侧墙宽度负载效应的工艺	发明	ZL201210259241.9	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1543.	一种有效判定铜扩散阻挡层阻挡能力的方法	发明	ZL201210259216.0	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1544.	一种形成无负载效应大尺寸沟槽的方法	发明	ZL201210259010.8	2012-07-25	申请日起二十年	原始取得
1545.	CMOS 图像传感器及其制作方法	发明	ZL201210229018.X	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1546.	一种具有低操作电压的 NROM 结构器件	发明	ZL201210228272.8	2012-07-04	申请日起二十年	原始取得
1547.	一种利用非对称分层势垒提高 SONNS 结构器件可靠性的方法	发明	ZL201210225804.2	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1548.	一种浅沟槽隔离工艺研磨装置及其使用方法	发明	ZL201210225801.9	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1549.	一种去除晶圆上 SiGe 薄膜的方法	发明	ZL201210225796.1	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得

1550.	一种具有低操作电压的 SONOS 结构器件	发明	ZL201210225786.8	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1551.	测算半导体器件井区注入离子横向扩散能力的方法	发明	ZL201210225784.9	2012-07-03	申请日起二十年	原始取得
1552.	超低介电材料的化学机械抛光方法	发明	ZL201210220362.2	2012-06-28	申请日起二十年	原始取得
1553.	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210209049.9	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1554.	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210209048.4	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1555.	金属硬掩膜层制备方法以及半导体制造方法	发明	ZL201210208994.7	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1556.	NMOS 器件制作方法	发明	ZL201210208991.3	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1557.	使用应力记忆技术的半导体器件制造方法	发明	ZL201210208961.2	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1558.	双应力氮化硅蚀刻阻挡层形成方法和半导体器件制造方法	发明	ZL201210208909.7	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得
1559.	使用应力记忆技术的半导体器件制造方法	发明	ZL201210208906.3	2012-06-21	申请日起二十年	原始取得

1560.	一种形成厚度均匀二氧化硅侧墙的方法	发明	ZL201210204506.5	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1561.	一种检测接触孔和多晶硅栅极对准度的方法	发明	ZL201210204463.0	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1562.	一种具有低编译电压捕获电荷的 BE-SONOS 结构器件及形成方法	发明	ZL201210204452.2	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1563.	一种短沟道围栅结构 MOSFET 的阈值电压解析模型	发明	ZL201210204444.8	2012-06-20	申请日起二十年	原始取得
1564.	SONOS 栅极结构及其制备方法、以及半导体器件	发明	ZL201210170390.8	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1565.	提高载流子迁移率的 PMOS 器件的制作方法及器件结构	发明	ZL201210170354.1	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1566.	一次性可编程器件以及集成电路	发明	ZL201210169827.6	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1567.	利用应力技术提高 SONOS 结构器件编译速度的方法	发明	ZL201210169810.0	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1568.	提高载流子迁移率的 CMOS 器件的制作方法及器件结构	发明	ZL201210169809.8	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得

1569.	一次性可编程器件以及集成电路	发明	ZL201210169500.9	2012-05-28	申请日起二十年	原始取得
1570.	降低 N 型掺杂和非掺杂多晶硅栅极刻蚀后形貌差异的方法	发明	ZL201210163138.4	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1571.	一种具有低操作电压的 BE-SONOS 结构器件及形成方法	发明	ZL201210158901.4	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1572.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210158843.5	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1573.	一种形成半导体通孔的方法	发明	ZL201210158835.0	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1574.	一种形成双应力刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201210158828.0	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1575.	一种形成双应力刻蚀阻挡层的方法	发明	ZL201210158826.1	2012-05-22	申请日起二十年	原始取得
1576.	一种用于 45 纳米及以下技术节点的金属前介质集成工艺	发明	ZL201210136032.5	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1577.	一种离子注入阻挡层的制作方法	发明	ZL201210136017.0	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1578.	一种提高金属-绝缘体-金属电容器可靠性的方法及其工艺结构	发明	ZL201210136004.3	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得

1579.	一种提高金属-绝缘体-金属电容器介电质质量的方法	发明	ZL201210135983.0	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1580.	一种用于 45 纳米及以下技术节点的金属前介质集成工艺	发明	ZL201210135982.6	2012-05-04	申请日起二十年	原始取得
1581.	基于 SOI 的后栅型积累模式 Si-NWFET 制备方法	发明	ZL201210135272.3	2012-05-03	申请日起二十年	原始取得
1582.	SOI 上双层隔离混合晶向后栅型反型模式 SiNWFET 的制备方法	发明	ZL201210133935.8	2012-05-03	申请日起二十年	原始取得
1583.	多层金属-氧化硅-金属电容器的制作方法	发明	ZL201210116158.6	2012-04-20	申请日起二十年	原始取得
1584.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210114142.1	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1585.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210114141.7	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1586.	连接孔的形成方法	发明	ZL201210114135.1	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得
1587.	一种形成双应力层氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201210113716.3	2012-04-17	申请日起二十年	原始取得

1588.	多层金属-多层绝缘体-金属电容器的制作方法	发明	ZL201210109591.7	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1589.	一种成型无定形碳牺牲栅极的基体的制备方法	发明	ZL201210109584.7	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1590.	一种无定形碳牺牲栅极结构的浅结和侧墙的制备方法	发明	ZL201210109582.8	2012-04-16	申请日起二十年	原始取得
1591.	一种防止磷硅酸盐玻璃或硼磷硅酸盐玻璃薄膜吸水的方法	发明	ZL201210100763.4	2012-04-09	申请日起二十年	原始取得
1592.	一种制备无定形碳牺牲栅极结构的浅结和侧墙的方法	发明	ZL201210098261.2	2012-04-06	申请日起二十年	原始取得
1593.	一种埋入式可编程闪存器件及其控制方法	发明	ZL201210098232.6	2012-04-06	申请日起二十年	原始取得
1594.	提高静态随机存储器写入冗余度的方法	发明	ZL201210093940.0	2012-03-31	申请日起二十年	原始取得
1595.	基于体硅的纵向堆叠式后栅型SiNWFET 制备方法	发明	ZL201210093913.3	2012-03-31	申请日起二十年	原始取得

1596.	金属-多层绝缘体-金属电容器及其制造方法、集成电路	发明	ZL201210081402.X	2012-03-23	申请日起二十年	原始取得
1597.	金属-多层绝缘体-金属电容器及其制造方法、集成电路	发明	ZL201210081401.5	2012-03-23	申请日起二十年	原始取得
1598.	一种表征多层栅极中多晶硅电阻的方法	发明	ZL201210077724.7	2012-03-22	申请日起二十年	原始取得
1599.	一种形成双应力刻蚀阻挡层及前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064639.7	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1600.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064629.3	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1601.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064628.9	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1602.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064615.1	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1603.	一种形成前金属介电质层的方法	发明	ZL201210064614.7	2012-03-13	申请日起二十年	原始取得
1604.	双层隔离纵向堆叠式半导体纳米线 MOSFET	发明	ZL201210050780.1	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1605.	一种用于铜互连冗余金属图形的插入算法	发明	ZL201210049162.5	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得

1606.	一种超低介电常数薄膜生长中形成渐进二氧化硅层的方法	发明	ZL201210047381.X	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1607.	一种利用应变硅技术提高 SONOS 的擦写速度的方法	发明	ZL201210047380.5	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1608.	一种增加浅沟槽隔离压应力提高 NMOS 电子迁移率的方法	发明	ZL201210047378.8	2012-02-28	申请日起二十年	原始取得
1609.	一种用于栅极侧墙的二氧化硅薄膜的沉积方法	发明	ZL201210046161.5	2012-02-27	申请日起二十年	原始取得
1610.	一种宽频带锁相环频率综合器电路	发明	ZL201210016167.8	2012-01-18	申请日起二十年	原始取得
1611.	一种栅极图形尺寸收缩方法	发明	ZL201210014989.2	2012-01-18	申请日起二十年	原始取得
1612.	SONOS 结构制造方法以及 SONOS 结构	发明	ZL201210009215.0	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1613.	双位氮化硅只读存储器制造方法及双位氮化硅只读存储器	发明	ZL201210009093.5	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得
1614.	改善高密度等离子体化学气相淀积的磷硅玻璃形貌的方法	发明	ZL201210009089.9	2012-01-12	申请日起二十年	原始取得

1615.	一种形成高阶电常数 K 和 T 型金属栅极的形成方法	发明	ZL201110393469.2	2011-12-02	申请日起二十年	原始取得
1616.	用于等离子体刻蚀的先进工艺控制方法	发明	ZL201110392794.7	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1617.	一种相位移焦距检测光罩及制造方法及检测焦距差的方法	发明	ZL201110392792.8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1618.	一种低介电常数阻挡层工艺中的预处理的监控方法及装置	发明	ZL201110392783.9	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1619.	一种金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110392608.X	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1620.	金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110392607.5	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1621.	一种多层金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110391743.2	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1622.	一种多层金属-氧化硅-金属电容的制作方法	发明	ZL201110391732.4	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得

1623.	用于等离子体刻蚀结构的光学探测方法及计算机辅助系统	发明	ZL201110391728.8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1624.	一种光刻机曝光方法	发明	ZL201110391163.3	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1625.	CMOS 半导体器件及其制造方法	发明	ZL201110389208.3	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1626.	可降低方块电阻的铜互连结构的制造方法	发明	ZL201110388945.1	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1627.	应力记忆作用的半导体器件及其制造方法	发明	ZL201110388942.8	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1628.	PMOS 源漏区离子注入方法及相应的器件制造方法	发明	ZL201110388784.6	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1629.	可降低方块电阻的铜互连结构的制造方法	发明	ZL201110388783.1	2011-11-30	申请日起二十年	原始取得
1630.	一种形成厚金属的单大马士革方法	发明	ZL201110388371.8	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1631.	一种双镶嵌结构的形成方法	发明	ZL201110386916.1	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1632.	一种提高金属绝缘层金属电容层多次光刻重复性的方法	发明	ZL201110386908.7	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得

1633.	一种降低铜互连方块电阻的单大马士革方法	发明	ZL201110386892.X	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1634.	一种形成高介电常数 K 和 T 型金属栅极的形成方法	发明	ZL201110386890.0	2011-11-29	申请日起二十年	原始取得
1635.	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386297.6	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1636.	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386296.1	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1637.	具有部分冗余通孔的集成电路制作方法及集成电路	发明	ZL201110386112.1	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1638.	扫描电子显微镜的检测方法	发明	ZL201110386090.9	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1639.	一种降低铜互连方块电阻的全光阻双大马士革方法	发明	ZL201110385563.3	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1640.	一种利用上掩膜实现铜互连的方法	发明	ZL201110384049.8	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1641.	一种半导体制程中的偏移管理的良率提升系统	发明	ZL201110384048.3	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得

1642.	一种利用上掩膜实现高性能铜互连的方法	发明	ZL201110384046.4	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1643.	一种半导体制程中的设备监控方法	发明	ZL201110384000.2	2011-11-28	申请日起二十年	原始取得
1644.	钨生长控制设备及方法	发明	ZL201110379861.1	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1645.	提高空穴迁移率的方法以及半导体器件制造方法	发明	ZL201110379854.1	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1646.	通孔刻蚀方法、集成电路制造方法和集成电路	发明	ZL201110379853.7	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1647.	铜填充硅通孔的制作方法	发明	ZL201110379852.2	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1648.	具有空气侧墙的 CMOS 制作方法	发明	ZL201110379535.0	2011-11-24	申请日起二十年	原始取得
1649.	光刻机投影物镜温度均衡装置及均衡方法	发明	ZL201110374963.4	2011-11-22	申请日起二十年	原始取得
1650.	提高浮体效应存储单元写入速度的方法及半导体器件	发明	ZL201110366206.2	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得
1651.	提高浮体效应存储单元写入速度的方法及半导体器件	发明	ZL201110366188.8	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得

1652.	接触孔刻蚀方法、集成电路制造方法以及集成电路	发明	ZL201110366186.9	2011-11-17	申请日起二十年	原始取得
1653.	一种多层金属-氮化硅-金属电容的制造方法	发明	ZL201110361155.4	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1654.	一种金属-氮化硅-金属电容的制造方法	发明	ZL201110361154.X	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1655.	一种多层金属-氮化硅-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110361149.9	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1656.	一种导电聚合物凝胶填充硅通孔的方法	发明	ZL201110359862.X	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1657.	一种利用上掩膜实现高性能铜互连的方法	发明	ZL201110359760.8	2011-11-15	申请日起二十年	原始取得
1658.	一种存储器单元的制备方法	发明	ZL201110349900.3	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1659.	用 DPN 氮氧化硅作为 SONOS 存储介质层的 ONO 结构及其制备方法	发明	ZL201110349894.1	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得
1660.	形成绝缘体上碳硅-锗硅异质结 1T--DRAM 结构的方法及形成结构	发明	ZL201110349874.4	2011-11-08	申请日起二十年	原始取得

1661.	一种低应力金属硬掩膜层的制备方法	发明	ZL201110347738.1	2011-11-07	申请日起二十年	原始取得
1662.	提高浮体效应存储单元写入速度的方法	发明	ZL201110341117.2	2011-11-02	申请日起二十年	原始取得
1663.	一种形成浅沟槽隔离的方法	发明	ZL201110341116.8	2011-11-02	申请日起二十年	原始取得
1664.	半导体器件制作方法	发明	ZL201110335363.7	2011-10-29	申请日起二十年	原始取得
1665.	硅纳米线器件的制作方法	发明	ZL201110328162.4	2011-10-25	申请日起二十年	原始取得
1666.	保留部分无定形碳层的方法	发明	ZL201110328160.5	2011-10-25	申请日起二十年	原始取得
1667.	高速电流模式逻辑到互补金属氧化物半导体信号转换电路	发明	ZL201110322330.9	2011-10-21	申请日起二十年	原始取得
1668.	一种形成侧墙的方法及由该方法形成存储单元	发明	ZL201110322309.9	2011-10-21	申请日起二十年	原始取得
1669.	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其形成方法	发明	ZL201110314347.X	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1670.	提高写入速度的浮体动态随机存储器单元及其制作方法	发明	ZL201110314346.5	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得

1671.	提高写入速度的浮体动态随机存储器单元及其制作方法	发明	ZL201110314344.6	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1672.	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其制备方法	发明	ZL201110314331.9	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1673.	一种提高写入速度的浮体动态随机存储器单元的制作方法	发明	ZL201110314327.2	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1674.	基于埋层 N 型阱的异质结 1T-DRAM 结构及其制备方法	发明	ZL201110314325.3	2011-10-17	申请日起二十年	原始取得
1675.	超低介电常数薄膜铜互连的制作方法	发明	ZL201110310575.X	2011-10-13	申请日起二十年	原始取得
1676.	一种金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110308004.2	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1677.	一种高性能金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110308002.3	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1678.	一种金属-氧化物-金属电容	发明	ZL201110307989.7	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1679.	一种金属-氧化物-金属电容及其制作方法	发明	ZL201110307984.4	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得

1680.	一种降低化学机械抛光后微粒缺陷的方法	发明	ZL201110307983.X	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1681.	一种金属-氧化物-金属电容的制作方法	发明	ZL201110307976.X	2011-10-12	申请日起二十年	原始取得
1682.	铜互连结构的制作方法	发明	ZL201110301126.9	2011-09-28	申请日起二十年	原始取得
1683.	一种降低双大马士革氮化硅工艺颗粒的处理方法	发明	ZL201110299091.X	2011-09-29	申请日起二十年	原始取得
1684.	一种避免双刻蚀阻挡层引起的接触孔不通的方法	发明	ZL201110298921.7	2011-09-29	申请日起二十年	原始取得
1685.	一种提高浅沟隔离多次曝光稳定性的方法	发明	ZL201110285100.X	2011-09-23	申请日起二十年	原始取得
1686.	超低介电常数薄膜铜互连的制作方法	发明	ZL201110274496.8	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1687.	具有金属前介质填充结构的半导体器件及其制备方法	发明	ZL201110274490.0	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1688.	金属铜大马士革互联结构的制造方法	发明	ZL201110274227.1	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得

1689.	一种大马士革的集成方法	发明	ZL201110272665.4	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1690.	预防物理气相沉积溅射工艺过程中金属靶材被击穿的方法	发明	ZL201110272663.5	2011-09-15	申请日起二十年	原始取得
1691.	一种改进的硬质掩膜与多孔低介电常数值材料的集成方法	发明	ZL201110266463.9	2011-09-09	申请日起二十年	原始取得
1692.	制备具有多厚度硅化物掩模层的半导体器件的方法	发明	ZL201110266445.0	2011-09-09	申请日起二十年	原始取得
1693.	一种单一厚度栅氧化层实现多级工作电压的 CMOS 器件的制备方法	发明	ZL201110265327.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1694.	一种提高浮体动态随机存储器单元性能的栅刻蚀方法	发明	ZL201110265311.7	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1695.	一种根据不同衬底进行光学临近修正的方法	发明	ZL201110265304.7	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1696.	一种解决高磷浓度 PSG 薄膜表面雾状颗粒的工艺方法	发明	ZL201110265302.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得

1697.	一种增加两次图形曝光工艺窗口的方法	发明	ZL201110265283.9	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1698.	一种用于提高半导体器件性能的硅化物掩模刻蚀方法	发明	ZL201110265270.1	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1699.	一种降低碳辅助注入工艺流程中多晶硅栅电阻的方法	发明	ZL201110265267.X	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1700.	一种利用侧向边墙技术提高 STI 凹陷区特性的方法	发明	ZL201110265265.0	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1701.	提高浮体动态随机存储单元写入速度的方法	发明	ZL201110265239.8	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1702.	一种金属—绝缘层—金属电容结构的制造工艺	发明	ZL201110265234.5	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1703.	一种减小半导体器件热载流子注入损伤的方法	发明	ZL201110265219.0	2011-09-08	申请日起二十年	原始取得
1704.	绝缘体上硅硅片及浮体动态随机存储器单元的制造方法	发明	ZL201110256001.9	2011-08-31	申请日起二十年	原始取得

1705.	绝缘体上硅硅片及浮体动态随机存储器单元的制造方法	发明	ZL201110256000.4	2011-08-31	申请日起二十年	原始取得
1706.	一种新的硅化物和金属前介质集成工艺及该形成的结构	发明	ZL201110250281.2	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1707.	一种新型的双 bit 线 SONOS 单元结构及其制作方法	发明	ZL201110250278.0	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1708.	一种提高浮体动态随机存储器单元性能的栅氧预清洗方法	发明	ZL201110250276.1	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1709.	一种 STI 结构 CMP 方法以及 STI 结构制作方法	发明	ZL201110250266.8	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1710.	一种 CMP 机台内置清洗结构及方法	发明	ZL201110250265.3	2011-08-29	申请日起二十年	原始取得
1711.	一种简化侧墙定义的两次图形曝光工艺的方法	发明	ZL201110235262.2	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1712.	一种实现两种不同绝缘层厚度电容的集成方法	发明	ZL201110235259.0	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得

1713.	一种减小半导体器件热载流子注入损伤的方法	发明	ZL201110235255.2	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1714.	一种提高浮体动态随机存储器单元写入速度的注入方法及结构	发明	ZL201110235254.8	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1715.	一种后栅极两晶体管 DRAM 的制造方法	发明	ZL201110235244.4	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1716.	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区通孔刻蚀的方法	发明	ZL201110235240.6	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1717.	一种源漏区超浅结的改进方法	发明	ZL201110235237.4	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1718.	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区域通孔刻蚀的方法	发明	ZL201110235219.6	2011-08-17	申请日起二十年	原始取得
1719.	后栅极两晶体管零电容动态随机存储器的制备方法	发明	ZL201110232271.6	2011-08-15	申请日起二十年	原始取得
1720.	增强应力记忆技术效果的方法	发明	ZL201110232262.7	2011-08-15	申请日起二十年	原始取得
1721.	一种有助于消除倒 U 形镍硅化物的器件结构及其制备工艺	发明	ZL201110222302.X	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得

1722.	一种改善 PMOS 器件载流子迁移率的方法	发明	ZL201110222150.3	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1723.	一种改善 NMOS 器件载流子迁移率的方法	发明	ZL201110222138.2	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1724.	一种利用 P 型离子注入形成双深度隔离沟道的方法	发明	ZL201110222125.5	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1725.	改进双重通孔刻蚀停止层交叠区通孔刻蚀的方法及其器件	发明	ZL201110222089.2	2011-08-04	申请日起二十年	原始取得
1726.	一种不同多晶硅栅电极厚度的集成工艺	发明	ZL201110206448.5	2011-07-22	申请日起二十年	原始取得
1727.	一种提高光刻胶与金属/金属化合物表面之间粘附力的方法	发明	ZL201110206446.6	2011-07-22	申请日起二十年	原始取得
1728.	无金属阻挡层的铜后道互连工艺	发明	ZL201110194242.5	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1729.	用于高、低压器件的多晶硅栅电极集成工艺	发明	ZL201110194223.2	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1730.	一种铜后道互连工艺	发明	ZL201110194154.5	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得

1731.	一种优化的多晶栅极氧化硅硬质掩膜去除方法	发明	ZL201110194153.0	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1732.	MOS 电容器的结构的制作方法	发明	ZL201110194151.1	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1733.	一种提高半导体器件中 MIM 电容密度的方法及其器件	发明	ZL201110194148.X	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1734.	一种增加半导体器件中 MIM 电容密度的方法及其结构	发明	ZL201110194118.9	2011-07-12	申请日起二十年	原始取得
1735.	抑制 GIDL 效应的后栅极工艺半导体器件及其制备方法	发明	ZL201110163853.3	2011-06-17	申请日起二十年	原始取得
1736.	一种双晶体管零电容动态 RAM 的制备方法	发明	ZL201110163852.9	2011-06-17	申请日起二十年	原始取得
1737.	一种抑制漏极感应势垒降低效应的后栅极工艺 CMOS 器件及其制备方法	发明	ZL201110160322.9	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1738.	一种抑制漏极感应势垒降低效应的 CMOS 器件及其制备方法	发明	ZL201110160321.4	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得

1739.	一种提高 MIM 器件电容均匀性的方法	发明	ZL201110160311.0	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1740.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110160309.3	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1741.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110160305.5	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1742.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容结构及制造工艺	发明	ZL201110160301.7	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1743.	设置顶部刻蚀阻挡层以增加接触孔刻蚀制程窗口的方法	发明	ZL201110160287.0	2011-06-15	申请日起二十年	原始取得
1744.	一种双大马士革工艺中通孔填充的方法	发明	ZL201110150744.8	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1745.	改善双应力氮化硅薄膜集成的工艺及其中的结构	发明	ZL201110150725.5	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1746.	一种用于双刻蚀阻挡层技术的应变硅工艺制作方法	发明	ZL201110150724.0	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得

1747.	一种增强氮化硅薄膜张应力的方法	发明	ZL201110150722.1	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1748.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容制造工艺及结构	发明	ZL201110150721.7	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1749.	消除栅极凹形缺陷的方法	发明	ZL201110150717.0	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1750.	一种提高铜互连可靠性的表面处理方法	发明	ZL201110150700.5	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1751.	一种 MIM（金属-绝缘层-金属）电容制作方法	发明	ZL201110150697.7	2011-06-07	申请日起二十年	原始取得
1752.	铜大马士革工艺金属-绝缘层-金属电容结构及制造工艺	发明	ZL201110138154.3	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1753.	一种形成 MIM 电容器结构的方法及 MIM 电容器	发明	ZL201110138130.8	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1754.	一种针对氟基等离子体刻蚀后的氮化钛薄膜的处理方法	发明	ZL201110138127.6	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得
1755.	一种利用铜大马士革工艺制造双层金属-绝缘层-金属电容的方法	发明	ZL201110138065.9	2011-05-26	申请日起二十年	原始取得

1756.	离子注入调整隔离氧化物应力的浅沟槽隔离结构制备方法	发明	ZL201110133619.6	2011-05-23	申请日起二十年	原始取得
1757.	用于提高半导体器件性能的在浅沟槽上形成接触孔的方法	发明	ZL201110123709.7	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1758.	一种具有自对准空洞层的 SON 互补型金属氧化物半导体制备方法	发明	ZL201110123708.2	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1759.	一种提高 MIM 电容密度的结构及其制作工艺	发明	ZL201110123645.0	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1760.	一种 CMOS 侧墙结构及其制备方法	发明	ZL201110123643.1	2011-07-27	申请日起二十年	原始取得
1761.	一种 MIM 电容的改进结构及其制造工艺	发明	ZL201110123642.7	2011-05-13	申请日起二十年	原始取得
1762.	在浅沟槽上形成接触孔以提高半导体器件性能的方法	发明	ZL201110110384.9	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1763.	提高半导体器件中空穴迁移率的方法	发明	ZL201110110382.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得

1764.	一种提高 PMOS 器件中空穴迁移率的多晶硅栅附加样本填充方法	发明	ZL201110110369.4	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1765.	一种增强应力记忆效应的栅多晶硅刻蚀方法	发明	ZL201110110368.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1766.	一种制造高拉应力氮化硅薄膜的方法	发明	ZL201110110367.5	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1767.	一种用于表征低介电常数介质材料损伤的检测方法	发明	ZL201110110175.4	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1768.	集成电路钝化层及其制造方法	发明	ZL201110110174.X	2011-04-29	申请日起二十年	原始取得
1769.	一种用于双刻蚀阻挡层技术的应变硅工艺集成方法	发明	ZL201110099265.8	2011-04-20	申请日起二十年	原始取得
1770.	改进晶体管载流子迁移率的半导体器件及方法	发明	ZL201110078473.X	2011-03-30	申请日起二十年	原始取得
1771.	一种减小半导体器件中交叠电容的方法	发明	ZL201110078449.6	2011-03-30	申请日起二十年	原始取得
1772.	一种干泵信号接头及 CVD 成膜设备信号接头	实用新型	ZL202421830222.1	2024-07-30	申请日起十年	原始取得

1773.	定位装置以及蚀刻机	实用新型	ZL202421524674.7	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1774.	线圈支架、射频匹配电路组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202421520067.3	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1775.	具有位置偏移检测装置的离子注入机	实用新型	ZL202421520050.8	2024-06-28	申请日起十年	原始取得
1776.	等离子刻蚀装置	实用新型	ZL202420910871.6	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1777.	石英管固定结构及反应腔体	实用新型	ZL202420908366.8	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1778.	立式炉管装置	实用新型	ZL202420907843.9	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1779.	具有除湿装置的前开式晶圆盒	实用新型	ZL202420907810.4	2024-04-28	申请日起十年	原始取得
1780.	用于气化装置的进出口管路及具有其的气化设备	实用新型	ZL202420590490.4	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1781.	喷嘴支撑臂位置偏移检测装置及旋涂单元和涂胶设备	实用新型	ZL202420590463.7	2024-03-26	申请日起十年	原始取得
1782.	用于掩膜版存储柜的喷气组件	实用新型	ZL202420392586.X	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1783.	固定装置及具有其的炉管机台	实用新型	ZL202420390531.5	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1784.	一种干燥槽顶针	实用新型	ZL202420389435.9	2024-02-29	申请日起十年	原始取得
1785.	涂料装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420385391.2	2024-02-29	申请日起十年	原始取得

1786.	用于牵引天车的连接杆结构	实用新型	ZL202420344486.X	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1787.	隔振装置以及光刻设备	实用新型	ZL202420344063.8	2024-02-23	申请日起十年	原始取得
1788.	防降温保护装置	实用新型	ZL202420232425.4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1789.	货物载入台以及测试机台	实用新型	ZL202420232052.0	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1790.	天车维修系统	实用新型	ZL202420232021.5	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1791.	检漏装置	实用新型	ZL202420231968.4	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1792.	燃烧式除害设备	实用新型	ZL202420231058.6	2024-01-30	申请日起十年	原始取得
1793.	辅助上油装置以及测试机台	实用新型	ZL202420143421.9	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1794.	一种烘烤排气管清洗装置	实用新型	ZL202420141150.3	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1795.	晶圆刻蚀均匀度提升装置	实用新型	ZL202420141145.2	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1796.	连接组件以及半导体制造设备	实用新型	ZL202420141126.X	2024-01-19	申请日起十年	原始取得
1797.	清针砂纸粘贴辅助装置	实用新型	ZL202322019571.7	2023-07-28	申请日起十年	原始取得
1798.	一种信号线和背氦流量控制器的防干扰结构	实用新型	ZL202321351972.6	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1799.	安装辅助支架	实用新型	ZL202321349596.7	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1800.	一种阳极装置及电镀设备	实用新型	ZL202321349565.1	2023-05-30	申请日起十年	原始取得
1801.	一种支撑架及收纳装置	实用新型	ZL202321251352.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得

1802.	一种手动取片机械爪	实用新型	ZL202321251340.2	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1803.	一种冷却水管路连接装置	实用新型	ZL202321251328.1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1804.	接头保护装置和液压快速接头	实用新型	ZL202321247559.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1805.	清洁治具及刻蚀机	实用新型	ZL202321247527.5	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1806.	研磨保护装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202321246644.X	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1807.	漏液检测报警装置及刻蚀机	实用新型	ZL202321246628.0	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1808.	校准治具及量测系统	实用新型	ZL202321246619.1	2023-05-22	申请日起十年	原始取得
1809.	工艺腔清洁装置	实用新型	ZL202320982876.5	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1810.	一种快速热处理半导体加工机台及半导体加工系统	实用新型	ZL202320982859.1	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1811.	气柜部件清洗保护结构及半导体设备	实用新型	ZL202320982844.5	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1812.	一种对石英腔体进行降温的装置	实用新型	ZL202320982818.2	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1813.	适用于紫外线灯照射台的吸尘装置	实用新型	ZL202320982746.1	2023-04-26	申请日起十年	原始取得
1814.	晶圆清洗装置	实用新型	ZL202320704865.0	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1815.	清洗装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202320698685.6	2023-03-31	申请日起十年	原始取得

1816.	一种真空吸附式取放装置	实用新型	ZL202320696516.9	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1817.	一种用于晶圆存储盒的承载装置	实用新型	ZL202320695689.9	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1818.	检测设备、工艺腔室及离子注入机	实用新型	ZL202320680210.4	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1819.	一种晶圆存储盒的防坠落装置	实用新型	ZL202320680205.3	2023-03-31	申请日起十年	原始取得
1820.	倾角传感器的保护结构及倾角传感器	实用新型	ZL202320351401.6	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1821.	卡盘销组件及晶圆清洗设备	实用新型	ZL202320348444.9	2023-02-28	申请日起十年	原始取得
1822.	晶圆级半自动探针台	实用新型	ZL202320347595.2	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1823.	一种输送链的承载装置	实用新型	ZL202320347565.1	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1824.	一种半导体设备及反应气体供应装置	实用新型	ZL202320347548.8	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1825.	沉积环装置、静电卡盘装置及高温铝腔	实用新型	ZL202320345982.2	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1826.	一种石英窗保温装置、等离子体反应设备及半导体加工机台	实用新型	ZL202320345925.4	2023-02-27	申请日起十年	原始取得
1827.	臭氧分解装置及其保护结构	实用新型	ZL202320339205.7	2023-02-24	申请日起十年	原始取得

1828.	一种防脱治具和静电吸盘	实用新型	ZL202320339162.2	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1829.	电容防护装置	实用新型	ZL202320328598.1	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1830.	一种真空管收集粉尘装置及真空吸附系统	实用新型	ZL202320328408.6	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1831.	防光罩盒底盘掉落装置及光罩检测设备	实用新型	ZL202320328390.X	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1832.	光罩传送台防尘装置	实用新型	ZL202320320779.X	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1833.	起膜顶针的移动装置	实用新型	ZL202320320743.1	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1834.	基座装置、溅射腔体及物理气相沉积设备	实用新型	ZL202320320717.9	2023-02-24	申请日起十年	原始取得
1835.	光刻机温控用储液装置	实用新型	ZL202320171574.X	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1836.	一种更换上部电极的治具	实用新型	ZL202320171532.6	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1837.	阀门切换检测装置	实用新型	ZL202320163729.5	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1838.	芯片测试板除霜装置	实用新型	ZL202320163714.9	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1839.	一种高度测量治具和涂胶显影机	实用新型	ZL202320152873.9	2023-01-30	申请日起十年	原始取得
1840.	铜电极组装装置及电化学电镀设备	实用新型	ZL202222915186.6	2022-10-31	申请日起十年	原始取得

1841.	晶圆传送位置检测装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222877144.8	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1842.	管路装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222876868.0	2022-10-31	申请日起十年	原始取得
1843.	一种晶圆前开式传送盒的运输装置	实用新型	ZL202222623922.0	2022-09-30	申请日起十年	原始取得
1844.	漏气检测装置及半导体工艺设备	实用新型	ZL202222614300.1	2022-09-30	申请日起十年	原始取得
1845.	一种半导体设备电气柜的温度监控装置	实用新型	ZL202222601790.1	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1846.	老化板及芯片老化测试系统	实用新型	ZL202222598976.6	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1847.	一种光刻机的光罩传送手臂	实用新型	ZL202222598910.7	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1848.	一种晶圆工作台用偏差矫正机构	实用新型	ZL202222596169.0	2022-09-29	申请日起十年	原始取得
1849.	贯穿装置	实用新型	ZL202222304331.7	2022-08-31	申请日起十年	原始取得
1850.	一种探针卡清洁纸辅助夹具	实用新型	ZL202222121460.2	2022-08-12	申请日起十年	原始取得
1851.	清洗装置	实用新型	ZL202222110611.4	2022-08-11	申请日起十年	原始取得
1852.	一种排气装置及尾气处理系统	实用新型	ZL202221984746.7	2022-07-29	申请日起十年	原始取得
1853.	一种药液桶推车	实用新型	ZL202221982328.4	2022-07-29	申请日起十年	原始取得
1854.	量测机台照明开关监控系统	实用新型	ZL202220927550.8	2022-04-20	申请日起十年	原始取得

1855.	等离子刻蚀机台	实用新型	ZL202220924713.7	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1856.	一种粉尘收集装置	实用新型	ZL202220923322.3	2022-04-20	申请日起十年	原始取得
1857.	一种基座及半导体设备	实用新型	ZL202220421787.9	2022-02-28	申请日起十年	原始取得
1858.	一种推车柜	实用新型	ZL202220348470.7	2022-02-21	申请日起十年	原始取得
1859.	机械臂模块	实用新型	ZL202220260638.9	2022-02-07	申请日起十年	原始取得
1860.	一种臭氧分解装置	实用新型	ZL202220252166.2	2022-01-28	申请日起十年	原始取得
1861.	一种紫外线照射装置	实用新型	ZL202220250842.2	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1862.	一种温控装置的加液口盖帽及温控装置的排气系统	实用新型	ZL202220238947.6	2022-01-28	申请日起十年	原始取得
1863.	一种清洗装置	实用新型	ZL202220229831.6	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1864.	清洗装置	实用新型	ZL202220228704.4	2022-01-27	申请日起十年	原始取得
1865.	一种晶圆检测装置及半导体设备	实用新型	ZL202123436186.X	2021-12-30	申请日起十年	原始取得
1866.	一种反应装置及半导体设备	实用新型	ZL202123348685.3	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1867.	干法刻蚀机台的设备前端模块的颗粒堆积物清理检测系统	实用新型	ZL202123348572.3	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1868.	一种校准装置及真空传送装置	实用新型	ZL202123348110.1	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1869.	一种排湿装置、送风管和空调机	实用新型	ZL202123348080.4	2021-12-28	申请日起十年	原始取得

1870.	一种研磨机台的冷却装置及研磨机台	实用新型	ZL202123347985.X	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1871.	一种清洗设备	实用新型	ZL202123346972.0	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1872.	一种清洗槽及具有其的清洗机台	实用新型	ZL202123341787.2	2021-12-28	申请日起十年	原始取得
1873.	一种干式真空泵及半导体设备	实用新型	ZL202122963402.X	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1874.	一种显影设备	实用新型	ZL202122961152.6	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1875.	一种光刻机的载片台平坦度的检测系统及光刻机	实用新型	ZL202122953910.X	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1876.	一种过热报警装置	实用新型	ZL202122953908.2	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1877.	一种排风结构及除胶机	实用新型	ZL202122953885.5	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1878.	一种 DRIE 机台的等离子体约束环用定位锁定结构	实用新型	ZL202122945564.0	2021-11-29	申请日起十年	原始取得
1879.	一种热电偶及半导体设备	实用新型	ZL202122638508.2	2021-10-29	申请日起十年	原始取得
1880.	一种监测特气的装置及半导体设备	实用新型	ZL202122388633.2	2021-09-29	申请日起十年	原始取得
1881.	一种加热器水平调节装置	实用新型	ZL202122377375.8	2021-09-29	申请日起十年	原始取得
1882.	一种改造后的 LPCVD 反应室	实用新型	ZL202122065570.7	2021-08-30	申请日起十年	原始取得

1883.	一种 LPCVD 晶舟旋转装置	实用新型	ZL202122065555.2	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1884.	一种用于 LPCVD 模块的底座及其 LPCVD 模块	实用新型	ZL202122063121.9	2021-08-30	申请日起十年	原始取得
1885.	一种光刻胶去除机台的晶圆传送手臂的清洁及干燥机构	实用新型	ZL202121585532.8	2021-07-13	申请日起十年	原始取得
1886.	一种用于校正遮光板位置精度的监控光罩	实用新型	ZL202121584306.8	2021-07-13	申请日起十年	原始取得
1887.	一种用于管道法兰拆装的工具	实用新型	ZL202120651747.9	2021-03-30	申请日起十年	原始取得
1888.	一种间隙测量仪、反应腔及半导体设备	实用新型	ZL202120536419.4	2021-03-15	申请日起十年	原始取得
1889.	晶圆清洗装置	实用新型	ZL202120412470.4	2021-02-24	申请日起十年	原始取得
1890.	一种气体吹扫管路、反应腔及半导体设备	实用新型	ZL202120249404.X	2021-01-28	申请日起十年	原始取得
1891.	预热激光光源冷却系统	实用新型	ZL202023245543.X	2020-12-29	申请日起十年	原始取得
1892.	掩模板清洁装置	实用新型	ZL202023242011.0	2020-12-29	申请日起十年	原始取得
1893.	炉管设备中的晶舟运动机构	实用新型	ZL202023180549.3	2020-12-25	申请日起十年	原始取得
1894.	半导体冷却装置及半导体机台	实用新型	ZL202023036249.8	2020-12-16	申请日起十年	原始取得

1895.	半导体传送装置	实用新型	ZL202023020628.8	2020-12-16	申请日起十年	原始取得
1896.	接口阀及化学气相沉积设备	实用新型	ZL202022479572.6	2020-10-30	申请日起十年	原始取得
1897.	显影液供应系统	实用新型	ZL202020671981.3	2020-04-27	申请日起十年	原始取得
1898.	一种排气取样装置及湿法清洗机	实用新型	ZL202020328502.8	2020-03-16	申请日起十年	原始取得
1899.	气体管路分流装置及干法刻蚀机	实用新型	ZL201922088521.8	2019-11-27	申请日起十年	原始取得
1900.	一种腔体结构	实用新型	ZL201922081130.3	2019-11-27	申请日起十年	原始取得
1901.	紫外光固化装置	实用新型	ZL201921603197.2	2019-09-24	申请日起十年	原始取得
1902.	电极保护装置	实用新型	ZL201921576498.0	2019-09-20	申请日起十年	原始取得
1903.	一种遮光结构和涂胶显影机	实用新型	ZL201921189178.X	2019-07-25	申请日起十年	原始取得
1904.	预对准装置及晶圆处理系统	实用新型	ZL201920784669.2	2019-05-28	申请日起十年	原始取得
1905.	一种光罩盒锁定/解锁装置及相应的光刻机	实用新型	ZL201920613386.1	2019-04-29	申请日起十年	原始取得
1906.	一种改善白色像素点的隔离结构	实用新型	ZL201920391846.0	2019-03-26	申请日起十年	原始取得
1907.	一种化学药液混合装置及湿法刻蚀装置	实用新型	ZL201920391750.4	2019-03-26	申请日起十年	原始取得
1908.	一种改善 HCD 炉管硅片间均匀性差异的装置	实用新型	ZL201821904812.9	2018-11-19	申请日起十年	原始取得

1909.	一种用于监控尼康光刻机底部镜头雾化散光程度的掩膜板	实用新型	ZL201821903870.X	2018-11-19	申请日起十年	原始取得
1910.	一种用于研磨装置的新型研磨头	实用新型	ZL201821675862.4	2018-10-16	申请日起十年	原始取得
1911.	电镀洗边结构	实用新型	ZL201820975644.6	2018-06-25	申请日起十年	原始取得
1912.	用于刻蚀设备的新型陶瓷环	实用新型	ZL201820760179.4	2018-05-22	申请日起十年	原始取得
1913.	化学气相沉淀机台中静电吸盘的拆装夹具	实用新型	ZL201721797367.6	2017-12-21	申请日起十年	原始取得
1914.	一种高电流离子注入机末端测流器	实用新型	ZL201721682661.2	2017-12-06	申请日起十年	原始取得
1915.	一种用于改善白像素的 CMOS 图像传感器	实用新型	ZL201721592960.7	2017-11-24	申请日起十年	原始取得
1916.	一种改善 low-k 薄膜均一性的装置	实用新型	ZL201721252681.6	2017-09-27	申请日起十年	原始取得
1917.	一种改善氮化硅薄膜膜厚均一性的炉管石英外管	实用新型	ZL201721251982.7	2017-09-27	申请日起十年	原始取得
1918.	一种加热装置及化学气相沉积设备	实用新型	ZL201720969251.X	2017-08-04	申请日起十年	原始取得

1919.	一种超声波修整盘及化学机械研磨机	实用新型	ZL201720948244.1	2017-08-01	申请日起十年	原始取得
1920.	一种组合式溅射靶材及磁控溅射装置	实用新型	ZL201720931858.9	2017-07-28	申请日起十年	原始取得
1921.	一种侦测电镀洗边异常的装置	实用新型	ZL201621209504.5	2016-11-09	申请日起十年	原始取得
1922.	一种铜电镀机台腔体	实用新型	ZL201621151042.6	2016-10-24	申请日起十年	原始取得
1923.	套准精度量测图形结构	实用新型	ZL201620809339.0	2016-07-29	申请日起十年	原始取得
1924.	一种用于机台 RF 电感线圈的防电弧击伤装置	实用新型	ZL201620807709.7	2016-07-28	申请日起十年	原始取得
1925.	一种化学气相成膜机台	实用新型	ZL201620283550.3	2016-04-07	申请日起十年	原始取得
1926.	一种化学气相沉积工艺设备	实用新型	ZL201520861935.9	2015-10-30	申请日起十年	原始取得
1927.	一种改善晶圆边缘缺陷的装置	实用新型	ZL201520857832.5	2015-10-29	申请日起十年	原始取得
1928.	高密度等离子体机台顶端喷嘴与气体集流器的连接结构	实用新型	ZL201520856143.2	2015-10-29	申请日起十年	原始取得
1929.	一种氧化炉晶舟	实用新型	ZL201520839960.7	2015-10-27	申请日起十年	原始取得
1930.	一种探针台	实用新型	ZL201520828827.1	2015-10-23	申请日起十年	原始取得
1931.	一种恒转矩控制系统	实用新型	ZL201520794773.1	2015-10-14	申请日起十年	原始取得

1932.	一种探针卡	实用新型	ZL201520793943.4	2015-10-14	申请日起十年	原始取得
1933.	一种机械手臂	实用新型	ZL201520739022.X	2015-09-22	申请日起十年	原始取得

表 2：标的公司拥有的分立后拟保留在其名下的主要境外已授权专利

序号	专利名称	专利类型	授权国家/地区	申请号	申请日	专用权期限	取得方式
1.	Stack capacitor, a flash memory device and a manufacturing method thereof	发明	美国	US17/872,534	2022-7-25	申请日起二十年	原始取得
2.	Stack capacitor, a flash memory device and a manufacturing method thereof	发明	美国	US17/213,885	2021-3-26	申请日起二十年	原始取得
3.	One-time programmable memory and an operation method thereof	发明	美国	US17/206,631	2021-3-19	申请日起二十年	原始取得
4.	Method for improving HDP filling defects through STI etching process	发明	美国	US17/142,623	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
5.	Self-aligned two-time forming method capable of preventing sidewalls from being deformed	发明	美国	US17/142,500	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
6.	Programmable memory	发明	美国	US16/952,262	2020-11-19	申请日起二十年	原始取得

7.	Reading reference current automatic regulation circuit of non-volatile memory	发明	美国	US16/951,018	2020-11-18	申请日起二十年	原始取得
8.	Method of sub resolution assist feature	发明	美国	US16/702,492	2019-12-3	申请日起二十年	原始取得
9.	Flash with shallow trench in channel region and method for manufacturing the same	发明	美国	US16/854,129	2020-4-21	申请日起二十年	原始取得
10.	Semiconductor structure of split gate flash memory cell and method for manufacturing the same	发明	美国	US16/861,967	2020-4-29	申请日起二十年	原始取得
11.	1.5T SONOS memory structure and manufacturing method	发明	美国	US16/826,554	2020-3-23	申请日起二十年	原始取得
12.	Method of making resistive structure of RRAM	发明	美国	US16/850,993	2020-4-16	申请日起二十年	原始取得
13.	LDO circuit device and overcurrent protection circuit thereof	发明	美国	US16/800,614	2020-2-25	申请日起二十年	受让取得

14.	Oscillator	发明	美国	US16/815,379	2020-3-11	申请日起二十年	原始取得
15.	Erase-write cycling method of a flash device	发明	美国	US16/830,740	2020-3-26	申请日起二十年	原始取得
16.	Power Supply Powering-On Structure	发明	美国	US16/822,757	2020-3-18	申请日起二十年	原始取得
17.	Voltage-controlled oscillator circuit and phase-locked loop circuit	发明	美国	US16/789,550	2020-2-13	申请日起二十年	原始取得
18.	50%-duty-cycle consecutive integer frequency divider and phase-locked loop circuit	发明	美国	US16/857,617	2020-4-24	申请日起二十年	原始取得
19.	Classification method for automatically identifying wafer spatial pattern distribution	发明	美国	US16/690,470	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得
20.	Nonvolatile memory device having a memory-transistor gate-electrode provided with a charge-trapping gate-	发明	美国	US16/666,418	2019-10-29	申请日起二十年	原始取得

	dielectric layer and two sidewall select-transistor gate-electrodes						
21.	Global shutter CMOS image sensor having photosensitive doped region with inhomogeneous potentials	发明	美国	US16/692,832	2019-11-22	申请日起二十年	原始取得
22.	Method and apparatus for analyzing semiconductor wafer	发明	美国	US16/681,843	2019-11-13	申请日起二十年	原始取得
23.	Etching method and a semiconductor device	发明	美国	US16/680,512	2019-11-12	申请日起二十年	原始取得
24.	Method for detecting ultra-small defect on wafer surface	发明	美国	US16/691,180	2019-11-21	申请日起二十年	原始取得
25.	Semiconductor device and manufacturing method therefor	发明	美国	US16/384,966	2019-4-16	申请日起二十年	原始取得
26.	Semiconductor structure and method of manufacturing the same	发明	美国	US16/681,830	2019-11-13	申请日起二十年	原始取得

27.	Method of ion implantation and an apparatus for the same	发明	美国	US16/566,876	2019-9-11	申请日起二十年	原始取得
28.	Electrostatic protection circuit and a semiconductor structure	发明	美国	US16/566,875	2019-9-11	申请日起二十年	受让取得
29.	Methods and systems for reducing dislocation defects in high concentration epitaxy processes	发明	美国	US16/409,876	2019-5-13	申请日起二十年	原始取得
30.	Method of manufacturing a bipolar transistor with trench structure	发明	美国	US16/427,356	2019-5-31	申请日起二十年	原始取得
31.	Method for measuring interface state density	发明	美国	US13/656,701	2012-10-20	申请日起二十年	原始取得
32.	Structure for critical dimension and overlay measurement	发明	美国	US13/667,363	2012-11-2	申请日起二十年	原始取得
33.	Method of forming Cu interconnects	发明	美国	US13/667,492	2012-11-2	申请日起二十年	原始取得
34.	CML to CMOS conversion circuit	发明	美国	US13/656,700	2012-10-20	申请日起二十年	原始取得

35.	Method for producing silicon nanowire devices	发明	美国	US13/659,907	2012-10-24	申请日起二十年	原始取得
36.	Temperature balancing device of projection objective of lithography machine and method thereof	发明	美国	US13/682,069	2012-11-20	申请日起二十年	原始取得
37.	Method for depositing phosphosilicate glass	发明	美国	US13/728,743	2012-12-27	申请日起二十年	原始取得
38.	Method for monitoring alignment between contact holes and polycrystalline silicon gate	发明	美国	US13/731,294	2012-12-31	申请日起二十年	原始取得
39.	Integration flow for LDD and spacer fabrication on a sacrificial amorphous carbon gate structure	发明	美国	US13/716,990	2012-12-17	申请日起二十年	原始取得
40.	Method for etching polysilicon gate	发明	美国	US13/730,532	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
41.	Method for improving write margins of SRAM cells	发明	美国	US13/721,071	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得

42.	Method of manufacturing a tungsten plug	发明	美国	US13/706,576	2012-12-6	申请日起二十年	原始取得
43.	Dummy wafer structure and method of forming the same	发明	美国	US13/730,576	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
44.	Method of forming contact hole	发明	美国	US13/730,486	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
45.	Phase shift focus monitor reticle, manufacturing method thereof and method for monitoring focus difference	发明	美国	US13/688,407	2012-11-29	申请日起二十年	原始取得
46.	Fabrication method for improving surface planarity after tungsten chemical mechanical polishing	发明	美国	US13/730,103	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
47.	Method and structure to improve the erasing speed operation of SONOS memory device having a graded silicon nitride layer	发明	美国	US13/721,078	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得

48.	Method of forming connection holes	发明	美国	US13/721,070	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
49.	Method for reducing morphological difference between N-doped and undoped polysilicon gates after etching	发明	美国	US13/721,073	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
50.	Measurement of lateral diffusion of implanted ions in doped well region of semiconductor devices	发明	美国	US13/721,082	2012-12-20	申请日起二十年	原始取得
51.	Method of dual-depth STI formation	发明	美国	US13/728,190	2012-12-27	申请日起二十年	原始取得
52.	Method of improving PMOS performance in a contact etch stop layer process	发明	美国	US13/730,169	2012-12-28	申请日起二十年	原始取得
53.	Method to manufacture trench-first copper interconnection	发明	美国	US13/726,532	2012-12-24	申请日起二十年	原始取得
54.	Algorithm of Cu interconnect dummy inserting	发明	美国	US13/731,128	2012-12-31	申请日起二十年	原始取得

55.	Method of depositing the metal barrier layer comprising silicon dioxide	发明	美国	US14/069,570	2013-11-1	申请日起二十年	原始取得
56.	Semiconductor structure with means for testing metal-insulator-metal capacitors	发明	美国	US14/040,741	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
57.	Test module device and a test method for monitoring the stability of processes	发明	美国	US14/080,534	2013-11-14	申请日起二十年	原始取得
58.	Method of manufacturing semiconductor device	发明	美国	US14/103,496	2013-12-11	申请日起二十年	原始取得
59.	Layout pattern modification method	发明	美国	US14/105,689	2013-12-13	申请日起二十年	原始取得
60.	Optical proximity correction method based on hybrid simulation model	发明	美国	US14/086,222	2013-11-21	申请日起二十年	原始取得
61.	Method of detecting and measuring contact alignment shift relative to	发明	美国	US14/040,730	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得

	gate structures in a semicondcutor device						
62.	Method of detecting transistors mismatch in a SRAM cell	发明	美国	US14/040,733	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
63.	Method of reducing contamination in CVD chamber	发明	美国	US14/040,739	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
64.	Method of manufacturing dual gate oxide devices	发明	美国	US14/040,737	2013-09-30	申请日起二十年	原始取得
65.	Method of detecting the circular uniformity of the semiconductor circular contact holes	发明	美国	US14/053,750	2013-10-15	申请日起二十年	原始取得
66.	Forming method of an annular storage unit of a magneto-resistive memory	发明	美国	US14/063,398	2013-10-25	申请日起二十年	原始取得
67.	Method of manufacturing the trench of U-shape	发明	美国	US14/070,060	2013-11-1	申请日起二十年	原始取得
68.	Method of forming the gate with the LELE double pattern	发明	美国	US14/085,380	2013-11-20	申请日起二十年	原始取得

69.	CMOS charge pump circuit	发明	美国	US14/091,337	2013-11-26	申请日起二十年	原始取得
70.	Apparatus for detecting the flatness of wafer and the method thereof	发明	美国	US14/092,056	2013-11-27	申请日起二十年	原始取得
71.	Method of inspecting misalignment of polysilicon gate	发明	美国	US14/142,584	2013-12-27	申请日起二十年	原始取得
72.	Methods and systems for using oxidation layers to improve device surface uniformity	发明	美国	US14/590,011	2015-1-6	申请日起二十年	原始取得
73.	Embedded SiGe epitaxy test pad	发明	美国	US15/937,881	2018-3-28	申请日起二十年	原始取得
74.	Embedded SiGe epitaxy test pad	发明	美国	US14/691,516	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得
75.	Semiconductor devices with shaped cavities for embedding germanium material and manufacturing processes thereof	发明	美国	US14/691,508	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得

76.	Methods and Systems for Improved Uniformity of SiGe Thickness	发明	美国	US14/691,520	2015-4-20	申请日起二十年	原始取得
77.	Shaped cavity for SiGe filling material	发明	美国	US14/706,986	2015-5-8	申请日起二十年	原始取得
78.	Methods and systems for using conformal filling layers to improve device surface uniformity	发明	美国	US14/720,829	2015-5-24	申请日起二十年	原始取得
79.	Method for forming cobalt barrier layer and metal interconnection process	发明	美国	US14/753,311	2015-6-29	申请日起二十年	原始取得
80.	Floating gate flash memory device and compilation method thereof	发明	美国	US14/753,220	2015-6-29	申请日起二十年	原始取得
81.	Methods and systems for reducing dislocation defects in high concentration epitaxy processes	发明	美国	US14/879,057	2015-10-8	申请日起二十年	原始取得
82.	Method of fabricating semiconductor device and semiconductor device fabricated thereby	发明	美国	US15/235,235	2016-8-12	申请日起二十年	原始取得

83.	Method for establishing mapping relation in STI etch and controlling critical dimension of STI	发明	美国	US15/083,292	2016-3-29	申请日起二十年	原始取得
84.	Method of planarizing polysilicon gate	发明	美国	US15/235,172	2016-8-12	申请日起二十年	原始取得
85.	Method of preparing a plan-view transmission electron microscope sample used in an integrated circuit analysis	发明	美国	US15/241,284	2016-8-19	申请日起二十年	原始取得
86.	Structure for interconnect parasitic extraction	发明	美国	US15/241,108	2016-8-19	申请日起二十年	原始取得
87.	System, method and test layout for detecting leakage current	发明	美国	US15/260,361	2016-9-9	申请日起二十年	原始取得
88.	Simulation method of CMP process	发明	美国	US15/283,286	2016-9-30	申请日起二十年	原始取得
89.	Method for forming shallow trenches of the dual active regions	发明	美国	US15/283,271	2016-9-30	申请日起二十年	原始取得

90.	Photoresist bottle capable of improving poor coating coverage	发明	美国	US15/333,105	2016-10-24	申请日起二十年	原始取得
91.	High pressure low thermal budge high-k post annealing process	发明	美国	US16/057,829	2018-8-8	申请日起二十年	原始取得
92.	SiGe source/drain structure	发明	美国	US16/112,640	2018-8-24	申请日起二十年	原始取得
93.	Method of sub resolution assist feature	发明	美国	US15/822,230	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
94.	Hotspot correction method	发明	美国	US15/826,705	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
95.	SiGe source/drain structure and preparation method thereof	发明	美国	US15/390,528	2016-12-25	申请日起二十年	原始取得
96.	Method for forming high aspect ratio patterning structure	发明	美国	US15/385,884	2016-12-21	申请日起二十年	原始取得
97.	Method for quickly establishing lithography process condition by a pre-compensation value	发明	美国	US15/800,043	2017-10-31	申请日起二十年	原始取得

98.	Method of etching a shallow trench	发明	美国	US15/389,414	2016-12-22	申请日起二十年	原始取得
99.	Structure and generation method of clock distribution network	发明	美国	US15/659,577	2017-7-25	申请日起二十年	原始取得
100.	Method and system for MOM capacitance value control	发明	美国	US15/826,726	2017-11-30	申请日起二十年	原始取得
101.	Optimization method and system for overlay error compensation	发明	美国	US15/800,071	2017-11-1	申请日起二十年	原始取得
102.	OPC method for a pattern corner	发明	美国	US15/800,088	2017-11-1	申请日起二十年	原始取得
103.	OPC method for a shallow ion implanting layer	发明	美国	US15/800,081	2017-11-1	申请日起二十年	原始取得
104.	Manufacturing method of a flash wafer	发明	美国	US15/822,226	2017-11-27	申请日起二十年	原始取得
105.	High pressure low thermal budge high-k post annealing process	发明	美国	US15/429,194	2017-2-10	申请日起二十年	原始取得

106.	Device and method for inrush current control	发明	美国	US15/638,383	2017-6-30	申请日起二十年	原始取得
107.	Transistor with SONOS structure having barrier wall over adjacent portions of the select transistor well and memory transistor well	发明	美国	US15/944,802	2018-4-4	申请日起二十年	原始取得
108.	Bipolar transistor with trench structure	发明	美国	US15/944,801	2018-4-4	申请日起二十年	原始取得
109.	Pixel structure and manufacturing method therefor	发明	美国	US16/203,628	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
110.	Pattern density analysis method	发明	美国	US16/203,624	2018-11-29	申请日起二十年	原始取得
111.	Silicon-controlled rectifier structure and manufacturing method thereof	发明	美国	US16/192,818	2018-11-16	申请日起二十年	原始取得
112.	Manufacturing method of a high performance metal-oxide-metal	发明	美国	US13/339,593	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得

113.	Method for reducing a minimum line width in a spacer-defined double patterning process	发明	美国	US13/339,559	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
114.	Treatment method for reducing particles in dual damascene silicon nitride process	发明	美国	US13/339,400	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
115.	Method of making optical proximity correction to original gate photomask pattern based on different substrate areas	发明	美国	US13/339,411	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
116.	Method for improving capacitance uniformity in a MIM device	发明	美国	US13/339,406	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
117.	Method for decreasing polysilicon gate resistance in a carbon co-implantation process	发明	美国	US13/339,417	2011-12-29	申请日起二十年	原始取得
118.	Global shutter CMOS image sensor and method for making the same	发明	美国	US18/063808	2022-12-9	申请日起二十年	原始取得

119.	Method for locating open circuit failure point of test structure	发明	美国	US17/896336	2022-8-26	申请日起二十年	原始取得
120.	Semiconductor structure and the manufacturing method thereof	发明	美国	US17/723305	2022-4-18	申请日起二十年	原始取得
121.	Semiconductor structure of split gate flash memory cell	发明	美国	US17/409146	2021-8-23	申请日起二十年	原始取得
122.	Method for manufacturing shallow trench isolations	发明	美国	US17/493229	2021-10-4	申请日起二十年	原始取得
123.	Method for detecting flare degree of lens of exposure machine	发明	美国	US17/492786	2021-10-4	申请日起二十年	原始取得
124.	Semiconductor device and method for manufacturing the same	发明	美国	US17/389182	2021-7-29	申请日起二十年	原始取得
125.	Semiconductor device and manufacturing method thereof	发明	美国	US17/388842	2021-7-29	申请日起二十年	原始取得
126.	Voltage controlled oscillator structure and phase-locked loop	发明	美国	US17/327294	2021-5-21	申请日起二十年	原始取得

127.	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/240862	2021-4-26	申请日起二十年	原始取得
128.	No-snapback silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/217644	2021-3-30	申请日起二十年	原始取得
129.	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/217517	2021-3-30	申请日起二十年	原始取得
130.	Manufacturing method for a semiconductor device	发明	美国	US17/244620	2021-4-29	申请日起二十年	原始取得
131.	Silicon controlled rectifier and method for making the same	发明	美国	US17/234,633	2021-4-19	申请日起二十年	原始取得
132.	Method for forming doped epitaxial layer of contact image sensor	发明	美国	US17/142431	2021-1-6	申请日起二十年	原始取得
133.	Global shutter CMOS image sensor and method for making the same	发明	美国	US16/951606	2020-11-18	申请日起二十年	原始取得
134.	Semiconductor structure and the manufacturing method thereof	发明	美国	US16/855803	2020-4-22	申请日起二十年	原始取得

135.	Preventive maintenance method for chamber of metal etching machine	发明	美国	US17/958,548	2022-10-3	申请日起二十年	原始取得
136.	Method for manufacturing deep trench isolation grid structure	发明	美国	US17/385,430	2021-7-26	申请日起二十年	原始取得
137.	SONOS memory and method for making the same	发明	美国	US17/352,451	2021-6-21	申请日起二十年	原始取得
138.	Layout structure of eFuse unit	发明	美国	US16/952,288	2020-11-19	申请日起二十年	原始取得
139.	Power-on-reset circuit	发明	美国	US18/231,851	2025-1-28	申请日起二十年	原始取得
140.	Method for Preparing Pixel Cell of CMOS Image Sensor	发明	美国	US17/890,376	2022-8-18	申请日起二十年	原始取得
141.	Method for Measuring Stitching Overlay Accuracy of Image Sensor Stitching Manufacturing	发明	美国	US17/893,425	2022-8-23	申请日起二十年	原始取得
142.	Image Stitching Method for Stitching Product	发明	美国	US17/895,279	2022-8-25	申请日起二十年	原始取得

143.	Method for Automatically Detecting Wafer Backside Brightfield Image Anomaly	发明	美国	US17/941,222	2022-9-9	申请日起二十年	原始取得
144.	Method for purge clean of low pressure furnace	发明	美国	US18/305,983	2023-4-24	申请日起二十年	原始取得
145.	Super Flash and Method for Manufacturing Same	发明	美国	US18/139,530	2023-4-26	申请日起二十年	原始取得
146.	System for Truning Off Power Consumption of Auxiliary Startup Circuit	发明	美国	US18/368,775	2023-9-15	申请日起二十年	原始取得
147.	One Time Programmable Memory Cell	发明	美国	US18/368,691	2023-9-15	申请日起二十年	原始取得
148.	Method for Manufacturing Photomask and Photomask	发明	美国	US17/893,387	2022-8-23	申请日起二十年	原始取得

表 3：标的公司拥有的主要集成电路布图设计专有权

序号	布图设计名称	登记号	专有权人	申请日	登记日
1.	HL55LPPOR06S1V1P0	BS.165515805	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
2.	HL55LPPOR12D1V1P0	BS.165515813	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
3.	HL55LPAD12S025D1V1	BS.165515791	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
4.	AD12S025D1V1_DAC	BS.165515783	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
5.	HL55LPBGR12D1V1P0 TOP_B	BS.165515775	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
6.	HL55LPVR100D1V1P0	BS.165515767	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
7.	HL55LPBGR12D1V1P0 TOP_A	BS.165515759	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
8.	HL55LPPLL1500S1V1P0_A	BS.165515732	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 12 日
9.	HL55LPPLL1500D1V1P0	BS.165515740	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日
10.	HL55LPLDO100D1V1P0	BS.165515724	华力微	2016 年 8 月 29 日	2016 年 10 月 11 日

附件二：标的公司报告期内关联交易情况

一. 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
华力集	采购货物	289,556,083.80	278,582,785.84
公司 B	采购货物	5,486,901.00	128,310.00
上海华虹虹日电子有限公司	采购货物	14,318,999.29	38,475,798.67
上海华虹挚芯电子科技有限公司	采购货物	1,008,159.93	1,621,553.57
挚芯电子（上海）有限公司	采购货物	541,987.00	13,562.00
华海清科股份有限公司	采购货物	10,620.46	120,786.15
华力集	接受服务	66,214,382.51	31,562,775.64
公司 B	接受服务	33,311.01	71,904.03

二. 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度

华力集	销售货物	206,495,606.97	271,167,801.10
公司 B	销售货物	2,098,652.82	-
挚芯电子（上海）有限公司	销售货物	-	628,432.00
上海复旦微电子集团股份有限公司	销售货物	70,211,820.00	54,346,165.00
华力集	提供服务	16,698,951.01	22,721,820.09
公司 B	提供服务	5,267,828.48	5,678,354.79
挚芯电子（上海）有限公司	提供服务	-	71,798.00
上海复旦微电子集团股份有限公司	提供服务	5,719,318.40	8,008,543.00
公司 B	技术开发	-	471,000,000.00

三. 关联租赁情况

1. 本公司作为出租方

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度确认的租赁收入	2024 年度确认的租赁收入
华力集	房屋及建筑物	561,369.03	571,066.86
公司 B	设备	1,384,633.42	-

2. 本公司作为承租方

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2025 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力	房屋及建筑物	99,595,621.28	19,470,211.16	786,033.11

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	使用权资产重估调整
上海华虹宏力	房屋及建筑物	97,846,263.60	23,249,978.04	1,136,643.66

四. 关联方委托贷款

单位：元

委托人	2024 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2025 年 12 月 31 日
华虹集团	-	137,550,000.00	-	137,550,000.00

五. 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
公司 B	融资租出设备	59,292,984.00	-

六. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
关键管理人员薪酬	16,212,816.78	36,527,033.43

七. 其他关联交易

单位：元

交易类型	关联方名称	2025 年度	2024 年度
由关联方代收代付水电物业费等	上海华虹宏力	203,724,693.70	203,582,910.27

八. 关联方应收应付款项

1. 应收账款

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
华力集	75,067,747.91	33,886,020.36
公司 B	374,771.65	1,191,472.39
上海复旦微电子集团股份有限公司	440,146.30	2,997,737.45

2. 其他应收款

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
华力集	12,240.05	4,174.00

3. 长期应收款（含一年内到期的非流动资产）

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日

公司 B	69,457,501.42	-

4. 其他非流动资产

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力	3,498,229.31	3,876,226.67
华力集	-	51,585,101.89

5. 应付账款

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
华力集	86,965,487.00	85,795,520.74
公司 B	-	128,310.00
上海华虹宏力	46,759,356.11	62,806,966.77
上海华虹虹日电子有限公司	319,712.80	15,474,109.26
上海华虹挚芯电子科技有限公司	212,470.00	476,905.12

挚芯电子（上海）有限公司	334,915.00	13,562.00
华海清科股份有限公司	105.00	2,049.04

6. 其他应付款

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
华力集	2,151,177.48	7,022,838.92
公司 B	1,137.48	33,234.90
上海华虹宏力	5,738,944.95	4,173,815.32

7. 租赁负债（含一年内到期的非流动负债）

单位：元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
上海华虹宏力	391,445,003.95	470,784,380.79

华虹半导体有限公司

备考合并财务报表及审阅报告

2024年度及2025年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京265KTZL45A

目 录

		页 次
一、	审阅报告	1 - 2
二、	备考合并财务报表	
	备考合并资产负债表	3 - 5
	备考合并利润表	6 - 7
	备考合并财务报表附注	8 - 99

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审阅报告

安永华明（2026）专字第70013197_B04号
华虹半导体有限公司

华虹半导体有限公司全体股东：

我们审阅了华虹半导体有限公司按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2024年12月31日及2025年12月31日的合并备考资产负债表，2024年度及2025年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是华虹半导体有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信后附的备考合并财务报表没有在所有重大方面按照备考财务报表附注二所述编制基础编制。

我们提醒备考合并财务报表使用者关注备考合并财务报表附注二对编制基础的说明，华虹半导体有限公司管理层编制备考合并财务报表是为了上市公司重大资产重组的目的。因此，备考合并财务报表可能不适于其他目的。本报告仅供华虹半导体有限公司为重大资产重组目的向上海证券交易所报送文件之用，不得用于任何其他目的。本段内容不影响已发表的审阅结论。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

审阅报告（续）

安永华明（2026）专字第70013197_B04号
华虹半导体有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨　磊

中国注册会计师：王顺华

中国　北京

2026 年 3 月 30 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

华虹半导体有限公司
备考合并资产负债表
2024年12月31日及2025年12月31日

单位：人民币元

资产	附注五	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产			
货币资金	1	37, 866, 504, 977. 03	33, 975, 706, 759. 60
应收票据	2	334, 522, 025. 13	351, 673, 900. 23
应收账款	3	2, 320, 446, 612. 87	2, 297, 708, 908. 61
预付款项	4	63, 855, 714. 88	46, 300, 375. 36
其他应收款	5	47, 212, 315. 80	23, 888, 760. 30
存货	6	6, 596, 213, 769. 06	6, 537, 913, 978. 02
一年内到期的非流动资产	7	13, 028, 672. 74	-
其他流动资产	8	3, 682, 335, 631. 49	2, 445, 680, 125. 47
流动资产合计		50, 924, 119, 719. 00	45, 678, 872, 807. 59
非流动资产			
长期应收款	9	56, 428, 828. 68	-
长期股权投资	10	590, 452, 131. 36	539, 500, 990. 07
其他权益工具投资	11	3, 200, 360, 000. 00	2, 009, 304, 000. 00
投资性房地产	12	366, 733, 220. 18	-
固定资产	13	34, 087, 975, 236. 24	30, 575, 302, 664. 68
在建工程	14	14, 561, 972, 197. 82	13, 518, 313, 222. 02
使用权资产	15	109, 881, 602. 38	145, 558, 295. 19
无形资产	16	645, 794, 341. 63	739, 128, 869. 86
长期待摊费用	17	5, 637, 833. 43	6, 724, 584. 85
递延所得税资产	18	-	145, 122, 823. 55
其他非流动资产	19	1, 559, 972, 916. 87	202, 600, 031. 35
非流动资产合计		55, 185, 208, 308. 59	47, 881, 555, 481. 57
资产总计		106, 109, 328, 027. 59	93, 560, 428, 289. 16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华虹半导体有限公司
备考合并资产负债表（续）
2024年12月31日及2025年12月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注五	2025年12月31日	2024年12月31日
流动负债			
应付账款	21	3,014,300,410.10	3,008,803,169.46
预收款项	22	416,522.94	-
合同负债	23	1,063,573,175.44	894,985,562.13
应付职工薪酬	24	887,946,408.87	728,251,680.34
应交税费	25	166,375,835.88	297,602,392.19
其他应付款	26	5,243,240,589.44	4,909,568,201.50
一年内到期的非流动负债	27	3,337,473,529.19	2,859,597,372.22
其他流动负债	28	756,632,684.18	517,199,527.23
流动负债合计		14,469,959,156.04	13,216,007,905.07
非流动负债			
长期借款	29	22,062,189,159.44	16,209,850,630.90
租赁负债	30	110,206,498.54	129,880,868.49
长期应付款	33	4,179,190,000.00	-
预计负债	31	207.77	5,273,501.96
递延收益	32	16,110,000.00	16,110,000.00
递延所得税负债	18	85,074,969.00	72,962,063.68
非流动负债合计		26,452,770,834.75	16,434,077,065.03
负债合计		40,922,729,990.79	29,650,084,970.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华虹半导体有限公司
备考合并资产负债表（续）
2024年12月31日及2025年12月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益	附注五	2025年12月31日	2024年12月31日
股东权益			
股本	34	35,004,886,606.30	34,654,703,268.47
资本公积	35	7,067,544,561.90	6,930,371,491.65
其他综合收益	36	1,387,782,104.97	555,975,084.95
专项储备	37	1,969,388.66	-
盈余公积	38	1,854,894,408.25	1,703,681,884.84
未分配利润	39	1,935,058,661.32	901,987,450.55
归属于母公司股东权益合计		47,252,135,731.40	44,746,719,180.46
少数股东权益		17,934,462,305.40	19,163,624,138.60
股东权益合计		65,186,598,036.80	63,910,343,319.06
负债和所有者权益总计		106,109,328,027.59	93,560,428,289.16

本财务报表由以下人士签署：

企业负责人：白鹏 主管会计工作负责人：王鼎 会计机构负责人：黄英娜

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

华虹半导体有限公司
备考合并利润表
2024年度及2025年度

单位：人民币元

	附注五	2025年	2024年
营业收入	40	22,287,957,086.69	19,274,055,492.92
减：营业成本	40	17,879,181,598.64	15,976,733,320.26
税金及附加	41	126,465,374.60	105,403,064.64
销售费用	42	84,501,019.18	78,627,154.55
管理费用	43	961,290,410.72	941,539,982.83
研发费用	44	2,225,109,395.81	1,855,210,557.98
财务费用	45	155,717,990.83	45,287,745.99
其中：利息费用	45	556,122,942.67	740,595,389.56
利息收入	45	533,504,049.56	892,524,563.08
加：其他收益	46	390,569,582.11	263,837,391.30
投资收益	47	30,951,141.29	10,990,874.46
其中：对联营企业的投资收益		30,951,141.29	10,978,414.46
信用减值损失	48	(23,309,775.25)	19,499,477.49
资产减值损失	49	(1,176,119,903.21)	(932,940,319.67)
资产处置收益	50	32,018,966.18	(1,008,229.36)
营业利润/（亏损）		109,801,308.03	(368,367,139.11)
加：营业外收入	51	2,540,789.34	5,968,286.42
减：营业外支出	52	1,083,329.05	5,772,458.36
利润/（亏损）总额		111,258,768.32	(368,171,311.05)
减：所得税费用	53	156,136,867.34	43,865,693.88
净亏损		(44,878,099.02)	(412,037,004.93)
按经营持续性分类			
持续经营净亏损		(44,878,099.02)	(412,037,004.93)
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,184,283,734.18	955,315,517.52
少数股东损益		(1,229,161,833.20)	(1,367,352,522.45)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位：人民币元

	附注五	2025年	2024年
其他综合收益的税后净额	36		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		831,807,020.02	97,388,337.20
不能重分类进损益的其他综合收益			
其他权益工具投资公允价值变动		906,147,600.00	47,092,246.35
权益法下不能转损益的其他综合亏损		-	(4,765,200.00)
外币财务报表折算差额		(62,727,560.31)	47,538,805.76
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		(11,613,019.67)	7,522,485.09
综合收益/（亏损）总额		786,928,921.00	(314,648,667.73)
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		2,016,090,754.20	1,052,703,854.72
归属于少数股东的综合亏损总额		(1,229,161,833.20)	(1,367,352,522.45)
每股收益	54		
基本每股收益		0.62	0.50
稀释每股收益		0.62	0.50

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、 发行股份购买资产交易的基本情况

1. 参与发行股份购买资产交易的各方

(1) 华虹半导体有限公司（“本公司”）

本公司是一家于2005年1月成立在中国香港特别行政区的有限责任公司。本公司所发行股票，已在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）和上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司总部位于上海市张江高科技园区哈雷路288号。

本公司为投资控股公司。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事集成电路有关的设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。

本公司的直接控股股东为于开曼群岛注册成立的上海华虹国际公司（“华虹国际”）。本公司的间接控股股东为于中华人民共和国成立的上海华虹（集团）有限公司（“华虹集团”）。本公司的实际控制人为于中华人民共和国成立的上海市国有资产监督管理委员会（“上海市国资委”）。

(2) 上海华力微电子有限公司（“华力微”）

华力微是一家于 2010 年 1 月成立在中华人民共和国注册的有限责任公司。华力微注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号。

华力微经批准的经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品，从事货物及技术的进出口业务。

华力微的母公司为华虹集团，最终控制方为上海市国资委。

2025 年 6 月 26 日，根据沪华力微股（2025）第 4 号股东会决议，全体股东一致同意华力微存续分立的方案，采取存续分立的形式，将公司分立为上海华力微电子有限公司（存续公司，以下简称“分立后的华力微”）及新设公司。分立后的华力微继续运营位于中国（上海）自由贸易试验区高斯路 568 号的 12 英寸晶圆厂晶圆代工等相关的业务，并承继与之相关的资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务，新设公司承继长期股权投资及相应的业务、资产、债权债务、人员及其他约定的权利义务。分立后的华力微与新设公司保持业务、资产、人员、财务、机构等方面的相互独立。华力微于 2025 年 8 月 21 日完成了本次分立行为。分立后的华力微注册资本与新设公司的注册资本之和等于本次分立前华力微的注册资本。分立后本集团分别持有分立后的华力微和新设公司 2.5012%的股权。分立后的华力微作为本次交易的标的公司（“标的公司”）。

一、 发行股份购买资产交易的基本情况（续）

2. 发行股份购买资产交易方案

2025年8月29日，本公司2025年第六次董事会会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，批准本公司通过发行股份的方式向华虹集团、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的标的公司97.4988%股权并募集配套资金。本次交易完成后，标的公司将成为本公司100%全资子公司。

2026年2月10日，本公司2026年第一次临时股东大会决议通过上述交易相关议案。

根据有关法律法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、 编制基础

按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》（以下简称“格式准则第26号”）之相关规定，本备考财务报表系本公司向中国证监会申请拟实施如附注一中所述的发行股份购买资产之目的而编制，仅供本公司向中国证券监督管理委员会申报发行股份购买资产并募集配套资金事宜使用。

为给使用者提供更相关的信息，本备考合并财务报表之编制系假定附注一、1（2）所述的分立以及附注一、2所述的交易所形成的业务架构于备考合并财务报表列报之最早列报期初已经存在，并根据下述之具体方法编制：

(1) 本备考合并财务报表系以本集团2024年度和2025年度（“相关期间”）的合并财务报表和标的公司相关期间分立后的财务报表（经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告号为大华审字[2025]0011016213号、大华审字[2026]0011007164号)为基础编制；

(2) 本备考合并财务报表根据附注一、2中所述发行股份购买资产交易方案考虑新发行股份的影响，假设本公司按照本次重组中拟以人民币43.34元每股的价格新发行190,768,392股A股股票购买标的公司97.4988%股权的交易于2024年1月1日已完成，由于本公司股票无面值，按购买97.4988%股权所享有的标的公司2024年1月1日账面净资产的份额计入股本；

(3) 假设分立于2024年1月1日已完成，本集团于2024年1月1日持有新设公司2.5012%的股权；

二、 编制基础（续）

(4) 如附注一中所述，本公司及标的公司的最终实际控制方均为上海市国资委，基于本次发行股份购买资产交易于2024年1月1日前已完成，收购完成后的组织架构及相关业务于2024年1月1日已存在的假设，本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则，即自本备考财务合并财务报表之最早列报期初（2024年1月1日）起本公司取得标的公司的资产和负债按其在最终控制方财务报表中的账面价值并入备考合并财务报表，与交易价格的差额调整资本公积；备考合并利润表中的归属于母公司股东的净利润/综合收益总额代表归属于重组前本公司股东的净利润/综合收益总额与归属于重组前标的公司的净利润/综合收益总额的合计并考虑合并抵消调整；

(5) 本备考合并财务报表已按上述假定交易完成后的业务架构，将本集团与标的公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用进行抵消；

(6) 基于编制本备考合并财务报表的特定目的，本备考合并财务报表仅列示相关期间经扩大集团的备考合并资产负债表和合并利润表，未列示合并现金流量表、合并所有者权益变动表及相关附注。本公司管理层认为，相关期间的备考合并现金流量表、备考合并所有者权益变动表及相关附注对作为特定用途的本备考合并财务报表的使用者无实质意义，因此本备考合并财务报表未编制备考合并现金流量表和备考合并所有者权益变动表及相关附注，同时本备考合并财务报表仅列示与上述备考合并财务报表编制基础相关的有限备考合并附注，亦未披露与金融工具相关的风险、公允价值、资本管理与分部报告等信息；

(7) 由于标的公司相关期间分立后的财务报表附注中未披露未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损的金额以及所得税费用与会计利润关系的说明，因此本备考合并财务报表亦未进行相关披露；

(8) 根据格式准则第26号之相关规定，标的公司相关期间经审计的财务报表已经按照与本公司相同的会计制度和会计政策编制；

(9) 备考合并财务报表附注一、2所述的相关议案能够获得中国证券监督管理委员会的批准（核准），本次重组事项能够按此重组方案得以实施；

(10) 不考虑本次交易可能发生的交易费用及相关税费。

二、 编制基础（续）

除上述所述的假设外，本备考合并财务报表未考虑其他与本次发行股份购买资产交易可能相关的事项的影响。由于本备考合并财务报表的编制具有某些能够影响信息可靠性的固有限制，未必真实反映如果本次发行股份购买资产交易已于2024年1月1日完成的情况下本集团于2024年12月31日及2025年12月31日的合并财务状况、2024年度及2025年度的合并经营成果。

本备考财务报表以持续经营为基础列报。

编制本备考合并财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

本公司编制备考合并财务报表是为了向中国证券监督管理委员会申报发行股份购买资产并募集配套资金事宜使用，不得用作其他目的。

三、 重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在存货跌价准备、固定资产折旧、投资性房地产折旧以及无形资产摊销。

1. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司记账本位币为美元，本公司确定美元为记账本位币的原因是：投资活动和融资活动所使用的货币主要为美元。编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，本财务报表以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

3. 重要性标准确定方法和选择依据

	重要性标准
重要的应收账款/其他应收款坏账准备收回或转回金额，重要的应收账款/其他应收款实际核销项目	占应收账款、其他应收款账面价值比例10%以上
重要的单项计提坏账准备的应收款项/其他应收款	占应收账款、其他应收款账面价值比例10%以上
重要的应付账款/预收款项/合同负债/其他应付款	单项应付账款/预收款项/合同负债/其他应付款占应付账款/预收款项/合同负债/其他应付款总额的10%以上
重要的在建工程	项目预算超过人民币10亿元，且本期增加额超过人民币5,000万元
存在重要少数股东权益的子公司	单项少数股东权益占集团净资产总额的5%以上
重要的联营企业	集团出资额人民币5亿元以上且并非为投资性主体

4. 企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

5. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

5. 合并财务报表（续）

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

6. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

7. 外币业务和外币报表折算（续）

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1） 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分）即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

8. 金融工具（续）

（2） 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

8. 金融工具（续）

（2） 金融资产分类和计量（续）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3） 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

8. 金融工具（续）

（4） 金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以逾期账龄组合为基础评估相关金融工具的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

8. 金融工具（续）

（4） 金融工具减值（续）

按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

（5） 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6） 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

9. 存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、房地产开发产品及房地产开发成本。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。房地产开发成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品，开发产品采用个别计价法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按类别计提。

对于原材料，集团根据生产计划或技术进步情况确认的未来使用的物料清单判断原材料是否陈旧或过时，同时考虑原材料用途、库龄、损毁、退货等因素的影响，按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备；集团以存货的预计销售价格减去估计的销售费用、相关税费、为达到预定可销售状态后续可能发生的加工成本后的金额作为可变现净值的计算基础，并计提跌价准备。对于在产品，考虑到其后续仍要继续加工库存商品，以库存商品的预计销售价格减去估计的销售费用、相关税费、为达到预定可销售状态后续可能发生的加工成本后的金额作为可变现净值的计算基础；集团根据在产品可变现净值与账面价值的差额计提存货跌价准备。对于库存商品，集团以销售订单的价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额作为可变现净值的计算基础；集团根据库存商品可变现净值与账面价值的差额计提存货跌价准备。对于房地产开发成本及开发产品，本集团以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为可变现净值的计算基础，根据可变现净值与账面净值的差额计提存货跌价准备。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

10. 长期股权投资

长期股权投资包括对联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团对被投资单位具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

11. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧和摊销。投资性房地产的使用寿命、预计净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	25年	5.00%	3.80%
土地使用权	40年	-	2.50%

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法进行复核，必要时进行调整。

投资性房地产的用途改为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

12. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25年	5.00%	3.80%
厂务设施	10年	5.00%	9.50%
机器设备	5-7年	5.00%	13.60%-19.00%
运输工具	5年	5.00%	19.00%
办公设备	5年	5.00%	19.00%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

13. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	投入使用
厂务设施	投入使用
机器设备	完成安装调试
运输工具	办理完成车辆登记证明完成验收
办公设备	资产到达完成验收

三、 重要会计政策和会计估计（续）

14. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

15. 无形资产

（1） 无形资产使用寿命

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命	确定依据
土地使用权	42或50年	土地使用权期限
生产管理软件	1-10年	软件使用年限/预计使用年限孰短
非专利技术	3-10年	非专利技术使用年限/预计使用年限孰短

三、 重要会计政策和会计估计（续）

15. 无形资产（续）

（2） 研发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

16. 资产减值

对除存货、递延所得税及金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费	租入固定资产：5年与剩余租赁年限孰短 自有固定资产：5年
实施服务费	5年与受益期孰短

三、 重要会计政策和会计估计（续）

18. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

（1） 短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

19. 股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

20. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反应当前最佳估计数。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

21. 与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

（1） 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团将因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额作为交易价格，并根据合同条款，结合以往的商业惯例予以确定。

本集团通常通过向客户交付商品履行履约义务，本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点，即本集团商品由客户签收或确认时确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2） 提供服务

本集团与客户订立合同，向客户提供管理服务，为单项履约义务。在服务已完成，客户取得相关服务控制权时确认收入。

（3） 授予技术许可

本集团与客户订立合同，向客户授予技术许可，构成单项履约义务。本集团向客户授予知识产权许可，确定该技术许可是在某一时段内履行还是在某一时点履行。同时满足合同要求或客户能够合理预期本集团将从事对该项知识产权有重大影响的活动，该活动对客户将产生有利或不利影响，且该活动不会导致向客户提供某项服务三项条件时，作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

22. 合同负债

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

23. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为负债，并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本；用于对本集团过去行为的奖励，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

24. 递延所得税

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1） 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
（2） 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

24. 递延所得税（续）

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1） 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
（2） 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

25. 租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

25. 租赁（续）

（1） 作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

25. 租赁（续）

（2） 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和，包括初始直接费用。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

26. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

27. 公允价值计量

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

28. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

28. 重大会计判断和估计（续）

（1） 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

投资性房地产与自用房地产的分类
本集团决定物业是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相关标准。投资性房地产是为赚取租金或资本增值或同时为此两项目的而持有的物业。因此，本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于本集团持有的其他资产。本集团将为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产项目作为投资性房地产核算，而为生产商品、提供劳务或者经营管理而持有的房地产项目则作为自用房地产核算。

经营租赁——作为出租人
本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

融资租赁——作为出租人
本集团就机器设备签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团转移了这些机器设备所有权上的几乎全部重大风险和报酬，因此作为融资租赁处理。

（2） 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

三、 重要会计政策和会计估计（续）

28. 重大会计判断和估计（续）

（2） 估计的不确定性（续）

非上市股权投资的公允价值
本集团采用市场法确定对某些非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

金融工具减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

四、 税项

1. 主要税种及税率

	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)；或应税销售额（应纳税额按当期应纳税销售额乘以征收率计算）	5%、6%、9%或13%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	5%或7%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的增值税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、29.84%、33.58%或25%
房产税	房屋的计税余值	1.2%
印花税	借款合同：借款金额	0.05‰
	买卖合同、建设工程合同：合同价款	0.3‰
	加工承揽合同：加工或承揽收入	0.3‰
	财产保险合同：保险费	1.0‰
	租赁合同：租金	1.0‰
	运输合同：运输费用	0.3‰
	仓储、保管合同：仓储费、保管费	1.0‰
	技术合同：合同价款、报酬或使用费	0.3‰
	营业账簿中记载资金的账簿：股本和资本公积的合计金额	0.25‰

执行不同企业所得税税率纳税主体如下：

	所得税税率
华虹半导体有限公司	16.5%
Grace Semiconductor Manufacturing Corporation	于报告期间在当地无须纳税
HHGrace Semiconductor USA	联邦企业所得税税率21%，州税税率8.84%
HHGrace Semiconductor Japan	33.58%
上海华虹宏力半导体制造有限公司	15%
除上述以外的纳税主体	25%

四、 税项（续）

2. 税收优惠

企业所得税税收优惠

本公司下属子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的有关规定自2023年度至2025年度享受企业所得税优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司华虹半导体（无锡）有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司以及标的公司，符合根据财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部发布的财税[2018]27号《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》、国务院发布的国发[2020]8号《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部发布的公告[2020]45号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》的规定，符合前述规定范围和条件的集成电路生产企业，可自获利年度起在相应期间内享受免征企业所得税或按照25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠。截至2025年12月31日，上述公司均尚未进入获利年度，实际所得税税率为零。

研究开发费加计扣除

本公司于中国境内设立的子公司2023年度起，根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（公告[2023]44号），集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的220%在税前摊销。

增值税加计扣除

本公司于中国境内设立的子公司，根据《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17号文），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2025年12月31日	2024年12月31日
现金	159,721.90	177,877.34
银行存款	37,451,621,397.86	33,486,223,440.86
应计利息	187,397,863.73	255,707,067.06
其他货币资金	227,325,993.54	233,598,374.34
合计	37,866,504,977.03	33,975,706,759.60
其中：存放在境外的款项总额	470,886,959.54	221,752,860.93

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，账面价值分别为人民币 227,324,393.54 元及人民币 228,338,703.94 元的货币资金的所有权受到限制，参见附注五、20。

2. 应收票据

（1） 应收票据分类列示

	2025年12月31日	2024年12月31日
银行承兑汇票	312,356,931.02	318,249,234.03
商业承兑汇票	22,181,805.00	33,449,866.00
	334,538,736.02	351,699,100.03
减：应收票据坏账准备	16,710.89	25,199.80
合计	334,522,025.13	351,673,900.23

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

2. 应收票据（续）

（2） 应收票据坏账准备的变动

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
2025年	25,199.80	–	(8,488.91)	16,710.89
2024年	10,779.85	14,419.95	–	25,199.80

	2025年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
银行承兑汇票	312,356,931.02	93.37	–	–	312,356,931.02
商业承兑汇票	22,181,805.00	6.63	16,710.89	0.08	22,165,094.11
合计	334,538,736.02	100.00	16,710.89		334,522,025.13

	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备					
银行承兑汇票	318,249,234.03	90.49	–	–	318,249,234.03
商业承兑汇票	33,449,866.00	9.51	25,199.80	0.08	33,424,666.20
合计	351,699,100.03	100.00	25,199.80		351,673,900.23

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款

（1） 按账龄披露

	2025年12月31日	2024年12月31日
1年以内	2,360,991,751.00	2,315,872,432.62
1年至2年	13,492,777.53	5,752,928.50
2年至3年	5,120,603.93	46,609,215.71
3年至4年	34,825,485.29	-
5年以上	7,790,828.19	9,868,640.00
	2,422,221,445.94	2,378,103,216.83
减：应收账款坏账准备	101,774,833.07	80,394,308.22
合计	2,320,446,612.87	2,297,708,908.61

（2） 按坏账计提方法分类披露

	2025年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,422,221,445.94	100.00	101,774,833.07	4.20	2,320,446,612.87

	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,378,103,216.83	100.00	80,394,308.22	3.38	2,297,708,908.61

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款（续）

（2） 按坏账计提方法分类披露（续）

于2025年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	减值准备	计提比例（%）
信用期内	2,244,106,804.42	8,489,916.21	0.38
逾期90天内	63,692,668.92	2,209,857.85	3.47
逾期90天-180天	34,462,771.73	11,115,858.14	32.25
逾期180天以上	79,959,200.87	79,959,200.87	100.00
合计	2,422,221,445.94	101,774,833.07	

于2024年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	减值准备	计提比例（%）
信用期内	2,087,384,901.03	3,841,459.37	0.18
逾期90天内	191,109,158.21	2,919,708.43	1.53
逾期90天-180天	36,797,736.13	10,821,718.96	29.41
逾期180天以上	62,811,421.46	62,811,421.46	100.00
合计	2,378,103,216.83	80,394,308.22	

（3） 坏账准备的情况

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年收回或转回	本年转销	本年核销	折算差异	年末余额
2025年	80,394,308.22	23,952,871.51	(634,607.35)	-	(1,907,033.21)	(30,706.10)	101,774,833.07
2024年	99,885,482.35	-	(19,513,897.44)	-	-	22,723.31	80,394,308.22

（4） 实际核销的应收账款情况

2025年度实际核销金额为人民币1,907,033.21元，其中无重大的应收款项。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款（续）

（5） 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

2025年

	年末余额	坏账准备金额	占应收账款合计的比例(%)
余额前五名的应收账款总额	787,942,955.99	2,709,255.39	32.42

2024年

	年末余额	坏账准备金额	占应收账款合计的比例(%)
余额前五名的应收账款总额	703,970,795.29	6,590,640.81	29.60

4. 预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

	2025年12月31日	2024年12月31日
1年以内	63,855,714.88	46,300,375.36

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

2025年

	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	44,133,946.84	69.12

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

4. 预付款项（续）

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况（续）

2024年

	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	36,536,880.40	78.91

5. 其他应收款

（1） 按账龄披露

	2025年12月31日	2024年12月31日
1年以内	32,945,817.04	15,972,060.46
1年至2年	9,293,841.62	914,837.20
2年至3年	320,695.97	978,145.56
3年至4年	406,183.65	42,943.15
4年至5年	32,357.58	1,613,944.20
5年以上	10,490,210.81	10,688,950.09
	53,489,106.67	30,210,880.66
减：其他应收款坏账准备	6,276,790.87	6,322,120.36
合计	47,212,315.80	23,888,760.30

（2） 按款项性质分类情况

	2025年12月31日	2024年12月31日
代收代付款项	8,739,120.60	8,739,120.60
应收押金以及保证金	11,230,179.03	7,418,342.36
应收股权激励行权成本	23,102,304.61	770,032.62
其他	4,140,711.56	6,961,264.72
合计	47,212,315.80	23,888,760.30

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（3） 坏账准备计提情况

	2025年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
信用风险特征组合计提坏账准备	47, 212, 315. 80	88. 27	–	–	47, 212, 315. 80
单项计提坏账准备	6, 276, 790. 87	11. 73	6, 276, 790. 87	100. 00	–
合计	53, 489, 106. 67	100. 00	6, 276, 790. 87	11. 70	47, 212, 315. 80

	2024年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
信用风险特征组合计提坏账准备	23, 888, 760. 30	79. 07	–	–	23, 888, 760. 30
单项计提坏账准备	6, 322, 120. 36	20. 93	6, 322, 120. 36	100. 00	–
合计	30, 210, 880. 66	100. 00	6, 322, 120. 36	20. 93	23, 888, 760. 30

其他应收款按照未来12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

2025年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 （未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 （已发生信用减值）	合计
年初余额	–	–	6, 322, 120. 36	6, 322, 120. 36
折算差异	–	–	(45, 329. 49)	(45, 329. 49)
年末余额	–	–	6, 276, 790. 87	6, 276, 790. 87

2024年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 （未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期 预期信用损失 （已发生信用减值）	合计
年初余额	–	–	6, 292, 099. 51	6, 292, 099. 51
折算差异	–	–	30, 020. 85	30, 020. 85
年末余额	–	–	6, 322, 120. 36	6, 322, 120. 36

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 其他应收款（续）

（4） 坏账准备的情况

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	折算差异	年末余额
2025年	6,322,120.36	–	–	–	(45,329.49)	6,276,790.87
2024年	6,292,099.51	–	–	–	30,020.85	6,322,120.36

（5） 按欠款方归集的年末余额其他应收款金额前五名

2025年

	年末余额	占其他应收款余额合计数比例（%）	性质	账龄	坏账准备年末金额
核聚证券有限公司	23,102,304.61	48.93	应收股权激励行权成本	1年以内	–
无锡海关	5,227,587.60	11.07	押金以及保证金	1年以内	–
无锡华润燃气有限公司	1,282,200.00	2.72	押金以及保证金	1年至2年、5年以上	–
上海浦东国际机场海关	1,126,143.35	2.39	押金以及保证金	1年以内，1年至2年，2年至3年，3年至4年，4年至5年，5年以上	–
苏州东微半导体股份有限公司	788,336.30	1.67	应收基片款	1年以内	
合计	31,526,571.86	66.78			–

2024年

	年末余额	占其他应收款余额合计数比例（%）	性质	账龄	坏账准备年末金额
苏南冠寓商业运营管理（无锡）有限公司	1,505,042.00	4.98	押金以及保证金	5年以上	–
紫光同芯微电子有限公司	1,304,962.00	4.32	应收基片款	1年以内	–
无锡华润燃气有限公司	1,282,200.00	4.24	押金以及保证金	1年以内，4年至5年	–
上海盛朵实业有限公司	1,114,300.00	3.69	押金以及保证金	4年至5年，5年以上	–
核聚证券有限公司	770,032.62	2.55	应收股权激励行权成本	1年以内	–
合计	5,976,536.62	19.78			–

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 存货

（1） 存货分类

	2025年12月31日	2024年12月31日
原材料	2,264,465,882.47	2,441,584,417.14
在产品	2,285,809,098.96	2,032,497,181.58
库存商品	1,148,536,409.39	1,070,817,246.01
房地产开发产品	1,586,672,501.14	-
房地产开发成本	-	1,595,140,123.64
	7,285,483,891.96	7,140,038,968.37
减：存货跌价准备	689,270,122.90	602,124,990.35
合计	6,596,213,769.06	6,537,913,978.02

（2） 存货跌价准备

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少 转回或转销	年末余额
原材料	314,124,979.06	217,788,394.67	131,696,453.73	400,216,920.00
在产品	221,274,720.46	640,986,584.87	722,138,662.42	140,122,642.91
库存商品	66,725,290.83	245,453,326.53	235,139,654.51	77,038,962.85
房地产开发产品	-	71,891,597.14	-	71,891,597.14
合计	602,124,990.35	1,176,119,903.21	1,088,974,770.66	689,270,122.90

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少 转回或转销	年末余额
原材料	205,376,383.72	169,918,111.30	61,169,515.96	314,124,979.06
在产品	250,913,753.53	630,926,398.68	660,565,431.75	221,274,720.46
库存商品	244,617,364.19	132,095,809.69	309,987,883.05	66,725,290.83
合计	700,907,501.44	932,940,319.67	1,031,722,830.76	602,124,990.35

本年存货跌价准备减少主要是由于已计提存货跌价准备的存货本年已领用或销售。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 存货（续）

（2） 存货跌价准备（续）

按组合计提存货跌价准备的情况如下：

	2025年		
	账面余额	跌价准备	计提比例（%）
原材料	2,264,465,882.47	400,216,920.00	17.67
在产品	2,285,809,098.96	140,122,642.91	6.13
库存商品	1,148,536,409.39	77,038,962.85	6.71
房地产开发产品	1,586,672,501.14	71,891,597.14	4.53
合计	7,285,483,891.96	689,270,122.90	

	2024年		
	账面余额	跌价准备	计提比例（%）
原材料	2,441,584,417.14	314,124,979.06	12.87
在产品	2,032,497,181.58	221,274,720.46	10.89
库存商品	1,070,817,246.01	66,725,290.83	6.23
房地产开发成本	1,595,140,123.64	–	–
合计	7,140,038,968.37	602,124,990.35	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 存货（续）

于2025年12月31日，房地产开发产品明细如下：

项目名称	年初余额	本年从房地产开发成本转入额	本年减少额	2024年12月31日	存货跌价准备
华虹无锡集成电路产业配套及人才用房项目	-	1,586,672,501.14	-	1,586,672,501.14	71,891,597.14

于2025年12月31日，房地产开发成本明细如下：

项目名称	年初余额	本年增加额	本年向房地产开发产品转出额	2024年12月31日	存货跌价准备
华虹无锡集成电路产业配套及人才用房项目	1,595,140,123.64	-	1,595,140,123.64	-	-

于2025年12月31日，房地产开发成本明细如下：

项目名称	年初余额	本年增加额	本年向房地产开发产品转出额	2024年12月31日	存货跌价准备
华虹无锡集成电路产业配套及人才用房项目	1,266,584,464.48	328,555,659.16	-	1,595,140,123.64	-

于2025年12月31日及2024年12月31日，账面价值分别为人民币1,514,780,904.00元及人民币648,933,968.48元的存货的所有权受到限制，参见附注五、20。

于2025年12月31日，存货中房地产开发产品期末余额中含借款费用资本化金额为人民币44,024,150.13元，无2025年资本化金额。

于2025年12月31日，存货中房地产开发成本期末余额中含借款费用资本化金额为人民币44,024,150.13元，其中2024年资本化金额为人民币27,983,468.46元，

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 一年内到期的非流动资产

	2025年12月31日	2024年12月31日
一年内到期的融资租赁款	13,028,672.74	-

8. 其他流动资产

	2025年12月31日	2024年12月31日
增值税留抵税额	3,591,695,735.06	2,402,308,359.85
预缴税金	90,639,896.43	43,371,765.62
合计	3,682,335,631.49	2,445,680,125.47

9. 长期应收款

（1） 长期应收款情况

	2025年12月31日			2024年12月31日			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	56,428,828.68	-	56,428,828.68	-	-	-	2.44%

（2） 坏账准备计提情况

于 2024 及 2025 年 12 月 31 日，所有长期应收款的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团评估了未来 12 个月内预期信用损失，金额不重大，因此未计提坏账准备。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 长期股权投资

2025年

	年初账面价值	年初减值准备	本年变动								年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利	计提减值准备	其他		
联营企业												
上海华虹科技发展有限公司	407,939,274.95	-	-	-	22,775,233.74	-	-	-	-	-	430,714,508.69	-
上海华虹投资发展有限公司	131,561,715.12	-	20,000,000.00	-	8,175,907.55	-	-	-	-	-	159,737,622.67	-
合计	539,500,990.07	-	20,000,000.00	-	30,951,141.29	-	-	-	-	-	590,452,131.36	-

2024年

	年初账面价值	年初减值准备	本年变动								年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利	计提减值准备	其他		
联营企业												
上海华虹科技发展有限公司	375,745,287.11	-	-	-	32,193,987.84	-	-	-	-	-	407,939,274.95	-
上海华虹投资发展有限公司	157,542,488.50	-	-	-	(21,215,573.38)	(4,765,200.00)	-	-	-	-	131,561,715.12	-
合计	533,287,775.61	-	-	-	10,978,414.46	(4,765,200.00)	-	-	-	-	539,500,990.07	-

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 其他权益工具投资

（1） 其他权益工具投资情况

2025年

	年初余额	增资	本年计入其他综合收益的利得/（损失）	本年转入留存收益的利得/（损失）	年末余额	累计计入其他综合收益的利得/（损失）	本年股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
公司A*	1,864,224,000.00	-	1,065,136,000.00	-	2,929,360,000.00	1,580,288,299.62	-	该笔投资具有战略性质
公司C*	125,000,000.00	125,000,000.00	(8,450,000.00)	-	241,550,000.00	(8,450,000.00)	-	该笔投资具有战略性质
上海矽睿科技股份有限公司	20,080,000.00	-	9,370,000.00	-	29,450,000.00	18,950,000.00	-	该笔投资具有战略性质
合计	2,009,304,000.00	125,000,000.00	1,066,056,000.00	-	3,200,360,000.00	1,590,788,299.62	-	

2024年

	年初余额	增资	本年计入其他综合收益的利得/（损失）	本年转入留存收益的利得/（损失）	年末余额	累计计入其他综合收益的利得/（损失）	本年股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
公司A*	1,809,510,000.00	-	54,714,000.00	-	1,864,224,000.00	515,152,299.62	-	该笔投资具有战略性质
公司C*	-	125,000,000.00			125,000,000.00	-	-	该笔投资具有战略性质
上海矽睿科技股份有限公司	20,894,000.00	-	(814,000.00)	-	20,080,000.00	9,580,000.00	-	该笔投资具有战略性质
上海艾为电子技术股份有限公司	3,506,737.69	-	751,235.69	(4,257,973.38)	-	4,257,973.38	12,460.00	该笔投资具有战略性质
合计	1,833,910,737.69	125,000,000.00	54,651,235.69	(4,257,973.38)	2,009,304,000.00	528,990,273.00	12,460.00	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 其他权益工具投资（续）

（1） 其他权益工具投资情况（续）

*根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本集团《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，本集团部分信息因涉及商业秘密申请豁免披露，并已在《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息豁免披露的申请报告》中申请信息豁免披露。

（2） 终止确认其他权益工具投资的情况

2024年

	终止确认时的公允价值	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
上海艾为电子技术股份有限公司	17,953,511.68	4,257,973.38	-	出售股权

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 投资性房地产

2025年

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原价			
年初余额	-	-	-
在建工程/无形资产转入	322,087,604.47	62,706,571.46	384,794,175.93
年末余额	322,087,604.47	62,706,571.46	384,794,175.93
累计折旧和摊销			
年初余额	-	-	-
计提或摊销	16,319,106.55	1,741,849.20	18,060,955.75
年末余额	16,319,106.55	1,741,849.20	18,060,955.75
减值准备			
年初/年末余额	-	-	-
账面价值			
年末	305,768,497.92	60,964,722.26	366,733,220.18
年初	-	-	-

本集团投资性房地产位于中国江苏省无锡市，以经营租赁的形式向第三方出租。

于2025年12月31日，账面价值为人民币305,768,497.91元的房屋及建筑物所有权受到限制，参见附注五、20。

于2025年12月31日，账面价值为人民币60,964,722.26元的土地使用权受到限制，参见附注五、20。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产

（1） 固定资产情况

2025年

	房屋及建筑物	厂务设施	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原价						
年初余额	6,693,394,145.84	12,104,916,861.66	63,166,148,541.62	13,938,784.52	707,763,997.00	82,686,162,330.64
在建工程转入	830,691,970.77	252,779,984.90	8,104,642,744.65	-	64,915,620.99	9,253,030,321.31
政府补助抵减	-	34,718,747.77	125,976,177.73	-	-	160,694,925.50
处置或报废	-	25,949,293.94	539,790,982.03	4,346,067.21	82,716,237.35	652,802,580.53
年末余额	7,524,086,116.61	12,297,028,804.85	70,605,024,126.51	9,592,717.31	689,963,380.64	91,125,695,145.92
累计折旧						
年初余额	1,923,058,018.86	5,671,019,603.05	41,305,455,574.39	10,677,664.11	541,228,268.02	49,451,439,128.43
计提	248,038,077.58	707,783,041.01	4,538,226,108.16	1,022,013.60	46,552,795.27	5,541,622,035.62
处置或报废	-	24,651,829.25	482,145,178.59	4,128,763.85	78,298,231.28	589,224,002.97
年末余额	2,171,096,096.44	6,354,150,814.81	45,361,536,503.96	7,570,913.86	509,482,832.01	54,403,837,161.08
减值准备						
年初余额	78,927,093.55	557,751,676.10	2,016,599,756.88	-	6,142,011.00	2,659,420,537.53
处置或报废	-	640,490.65	21,551,050.39	-	3,346,247.89	25,537,788.93
年末余额	78,927,093.55	557,111,185.45	1,995,048,706.49	-	2,795,763.11	2,633,882,748.60
账面价值						
年末	5,274,062,926.62	5,385,766,804.59	23,248,438,916.06	2,021,803.45	177,684,785.52	34,087,975,236.24
年初	4,691,409,033.43	5,876,145,582.51	19,844,093,210.35	3,261,120.41	160,393,717.98	30,575,302,664.68

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产（续）

（1） 固定资产情况（续）

2024年

	房屋及建筑物	厂务设施	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原价						
年初余额	3,433,897,966.90	8,319,468,648.79	57,428,366,194.26	17,123,760.87	673,421,293.84	69,872,277,864.66
在建工程转入	3,259,496,178.94	3,797,908,803.81	5,947,902,450.10	1,171,373.65	62,113,237.56	13,068,592,044.06
政府补助抵减	–	–	207,074,940.38	–	–	207,074,940.38
处置或报废	–	12,460,590.94	3,045,162.36	4,356,350.00	27,770,534.40	47,632,637.70
年末余额	6,693,394,145.84	12,104,916,861.66	63,166,148,541.62	13,938,784.52	707,763,997.00	82,686,162,330.64
累计折旧						
年初余额	1,813,168,916.79	5,312,527,112.47	37,518,032,076.28	13,757,095.95	528,545,050.90	45,186,030,252.39
计提	109,889,102.07	369,102,584.23	3,790,293,353.54	1,059,100.66	37,912,442.76	4,308,256,583.26
处置或报废	–	10,610,093.65	2,869,855.43	4,138,532.50	25,229,225.64	42,847,707.22
年末余额	1,923,058,018.86	5,671,019,603.05	41,305,455,574.39	10,677,664.11	541,228,268.02	49,451,439,128.43
减值准备						
年初余额	78,927,093.55	559,246,319.34	2,016,646,685.72	–	7,552,311.64	2,662,372,410.25
处置或报废	–	1,494,643.24	46,928.84	–	1,410,300.64	2,951,872.72
年末余额	78,927,093.55	557,751,676.10	2,016,599,756.88	–	6,142,011.00	2,659,420,537.53
账面价值						
年末	4,691,409,033.43	5,876,145,582.51	19,844,093,210.35	3,261,120.41	160,393,717.98	30,575,302,664.68
年初	1,541,801,956.56	2,447,695,216.98	17,893,687,432.26	3,366,664.92	137,323,931.30	22,023,875,202.02

于2025年12月31日及2025年12月31日，账面价值分别为人民币3,944,283,841.60元及人民币904,687,333.93元的房屋及建筑物的所有权受到限制，参见附注五、20。

于2025年12月31日及2025年12月31日，账面价值分别为人民币12,710,225,240.09元及人民币13,915,209,997.60元的机器设备的所有权受到限制，参见附注五、20。

（2） 未办妥产权证书的固定资产

于2025年12月31日，账面价值为人民币3,257,791,810.13元的房屋及建筑物的产权证书尚在办理中。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产（续）

（3） 固定资产的减值测试情况

于2025年12月31日，由于华虹半导体（无锡）有限公司（“华虹无锡资产组”）存在减值迹象，本集团对华虹无锡资产组内的固定资产、在建工程及无形资产进行了减值测试。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定的：

	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的关键参数	稳定期的关键参数
华虹无锡资产组	14,600,545,433.85	16,954,706,223.55	-	年限：5年； 折现率：13%； 收入增长率：0.8%-2%； 毛利率：6.7%-39.0%	年限：2年； 折现率：13%； 收入增长率：0.8%； 毛利率：44.2%-46.6%

于2024年12月31日，由于华虹半导体（无锡）有限公司（“华虹无锡资产组”）存在减值迹象，本集团对华虹无锡资产组内的固定资产、在建工程及无形资产进行了减值测试。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定的：

	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的关键参数	稳定期的关键参数
华虹无锡资产组	17,710,948,961.67	18,705,352,701.14	-	年限：5年； 折现率：14%； 收入增长率：3.7%-17.1%； 毛利率：-3.7%-37.8%	年限：2.5年； 折现率：14%； 收入增长率：3.7%； 毛利率：45.3%-54.6%

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程

（1） 在建工程情况

	2025年12月31日			2024年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华虹制造（无锡）项目	13,315,890,754.37	-	13,315,890,754.37	11,751,994,260.36	-	11,751,994,260.36
8英寸厂优化升级项目	222,857,951.85	-	222,857,951.85	131,017,451.56	-	131,017,451.56
华虹无锡产能优化项目	15,300.00	-	15,300.00	10,757,719.84	-	10,757,719.84
华虹无锡一期增资扩产2.95万片/月项目	39,651,981.26	-	39,651,981.26	78,059,020.01	-	78,059,020.01
华虹无锡综合配套用房项目	-	-	-	910,612,186.72	-	910,612,186.72
其他	1,091,236,675.72	107,680,465.38	983,556,210.34	743,553,048.91	107,680,465.38	635,872,583.53
合计	14,669,652,663.20	107,680,465.38	14,561,972,197.82	13,625,993,687.40	107,680,465.38	13,518,313,222.02

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

（2） 重要的在建工程变动情况

2025年

	预算	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他增加/减少	年末余额	资金来源	工程投入占预算比例（%）
华虹制造（无锡）项目	43,170,985,000.00	11,751,994,260.36	9,035,438,759.51	7,471,542,265.50	-	13,315,890,754.37	借款及自有资金	68.38
8英寸厂优化升级项目	2,000,000,000.00	131,017,451.56	333,472,951.78	241,632,451.49	-	222,857,951.85	自有资金	31.63
华虹无锡综合配套用房项目	1,316,000,000.00	910,612,186.72	125,961,202.57	1,036,573,389.29	-	-	自有资金	78.77
合计	46,486,985,000.00	12,793,623,898.64	9,494,872,913.86	8,749,748,106.28	-	13,538,748,706.22		

2024年

	预算	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他增加/减少	年末余额	资金来源	工程投入占预算比例（%）
8英寸厂优化升级项目	2,000,000,000.00	64,039,268.46	234,993,268.42	168,015,085.32	-	131,017,451.56	自有资金	14.96
华虹无锡一期增资扩产2.95万片/月项目	7,586,640,000.00	2,007,575,177.75	86,224,101.96	2,015,740,259.70	-	78,059,020.01	借款及自有资金	94.88
华虹无锡综合配套用房项目	1,316,000,000.00	310,787,934.04	599,824,252.68	-	-	910,612,186.72	自有资金	69.20
华虹无锡产能优化项目	1,255,915,209.00	492,679,211.14	732,710,925.68	1,214,632,416.98	-	10,757,719.84	自有资金	97.75
华虹制造（无锡）项目	43,170,985,000.00	1,503,366,367.06	18,979,935,416.33	8,731,307,523.03	-	11,751,994,260.36	借款及自有资金	47.45
合计	55,329,540,209.00	4,378,447,958.45	20,633,687,965.07	12,129,695,285.03	-	12,882,440,638.49	/	/

于2025年12月31日及2024年12月31日，账面价值分别为人民币1,626,656,888.25元及人民币129,989,189.89元的在建工程所有权受到限制，参见附注五、20。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

（3） 在建工程减值准备情况

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
上海华虹宏力维持改善项目	107,680,465.38	-	-	107,680,465.38	生产工艺迭代

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提原因
上海华虹宏力维持改善项目	107,680,465.38	-	-	107,680,465.38	生产工艺迭代

（4） 在建工程的减值测试情况

由于华虹无锡资产组存在减值迹象，本集团对华虹无锡资产组内的固定资产、在建工程及无形资产进行了减值测试。减值测试情况信息详见附注五、13。

15. 使用权资产

	2025年12月31日 房屋及建筑物	2024年12月31日 房屋及建筑物
成本		
年初余额	337,189,139.87	296,472,200.06
增加	-	40,849,500.99
处置	18,813,645.24	132,561.18
年末余额	318,375,494.63	337,189,139.87
累计折旧		
年初余额	191,630,844.68	156,500,145.72
计提	32,202,184.85	35,263,260.14
处置	15,339,137.28	132,561.18
年末余额	208,493,892.25	191,630,844.68
账面价值		
年末	109,881,602.38	145,558,295.19
年初	145,558,295.19	139,972,054.34

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产

（1） 无形资产情况

2025年

	土地使用权	生产管理软件	非专利技术	合计
原价				
年初余额	550,467,705.72	1,533,585,650.90	1,891,992,971.05	3,976,046,327.67
购置	-	85,594,432.44	-	85,594,432.44
转入投资性房地产	69,673,968.29	-	-	69,673,968.29
处置	-	2,043,899.35	-	2,043,899.35
年末余额	480,793,737.43	1,617,136,183.99	1,891,992,971.05	3,989,922,892.47
累计摊销				
年初余额	129,771,134.43	1,192,137,519.70	1,796,156,846.86	3,118,065,500.99
计提	10,169,735.62	99,288,535.00	6,764,118.59	116,222,389.21
转入投资性房地产	6,967,396.83	-	-	6,967,396.83
处置	-	2,043,899.35	-	2,043,899.35
年末余额	132,973,473.22	1,289,382,155.35	1,802,920,965.45	3,225,276,594.02
减值准备				
年初/年末余额	-	31,794,713.58	87,057,243.24	118,851,956.82
账面价值				
年末	347,820,264.21	295,959,315.06	2,014,762.36	645,794,341.63
年初	420,696,571.29	309,653,417.62	8,778,880.95	739,128,869.86

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 无形资产（续）

（1） 无形资产情况（续）

2024年

	土地使用权	生产管理软件	非专利技术	合计
原价				
年初余额	543,812,471.75	1,611,234,228.33	1,891,992,971.05	4,047,039,671.13
购置	6,655,233.97	72,621,576.96	-	79,276,810.93
政府补助抵减	-	1,197,857.15	-	1,197,857.15
处置	-	149,072,297.24	-	149,072,297.24
年末余额	550,467,705.72	1,533,585,650.90	1,891,992,971.05	3,976,046,327.67
累计摊销				
年初余额	117,360,407.04	1,236,479,328.75	1,788,893,488.40	3,142,733,224.19
计提	12,410,727.39	104,730,488.19	7,263,358.46	124,404,574.04
处置	-	149,072,297.24	-	149,072,297.24
年末余额	129,771,134.43	1,192,137,519.70	1,796,156,846.86	3,118,065,500.99
减值准备				
年初/年末余额	-	31,794,713.58	87,057,243.24	118,851,956.82
账面价值				
年末	420,696,571.29	309,653,417.62	8,778,880.95	739,128,869.86
年初	426,452,064.71	342,960,186.00	16,042,239.41	785,454,490.12

于2025年12月31日及2024年12月31日，账面价值分别为人民币239,345,719.61元及人民币338,349,546.69元的土地使用权受到限制，参见附注五、20。

（2） 无形资产的减值测试情况

由于华虹无锡资产组存在减值迹象，本集团对华虹无锡资产组内的固定资产、在建工程及无形资产进行了减值测试。减值测试情况信息详见附注五、13。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 长期待摊费用

2025年

	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
装修费	6,246,267.26	1,079,408.72	1,968,235.62	-	5,357,440.36
实施服务费	478,317.59	-	197,924.52	-	280,393.07
合计	6,724,584.85	1,079,408.72	2,166,160.14	-	5,637,833.43

2024年

	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
装修费	8,166,449.56	-	1,920,182.30	-	6,246,267.26
实施服务费	676,242.11	-	197,924.52	-	478,317.59
合计	8,842,691.67	-	2,118,106.82	-	6,724,584.85

18. 递延所得税资产/负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

	2025年12月31日		2024年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提费用	129,395,515.87	19,409,327.38	237,939,075.40	35,690,861.31
资产减值准备	207,256,164.53	31,088,424.68	179,180,900.33	26,877,135.05
固定资产折旧	978,092,007.73	146,713,801.16	958,443,197.93	143,766,479.69
租赁负债	130,407,997.67	19,561,199.65	163,160,619.53	24,474,092.93
政府补助	236,250,853.33	35,437,628.00	204,738,580.60	30,710,787.09
合计	1,681,402,539.13	252,210,380.87	1,743,462,373.79	261,519,356.07

（2） 未经抵销的递延所得税负债

	2025年12月31日		2024年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值	1,590,788,299.62	238,618,244.93	524,732,299.62	78,709,844.93
固定资产折旧	76,240,897.00	11,436,134.55	108,754,286.93	16,313,143.04
使用权资产	109,443,316.84	16,416,497.53	142,490,297.01	21,373,544.55
代扣代缴股息税	708,144,728.60	70,814,472.86	729,620,636.80	72,962,063.68
合计	2,484,617,242.06	337,285,349.87	1,505,597,520.36	189,358,596.20

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 递延所得税资产/负债（续）

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

	2025年12月31日		2024年12月31日	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	252,210,380.87	-	116,396,532.52	145,122,823.55
递延所得税负债	252,210,380.87	85,074,969.00	116,396,532.52	72,962,063.68

19. 其他非流动资产

	2025年12月31日	2024年12月31日
预付设备及工程款	1,559,972,916.87	202,600,031.35

20. 所有权或使用权受到限制的资产

2025年

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	227,325,993.54	227,325,993.54	冻结、质押	冻结的派息账户余额或为商务卡和借款业务存入的保证金。
存货	1,586,672,501.14	1,514,780,904.00	抵押	抵押用于长期借款的房地产开发产品
投资性房地产	391,761,572.76	366,733,220.17	抵押	抵押用于长期借款的投资性房地产
固定资产	36,234,353,089.94	16,654,509,081.69	抵押	抵押用于长期借款的房屋建筑物和机器设备
在建工程	1,626,656,888.25	1,626,656,888.25	抵押	抵押用于长期借款的待安装设备
无形资产	274,892,113.58	239,345,719.61	抵押	抵押用于长期借款的土地使用权
合计	40,341,662,159.21	20,629,351,807.26		

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

20. 所有权或使用权受到限制的资产（续）

2024年

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	228,338,703.94	228,338,703.94	冻结、质押	冻结的派息账户余额或为商务卡和借款业务存入的保证金。
存货	648,933,968.48	648,933,968.48	抵押	抵押用于长期借款的开发成本。
固定资产	24,879,673,250.05	14,819,897,331.53	抵押	抵押用于长期借款的房屋建筑物和机器设备。
在建工程	129,989,189.89	129,989,189.89	抵押	抵押用于长期借款的待安装设备。
无形资产	406,366,081.87	338,349,546.69	抵押	抵押用于长期借款的土地使用权。
合计	26,293,301,194.23	16,165,508,740.53		

用于抵押的无形资产于2025年及2024年的摊销额分别为人民币5,687,423.03元、人民币9,403,587.45元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 应付账款

	2025年12月31日	2024年12月31日
应付账款	3,014,300,410.10	3,008,803,169.46

于2025年12月31日及2024年12月31日，应付账款余额中均无账龄超过1年的重大应付账款。

22. 预收款项

	2025年12月31日	2024年12月31日
预收租金	416,522.94	-

于2025年12月31日，预收款项余额中无账龄超过1年的重大预收款项。

23. 合同负债

	2025年12月31日	2024年12月31日
预收货款	1,063,573,175.44	894,985,562.13

于2025年12月31日及2024年12月31日，合同负债余额中均无账龄超过1年的重大合同负债。

24. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	709,414,654.20	3,453,075,372.16	3,293,152,518.37	869,337,507.99
离职后福利（设定提存计划）	18,837,026.14	339,962,407.01	340,190,532.27	18,608,900.88
辞退福利	-	487,990.00	487,990.00	-
合计	728,251,680.34	3,793,525,769.17	3,633,831,040.64	887,946,408.87

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

24. 应付职工薪酬（续）

（1） 应付职工薪酬列示（续）

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	735,049,419.09	2,994,629,216.68	3,020,263,981.57	709,414,654.20
离职后福利（设定提存计划）	21,252,419.01	330,427,286.18	332,842,679.05	18,837,026.14
辞退福利	-	1,001,839.00	1,001,839.00	-
合计	756,301,838.10	3,326,058,341.86	3,354,108,499.62	728,251,680.34

（2） 短期薪酬列示

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	664,299,251.71	2,959,040,035.45	2,798,061,836.98	825,277,450.18
职工福利费	21,975,227.93	65,971,050.17	68,713,548.82	19,232,729.28
社会保险费	10,785,708.56	203,324,281.87	203,328,668.90	10,781,321.53
其中：医疗保险费	10,274,539.72	184,338,056.22	184,462,482.31	10,150,113.63
工伤保险费	511,168.84	13,400,914.76	13,280,875.70	631,207.90
生育保险费	-	5,585,310.89	5,585,310.89	-
住房公积金	12,354,466.00	180,496,325.00	178,804,784.00	14,046,007.00
工会经费和职工教育经费	-	44,243,679.67	44,243,679.67	-
合计	709,414,654.20	3,453,075,372.16	3,293,152,518.37	869,337,507.99

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	694,058,756.44	2,525,722,070.07	2,555,481,574.80	664,299,251.71
职工福利费	14,702,245.09	55,941,239.36	48,668,256.52	21,975,227.93
社会保险费	13,456,682.56	198,902,252.22	201,573,226.22	10,785,708.56
其中：医疗保险费	12,880,306.28	183,091,177.48	185,696,944.04	10,274,539.72
工伤保险费	576,376.28	11,215,072.16	11,280,279.60	511,168.84
生育保险费	-	4,596,002.58	4,596,002.58	-
住房公积金	12,831,735.00	175,528,844.00	176,006,113.00	12,354,466.00
工会经费和职工教育经费	-	38,534,811.03	38,534,811.03	-
合计	735,049,419.09	2,994,629,216.68	3,020,263,981.57	709,414,654.20

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

24. 应付职工薪酬（续）

（3） 设定提存计划列示

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	18,265,678.63	329,660,382.24	329,881,598.51	18,044,462.36
失业保险费	571,347.51	10,302,024.77	10,308,933.76	564,438.52
合计	18,837,026.14	339,962,407.01	340,190,532.27	18,608,900.88

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	20,607,869.70	320,414,267.26	322,756,458.33	18,265,678.63
失业保险费	644,549.31	10,013,018.92	10,086,220.72	571,347.51
合计	21,252,419.01	330,427,286.18	332,842,679.05	18,837,026.14

25. 应交税费

	2025年12月31日	2024年12月31日
所得税	105,529,712.28	223,664,725.36
增值税	40,870,789.02	49,290,512.30
代扣代缴个人所得税	8,990,082.27	8,647,851.91
其他	10,985,252.31	15,999,302.62
合计	166,375,835.88	297,602,392.19

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 其他应付款

	2025年12月31日	2024年12月31日
应付资产采购款	4,817,641,588.54	4,443,505,382.98
应付维修费	149,746,808.92	170,459,590.07
应付水电费	81,085,247.52	84,899,228.68
应付技术使用费	67,026,220.01	56,421,767.89
应付股利	230,911.61	236,745.78
其他	127,509,812.84	154,045,486.10
合计	5,243,240,589.44	4,909,568,201.50

于2025年12月31日及2024年12月31日，其他应付款余额中均无账龄超过1年的重大其他应付款。

27. 一年内到期的非流动负债

	2025年12月31日	2024年12月31日
一年内到期的长期借款	3,314,778,889.99	2,821,557,421.16
一年内到期的租赁负债	22,694,639.20	38,039,951.06
合计	3,337,473,529.19	2,859,597,372.22

28. 其他流动负债

	2025年12月31日	2024年12月31日
与政府补助相关的收款	625,909,874.59	413,784,042.92
待转销项税额	130,722,809.59	103,415,484.31
合计	756,632,684.18	517,199,527.23

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 长期借款

	2025年12月31日	2024年12月31日
信用借款	9,931,420,286.61	2,398,950,338.89
抵押借款	15,445,547,762.82	16,632,457,713.17
减：一年内到期的非流动负债	3,314,778,889.99	2,821,557,421.16
合计	22,062,189,159.44	16,209,850,630.90

于2025年12月31日及2024年12月31日，上述借款利率分别为1.20%至5.35%及1.20%至6.40%。

于2025年12月31日，上述借款由账面价值为人民币224,928,481.93元的货币资金、人民币1,514,780,904.00元的存货、人民币366,733,220.17元的投资性房地产、人民币3,944,283,841.60元的房屋及建筑物、人民币12,710,225,240.09元的机器设备、人民币1,626,656,888.25元的在建工程及人民币239,345,719.61元的土地使用权作为抵押。

于2024年12月31日上述借款由账面价值为人民币224,924,958.30元的货币资金、人民币648,933,968.48元的存货、人民币904,687,333.93元房屋及建筑物、人民币13,915,209,997.60元的机器设备、人民币129,989,189.89元的在建工程以及人民币338,349,546.69元的土地使用权作为抵押。

30. 租赁负债

	2025年12月31日	2024年12月31日
应付租赁款	132,901,137.74	167,920,819.55
减：一年内到期的租赁负债	22,694,639.20	38,039,951.06
合计	110,206,498.54	129,880,868.49

31. 预计负债

	2025年12月31日	2024年12月31日
待执行亏损合同	207.77	5,273,501.96

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 递延收益

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	16,110,000.00	24,180,000.00	(24,180,000.00)	16,110,000.00
合计	16,110,000.00	24,180,000.00	(24,180,000.00)	16,110,000.00

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	23,580,000.00	11,260,000.00	(18,730,000.00)	16,110,000.00
合计	23,580,000.00	11,260,000.00	(18,730,000.00)	16,110,000.00

33. 长期应付款

	2025年12月31日	2024年12月31日
可回售金融工具	4,179,190,000.00	-

本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行相关合同义务，因此符合金融负债的定义。于2025年12月31日，上述可回售工具的利率为2.30%。

34. 股本

	2025年	2024年
人民币普通股		
年初/年末余额	21,644,514,897.87	21,644,514,897.87
境外上市的外资股：		
年初余额	13,010,188,370.60	12,975,365,172.33
员工行权	350,183,337.83	34,823,198.27
年末余额	13,360,371,708.43	13,010,188,370.60
合计	35,004,886,606.30	34,654,703,268.47

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 股本（续）

	2025年	2024年
已发行股票数量：		
人民币普通股：		
年初/年末数量	598,518,392	598,518,392
境外上市的外资股：		
年初数量	1,310,718,815	1,308,838,694
员工行权	19,145,378	1,880,121
年末数量	1,329,864,193	1,310,718,815
合计	1,928,382,585	1,909,237,207

35. 资本公积

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
同一控制下企业合并产生的资本公积	1,098,881,918.36	218,264,141.22	–	1,317,146,059.58
其他资本公积	5,831,489,573.29	–	81,091,070.97	5,750,398,502.32
合计	6,930,371,491.65	218,264,141.22	81,091,070.97	7,067,544,561.90

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
同一控制下企业合并产生的资本公积	1,095,880,301.14	3,001,617.22	–	1,098,881,918.36
其他资本公积	5,840,051,216.99	75,009.72	8,636,653.42	5,831,489,573.29
合计	6,935,931,518.13	3,076,626.94	8,636,653.42	6,930,371,491.65

同一控制下企业合并产生的资本公积发生的变动是由于标的公司增资导致的，其他资本公积的增加是因为股份支付计划授予日的公允价值摊销所致，减少系员工行权所致。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：

2025年

	2025年1月1日	增减变动	2025年12月31日
其他权益工具投资公允价值变动	446,022,455.38	906,147,600.00	1,352,170,055.38
权益法下不能转损益的其他综合收益	4,827,000.00	-	4,827,000.00
外币财务报表折算差额	105,125,629.57	(74,340,579.98)	30,785,049.59
合计	555,975,084.95	831,807,020.02	1,387,782,104.97

2024年

	2024年1月1日	增减变动	2024年12月31日
其他权益工具投资公允价值变动	403,188,182.41	42,834,272.97	446,022,455.38
权益法下不能转损益的其他综合收益	9,592,200.00	(4,765,200.00)	4,827,000.00
外币财务报表折算差额	50,064,338.72	55,061,290.85	105,125,629.57
合计	462,844,721.13	93,130,363.82	555,975,084.95

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 其他综合收益（续）

其他综合收益发生额：

2025年

	税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税	归属于母公司股东	归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	1,066,056,000.00	-	159,908,400.00	906,147,600.00	-
外币财务报表折算差额	(62,727,560.31)	-	-	(62,727,560.31)	-
将重分类进损益的其他综合收益					
外币财务报表折算差额	(11,613,019.67)	-	-	(11,613,019.67)	-
合计	991,715,420.02	-	159,908,400.00	831,807,020.02	-

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 其他综合收益（续）

其他综合收益发生额：（续）

2024年

	税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税	归属于母公司股东	归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	54,651,235.69	4,257,973.38	7,558,989.34	42,834,272.97	-
权益法下不能转损益的其他综合亏损	(4,765,200.00)	-	-	(4,765,200.00)	-
外币财务报表折算差额	47,538,805.76	-	-	47,538,805.76	-
将重分类进损益的其他综合收益					
外币财务报表折算差额	7,522,485.09	-	-	7,522,485.09	-
合计	104,947,326.54	4,257,973.38	7,558,989.34	93,130,363.82	-

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 专项储备

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	-	39,270,041.32	37,300,652.66	1,969,388.66

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	-	33,665,146.63	33,665,146.63	-

38. 盈余公积

2025年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,703,681,884.84	151,212,523.41	-	1,854,894,408.25

2024年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,537,901,174.58	165,780,710.26	-	1,703,681,884.84

本公司于境内设立的子公司根据公司法、章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。

39. 未分配利润

	2025年	2024年
上年年末未分配利润	901,987,450.55	366,096,969.07
归属于母公司股东的净利润	1,184,283,734.18	955,315,517.52
减：提取法定盈余公积	151,212,523.41	165,780,710.26
应付普通股现金股利	-	257,902,299.16
加：其他综合收益结转留存收益	-	4,257,973.38
年末未分配利润	1,935,058,661.32	901,987,450.55

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

40. 营业收入和营业成本

（1） 营业收入和营业成本情况

	2025年		2024年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,207,911,666.51	17,833,591,276.37	18,734,808,462.25	15,940,351,429.75
其他业务	80,045,420.18	45,590,322.27	539,247,030.67	36,381,890.51
合计	22,287,957,086.69	17,879,181,598.64	19,274,055,492.92	15,976,733,320.26

（2） 营业收入分解信息

	2025年	2024年
	收入	收入
商品类型		
集成电路晶圆代工	21,291,107,414.71	17,795,073,735.64
其他	996,849,671.98	1,478,981,757.28
合计	22,287,957,086.69	19,274,055,492.92
商品转让的时间		
在某一时点转让	22,267,127,550.11	19,245,653,156.09
在某一时段内转让	20,829,536.58	28,402,336.83
合计	22,287,957,086.69	19,274,055,492.92
经营地区		
中国境内	16,740,173,788.47	14,396,186,645.67
中国境外	5,547,783,298.22	4,877,868,847.25
合计	22,287,957,086.69	19,274,055,492.92

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

40. 营业收入和营业成本（续）

（3） 营业成本分解信息

	2025年 成本	2024年 成本
商品类型		
集成电路晶圆代工	17,161,374,542.72	15,337,606,317.04
其他	717,807,055.92	639,127,003.22
合计	17,879,181,598.64	15,976,733,320.26
商品转让的时间		
在某一时点转让	17,875,334,336.45	15,968,879,546.87
在某一时段内转让	3,847,262.19	7,853,773.39
合计	17,879,181,598.64	15,976,733,320.26

（4） 履约义务

确认的收入来源于：

	2025年	2024年
合同负债年初账面价值	893,497,500.77	673,380,600.68

本集团的主要履约义务相关的信息如下：

	履行履约义务的时间	重要的支付条款	承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	承担的预期将退还给客户的款项	提供的质量保证类型及相关义务
商品销售	以客户取得相关商品控制权的时点	合同价款通常在交付商品后30-90天内到期，不存在重大融资成分	晶圆及相关产品	是	-	保证类质保
授予技术许可	以客户取得相关授权许可的时点	合同价款通常在服务交付后30天内支付	技术使用许可	是	-	无
提供服务	以客户取得相关服务控制权的时点	合同价款通常在服务交付后30天内支付	提供劳务	是	-	无

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 税金及附加

	2025年	2024年
房产税	55,626,594.29	30,460,506.35
印花税	22,543,679.70	30,735,863.59
城市维护建设税	20,849,890.56	19,463,169.86
教育费附加	20,849,890.56	19,463,169.86
土地使用税	4,203,645.28	2,981,860.96
其他	2,391,674.21	2,298,494.02
合计	126,465,374.60	105,403,064.64

42. 销售费用

	2025年	2024年
职工薪酬	76,651,255.24	76,078,179.97
其他	7,849,763.94	2,548,974.58
合计	84,501,019.18	78,627,154.55

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

43. 管理费用

	2025年	2024年
职工薪酬	341,542,022.05	434,855,061.08
折旧费用	134,166,105.66	58,219,082.54
环境保护费	106,136,240.47	85,635,863.61
日常运营费用	69,413,741.56	64,789,234.70
专业服务费	62,296,058.01	46,587,591.73
保险费	53,476,690.62	45,900,935.29
使用权资产折旧费	32,202,184.85	35,263,260.14
安保费	36,627,603.20	32,538,754.92
摊销费用	21,726,307.40	21,757,411.12
办公费	17,932,594.49	29,193,914.03
修理费	16,904,336.19	19,056,703.86
存货报废损失	15,023,720.08	29,811,129.11
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	10,172,054.24	19,154,885.37
政府补助抵减管理费用	(3,980,000.00)	(18,364,200.00)
其他	47,650,751.90	37,140,355.33
合计	961,290,410.72	941,539,982.83

44. 研发费用

	2025年	2024年
职工薪酬	901,823,868.80	780,334,621.16
折旧费用	560,726,127.92	363,724,502.51
研究测试费用	490,804,579.97	508,945,469.46
维修维护费	160,748,393.86	146,233,575.71
燃料动力及水电费	96,466,780.15	79,454,524.92
摊销费用	50,791,624.86	54,593,384.21
政府补助抵减研发费用	(37,068,439.05)	(79,544,862.93)
其他	816,459.30	1,469,342.94
合计	2,225,109,395.81	1,855,210,557.98

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

45. 财务费用

	2025年	2024年
利息支出	641,642,942.67	811,216,257.16
减：利息收入	533,504,049.56	892,524,563.08
减：利息资本化金额	-	31,380,767.60
减：政府补助抵减利息支出	85,520,000.00	39,240,100.00
汇兑损益	127,970,540.46	190,009,760.97
其他	5,128,557.26	7,207,158.54
合计	155,717,990.83	45,287,745.99

46. 其他收益

	2025年	2024年
增值税加计抵减	336,207,115.64	162,961,828.59
与日常活动相关的政府补助	75,205,854.93	97,244,382.10
代扣个人所得税手续费返还	3,336,611.54	3,631,180.61
合计	414,749,582.11	263,837,391.30

47. 投资收益

	2025年	2024年
按权益法核算的长期股权投资收益	30,951,141.29	10,978,414.46
其他权益工具投资的股利收入	-	12,460.00
合计	30,951,141.29	10,990,874.46

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

48. 信用减值损失

	2025年	2024年
应收账款坏账损失	(23, 318, 264. 16)	19, 513, 897. 44
应收票据坏账损失	8, 488. 91	(14, 419. 95)
合计	(23, 309, 775. 25)	19, 499, 477. 49

49. 资产减值损失

	2025年	2024年
存货跌价损失	(1, 176, 119, 903. 21)	(932, 940, 319. 67)

50. 资产处置收益

	2025年	2024年
固定资产处置收益/（损失）	31, 912, 422. 40	(1, 008, 229. 36)
使用权资产处置收益	106, 543. 78	-
合计	32, 018, 966. 18	(1, 008, 229. 36)

51. 营业外收入

	2025年	2024年
其他	2, 540, 789. 34	5, 968, 286. 42

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

52. 营业外支出

	2025年	2024年
其他	1,083,329.05	5,772,458.36

53. 所得税费用

	2025年	2024年
当期所得税费用	157,589,804.17	195,819,942.61
递延所得税抵减	(1,452,936.83)	(151,954,248.73)
合计	156,136,867.34	43,865,693.88

54. 每股收益

	2025年 元/股	2024年 元/股
基本每股收益		
持续经营	0.62	0.50
稀释每股收益		
持续经营	0.62	0.50

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

54. 每股收益（续）

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	2025年	2024年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
持续经营	1,184,283,734.18	955,315,517.52

	2025年	2024年
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,919,710,623	1,908,115,170
稀释效应——股份期权	110,374	3,739,068
调整后本公司发行在外普通股的加权平均数	1,919,820,997	1,911,854,238

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

55. 外币货币性项目

	2025年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币
货币资金			
美元	1,207,203,875.90	7.0288	8,485,194,602.93
港币	349,057,967.20	0.9032	315,276,155.98
日元	25,747,575.00	0.0448	1,153,491.36
欧元	36,865.43	8.2355	303,605.25
应收账款			
美元	110,624,344.47	7.0288	777,556,392.41
其他应收款			
港币	25,686,456.84	0.9032	23,200,007.82
美元	627,702.19	7.0288	4,411,993.15
日元	3,651,919.00	0.0448	163,605.97
应付账款			
美元	85,675,230.21	7.0288	602,194,058.10
日元	2,567,020,296.00	0.0448	115,002，509.26
欧元	416,036.99	8.2355	3,426,272.63
港币	159,260.00	0.9032	143,843.63
其他应付款			
美元	268,869,147.81	7.0288	1,889,827,466.13
日元	8,153,045,910.00	0.0448	365,256,456.77
欧元	39,541,571.87	8.2355	325,644,615.14
港币	844,336.00	0.9032	762,604.28
新台币	483,539.00	0.2235	108,070.97
一年内到期的非流动负债			
美元	108,513,871.15	7.0288	762,722,297.54
长期借款			
美元	514,267,981.15	7.0288	3,614,686,785.91

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

55. 外币货币性项目（续）

	2025年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币
货币资金			
美元	1,263,017,198.91	7.1884	9,079,072,832.64
港币	79,566,130.30	0.9260	73,678,236.66
日元	30,105,601.00	0.0462	1,390,878.77
欧元	33,469.51	7.5257	251,881.49
应收账款			
美元	105,125,875.01	7.1884	755,686,839.92
其他应收款			
美元	721,733.69	7.1884	5,188,110.46
港币	1,337,267.16	0.9260	1,238,309.39
应付账款			
美元	136,794,808.25	7.1884	983,335,799.62
日元	2,956,883,112.00	0.0462	136,607,999.77
欧元	7,291,187.52	7.5257	54,871,289.92
港币	40,000.00	0.9260	37,040.00
其他应付款			
美元	1,146,262,211.62	7.1884	8,239,791,282.01
欧元	255,272,618.95	7.5257	1,921,105,148.43
日元	50,790,675,936.00	0.0462	2,346,529,228.24
新台币	130,393.00	0.2228	29,051.56
港币	15,512.00	0.9260	14,364.11
一年内到期的非流动负债			
美元	236,405,955.03	7.1884	1,699,380,567.14
长期借款			
美元	1,264,261,725.02	7.1884	9,088,018,984.13

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

56. 租赁

（1） 作为承租人

	2025年	2024年
租赁负债利息费用	6,601,153.07	7,742,071.14
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	10,172,054.24	19,154,885.37

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物，房屋及建筑物的租赁期通常为1-20年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。

使用权资产，参见附注五、15；对短期租赁的简化处理，参见附注三、25；租赁负债，参见附注五、30。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

56. 租赁（续）

（2） 作为出租人

融资租赁

与融资租赁有关的损益列示如下：

	2025年
销售损益	24,000,844.99
租赁投资净额的融资收益	1,384,633.42

根据与承租人签订的租赁合同，未折现最低租赁收款额如下：

	2025年12月31日
1年以内（含1年）	14,352,902.07
1年至2年（含2年）	7,631,743.74
2年至3年（含3年）	7,631,743.74
3年至4年（含4年）	7,631,743.74
4年至5年（含5年）	7,631,743.74
5年以上	31,437,562.17
	76,317,439.20
减：未实现融资收益	6,859,937.78
租赁投资净额	69,457,501.42

六、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本（千元）	持股比例（%） 直接	持股比例（%） 间接	表决权比例（%）
通过设立方式取得的子公司：							
Grace Semiconductor Manufacturing Corporation	开曼群岛	开曼群岛	投资	美元 0.001	100.00	-	100.00
上海华虹宏力半导体制造有限公司	中国大陆	中国大陆	芯片制造及销售	人民币 20,460,928	100.00	-	100.00
华虹宏力半导体（无锡）有限公司	中国大陆	中国大陆	芯片制造及销售	人民币 6,680	-	100.00	100.00
Global Synergy Technology Limited	中国香港	中国香港	销售及贸易	港币 10	100.00	-	100.00
HHGrace Semiconductor USA, Inc	美国	美国	销售及贸易	-	100.00	-	100.00
HHGrace Semiconductor Japan Co., Ltd.	日本	日本	销售及贸易	日元 10,000	100.00	-	100.00
华虹半导体(无锡)有限公司	中国大陆	中国大陆	芯片制造及销售	美元 2,536,852	22.20	28.80	51.00
华宏置业（无锡）有限公司	中国大陆	中国大陆	房地产开发	人民币 30,000	-	51.00	51.00
华虹半导体制造（无锡）有限公司	中国大陆	中国大陆	芯片制造及销售	美元 4,020,000	21.90	29.10	51.00
同一控制下企业合并取得的子公司：							
标的公司	中国大陆	中国大陆	芯片制造及销售	人民币 2,036,192	97.50	2.50	100.00

本公司下属子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司于2025年度新设成立华虹宏力半导体（无锡）有限公司，注册资本为人民币6,680,000元，持股比例为100%。

（2） 存在重要少数股东权益的子公司

2025年

	少数股东持股比例（%）	归属于少数股东的损益	向少数股东支付股利	年末累计少数股东权益
华虹半导体（无锡）有限公司	49.00%	（392,513,334.40）	-	5,045,587,683.84
华虹半导体制造（无锡）有限公司	49.00%	（836,648,498.80）	-	12,888,874,621.56

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

（2） 存在重要少数股东权益的子公司（续）

2024年

	少数股东持股比例（%）	归属于少数股东的损益	向少数股东支付股利	年末累计少数股东权益
华虹半导体（无锡）有限公司	49.00%	(1,195,566,119.61)	-	5,438,101,018.24
华虹半导体制造（无锡）有限公司	49.00%	(171,786,402.84)	-	13,725,523,120.36

（3） 存在重要少数股东权益的子公司的主要财务信息

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：

华虹半导体（无锡）有限公司

	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产	9,897,973,723.62	9,713,082,023.38
非流动资产	16,486,431,923.86	18,092,936,858.41
资产合计	26,384,405,647.48	27,806,018,881.79
流动负债	5,231,451,248.51	4,698,435,726.19
非流动负债	10,818,326,519.44	12,062,198,990.90
负债合计	16,049,777,767.95	16,760,634,717.09
营业收入	8,952,924,506.74	7,347,203,317.34
净亏损	(710,756,285.17)	(2,532,599,074.61)
综合亏损总额	(710,756,285.17)	(2,532,599,074.61)
经营活动产生的现金流量净额	3,360,297,205.80	2,235,916,368.06

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

（3） 存在重要少数股东权益的子公司的主要财务信息（续）

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：（续）

华虹半导体制造（无锡）有限公司

	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产	8,762,481,850.04	12,783,909,998.69
非流动资产	28,608,184,916.59	20,820,688,001.68
资产合计	37,370,666,766.63	33,604,598,000.37
流动负债	5,346,889,008.35	4,357,501,876.76
非流动负债	5,719,952,000.00	1,237,310,000.00
负债合计	11,066,841,008.35	5,594,811,876.76
营业收入	1,635,538,975.89	4,323,651.42
净亏损	(1,705,960,365.33)	(351,475,826.14)
综合亏损总额	(1,705,960,365.33)	(351,475,826.14)
经营活动使用的现金流量净额	(966,150,250.80)	(278,545,399.14)

2. 在联营企业中的权益

（1） 不重要的联营企业的汇总财务信息

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值：

	2025年	2024年
投资账面价值合计	590,452,131.36	539,500,990.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	30,951,141.29	10,978,414.46
其他综合收益/（亏损）	-	(4,765,200.00)
综合收益总额	30,951,141.29	6,213,214.46

七、 政府补助

（1） 涉及政府补助的负债项目

2025年

	年初余额	本年新增	本年计入营业外收入	本年计入其他收益	本年净额法抵消	年末余额	与资产/收益相关
其他流动负债	187,245,459.94	348,310,757.17	-	-	(160,694,925.50)	374,861,291.61	资产相关
其他流动负债	226,538,582.98	137,097,442.83	-	-	(112,587,442.83)	251,048,582.98	收益相关
递延收益	16,110,000.00	24,180,000.00	-	-	(24,180,000.00)	16,110,000.00	收益相关
合计	429,894,042.92	509,588,200.00	-	-	(297,462,368.33)	642,019,874.59	

2024年

	年初余额	本年新增	本年计入营业外收入	本年计入其他收益	本年净额法抵消	年末余额	与资产/收益相关
其他流动负债	143,317,108.88	245,946,291.44	-	-	(202,017,940.38)	187,245,459.94	资产相关
其他流动负债	104,701,143.36	246,063,602.55	-	-	(124,226,162.93)	226,538,582.98	收益相关
递延收益	4,537,000.00	1,270,000.00	-	-	(5,807,000.00)	-	资产相关
递延收益	19,043,000.00	9,990,000.00	-	-	(12,923,000.00)	16,110,000.00	收益相关
合计	271,598,252.24	503,269,893.99	-	-	(344,974,103.31)	429,894,042.92	

七、 政府补助（续）

（2） 计入当期损益的政府补助

	2025年	2024年
与资产相关的政府补助		
通过冲减固定资产减少折旧	440,682,837.96	466,971,983.07
通过冲减无形资产减少摊销	6,397,985.43	8,953,221.79
与收益相关的政府补助		
计入其他收益	390,569,582.11	263,837,391.30
冲减营业成本	10,199,003.78	-
冲减管理费用	3,980,000.00	18,364,200.00
冲减研发费用	37,068,439.05	79,544,862.93
冲减财务费用	85,520,000.00	39,240,100.00
合计	998,597,848.33	876,911,759.09

八、关联方关系及其交易

1. 控股股东

直接控股股东名称	注册地	业务性质	持股比例(%)
华虹国际	开曼群岛	控股公司及贸易往来	20.00

本公司的间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。

2. 子公司

本公司的子公司详见附注七、1。

3. 联营企业

本集团发生关联交易的其他联营企业的情况如下。

上海华虹科技发展有限公司及其子公司	上海华虹科技发展有限公司为本集团联营企业以及受同一最终方控制的关联公司

八、关联方关系及其交易（续）

4. 其他关联方

	关联方关系
上海华虹挚芯电子科技有限公司	受华虹集团控制
挚芯电子（上海）有限公司	受华虹集团控制
上海华虹虹日电子有限公司	受华虹集团控制
上海华虹计通智能系统股份有限公司	受华虹集团控制
公司B*	受华虹集团控制
上海华力集成电路制造有限公司	受华虹集团控制
Hua Hong International (Americas), Inc.	受华虹集团控制
上海联和投资有限公司	持有本公司5%以上股权的参股股东
上海新微技术研发中心有限公司	受上海联和投资有限公司控制
上海矽睿科技股份有限公司	本公司董事于报告期内担任董事的公司
华海清科股份有限公司	华虹集团董事于报告期内担任董事兼总经理的公司
上海复旦微电子集团股份有限公司	华虹集团董事于报告期内曾担任董事长兼总经理的公司
芯原微电子（上海）股份有限公司	本公司董事于报告期内担任董事的公司
上海银行股份有限公司	本公司董事于报告期内担任董事的公司

*根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本集团《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，本集团部分信息因涉及商业秘密申请豁免披露，并已在《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息豁免披露的申请报告》中申请信息豁免披露。

八、关联方关系及其交易（续）

5. 关联方交易

（1） 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受服务

	2025年	2024年
上海华虹虹日电子有限公司	270,770,015.34	314,320,826.85
上海华力集成电路制造有限公司	355,770,466.31	310,145,561.48
华海清科股份有限公司	208,600,062.54	165,400,937.19
公司B	5,520,212.01	200,214.03
上海华虹挚芯电子科技有限公司	3,503,892.02	6,672,061.93
挚芯电子（上海）有限公司	1,391,529.90	229,959.42
上海华虹计通智能系统股份有限公司	30,188.70	112,028.28

本集团向关联公司购买商品和接受服务的价格由交易双方参考市场价格协商决定。

向关联方销售商品和提供劳务

	2025年	2024年
上海华力集成电路制造有限公司	223,194,557.98	293,889,621.09
上海复旦微电子集团股份有限公司	165,441,283.29	119,653,758.92
上海矽睿科技股份有限公司	109,596,573.36	106,303,250.50
上海华虹挚芯电子科技有限公司	81,968,535.83	142,090,039.32
公司B	7,366,481.30	5,678,354.79
芯原微电子（上海）股份有限公司	2,720,514.48	5,268,353.35
上海华虹虹日电子有限公司	1,604,294.15	3,353,173.63
上海新微技术研发中心有限公司	1,081,312.05	2,232,786.86
挚芯电子（上海）有限公司	-	700,230.00

向关联方提供技术授权

	2025年	2024年
公司B	-	471,000,000.00

本集团向关联公司销售商品、提供技术授权与服务的价格由交易双方参考市场价格协商决定。

八、关联方关系及其交易（续）

5. 关联方交易（续）

（2） 关联方租赁

作为出租人

经营租赁

	租赁资产种类	2025年租赁收入	2024年租赁收入
上海华力集成电路制造有限公司	房屋及建筑物	561,369.03	571,066.86

融资租赁

	租赁资产种类	2025年融资租赁利息收入	2024年融资租赁利息收入
公司B	设备	1,384,633.42	-

本集团向关联公司提供租赁服务，相关租赁收入、利息收入由交易双方参考市场价格协商决定。

作为承租人

2025年

	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
上海华虹科技发展有限公司及其子公司	房屋及建筑物	-	-	18,090,469.28	5,752,436.28	-

2024年

	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
上海华虹科技发展有限公司及其子公司	房屋及建筑物	-	-	18,090,469.28	6,328,760.04	-

八、关联方关系及其交易（续）

5. 关联方交易（续）

（3） 关联方资产转让

	交易内容	2025年	2024年
公司B	融资租出设备	59,292,984.00	-

（4） 物业管理费支出

	2025年	2024年
上海华虹科技发展有限公司及其子公司	4,133,582.02	3,932,929.46

本集团接受关联公司提供的物业管理服务的价格由交易双方参考市场价格协商决定。

（5） 为关联公司代收代付水电物业费等

	2025年	2024年
Hua Hong International (Americas), Inc.	88,271.20	87,907.72

（6） 取得借款

	2025年	2024年
上海银行股份有限公司	529,854,796.00	141,455,000.00

（7） 利息收入

	2025年	2024年
上海银行股份有限公司	5,613,339.41	19,981,758.75

（8） 银行借款利息支出

	2025年	2024年
上海银行股份有限公司	20,355,855.55	16,574,185.89

八、关联方关系及其交易（续）

5. 关联方交易（续）

（9） 取得委托贷款

	2025年	2024年
上海华虹(集团)有限公司	137,550,000.00	-

6. 关联方应收应付款项余额

（1） 应收款项

	2025年12月31日		2024年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
上海华力集成电路制造有限公司	75,067,747.91	7,018,929.69	33,886,020.36	3,994,350.68
上海华虹挚芯电子科技有限公司	16,588,113.00	12,496.85	59,287,420.00	411,237.28
上海矽睿科技股份有限公司	5,957,497.49	4,488.13	9,464,652.84	7,130.29
上海复旦微电子集团股份有限公司	4,074,422.80	7,755.60	16,591,407.24	26,176.36
公司B	374,771.65	114,695.31	1,191,472.39	5,309.86
芯原微电子（上海）股份有限公司	-	-	2,927,438.56	2,205.42
应收票据				
上海复旦微电子集团股份有限公司	244,218.16	-	3,451,602.70	-
其他应收款				
上海华虹挚芯电子科技有限公司	63,993.00	-	15,280.00	-
上海矽睿科技股份有限公司	3,140.00	-	628.00	-
上海华力集成电路制造有限公司	12,240.05	-	4,174.00	-
一年内到期的其他非流动资产				
公司B	13,028,672.74	-	-	-
其他非流动资产				
上海华力集成电路制造有限公司	-	-	51,585,101.89	-
长期应收款				
公司B	56,428,828.68	-	-	-

除一年内到期的其他非流动资产及长期应收款外，应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

八、关联方关系及其交易（续）

6. 关联方应收应付款项余额（续）

（2） 应付款项

	2025年12月31日	2024年12月31日
应付账款		
上海华力集成电路制造有限公司	86,965,487.00	85,795,520.74
上海华虹虹日电子有限公司	22,751,775.78	60,974,669.01
华海清科股份有限公司	3,073,876.31	3,142,098.96
挚芯电子（上海）有限公司	663,910.59	13,562.00
上海华虹挚芯电子科技有限公司	329,712.50	1,433,561.89
上海华虹科技发展有限公司及其子公司	187,159.06	79,743.30
上海华虹计通智能系统股份有限公司	48,788.70	130,628.28
公司B	-	128,310.00
其他应付款		
华海清科股份有限公司	128,651,590.00	34,922,162.00
上海华力集成电路制造有限公司	2,151,177.48	7,022,838.92
公司B	1,137.48	33,234.90
合同负债		
上海华虹挚芯电子科技有限公司	3,250,313.17	397,693.17
上海华虹虹日电子有限公司	1,052,423.80	794,457.15
上海矽睿科技股份有限公司	101,947.49	101,947.49
上海新微技术研发中心有限公司	-	42,154.41
一年内到期的非流动负债		
上海银行股份有限公司	42,283,041.41	46,812,183.64
上海华虹科技发展有限公司及其子公司	12,942,596.62	12,338,033.00
长期借款		
上海华虹(集团)有限公司	137,550,000.00	-
上海银行股份有限公司	305,712,811.00	365,869,148.00
租赁负债		
上海华虹科技发展有限公司及其子公司	110,206,498.54	123,149,095.18

除一年内到期的非流动负债、长期借款以及租赁负债外，应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

八、关联方关系及其交易（续）

7. 存放关联方的货币资金

	2025年12月31日	2024年12月31日
上海银行股份有限公司	33,173,337.98	1,388,368,481.09

九、股份支付

本公司实施了一项股份期权计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本集团运营作出贡献的人士。符合条件的人士包括本公司的董事、高级管理人员及对本集团经营业绩和持续发展有直接影响的核心管理与技术人员。本计划已授予两批次，分别于2015年9月4日（“2015年期权”），2018年12月24日（“2018年期权”）起生效，除非取消或修改，否则自生效日起7年内有效。

2015年期权以及2018年期权当前可授予的未行权股份期权的最大数量相当于行权时华虹半导体有限公司对外发行的股份数量的10%。根据本计划，任何一个跨度为12个月的期间内授予给每一合格人士的股份期权之股份数量上限为华虹半导体有限公司任何时候对外发行股份的1%。超过该上限的股份期权的授予均需经股东大会批准。

授予董事、总经理、本公司的大股东，或其关联方的股份期权需事先经独立董事批准。此外，在任何一个跨度为12个月的期间内,如果授予大股东、独立董事，或其关联方的股份期权超过华虹半导体有限公司任何时候所发行股份的0.1%或累计价值超过港币5,000,000.00元（以授予日的华虹半导体有限公司股价为基础确定），需事先经股东大会批准。

本计划所授予的股份期权的行权期由董事会决定，在为期2至4年的等待期后开始，并在提供授予股份期权之日起7年内或本计划到期之日的孰早日结束。

股份期权的行权价格由董事会决定，但不得低于两者中的孰高者：于提供授予股份期权之日华虹半导体有限公司股票的证券交易所收盘价；于提供授予股份期权之日的前5个交易日内华虹半导体有限公司股票的证券交易所收盘价的平均数。

股份期权未赋予持有人取得股利的权利或于股东大会的表决权。

九、股份支付（续）

1. 各项权益工具

各项权益工具如下：

2025年

	本年行权		本年失效	
	数量	金额	数量	金额
董事、高管及员工	19,145,378	269,092,266.86	12,715	174,503.70

2024年

	本年行权		本年解锁		本年失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高管及员工	1,880,121	26,186,544.85	200,000	3,324,619.22	204,426	3,114,285.26

2025年及2024年，本年行权、本年解锁及本年失效的权益工具金额根据股票期权的行权价计算。

2025年及2024年行权的股份期权于行权日的加权平均股价分别为46.737港元/股、15.272港元/股。

年末发行在外的各项权益工具如下：

2025年

	股票期权	
	行权价格的范围	合同剩余期限
本公司董事、高管及员工	港币17.952元	至2026年12月

2024年

	股票期权	
	行权价格的范围	合同剩余期限
本公司董事、高管及员工	港币15.056元至18.400元	介于2025年12月至2026年12月

九、股份支付（续）

2. 以权益结算的股份支付情况

	2025年
授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股息率、波动率、无风险利率、预期离职率、提前行权倍数、加权平均股价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	190,833,418.60

	2024年
授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股息率、波动率、无风险利率、预期离职率、提前行权倍数、加权平均股价
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本年估计与上年估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	190,833,418.60

3. 本年发生的股份支付费用

2025年，公司未发生以权益结算的股份支付费用。

2024年

	以权益结算的股份支付费用
董事	117,014.40

十、承诺事项

1. 重要承诺事项

	2025年12月31日	2024年12月31日
资本承诺	6,306,001,447.04	8,536,730,174.47

2. 或有事项

	2025年12月31日	2024年12月31日
银行保函业务担保形成的或有负债	305,349,548.31	184,112,510.00
未履行完毕的不可撤销信用证形成的或有负债	2,408,710,019.33	2,551,871,052.87
合计	2,714,059,567.64	2,735,983,562.87

十一、资产负债表日后事项

于2026年2月10日，本公司股东大会审议通过了关于收购上海华力微电子有限公司97.4988%股权的议案（“拟收购事项”）。截至财务报表批准日，完成拟收购事项的若干先决条件尚未满足，包括上海证券交易所的批准、中国证券监督管理委员会的注册登记。

除上述事项外，截至本财务报表批准日，本公司并无其他须作披露的重大资产负债表日后事项。

十二、 备考财务报表的批准

本备考财务报表业经本公司董事会于2026年3月30日决议批准报出。

企业业务报告用

统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副 本)(8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万元

成立日期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关　北京市市场监督管理局

2026 年 03 月 11 日

会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

样本 仅供参考

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
（截至2020年10月10日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390[illegible]	[illegible]0003	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	[illegible]0274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085546327O	11000[illegible]	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000558787OXB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101082726007Z	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT8I	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	91370100061188932J	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	913501000843430260	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105080509009G	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116079641707J	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	91310000060913434J	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102085492787A	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108569499230D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	91130203579568710J	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000083158582J	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000579342121J	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089664937G	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108592342556B	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91610136073401692X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000078563241Z	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	91120116668839041J	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101085530785F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102083765690D	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310111084119251J	31000003	2020-11-02

[illegible]不表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

[illegible]照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

[illegible]备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载：

从事证券服务业务会计师事务所名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期：2020年11月[illegible]日

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

仅供业务咨询用

姓名 Full name 杨磊

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1976-04-03

工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No. 310107604030[illegible]

ERNST & YOUNG HUA MING LLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1101030037404

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

证书编号：No. of Certificate 110002420016

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 200[illegible]年 09月 [illegible]2日

4

年度检验登记 Annual Renewal Registration

[illegible]证书经检验合格，继续有效一年。

[illegible]rtificate is valid for another year after [illegible]is renewal.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2016年 4月 08日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

杨磊(110002420016)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

11

专业业务报告专用

姓名 Full name 王顺华

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1987-07-14

工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No. 310103198707140037

ERNST & YOUNG HUA MING LLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 1101030031404

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

证书编号：110002433917
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2012 年 07 月 26 日
Date of Issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王顺华(110002433917)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

王顺华(110002433917)
您已通过 2021 年年检
上海市注册会计师协会
2021 年 10 月 30 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

9

专业业务报告专用

华虹半导体有限公司

独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联（连）交易相关事项的独立意见

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日作出董事会决议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们认真审阅了公司本次董事会的有关资料，现就本次董事会审议的与公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告

经审议，我们认为：

我们一致同意将大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海华力微电子有限公司审计报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告》用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

二、关于《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要

经审议，我们认为：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会根据更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告对《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新，并将根据监管机关审核

意见进行相应补充、修订（如需）。相关草案及其摘要符合公司的实际情况，具备可行性和可操作性。

（以下无正文，后附签署页）

（本页无正文，为《华虹半导体有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项的独立意见》之签署页）

_____　　_____

张祖同　　王桂壎，太平紳士

_____

封松林

华虹半导体有限公司

独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联（连）交易相关事项的事前认可意见

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会将于 2026 年 3 月 30 日作出董事会决议，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们认真审阅了公司提供的有关资料，现就本次董事会会议涉及的相关事项，基于独立判断发表事前认可意见如下：

公司拟通过发行股份的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已经届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日。我们已认真审阅董事会拟审议的《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案>等与本次交易相关的议案。

1、因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已经届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日。为本次交易之目的，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华力微电子有限公司审计报告》，公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华虹半导体有限公司备考合并财务报表及审阅报告》。

2、董事会提交的《关于<华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，具备基本的可行性和可操作性，

有效地保护了公司及投资者的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

3、公司为本次交易编制的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

综上，我们一致同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

（本页无正文，为《华虹半导体有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易相关事项的事前认可意见》之签署页）

_____　　_____

张祖同　　王桂壎，太平紳士

_____

封松林